

КАТАЛОГ
полупроводниковых
приборов

Москва 1971г.

МИНИСТЕРСТВО ЭЛЕКТРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

КАТАЛОГ
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ
ПРИБОРОВ

Москва 1971 г.

Под общей редакцией *Иванова В.И.*

Составители: *Гордеева В.И.,
Гришина Л.М.,
Домнин Б.К.,
Сардашовская Л.В.*

Технический редактор *Л.Е.Хованская*
Корректоры: *Н.С.Русецкая, А.В.Смирнова*

Подписано к печати 10.ХП.71 г.
Формат 60×90/8 Объем 20,5 п.л. Уч.-изд. л. 18,45
Тираж 2000 экз. Зак. 2003

Производственно-издательский отдел ЦНИИ "Электроника"

С О Д Е Р Ж А Н И Е

ПРЕДИСЛОВИЕ	5
СИСТЕМА УСЛОВНЫХ БУКВЕННЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ.....	6
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ.....	14
ПЕРЕЧЕНЬ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ	16
Часть I. ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ДИОДЫ И ТИРИСТОРЫ.....	27
1. Стабилитроны малой мощности	28
2. Стабилитроны средней мощности	32
3. Стабилитроны большой мощности	36
4. Выпрямительные диоды малой мощности	36
5. Выпрямительные диоды средней мощности	46
6. Выпрямительные столбы	50
7. Выпрямительные блоки средней мощности	52
8. Импульсные диоды	52
9. Туннельные диоды	56
10 Туннельные обращенные диоды	60
11. Универсальные диоды	62
12. Диодные матрицы	64
13. Варикапы	66
14. Переключательные СВЧ диоды	68
15. Видео-детекторные СВЧ диоды	72
16. Параметрические СВЧ диоды	74
17. Смесительные СВЧ диоды	76
18. Умножительные СВЧ диоды	80
19. Генераторные СВЧ диоды	82
20. Модуляторные СВЧ диоды	82
21. Диодные тиристоры	84
22. Тиристоры малой мощности	86
23. Тиристоры средней мощности	88
24. Светодиоды	93
Часть II. ТРАНЗИСТОРЫ	95
1. Транзисторы малой мощности	96
а. Транзисторы германиевые р-п-р	96
б. Транзисторы германиевые п-р-п	104
в. Транзисторы кремниевые р-п-р	106
г. Транзисторы кремниевые п-р-п	106
2. Транзисторы средней мощности	112
а. Транзисторы германиевые р-п-р	112
б. Транзисторы германиевые п-р-п	114
в. Транзисторы кремниевые п-р-п	116

3. Транзисторы большой мощности	116
а. Транзисторы германиевые р-п-р	116
б. Транзисторы кремниевые р-п-р	122
в. Транзисторы кремниевые п-р-п	122
4. Полевые транзисторы	128
ПРИЛОЖЕНИЕ:	130
1. Указатель нормативных документов, действующих в полупроводниковой промышленности	130
2. Приборы снятые с производства и рекомендуемые замены	135
3. Система обозначений полупроводниковых приборов	136
4. Габаритные чертежи диодов	139
5. Габаритные чертежи транзисторов	157

ПРЕДИСЛОВИЕ

Отечественной промышленностью выпускается широкий ассортимент полупроводниковых приборов, применение которых позволяет создать экономичную по питанию, малогабаритную и с высокой эксплуатационной надежностью радиоаппаратуру.

В настоящем справочнике в удобной табличной форме систематизированы важнейшие параметры полупроводниковых приборов. Справочник рассчитан на специалистов, занимающихся разработкой и сервисом (обслуживание, ремонт и регулировка) радиоэлектронной аппаратуры на полупроводниковых приборах.

Значения электрических параметров и размеры полупроводниковых приборов являются справочными, ими можно руководствоваться для принятия предварительного решения о возможности применения того или иного полупроводникового прибора. Для принятия окончательного решения о применении полупроводникового прибора в схеме следует руководствоваться ТУ. Справочник составлен по состоянию на 1 января 1970 г.

Впредь, по мере накопления новых данных, справочник будет выпускаться в виде отдельных выпусков.

СИСТЕМА УСЛОВНЫХ БУКВЕННЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ

Стабилитроны

- $U_{\text{ст.ном}}$ – номинальное значение напряжения стабилизации – номинальное значение величины напряжения стабилизации для стабилитронов данного типа.
- $\Delta U_{\text{ст.ном}}$ – допускаемый разброс величины напряжения стабилизации от номинального значения – максимально допустимое отклонение величины напряжения стабилизации от номинального значения для стабилитронов данного типа.
- $U_{\text{пр}}$ – постоянное прямое напряжение – падение напряжения при заданном постоянном прямом токе.
- $I_{\text{ст.ном}}$ – номинальное значение тока стабилизации – значение тока стабилизации, при котором определяются классификационные признаки стабилитронов.
- $I_{\text{ст.мин}}$ – минимальный ток стабилизации – минимальное значение тока, разрешаемое изготовителем при работе в режиме стабилизации.
- $I_{\text{ст.макс}}$ – максимально допустимый ток стабилизации – максимально допустимое значение тока стабилизации, обеспечивающее заданную надежность при длительной работе.
- $I_{\text{пр}}$ – постоянный прямой ток – постоянный ток в прямом направлении.
- R_d – дифференциальное сопротивление – отношение приращения напряжения на стабилитроне к вызвавшему его малому приращению тока через диод, измеряется при заданном в ТУ токе стабилизации.
- TKH – средний температурный коэффициент напряжения – отношение относительного изменения напряжения стабилизации к абсолютному изменению температуры окружающей среды, выраженное в процентах на градус (при постоянном токе стабилизации).
- R_t – общее тепловое сопротивление – отношение разности между температурой перехода и температурой окружающей среды к мощности, рассеиваемой на диоде в установившемся режиме.
- $P_{\text{макс}}$ – максимально допустимая мощность – максимально допустимая мощность, рассеиваемая на диоде, обеспечивающая заданную надежность при длительной работе при температуре окружающей среды, оговоренной в ТЗ или ЧТУ.

Выпрямительные диоды

- $I_{\text{пр}}$ – постоянный прямой ток – постоянный ток в прямом направлении.
- $I_{\text{макс}}$ – максимально допустимое значение тока перегрузки – максимально допустимое значение неповторяющегося прямого тока, обеспечивающего заданную надежность при длительной работе.

$I_{\text{пр.ср. макс}}$	– максимально допустимое среднее значение прямого тока – максимально допустимое значение прямого тока, обеспечивающее заданную надежность при длительной работе.
$I_{\text{пр.ср}}$	– среднее значение прямого тока – среднее за период значение тока в прямом направлении (без учета обратного тока).
$I_{\text{обр}}$	– постоянный обратный ток – постоянный ток в обратном направлении.
$I_{\text{обр.ср}}$	– среднее значение обратного тока – среднее за период значение тока в обратном направлении.
$U_{\text{пр}}$	– постоянное прямое напряжение – падение напряжения при заданном постоянном прямом токе.
$U_{\text{пр.ср}}$	– среднее значение прямого напряжения – среднее за период значение прямого напряжения при заданном среднем значении прямого тока.
$U_{\text{обр}}$	– постоянное обратное напряжение – постоянное напряжение в обратном направлении.
$U_{\text{обр. макс}}$	– максимально допустимое обратное напряжение – максимально допустимое напряжение на диоде любой формы и периодичности, обеспечивающее заданную надежность при длительной работе.
$U_{\text{обр.ср}}$	– среднее значение обратного напряжения – среднее за период значение постоянного обратного напряжения.

Импульсные диоды

$I_{\text{пр}}$	– постоянный прямой ток – постоянный ток в прямом направлении.
$I_{\text{пр. макс}}$	– максимально допустимый прямой ток – максимально допустимое значение постоянного или среднего прямого тока, обеспечивающее заданную надежность при длительной работе.
$I_{\text{пр.имп. макс}}$	– максимально допустимый прямой импульсный ток – максимально допустимый импульсный ток через диод при заданной максимальной длительности импульса, обеспечивающей заданную надежность при длительной работе.
$I_{\text{обр}}$	– постоянный обратный ток – постоянный ток в обратном направлении.
$U_{\text{пр}}$	– постоянное прямое напряжение – падение напряжения при заданном постоянном прямом токе.
$U_{\text{обр. макс}}$	– максимально допустимое обратное напряжение – максимально допустимое напряжение на диоде любой формы и периодичности, обеспечивающее заданную надежность при длительной работе.
$U_{\text{пр.имп. макс}}$	– максимальное импульсное прямое напряжение – максимальное падение напряжения на диоде при заданной величине импульса прямого тока.
$t_{\text{восст}}$	– время восстановления обратного сопротивления – отрезок времени от момента прохождения тока через нуль, при переключении диода с прямого тока на импульсное обратное напряжение до момента, когда обратный ток диода уменьшается до заданного уровня отсчета.
$R_{\text{имп. макс}}$	– максимальное импульсное сопротивление – отношение максимального импульсного прямого напряжения на диоде к заданной величине импульсного прямого тока.
$C_{\text{д}}$	– емкость диода – емкость между выводами диода при заданном напряжении смещения.

Туннельные и обращенные диоды

$I_{\text{пр}}$	– прямой ток – ток, вызванный воздействием прямого напряжения $U_{\text{пр}}$.
$I_{\text{пр. макс}}$	– максимально допустимый прямой ток – максимально допустимое значение постоянного тока на второй восходящей ветви, обеспечивающее заданную надежность (гарантированную ТУ) при длительной работе.

I_p	пиковый ток – прямой ток в точке максимума вольт-амперной характеристики.
I_b	ток впадины – прямой ток в точке минимума вольт-амперной характеристики.
I_p / I_b	отношение токов – отношение пикового тока к току впадины.
$I_{\text{пр. имп. макс}}$	максимально допустимый прямой импульсный ток – максимально допустимый импульсный ток через диод при заданной скважности и длительности импульсов, обеспечивающий заданную надежность (гарантированную ТУ) при длительной работе.
$I_{\text{обр}}$	обратный ток – ток, вызванный воздействием обратного напряжения $U_{\text{обр}}$.
$I_{\text{обр. макс}}$	максимально допустимый постоянный обратный ток – максимально допустимый обратный постоянный ток, обеспечивающий заданную надежность (гарантированную ТУ) при длительной работе.
$I_{\text{обр. имп. макс}}$	максимально допустимый импульсный обратный ток – максимально допустимый обратный импульсный ток при заданной скважности и длительности импульсов, обеспечивающий заданную надежность (гарантированную ТУ) при длительной работе.
$U_{\text{пр}}$	прямое напряжение – напряжение, приложенное "плюсом" к P-области.
U_p	напряжение пика – прямое напряжение, соответствующее пиковому току.
U_b	напряжение впадины – прямое напряжение, соответствующее току впадины.
U_{pp}	напряжение раствора – прямое напряжение на второй восходящей ветви при токе, равном пиковому.
r_p	сопротивление потерь – суммарное омическое сопротивление кристалла, контактных присоединений внутренних и внешних выводов.
R_d	отрицательное дифференциальное сопротивление диода – сопротивление на участке вольт-амперной характеристики между точками с координатами (U_p, I_p) и (U_b, I_b) (участок отрицательного сопротивления).
C_d	емкость диода – суммарная емкость перехода и корпуса диода.
$L_{\text{корп}}$	индуктивность корпуса – величина, равная минимальной индуктивности, которую можно получить в замкнутой цепи с диодом.
$f_{\text{макс}}$	пределная резистивная частота – частота, на которой активная составляющая полного сопротивления диода, рабочая точка которого соответствует минимуму отрицательного сопротивления, обращается в нуль.

Варикапы

$C_{\text{ном}}$	номинальная емкость диода – емкость между выводами диода при номинальном напряжении смещения.
Q_d	добротность диода – отношение реактивного сопротивления диода к полному сопротивлению потерь.
K_c	коэффициент перекрытия – отношение максимальной емкости диода к минимальной.
$U_{\text{макс}}$	максимально допустимое напряжение – максимально допустимое мгновенное значение периодического напряжения, обеспечивающее заданную надежность при длительной работе.

$P_{\text{макс}}$ – максимально допустимая мощность – максимально допустимая мощность, рассеиваемая на диоде, обеспечивающая заданную надежность при длительной работе при температуре окружающей среды, оговоренной в ТЗ или ЧТУ.

Переключательные СВЧ диоды

λ	длина волны – длина волны, на которой диоды имеют параметры, гарантированные нормами ТУ.
L_p	потери пропускания – отношение СВЧ мощности, подводимой к переключательному устройству с находящимся в нем переключательным диодом, к проходящей через это устройство мощности в случае, когда диод находится в состоянии пропускания.

L_3	потери запирания – отношение СВЧ мощности, подводимой к переключательному устройству с находящимся в нем переключательным диодом, к проходящей через это устройство мощности в случае, когда диод находится в состоянии запирания.
K	качество – основной параметр, характеризующий эффективность работы диода.
$U_{(пр)}$	пробивное напряжение – обратное напряжение на диоде, при котором обратный ток через диод начинает возрастать лавинообразно.
$\tau_{уст}$	время установления – время перехода диода из режима обратного или нулевого смещения в режим прямого смещения.
$\tau_{восст}$	время восстановления – время перехода диода из режима прямого смещения в режим обратного или нулевого смещения.
$C_{корп}$	емкость корпуса – емкость корпуса (патрона) диода.
$R_{пр}$	прямое сопротивление – сопротивление диодной структуры на СВЧ при токе прямого смещения, оговоренном в ТЗ или ЧТУ.
$P_{имп. макс}$	максимально допустимая импульсная мощность – максимально допустимая величина импульсной СВЧ мощности, рассеиваемой в диоде, обеспечивающей заданную надежность (гарантированную в ТУ).

Детекторные диоды

β	чувствительность по току – отношение выпрямленного тока диода к величине поглощаемой СВЧ мощности в режиме короткого замыкания.
R	сопротивление в рабочей точке – дифференциальное сопротивление диода при заданной частоте и смещении, соответствующим рабочему режиму.
$t_{ш}$	шумовое отношение – отношение мощности шумов на выходе диода в заданной полосе видеочастот к мощности тепловых шумов активного сопротивления, равного по величине сопротивлению диода в рабочей точке в том же диапазоне частот и при той же температуре.
M	добротность – обобщенный параметр, характеризующий чувствительность приемного устройства.
$K_{СВ}$	коэффициент стоячей волны – коэффициент стоячей волны (по напряжению) в передающей линии СВЧ, когда она погружена на диодную камеру с диодом в данном рабочем режиме.
$P_{подв}$	подводимая мощность
R_H	сопротивление нагрузки.
$P_{свч}$	мощность СВЧ импульсов при кратковременном воздействии (не более 20 минут) и при длительном воздействии ($R_H = 100$ ом).
$R_{ш}$	эквивалентное шумовое сопротивление видеоусилителя.

Параметрические и умножительные диоды

λ	длина волны – длина волны, на которой диоды имеют параметры, гарантированные нормами ТУ.
C	емкость перехода – емкость между выводами диода (без емкости корпуса) при нулевом или определенном обратном напряжении смещения.
$C_{корп}$	емкость корпуса – емкость корпуса (патрона) диода.
τ	постоянная времени диода – произведение емкости диода на сопротивление потерь.
$f_{макс}$	максимальная частота – предельная частота, определяющая максимальный частотный диапазон диода.
L_d	индуктивность диода – индуктивная составляющая полного сопротивления диода в условиях резонанса, измеренная на СВЧ.

$I_{обр}$	– обратный ток – ток, протекающий через диод в обратном направлении при определенном напряжении смещения.
$U_{(пр)}$	– пробивное напряжение – обратное напряжение на диоде, при котором обратный ток через диод начинает возрастать лавинообразно.
W	– энергия импульса – максимально допустимая величина энергии короткого (не более 10^{-8} сек) импульса, воздействующего на диод, при котором обеспечивается заданная надежность (гарантированная в ТУ).
$P_{имп, макс}$	– максимально допустимая импульсная мощность – максимально допустимая величина импульсной СВЧ мощности, рассеиваемой в диоде, обеспечивающей заданную надежность (гарантированную в ТУ).
$P_{макс}$	– максимально допустимая мощность – максимально допустимая величина непрерывной СВЧ мощности, рассеиваемой в диоде, обеспечивающей заданную надежность (гарантированную в ТУ).
P_3	– мощность третьей гармоники.
P_8	– мощность восьмой гармоники.

Смесительные СВЧ диоды

λ	– длина волны – длина волны, на которой диоды имеют параметры, гарантированные нормами ТУ.
L	– потери преобразования – отношение мощности СВЧ на входе к мощности промежуточной частоты на выходе диода.
$I_{выпр}$	– выпрямительный ток – постоянная составляющая тока, протекающая в выходной цепи диода при воздействии СВЧ мощности.
$t_{ш}$	– шумовое отношение – отношение мощности шумов на выходе диода в рабочем режиме к мощности тепловых шумов активного сопротивления, равного по величине выходному сопротивлению диода при той же температуре и одинаковой полосе частот.
$F_{ш}$	– нормированный коэффициент шума – обобщенный параметр, характеризующий чувствительность приемного устройства.
$R_{вых}$	– выходное сопротивление – дифференциальное сопротивление на промежуточной частоте в рабочем режиме диода.
R_H	– сопротивление нагрузки.
$K_{СВ}$	– коэффициент стоячей волны – коэффициент стоячей волны (по напряжению) в передающей линии СВЧ, когда она погружена на диодную камеру с диодом в данном рабочем режиме.
$P_{макс}$	– максимально допустимая мощность – максимально допустимая величина непрерывной СВЧ мощности, рассеиваемой в диоде.
$P_{имп, макс}$	– максимально допустимая импульсная мощность – максимально допустимая величина СВЧ мощности, рассеиваемой в диоде.
W	– энергия импульса – максимально допустимая величина энергии короткого (не более 10^{-8} сек) импульса, воздействующего на диод.

Тиристоры

$I_{пр, макс}$	– максимально допустимый прямой ток – наибольшее значение постоянного или среднего прямого тока, обеспечивающего заданную надежность при длительной работе.
$I_{ут}$	– ток утечки – прямой ток, соответствующий $U_{пр, макс}$ при нулевом токе в цепи управляющего электрода.
$I_{выкл}$	– ток выключения – минимальный прямой ток через тиристор в открытом состоянии при отсутствии тока в цепи управляющего электрода.

$I_{\text{спр. имп}}$	<ul style="list-style-type: none"> импульсный ток спрямления – минимальная величина импульса прямого тока управляющего электрода, обеспечивающая переключение тиристора при заданной величине напряжения.
$I_{\text{спр}}$	<ul style="list-style-type: none"> ток спрямления – прямой постоянный ток управляющего электрода, при котором напряжение включения равно заданной величине.
$I_{\text{ут. обр}}$	<ul style="list-style-type: none"> обратный ток утечки – обратный ток, соответствующий $U_{\text{обр. макс}}$
$I_{\text{упр. макс}}$	<ul style="list-style-type: none"> максимально допустимый ток управляющего электрода – наибольшее значение постоянного или среднего прямого тока, обеспечивающего заданную надежность при длительной работе.
$I_{\text{пр. имп. макс}}$	<ul style="list-style-type: none"> максимально допустимый прямой импульсный ток – наибольшее значение импульсного тока через тиристор при заданной максимальной длительности и скважности импульса, обеспечивающего заданную надежность при длительной работе.
$U_{\text{пр. макс}}$	<ul style="list-style-type: none"> максимально допустимое прямое напряжение – наибольшее значение прямого напряжения тиристора в закрытом состоянии, при котором отсутствует самопроизвольное включение тиристора и обеспечивается заданная стабильность при длительной работе.
$U_{\text{обр. макс}}$	<ul style="list-style-type: none"> максимально допустимое обратное напряжение – максимально допустимое значение постоянного или среднего обратного напряжения, обеспечивающего заданную надежность при длительной работе.
$U_{\text{ост}}$	<ul style="list-style-type: none"> остаточное напряжение – прямое напряжение, соответствующее протеканию максимально допустимого прямого тока.
$U_{\text{пом}}$	<ul style="list-style-type: none"> напряжение помех – максимальная величина амплитуды анодного импульса помехи, не включающая диодный тиристор.
$U_{\text{упр}}$	<ul style="list-style-type: none"> прямое напряжение на управляющем электроде – отрицательное напряжение между управляющим электродом и анодом для триодного тиристора П-типа или положительное напряжение между управляющим электродом и катодом для триодного тиристора Р-типа.
$U_{\text{упр. обр. макс}}$	<ul style="list-style-type: none"> максимально допустимое обратное напряжение на управляющем электроде – наибольшее значение обратного напряжения на управляющем электроде, обеспечивающее заданную надежность при длительной работе.
$U_{\text{спр}}$	<ul style="list-style-type: none"> напряжение спрямления – прямое напряжение на управляющем электроде, соответствующее току $I_{\text{спр}}$.
$t_{\text{вкл}}$	<ul style="list-style-type: none"> время включения – промежуток времени, в течение которого напряжение на тиристоре уменьшается до $2 U_{\text{ост}}$ с момента подачи пускового импульса.
$t_{\text{выкл}}$	<ul style="list-style-type: none"> время выключения – минимальное время между моментом, когда прямой ток через тиристор становится равным нулю или его напряжение изменяется с прямого на обратное, и моментом, когда на тиристор можно подавать напряжение $U_{\text{пр. макс}}$ с максимальной скоростью увеличения dU/dt, которое не переключает его в проводящее состояние.
C_{Π}	<ul style="list-style-type: none"> емкость переходов – статическая емкость переходов.
$P_{\text{упр. макс}}$	<ul style="list-style-type: none"> максимально допустимая мощность управления – мощность, рассеиваемая в цепи управляющего электрода, обеспечивающая заданную надежность при длительной работе при температуре окружающей среды, оговоренной в ТУ и ЧТУ.
$P_{\text{макс}}$	<ul style="list-style-type: none"> максимально допустимая мощность – мощность, рассеиваемая на диоде, обеспечивающая заданную надежность при длительной работе при температуре окружающей среды, оговоренной в ТЗ и ЧТУ.
dU/dt	<ul style="list-style-type: none"> максимальная скорость увеличения прямого напряжения – наибольшее значение скорости увеличения прямого напряжения на закрытом тиристоре, при котором обеспечивается закрытое состояние прибора, если амплитуда прямого напряжения не превышает $U_{\text{пр. макс}}$

Транзисторы

$I_{C \text{ max}}$	<ul style="list-style-type: none"> максимально допустимый ток коллектора – постоянный ток коллектора, обеспечивающий заданную надежность при длительной работе.
$I_{CM \text{ max}}$	<ul style="list-style-type: none"> максимально допустимый импульсный ток коллектора.

$I_{B \ max}$	– максимально допустимый ток базы – постоянный ток базы, обеспечивающий заданную надежность при длительной работе.
$I_{BM \ max}$	– максимально допустимый импульсный ток базы.
I_E, I_B, I_C	– ток эмиттера, базы, коллектора, соответствующие границе между областью насыщения и активной областью работы транзистора.
I_{CBO}	– обратный ток коллектора – ток через переход коллектор–база при заданном обратном напряжении на коллекторе и при прямом токе эмиттера, равном нулю.
I_{CEV}	– ток коллектора запертого транзистора – обратный ток через коллектор транзистора, на базу которого подан запирающий потенциал при заданном обратном напряжении на транзисторе.
I_{CER}	– начальный ток коллектора – ток через переход коллектор–база при заданном обратном напряжении на коллекторе и при включенном между базой и эмиттером сопротивлении.
I_{CERM}	– начальный импульсный ток коллектора.
I_{CES}	– начальный ток коллектора – ток через переход коллектор–база при заданном обратном напряжении на коллекторе и короткозамкнутых выводах эмиттера и базы.
$U_{CB \ max}$	– максимально допустимое напряжение коллектор–база – постоянное напряжение между коллектором и базой в обратном направлении, обеспечивающее заданную надежность при длительной работе.
$U_{CBM \ max}$	– максимально допустимое импульсное напряжение коллектор–база.
$U_{CE \ max}$	– максимально допустимое напряжение коллектор–эмиттер – постоянное напряжение между коллектором и эмиттером, обеспечивающее заданную надежность при длительной работе.
$U_{CER \ max}$	– максимально допустимое напряжение коллектор–эмиттер при наличии сопротивления в цепи эмиттер–база.
$U_{CEM \ max}$	– максимально допустимое импульсное напряжение коллектор–эмиттер.
$U_{BE \ max}$	– максимально допустимое напряжение эмиттер–база – постоянное напряжение между эмиттером и базой в обратном направлении, обеспечивающее заданную надежность при длительной работе.
$U_{BEM \ max}$	– максимально допустимое импульсное напряжение эмиттер–база.
$P_{C \ max}$	– максимально допустимая мощность на коллекторе – максимально допустимое значение мощности, рассеиваемой на коллекторе, обеспечивающее заданную надежность при длительной работе и при определенной температуре.
P_{av}	– средняя мощность транзистора.
R_{thjc}	– тепловое сопротивление транзистора – отношение разности температур между коллекторным переходом и корпусом транзистора к мощности, рассеиваемой на транзисторе в установившемся режиме.
t_{amb}	– температура окружающей среды – температура в определенной (заранее обусловленной) точке среды, окружающей транзистор.
h_{21E}	– коэффициент прямой передачи тока в режиме большого сигнала – отношение величины выходного тока к входному току при заданном постоянном обратном напряжении на коллекторе.
h_{21e}	– коэффициент прямой передачи тока в режиме малого сигнала.
h_{11e}	– входное сопротивление в режиме малого сигнала – отношение изменения напряжения на входе к вызвавшему его изменению входного тока при коротком замыкании по переменному току на выходе.
h_{22e}	– выходная проводимость в режиме малого сигнала – отношение изменения выходного тока к вызвавшему его изменению выходного напряжения в режиме холостого хода в выходной цепи по переменному току.

C_c	– емкость коллектора – емкость, измеряемая между базовым и коллекторным выводами транзистора на заданной частоте при токе эмиттера, равном нулю, и обратном смещении на коллекторе.
$r_{b'b} C_c$	– постоянная времени цепи обратной связи на высокой частоте – произведение сопротивления базы на емкость коллектора.
F	– коэффициент шума – отношение полной мощности шумов на выходе транзистора к той ее части, которая вызвана тепловыми шумами сопротивления источника сигнала. Это отношение показывает во сколько раз мощность шумов на выходе реального транзистора больше мощности шумов на выходе такого же идеального нешумящего транзистора.
f_T	– максимальная частота передачи тока – частота, при которой $ h_{21e} $ экстраполируется к единице.
f_{h21e}	– граничная частота передачи тока – частота, на которой модуль коэффициента передачи тока падает на 3 дБ по сравнению с его низкочастотным значением.
f_{max}	– максимальная частота генерации – наибольшая частота, на которой транзистор способен генерировать в схеме автогенератора.
$r_{CE\ sat}$	– сопротивление насыщения в режиме большого сигнала – сопротивление между коллекторным и эмиттерным выводами транзистора – отношение напряжения на выходе транзистора к входному току при заданном постоянном обратном напряжении на коллекторе.
$U_{CE\ sat}$	– напряжение насыщения коллектор–эмиттер – напряжение между выводами коллектора и эмиттера насыщенного транзистора при заданных значениях токов базы и коллектора.
t_S	– время рассасывания носителей – отрезок времени между моментом, когда на базу насыщенного транзистора подается запирающий импульс тока, и моментом, когда напряжение на коллекторе достигает заданного уровня в активной области.
t_r	– время нарастания.
t_f	– время спада.

Полевые транзисторы

I_G	– ток утечки затвора при заданных условиях смещения.
I_D	– ток стока при заданных условиях смещения.
U_{GD}	– напряжение затвор – сток – напряжение между затвором и стоком в обратном направлении, обеспечивающее заданную надежность при длительной работе.
U_{DS}	– напряжение сток–исток – постоянное напряжение между стоком и истоком, обеспечивающее заданную надежность при длительной работе.
U_{GS}	– напряжение исток–затвор – постоянное напряжение между истоком и затвором в обратном направлении, обеспечивающее заданную надежность при длительной работе.
$U_{GS(off)}$	– напряжение отсечки – напряжение затвор–исток, при котором происходит отсечка тока стока.
U_π	– напряжение шумов.
N_F	– коэффициент шума – отношение полной мощности шумов на выходе к той ее части, которая вызвана тепловыми шумами сопротивления источника сигнала.
Y_{21S}	– статическая крутизна характеристики.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

<i>Материал</i>	<i>Технология</i>
Si	– кремний
Ge	– германий
GaAs	– арсенид галлия
GaP	– фосфит галлия
Si(CO) ₂	– карбид кремния
Д	– диффузионная
ДМП	– диффузионно-меза-планарная
К	– конверсионная
МС	– меза-сплавная
МД	– меза-диффузионная
МП	– меза-планарная
МДС	– меза-диффузионно-сплавная
П	– планарная
C	– сплавная
СД	– сплавно-диффузионная
Т	– точечная
Э	– эпитаксиальная
ЭП	– эпитаксиально-планарная
ЭС	– эпитаксиально-сплавная

Тип прибора: * – прибор для специального применения с обозначением по ГОСТ.

СОКРАЩЕНИЯ

Стабилитроны

Графа "чертеж"

ОП – обратная полярность

Выпрямительные столбы и блоки

Графы $I_{\text{пр}}$ $U_{\text{пр}}$

* – данные для одного плеча

Переключательные СВЧ диоды

Графа $C_{\text{корп}}$

* – C_D

Графа $R_{\text{др}}$

* – r_b

Δ – r_h

Графа $P_{\text{макс}}$

* – $P_{\text{расс}}$

Смесительные СВЧ диоды

Графа $F_{\text{ш}}$

* – $N_{\text{ш}}$

Импульсные диоды

* – при $U_{\text{обр}} = 10$ в

Графа $P_{C \max}$

* – P_{av}

Графа f_{b21E}

* – f_T

Δ – f_{b21e}

ϕ – f_{\max}

Графа $U_{CB \max}$

* – $U_{CBM \max}$

Графа $U_{CE \max}$

* – U_{CER}

ϕ – $U_{CEM \max}$

Графа $U_{BE \max}$

* – $U_{BEM \max}$

Графа $I_{C \max}$

* – $I_{CM \max}$

Графа I_{CBO}

* – I_{CES}

ϕ – I_{CEV}

Графа "режим – $I_E(h_{21e})$ "

* – I_C

ϕ – I_B

Графа h_{21e}

* – h_{21E}

Транзисторы средней и большой мощности

Графа R_{thjc}

* – R_{thja}

Графа $P_{C \max}$

* – $P_{C \max}$ без теплоотвода

Графа $I_{C\max}$
 $*$ — $I_{CM\max}$
 Графа $I_{B\max}$
 $*$ — $I_{BM\max}$
 Графа $U_{CE\max}$
 $*$ — U_{CER}
 ϕ — U_{CEM}
 Графа I_{CBO}
 $*$ — I_{CER}
 ϕ — I_{CEV}
 Δ — I_{CERM}

Режим: $U_C \approx U_{CB\max}$
 Графа "режим $U_{CE}(h_{21e})$ "
 $*$ — U_{CB}
 Графа "режим $I_C(h_{21e})$ "
 $*$ — I_E
 Графа h_{21e}
 $*$ — h_{21E}
 Графа $f_{h_{21e}}$
 $*$ — f_T
 Графа "режим $I_C(U_{CE\text{sat}})$ "
 $*$ — I_B

Графа t_s
 $*$ — t_r
 ϕ — t_f
 Графа C_c
 Режим: $U_C \approx 0,5 U_{CB\max}$
 Графа F
 Режим:
 $f_{\text{ИЭМ}} = 1 \text{ нн}$
 $* - f_{\text{ИЭМ}} = 1,6 \text{ Мнн}$
 $\phi - f_{\text{ИЭМ}} = 5 \text{ Мнн}$
 $\Delta - f_{\text{ИЭМ}} = 100 \text{ Мнн}$
 $\delta - f_{\text{ИЭМ}} = 180 \text{ Мнн}$

ПЕРЕЧЕНЬ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ

Тип	Порядковый номер	Тип	Порядковый номер	Тип	Порядковый номер
1A106A	761	1A701Г	781	2A105БР	744
1A106Б	762	1A701Д	782	2A107А	750
1A106В	760	1Д402А	546	2A201А	694
1A401	737	1Д402Б	548	2A202А	692
1A401А	735	1Д507А	410	2A503А	677
1A401Б	731	1Д508А	395	2A503Б	678
1A401В	716	1Д905А	596	2A505А	682
1A402А	720	1Д905Б	597	2A505Б	663
1A402Б	717	1Д905В	598	2A505В	664
1A402В	721	1Д905Г	599	2A506А	665
1A402Г	718	1ДМ505А	405	2A506Б	666
1A403А	734	1И102А	459	2A506В	667
1A403Б	730	1И102Б	460	2A506Г	668
1A403В	726	1И102В	461	2A506Д	669
1A403Г	709	1И102Г	462	2A507А	670
1A403Д	710	1И102Д	463	2A507Б	671
1A404А	714	1И102Е	464	2A508А	681
1A404Б	711	1И102Ж	474	2A509А	672
1A404В	715	1И102И	475	2A509Б	673
1A404Г	719	1И102К	476	2A510А	674
1A404Д	724	1И304А	477	2A510Б	675
1A404Е	727	1И304Б	479	2A510В	676
1A404Ж	732	1И305А	490	2A601А	766
1A405А	725	1И305Б	492	2A602А	770
1A405Б	728	1И401А	527	2A602Б	771
1A501А	651	1И401Б	532	2A602В	772
1A501Б	652	2A101А	756	2A602Г	773
1A501В	653	2A101Б	754	2A602Д	774
1A501Г	654	2A102А	763	2B102А	617
1A501Д	655	2A103А	757	2B102Б	620
1A501Е	656	2A103АР	757	2B102В	625
1A501Ж	657	2A103Б	755	2B102Г	607
1A501И	658	2A103БР	755	2B102Д	612
1A504А	660	2A104А	740	2B102Е	626
1A504Б	659	2A104АР	740	2B102Ж	613
1A701А	778	2A105А	747	2B103А	611
1A701Б	779	2A105АР	747	2B103Б	633
1A701В	780	2A105Б	744	2B104А	639

Тип	Порядковый номер	Тип	Порядковый номер	Тип	Порядковый номер
2В104Б	642	2Д904Е	585	2С510А	82
2В104В	645	2Д906А	604	2С512А	85
2В104Г	641	2Д910А	565	2С515А	88
2В104Д	647	2Д910Б	566	2С518А	89
2В105А	649	2Д910В	567	2С522А	90
2В105Б	650	2Д911А	572	2С527А	93
2В106А	619	2Д911Б	573	2С920А	111
2В106Б	609	2ДМ101А	422	2С930А	113
2Д101А	421	2ДМ502А	424	2С950А	115
2Д102А	219	2ДМ502Б	426	2С980А	117
2Д102Б	225	2ДМ502В	452	2СМ133Б	7
2Д103А	183,448	2ДМ502Г	454	2СМ139Б	11
2Д104А	221	2Л101А	906	2СМ147Б	15
2Д201А	276	2Л101Б	907	2СМ158Б	19
2Д201Б	277	2Н101А	789	2СМ168Б	25
2Д201В	289	2Н101Б	794	2СМ180А	27
2Д201Г	300	2Н101В	798	2СМ190А	33
2Д202В	271	2Н101Г	799	2СМ210А	38
2Д202Г	269	2Н101Д	805	2СМ211А	58
2Д202Д	295	2Н101Е	795	2СМ213А	66
2Д202Е	296	2Н101Ж	803	2У101А	809
2Д202Ж	311	2Н101И	806	2У101Б	811
2Д202И	312	2Н102А	786	2У101Г	815
2Д202К	327	2Н102Б	788	2У101Д	816
2Д202Л	325	2Н102В	791	2У101Е	818
2Д202М	338	2Н102Г	793	2У101Ж	813
2Д202Н	336	2Н102Д	797	2У101И	812
2Д202Р	346	2Н102Е	800	2У102А	825
2Д202С	344	2Н102Ж	802	2У102Б	826
2Д203А	350	2Н102И	807	2У102В	827
2Д203Б	352	2С107А	1	2У102Г	828
2Д203В	354	2С113А	2	2У103А	823
2Д203Г	356	2С119А	3	2У103Б	824
2Д203Д	358	2С133А	5	2У201А	830
2Д401А	560	2С133Б	6	2У201Б	832
2Д401Б	562	2С139А	9	2У201В	838
2Д502А	423	2С139Б	10	2У201Г	840
2Д502Б	425	2С147А	13	2У201Д	846
2Д502В	451	2С147Б	14	2У201Е	848
2Д502Г	453	2С156А	17	2У201Ж	850
2Д503А	414	2С156Б	18	2У201И	852
2Д503Б	416	2С168А	23	2У201К	854
2Д504А	428	2С168Б	24	2У201Л	856
2Д509А	430	2С180А	26	2У202Д	878
2Д510А	432	2С190А	32	2У202Е	880
2Д901А	587	2С210А	37	2У202Ж	886
2Д901Б	589	2С211А	57	2У202И	888
2Д901В	591	2С213А	65	2У202К	890
2Д901Г	583	2С433А	70	2У202Л	892
2Д904А	575	2С439А	71	2У202М	894
2Д904Б	577	2С447А	72	2У202Н	896
2Д904В	579	2С456А	73	2У203А	857
2Д904Г	581	2С468А	74	2У203Б	859
2Д904Д	583	2С482А	75	2У203В	861

Тип	Порядковый номер	Тип	Порядковый номер	Тип	Порядковый номер
2У203Г	863	ЗИ402Е	536	ГД402Б	547
2У203Д	858	ЗИ402И	535	ГД403А	542
2У203Е	860	1602Ах	217	ГД403Б	543
2У203Ж	862	1602Бх	231	ГД403В	544
2У203И	864	1602Вх	243	ГД404АР	541
2Ц101А	361	1608Ах	742	ГД507А	409
2Ц102А	362	1608АПх	742	ГД508А	394
2Ц102Б	365	1608Бх	740	ГД508Б	396
2Ц102В	368	1608БПх	740	ГД511А	398
3А408А	729	1631Ах	177	ГД511Б	399
3А408Б	722	1631АТх	179	ГД511В	400
3А408В	708	1631Бх	180	ГД512А	401
3А603А	767	1631БТх	182	ГИ304А	478
3А603Б	768	1632Ах	178	ГИ304Б	480
3А603В	769	1632Бх	181	ГИ305А	491
ЗИ101А	455	1642х	166	ГИ305Б	493
ЗИ101Б	447	1643х	196	ГИ307А	473
ЗИ101В	465	1644х	206	ГИ401А	526
ЗИ101Г	466	1645х	133	ГИ401Б	531
ЗИ101Д	468	АА408Ж	733	ГИ403А	540
ЗИ101Е	481	АА406И	723	Д2Б	140
ЗИ101Ж	482	АА408К	712	Д2Бх	141
ЗИ101И	484	АА702А	775	Д2В	156
ЗИ201А	494	АА702Б	776	Д2Вх	157
ЗИ201Б	495	АА702В	777	Д2Г	170
ЗИ201В	497	АИ101А	456	Д2Гх	171
ЗИ201Г	506	АИ101Б	458	Д2Д	172
ЗИ201Д	507	АИ101В	467	Д2Дх	173
ЗИ201Е	509	АИ101Д	470	Д2Е	188
ЗИ201Ж	517	АИ101Е	483	Д2Ех	189
ЗИ201И	519	АИ101И	485	Д2Ж	202
ЗИ201К	521	АИ201А	496	Д2Жх	203
ЗИ201Л	523	АИ201В	499	Д2И	190
ЗИ202А	503	АИ201Г	508	Д2Их	191
ЗИ202Б	504	АИ201Е	510	Д3Ах	685
ЗИ202В	505	АИ201Ж	518	Д3Бх	691
ЗИ202Г	511	АИ201И	520	Д7А	168
ЗИ202Д	512	АИ201К	522	Д7Б	199
ЗИ202Е	513	АИ201Л	524	Д7Бх	200
ЗИ202Ж	514	АИ301А	471	Д7В	207
ЗИ202И	515	АИ301Б	487	Д7Г	215
ЗИ202К	516	АИ301В	488	Д7Гх	216
ЗИ306Г	469	АИ301Г	502	Д7Д	226
ЗИ306Е	472	АИ402Б	530	Д7Дх	227
ЗИ306Ж	486	АИ402Г	537	Д7Е	232
ЗИ306К	489	АИ402Е	538	Д7Ех	233
ЗИ306Л	498	АИ402И	539	Д7Ж	236
ЗИ306М	500	АЛ102А	900	Д7Жх	237
ЗИ306Н	501	АЛ102Б	901	Д9Б	138
ЗИ402А	525	АЛ102В	902	Д9Бх	139
ЗИ402Б	529	ГА401Г	736	Д9В	142
ЗИ402В	533	ГА401Д	713	Д9Вх	143
ЗИ402Г	534	ГД107	137	Д9Г	145
ЗИ402Д	528	ГД402А	545	Д9Гх	148

Тип	Порядковый номер	Тип	Порядковый номер	Тип	Порядковый номер
Д9Д	147	Д207 ^х	209	Д233 ^х	341
Д9Д ^х	148	Д208	222	Д233Б ^х	340
Д9Е	158	Д208 ^х	223	Д234Б ^х	348
Д9Е ^х	159	Д209	234	Д235А	833
Д9Ж	184	Д209 ^х	235	Д235Б	841
Д9Ж ^х	185	Д210	244	Д235В	835
Д9И	149	Д210 ^х	245	Д235Г	843
Д9И ^х	150	Д211	248	Д235А ^х	834
Д9К	151	Д211 ^х	249	Д235Б ^х	842
Д9К ^х	152	Д214 ^х	280	Д235В ^х	836
Д9Л	186	Д214А ^х	281	Д235Г ^х	844
Д9Л ^х	187	Д214Б ^х	274	Д237А ^х	210
Д9М ^х	153	Д215 ^х	302	Д237Б ^х	242
Д10	134	Д215А ^х	304	Д237В ^х	247
Д10А	135	Д215Б ^х	298	Д238А	869
Д10Б	136	Д217	251	Д238Б	873
Д11	144	Д217 ^х	252	Д238В	881
Д12	160	Д218	256	Д238Г	871
Д12А	181	Д218 ^х	257	Д238Д	875
Д13	174	Д219А	440	Д238Е	883
Д14	192	Д219А ^х	441	Д238А ^х	870
Д14А	193	Д219С	434	Д238Б ^х	874
Д18	406	Д220	436	Д238В ^х	882
Д18 ^х	407	Д220С	435	Д238Г ^х	872
Д20	408	Д220 ^х	437	Д238Д ^х	876
Д101	175	Д220А ^х	443	Д238Е ^х	884
Д101А	176	Д220А	442	Д242	278
Д102	162	Д220Б	447	Д242А	279
Д102А	163	Д220Б ^х	448	Д242Б	275
Д103	154	Д223	164	Д243	301
Д103А	155	Д223 ^х	165	Д243А	303
Д104	555	Д223А	194	Д243Б	297
Д104 ^х	563	Д223А ^х	195	Д245	315
Д104А	556	Д223Б	204	Д245А	316
Д104А ^х	564	Д223Б ^х	205	Д245Б	314
Д105	553	Д226 ^х	239	Д246	330
Д105 ^х	557	Д226А ^х	229	Д246А	331
Д105А	554	Д226Б	238	Д246Б	329
Д105А ^х	558	Д226В	228	Д247	342
Д106	549	Д226Г	212	Д247Б	339
Д106 ^х	550	Д226Д	201	Д248Б	347
Д106А	551	Д226Е ^х	213	Д302	290
Д106А ^х	552	Д229А ^х	288	Д302А	292
Д202	265	Д229Б ^х	322	Д302 ^х	291
Д202 ^х	266	Д229В	264	Д303	282
Д203	285	Д229Г	287	Д303А	284
Д203 ^х	286	Д229Д	307	Д303 ^х	283
Д204	305	Д229Е	321	Д304	272
Д204 ^х	306	Д231 ^х	317	Д304 ^х	273
Д205	319	Д231А ^х	318	Д305	262
Д205 ^х	320	Д231Б ^х	313	Д305 ^х	263
Д206 ^х	198	Д232 ^х	332	Д310	411
Д206	197	Д232А ^х	333	Д310 ^х	412
Д207	208	Д232Б ^х	328	Д311 ^х	418

Тип	Порядковый номер	Тип	Порядковый номер	Тип	Порядковый номер
Д311	417	Д814В	80	Д901В ^х	629
Д311А ^х	420	Д814В ^х	81	Д901Г	630
Д311А	419	Д814Г	83	Д901Г ^х	631
Д312	449	Д814Г ^х	84	Д901Д	634
Д312 ^х	450	Д814Д	86	Д901Д ^х	635
Д312А	444	Д814Д ^х	87	Д901Е	636
Д312А ^х	445	Д815А	119	Д901Е ^х	637
Д401	783	Д815А ^х	120	Д902	605
Д401А ^х	784	Д815Б	121	Д1004	369
Д402	758	Д815Б ^х	122	Д1004 ^х	370
Д403Б ^х	751	Д815В	123	Д1005А	375
Д403В ^х	751	Д815В ^х	124	Д1005А ^х	376
Д403ВП ^х	751	Д815Г	125	Д1005Б	377
Д404 ^х	752	Д815Г ^х	126	Д1005Б ^х	378
Д405 ^х	745	Д815Д	127	Д1006	379
Д405А ^х	741	Д815Д ^х	128	Д1006А	382
Д405АП ^х	741	Д815Е	129	Д1006 ^х	380
Д405Б ^х	738	Д815Е ^х	130	Д1006А ^х	381
Д405БП ^х	738	Д815Ж	131	Д1007	383
Д406А ^х	746	Д815Ж ^х	132	Д1007А	386
Д406АП ^х	746	Д815И	118	Д1007 ^х	384
Д407 ^х	759	Д816А	91	Д1007А ^х	385
Д408П ^х	764	Д816А ^х	92	Д1008	387
Д409А ^х	748	Д816Б	94	Д1008А	390
Д409АП ^х	748	Д816Б ^х	95	Д1008 ^х	388
Д501 ^х	765	Д816В	96	Д1008А ^х	389
Д601А ^х	679	Д816В ^х	97	Д1009	371
Д601Б ^х	680	Д816Г	98	Д1009 ^х	372
Д601В ^х	681	Д816Г ^х	99	Д1009А	363
Д602А ^х	682	Д816Д	100	Д1009А ^х	364
Д602Б ^х	684	Д816Д ^х	101	Д1010	373
Д603 ^х	693	Д817А	102	Д1010 ^х	374
Д604 ^х	690	Д817А ^х	103	Д1010А	366
Д605 ^х	706	Д817Б	104	Д1010А ^х	367
Д606 ^х	707	Д817Б ^х	105	Д1011А	359
Д607 ^х	686	Д817В	106	Д1011А ^х	360
Д607А ^х	687	Д817В ^х	107	ДК-В1	700
Д608 ^х	688	Д817Г	108	ДК-В2	704
Д608А ^х	689	Д817Г ^х	109	ДК-В3	697
Д609 ^х	695	Д818А	41	ДК-В4	701
Д808	29	Д818А ^х	42	ДК-В5М	702
Д808 ^х	30	Д818Б	43	ДК-В6М	703
Д809	34	Д818Б ^х	44	ДК-В7М	698
Д809 ^х	35	Д818В	45	ДК-В8 ^х	683
Д810	39	Д818В ^х	46	ДК-В11 ^х	705
Д810 ^х	40	Д818Г	47	ДК-И1М	699
Д811	59	Д818Г ^х	48	ДК-И2М	696
Д811 ^х	60	Д818Д ^х	49	ДК-С1М	753
Д813	67	Д818Е ^х	50	ДК-С2М	743
Д813 ^х	68	Д901А	621	ДК-С7М	749
Д814А	76	Д901А ^х	622	КВ101А	648
Д814А ^х	77	Д901Б	623	КВ102А	606
Д814Б	78	Д901Б ^х	624	КВ102Б	614
Д814Б ^х	79	Д901В	628	КВ102В	627

Тип	Порядковый номер	Тип	Порядковый номер	Тип	Порядковый номер
КВ102Г	615	КД513А	433	КН102Г	792
КВ102Д	616	КД901А	586	КН102Д	796
КВ103А	610	КД901Б	588	КН102Ж	801
КВ103Б	632	КД901В	590	КН102И	804
КВ104А	638	КД901Г	592	КУ101А	808
КВ104Б	642	КД902Д	588	КУ101Б	810
КВ104В	644	КД902Е	589	КУ101Г	814
КВ104Г	640	КД902Ж	570	КУ101Е	817
КВ104Д	646	КД902И	571	КУ103А	819
КВ108А	618	КД903А	584	КУ103Б	820
КВ108Б	608	КД903Б	585	КУ103Г	821
КД102А	218	КД904А	574	КУ103Е	822
КД102Б	224	КД904Б	576	КУ201А	829
КД103А	167,438	КД904В	578	КУ201Б	831
КД103Б	168,438	КД904Г	580	КУ201В	837
КД104А	220	КД904Д	582	КУ201Г	839
КД105А	211	КД904Е	584	КУ201Д	845
КД105Б	241	КД907А	600	КУ201Е	847
КД105В	250	КД907Б	601	КУ201Ж	849
КД105Г	255	КД907В	602	КУ201И	851
КД202А	281	КД907Г	603	КУ201К	853
КД202Б	260	КС133А	4	КУ201Л	855
КД202В	270	КС139А	8	КУ202А	865
КД202Г	268	КС147А	12	КУ202Б	866
КД202Д	294	КС158А	18	КУ202В	867
КД202Е	293	КС192А	20	КУ202Г	868
КД202Ж	810	КС168А	22	КУ202Д	877
КД202И	309	КС168В	21	КУ202Е	879
КД202К	326	КС170А	28	КУ202Ж	885
КД202Л	324	КС175А	31	КУ202И	887
КД202М	337	КС182А	38	КУ202К	889
КД202Н	335	КС191А	51	КУ202Л	891
КД202Р	345	КС198А	52	КУ202М	893
КД202С	343	КС198Б	53	КУ202Н	895
КД203А	349	КС198В	54	КУ204А	897
КД203Б	351	КС198Г	55	КУ204Б	898
КД203В	353	КС210Б	56	КУ204В	899
КД208Г	355	КС211Б	61	МД3х	402
КД203Д	357	КС211В	62	МД217	253
КД205А	384	КС211Г	63	МД217х	254
КД205Б	323	КС211Д	64	МД218	258
КД205В	308	КС213Б	69	МД218х	259
КД205Г	289	КС820А	110	МД226х	240
КД205Д	267	КС830А	112	МД226Ах	230
КД205Е	246	КС850А	114	МД226Ех	214
КД401А	559	КС880А	116	ДММЗ	403
КД401Б	561	КЦ401А	891	ДММЗВПх	404
КД503А	413	КЦ401Б	892	1Т101	30
КД508Б	415	КЛ101А	898	1Т101А	31
КД503В	397	КЛ101Б	903	1Т102	20
КД504А	427	КЛ101В	904	1Т102А	21
КД509А	429	КН102А	785	1Т116А	176
КД510А	431	КН102Б	787	1Т116Б	177
КД512А	401	КН102В	790	1Т116В	178
				1Т116Г	179

Тип	Порядковый номер	Тип	Порядковый номер	Тип	Порядковый номер
1T305A	100	1TM305B	105	2T907A	555
1T305Б	101	2P101A	583	2TM103A	297
1T305В	102	2P101Б	584	2TM103Б	298
1T308A	167	2P101В	585	2TM103В	299
1T308Б	168	2P102A	575	2TM103Г	300
1T308В	169	2P102Б	576	2TM103Д	301
1T311A	241	2P102В	577	2TM104A	249
1T311Б	242	2P102Г	578	2TM104Б	250
1T311Г	243	2P102Д	579	2TM104В	251
1T311Д	244	2T104A	253	2TM104Г	252
1T311К	245	2T104Б	254	1609А ^х	170
1T313A	118	2T104В	255	1609Б ^х	171
1T313Б	117	2T104Г	256	1610 ^х	172
1T313В	118	2T301Г	330	1610А ^х	173
1T320A	218	2T301Д	331	1610Б ^х	174
1T320Б	219	2T301Е	332	1611 ^х	175
1T320В	220	2T301Ж	333	ГТ108А	93
1T321A	191	2T306A	339	ГТ108Б	94
1T321Б	192	2T306Б	340	ГТ108В	95
1T321В	193	2T306В	341	ГТ108Г	96
1T321Г	194	2T306Г	342	ГТ109А	22
1T321Д	195	2T307A	260	ГТ109Б	23
1T321Е	196	2T307Б	261	ГТ109В	24
1T323A	422	2T307В	262	ГТ109Г	25
1T323Б	423	2T307Г	263	ГТ109Д	26
1T323В	424	2T312А	360	ГТ109Е	27
1T335A	180	2T312Б	361	ГТ109Ж	28
1T335Б	181	2T312В	362	ГТ109И	29
1T335В	182	2T316А	352	ГТ115А	36
1T335Г	183	2T316Б	353	ГТ115Б	37
1T335Д	184	2T316В	354	ГТ115В	38
1T403A	391	2T316Г	355	ГТ115Г	39
1T403Б	392	2T316Д	356	ГТ115Д	40
1T403В	393	2T317А	264	ГТ305А	97
1T403Г	394	2T317Б	265	ГТ305Б	98
1T403Д	395	2T317В	266	ГТ305В	99
1T403Е	396	2T336A	291	ГТ308А	164
1T403Ж	397	2T336Б	292	ГТ308Б	165
1T403И	398	2T336В	293	ГТ308В	166
1T702A	506	2T336Г	294	ГТ309А	41
1T702Б	507	2T336Д	295	ГТ309Б	42
1T702В	508	2T336Е	296	ГТ309В	43
1T806A	498	2T602A	525	ГТ309Г	44
1T806Б	499	2T602Б	526	ГТ309Д	45
1T806В	500	2T603A	533	ГТ309Е	46
1T901A	475	2T603Б	534	ГТ310А	1
1T901Б	476	2T603В	535	ГТ310Б	2
1T905A	454	2T603Г	536	ГТ310В	3
1TM115A	32	2T606A	539	ГТ310Г	4
1TM115Б	33	2T608A	432	ГТ310Д	5
1TM115В	34	2T608Б	433	ГТ310Е	6
1TM115Г	35	2T803A	589	ГТ311Е	238
1TM305A	103	2T903A	560	ГТ311Ж	239
1TM305Б	104	2T903Б	561	ГТ311И	240

Тип	Порядковый номер	Тип	Порядковый номер	Тип	Порядковый номер
ГТ313А	114	КТ801Б	324	КТ602Г	524
ГТ313Б	115	КТ301В	325	КТ603А	527
ГТ320А	215	КТ301Г	326	КТ603Б	528
ГТ320Б	216	КТ301Д	327	КТ603В	529
ГТ320В	217	КТ301Е	328	КТ603Г	530
ГТ321А	185	КТ301Ж	329	КТ603Д	531
ГТ321Б	186	КТ306А	334	КТ603Е	532
ГТ321В	187	КТ806Б	335	КТ604А	540
ГТ321Г	188	КТ806В	336	КТ604Б	541
ГТ321Д	189	КТ306Г	337	КТ605А	542
ГТ321Е	190	КТ306Д	338	КТ605Б	543
ГТ322А	47	КТ312А	357	КТ806А	537
ГТ322Б	48	КТ312Б	358	КТ806Б	538
ГТ322В	49	КТ312В	359	КТ808А	430
ГТ322Г	50	КТ315А	343	КТ808Б	431
ГТ322Д	51	КТ315Б	344	КТ801А	544
ГТ322Е	52	КТ315В	345	КТ801Б	545
ГТ323А	419	КТ315Г	346	КТ802А	567
ГТ323Б	420	КТ316А	347	КТ803А	568
ГТ323В	421	КТ316Б	348	КТ805А	558
ГТ328А	63	КТ316В	349	КТ805Б	557
ГТ328Б	64	КТ316Г	350	КТ807А	553
ГТ328В	55	КТ316Д	351	КТ807Б	554
ГТ402А	380	КТ319А	267	КТ902А	582
ГТ402Б	381	КТ319Б	268	КТ903А	558
ГТ403А	382	КТ319В	269	КТ903Б	559
ГТ403Б	383	КТ324А	270	КТ904А	546
ГТ403В	384	КТ324Б	271	КТ904Б	547
ГТ403Г	385	КТ324В	272	М4А	82
ГТ403Д	386	КТ324Г	273	М4Б	83
ГТ403Е	387	КТ324Д	274	М4В	84
ГТ403Ж	388	КТ324Е	275	М4Г	85
ГТ403И	389	КТ325А	363	М4Д	86
ГТ403Ю	390	КТ325Б	364	М4Е	87
ГТ404А	425	КТ325В	365	МП9А ^Х	225
ГТ404Б	426	КТ331А	276	МП10 ^Х	226
ГТ404В	427	КТ331Б	277	МП10А ^Х	227
ГТ404Г	428	КТ331В	278	МП10Б ^Х	228
ГТ701А	501	КТ331Г	279	МП11 ^Х	229
ГТ804А	472	КТ332А	280	МП11А ^Х	230
ГТ804Б	473	КТ332Б	281	МП13 ^Х	136
ГТ804В	474	КТ332В	282	МП13Б ^Х	137
ГТ905А	452	КТ332Г	283	МП14 ^Х	138
ГТ905Б	453	КТ332Д	284	МП14А ^Х	139
КП101Г	580	КТ336А	285	МП14Б ^Х	140
КП101Д	581	КТ336Б	286	МП14И ^Х	141
КП101Е	582	КТ336В	287	МП14Я ^Х	142
КП102Е	570	КТ336Г	288	МП15 ^Х	143
КП102Ж	571	КТ336Д	289	МП15А ^Х	144
КП102И	572	КТ336Е	290	МП15И ^Х	145
КП102К	573	КТ601А	429	МП16 ^Х	197
КП102Л	574	КТ602А	521	МП16А ^Х	198
КТ801	322	КТ602Б	522	МП16Б ^Х	199
КТ301А	323	КТ602В	523	МП16Я ^Х	146

Тип	Порядковый номер	Тип	Порядковый номер	Тип	Порядковый номер
МП16ЯП ^Х	147	МП114	257	П216Г ^Х	479
МП20 ^Х	154	МП115	258	П216Д ^Х	480
МП20А	148	МП116	259	П217 ^Х	495
МП20Б	149	П4АЭ	483	П217А ^Х	496
МП21 ^Х	155	П4БЭ	485	П217Б ^Х	497
МП21А ^Х	158	П4ВЭ	486	П217В ^Х	481
МП21Б ^Х	157	П4ГЭ	487	П217Г ^Х	482
МП21В	150	П4ДЭ	488	П302 ^Х	510
МП21Г	151	П4АЭ ^Х	484	П302	509
МП21Д	152	П4БЭ ^Х	489	П303 ^Х	518
МП21Е	153	П4ВЭ ^Х	490	П303А ^Х	517
МП25 ^Х	206	П4ГЭ ^Х	491	П303	511
МП25А ^Х	207	П4ДЭ ^Х	492	П303А	512
МП25Б ^Х	208	П27	7	П304	513
МП25	200	П27А	8	П304 ^Х	518
МП25А	201	П27 ^Х	13	П306	514
МП25Б	202	П27А ^Х	14	П306А	515
МП26 ^Х	209	П27Б ^Х	15	П306 ^Х	519
МП26А ^Х	210	П28	9	П306А ^Х	520
МП26Б ^Х	211	П28 ^Х	16	П307 ^Х	373
МП26	208	П29	10	П307А ^Х	374
МП26А	204	П29А	11	П307Б ^Х	375
МП26Б	205	П29 ^Х	17	П307В ^Х	376
МП35	231	П29А ^Х	18	П307Г ^Х	377
МП36А	232	П30	12	П307	366
МП37	233	П30 ^Х	19	П307А	367
МП37А	234	П201АЭ ^Х	463	П307Б	368
МП37Б	235	П201АЭ ^Х	467	П307В	369
МП38	236	П201Э	462	П307Г	370
МП38А	237	П201Э ^Х	466	П308	371
МП39	158	П202Э	464	П308 ^Х	378
МП39Б	159	П202Э ^Х	468	П309	372
МП40	160	П203Э	465	П309 ^Х	379
МП40А	161	П203Э ^Х	469	П401	119
МП41	162	П210А ^Х	505	П401 ^Х	123
МП41А	163	П210Б	503	П402	120
МП42	212	П210В	504	П402 ^Х	124
МП42А	213	П210Ш ^Х	502	П403 ^Х	125
МП42Б	214	П211 ^Х	399	П403	121
МП101 ^Х	310	П212 ^Х	400	П403А	122
МП101А ^Х	311	П212А ^Х	401	П410 ^Х	126
МП101Б ^Х	312	П212Б ^Х	402	П410А ^Х	127
МП102 ^Х	313	П213 ^Х	470	П411 ^Х	128
МП103 ^Х	314	П213А ^Х	455	П411А ^Х	129
МП103А ^Х	315	П213Б ^Х	456	П416	130
МП104 ^Х	246	П214 ^Х	457	П416А	131
МП105 ^Х	247	П214А ^Х	458	П416Б	132
МП106 ^Х	248	П214Б ^Х	471	П416 ^Х	133
МП111	316	П214В ^Х	459	П416А ^Х	134
МП111А	317	П214Г ^Х	460	П416Б ^Х	135
МП111Б	318	П215 ^Х	461	П417 ^Х	59
МП112	319	П216 ^Х	493	П417А ^Х	60
МП113	320	П216А ^Х	494	П417	58
МП113А	321	П216Б ^Х	477	П417А	57
		П216В ^Х	478		

Тип	Порядковый номер	Тип	Порядковый номер	Тип	Порядковый номер
П417Б	58	П607А ^х	412	Т3А ^х	112
П418Г ^х	61	П607	403	Т3Б ^х	113
П418Д ^х	62	П607А	404	ТМ2А ^х	71
П418Е ^х	63	П608 ^х	413	ТМ2Б ^х	72
П418Ж ^х	64	П608А ^х	414	ТМ2В ^х	73
П418И ^х	65	П608Б ^х	415	ТМ2Г ^х	74
П418К ^х	66	П608	405	ТМ2Д ^х	75
П418Л ^х	67	П608А	406	ТМ3А ^х	221
П418М ^х	68	П608Б	407	ТМ3В ^х	222
П422	69	П609 ^х	416	ТМ3Г ^х	223
П423	70	П609А ^х	417	ТМ3Д ^х	224
П601АИ ^х	440	П609Б ^х	418	ТМ4А ^х	76
П601АИ	435	П609	408	ТМ4Б ^х	77
П601БИ ^х	441	П609А	409	ТМ4В ^х	78
П601БИ	436	П609Б	410	ТМ4Г ^х	79
П601И ^х	439	П701 ^х	551	ТМ4Д ^х	80
П601И	434	П701А ^х	552	ТМ4Е ^х	81
П602АИ ^х	443	П701	548	ТМ5А ^х	88
П602АИ	438	П701А	549	ТМ5Б ^х	89
П602И	437	П701Б	550	ТМ5В ^х	90
П602И ^х	442	П702 ^х	565	ТМ5Г ^х	91
П605 ^х	448	П702А ^х	566	ТМ6Д ^х	92
П605А ^х	449	П702	563	ТМ10 ^х	302
П605	444	П702А	564	ТМ10А ^х	303
П605А	445	Т1А ^х	106	ТМ10Б ^х	304
П606 ^х	450	Т1Б ^х	107	ТМ10В ^х	305
П606А ^х	451	Т2А ^х	108	ТМ10Г ^х	306
П606	446	Т2Б ^х	109	ТМ10Д ^х	307
П606А	447	Т2В ^х	110	ТМ10Е ^х	308
П607 ^х	411	Т2К ^х	111	ТМ10Ж ^х	309

ЧАСТЬ 1

ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ
ДИОДЫ И ТИРИСТОРЫ

№ пп.	Тип прибора	$\Delta U_{\text{ст.норм.}}$, $\pm \%$	$U_{\text{ст.норм.}}$,		$P_{\text{макс.}}$,		R_{D_1} ,		R_{D_2} ,		$U_{\text{пр.}}$,	
			(в)	в	$I_{\text{ст.норм.}}$,	ма	мвт	°C	ом	ма	ом	ма
1	2C107A	(±0,07)	0,7	10	-		50	1	7	10		
2	2C113A	(±0,13)	1,3	10			90	1	12	10		
3	2C119A	(±0,19)	1,9	10			130	1	15	10		
4	KC133A	10	3,3	10	300	50	180	3	65	10	1	50
5	2C133A	10	3,3	10	300	50	180	3	65	10	1	50
6	2C133Б	(0,3)	3,3	10			180	3	65	10	1	50
7	2CM133Б	(0,3)	3,3	10			180	3	65	10	1	50
8	KC139A	10	3,9	10	300	50	180	3	60	10	1	50
9	2C139A	10	3,9	10	300	50	180	3	60	10	1	50
10	2C139Б	(0,4)	3,9	10			180	3	60	10	1	50
11	2CM139Б	(0,4)	3,9	10			180	3	60	10	1	50
12	KC147A	10	4,7	10	300	50	160	3	56	10	1	50
13	2C147A	10	4,7	10	300	50	160	3	56	10	1	50
14	2C147Б	(0,6)	4,7	10			180	3	56	10	1	50
15	2CM147Б	(0,6)	4,7	10			180	3	56	10	1	50
16	KC156A	10	5,6	10	300	50			46	10	1	50
17	2C156A	10	5,6	10	300	50			46	10	1	50
18	2C156Б	(0,6)	5,6	10			160	3	45	10	1	50
19	2CM156Б	(0,6)	5,6	10			160	3	45	10	1	50
20	KC162A	(0,4)	6,2	10	150	50	150	3	33	10		
21	KC168B	(0,5)	6,8	10	150	50	120	3	28	10		
22	KC168A	10	6,8	10	300	50			28	10	1	50
23	2C168A	10	6,8	10	300	50			28	10	1	50
24	2C168Б	(0,8)	6,8	10			40	3	15	10	1	50
25	2CM168Б	(0,8)	6,8	10			40	3	15	10	1	50
26	2C180A		7-8,5	5	125	50	15	1	8	5		
27	2CM180A		7-8,5	5	125	50	15	1	8	5		
28	KC170A	(0,3)	7	10	150	50	90	3	20	10		

МАЛОЙ МОЩНОСТИ

ТКН, 10 ⁻² %/°C (мВ/°C)	R _t , °C/вт	Предельные режимы								Материал Технология	Чер- теж №		
		I _{CT} ,		I _{пр.имп.макс,}			I _{авар,}		Интервал температур, °C				
		МИН	МАКС	ма	I _{пр.ср} ,	τ _u ,	ма	τ _u ,	сек				
		ма		ма		сек	ма	сек					
(2)	300	1	100	500	50	1,0	1000	0,5	-60 ÷ +120	Si C	31		
(-3-4)		1	100	200	50	0,1			-60 ÷ +120	Si СД	31		
(-5-6)		1	100	200	50	0,1			-60 ÷ +120	Si СД	31		
-10		3	81	162		1,0			-55 ÷ +100	Si C	31		
-11		3	81	162		1,0			-60 ÷ +120	Si C	31		
-10		3	30						-60 ÷ +120	Si C	18		
-10		3	30						-60 ÷ +120	Si C	103		
-10		3	70	140		1,0			-55 ÷ +100	Si C	31		
-10		3	70	140		1,0			-60 ÷ +120	Si C	31		
-10		3	26						-60 ÷ +120	Si C	18		
-10		3	26						-60 ÷ +120	Si C	103		
-8+2		3	58	116		1,0			-55 ÷ +100	Si C	31		
-9+1		3	58	116		1,0			-60 ÷ +120	Si C	31		
-8+2		3	21						-60 ÷ +120	Si C	18		
-8+2		3	21						-60 ÷ +120	Si C	103		
-5+5		3	55	110		1,0			-55 ÷ +100	Si C	31		
-5+5		3	55	110		1,0			-60 ÷ +120	Si C	31		
-4+7		3	18						-60 ÷ +120	Si C	18		
-4+7		3	18						-60 ÷ +120	Si C	103		
-6		3	22						-55 ÷ +100	Si C	83		
<u>+5</u>		3	20						-55 ÷ +100	Si C	31		
-6+6		3	45	90		1,0			-55 ÷ +100	Si C	31		
-6+6		3	45	90		1,0			-60 ÷ +120	Si C	31		
+7		3	15						-60 ÷ +120	Si C	18		
+7		3	15						-60 ÷ +120	Si C	103		
7			15						-60 ÷ +120	Si C	18		
7			15						-60 ÷ +120	Si C	103		
1		3	20						-55 ÷ +100	Si C	83		

СТАБИЛИТРОНЫ

№ пп.	Тип прибора	$\Delta U_{ст.}$ ном , $\pm \%$ (в)	$U_{ст.ном}$,		$P_{макс.}$ (t_k), МВт	t_k , °C	R_{D_1} ,		R_{D_2} ,		$U_{пр.}$	
			в	ма			ом	ма	ом	ма	в	ма
29	Д808		7-8,5	5	280	50			6	5	1	50
30	Д808 ^x		7-8,5	5	280	50	12	1	6	5	1	50
31	КС175А	(0,5)	7,5	5	150	50	70	3	16	5		
32	2С190А		8-9,5	5	125	50	22	1	12	5		
33	2СМ190А		8-9,5	5	125	50	22	1	12	5		
34	Д809		8-9,5	5	280	50			10	5	1	50
35	Д809 ^x		8-9,5	5	280	50	18	1	10	5	1	50
36	КС182А	(0,6)	8,2	5	150	50	30	3	14	5		
37	2С210А		9-10,5	5	125	50	32	1	15	5		
38	2СМ210А		9-10,5	5	125	50	32	1	15	5		
39	Д810		9-10,5	5	280	50			12	5	1	50
40	Д810 ^x		9-10,5	5	280	50	25	1	12	5	1	50
41	Д818А	+25	9		10	300	50	100	3	25	10	
42	Д818А ^x	+15	9		10	300	50	70	3	18	10	
43	Д818Б	-25	9		10	300	50	100	3	25	10	
44	Д818Б ^x	-15	9		10	300	50	70	3	18	10	
45	Д818В	20	9		10	300	50	100	3	25	10	
46	Д818В ^x	10	9		10	300	50	70	3	18	10	
47	Д818Г	15	9		10	300	50	100	3	25	10	
48	Д818Г ^x	5	9		10	300	50	70	3	18	10	
49	Д818Д ^x	5	9		10	300	50	70	3	18	10	
50	Д818Е ^x	5	9		10	300	50	70	3	18	10	
51	КС191А	(0,6)	9,1	5	150	50	30	3	18	5		
52	КС196А	5	9,4		10	200	50	70	3	18	10	
53	КС196Б	5	9,4		10	200	50	70	3	18	10	
54	КС196В	5	9,4		10	200	50	70	3	18	10	
55	КС196Г	5	9,4		10	200	50	70	3	18	10	
56	КС210Б	(0,7)	10	5	150	50	35	3	22	5		
57	2С211А		10-12	5	125	50	36	1	19	5		

МАЛОЙ МОЩНОСТИ

ТКН, $10^{-2\%}/^{\circ}\text{C}$ (мв/ $^{\circ}\text{C}$)	R_{t} $^{\circ}\text{C}/\text{вт}$	н Предельные режимы								Материал Технология	Чертеж №		
		I _{ст} ,		I _{пр.имп. макс} ,			I _{авар.} ,		Интервал температур, $^{\circ}\text{C}$				
		мин	макс	ма	I _{пр.ср} ,	τ_u , сек	ма	τ_u , сек					
+7	3	33							-55-+100	Si ₄ C	80		
7		38							-60-+120	Si C	35		
<u>+4</u>	3	18							-55-+100	Si C	83		
8		13							-60-+120	Si C	18		
8		13							-60-+120	Si C	103		
8	3	29							-55-+100	Si C	30		
8		29							-60-+120	Si C	35		
5	3	17							-55-+100	Si C	83		
9		11							-60-+120	Si C	18		
9		11							-60-+120	Si C	103		
9	3	26							-55-+100	Si C	30		
9		26							-60-+120	Si C	35		
+2	3	38							-55-+100	Si Д	31/оп		
+2	3	38							-60-+120	Si Д	31/оп		
-2	3	38							-55-+100	Si Д	31/оп		
-2	3	38							-60-+120	Si Д	31/оп		
<u>+1</u>	3	38							-55-+100	Si Д	31/оп		
<u>+1</u>	3	38							-60-+120	Si Д	31/оп		
<u>+0,5</u>	3	38							-55-+100	Si Д	31/оп		
<u>+0,5</u>	3	38							-60-+120	Si Д	31/оп		
<u>+0,1</u>	3	38							-60-+120	Si Д	31/оп		
<u>+0,1</u>	3	38							-60-+120	Si Д	31/оп		
6	3	15							-55-+100	Si C	83		
0,5	3	20							-60-+100	Si C	36		
0,25	3	20							-60-+100	Si C	36		
0,1	3	20							-60-+100	Si C	36		
0,05	3	20							-60-+100	Si C	36		
7	3	14							-55 -+ 100	Si C	88		
9,5		10							-60 -+ 120	Si C	18		

СТАБИЛИТРОНЫ

№ пп.	Тип прибора	$\Delta U_{\text{ст.норм.}}$, $\pm \%$ (В)	U _{ст.норм.} ,		P _{макс.} ,		R _{D₁} ,		R _{D₂} ,		U _{пр.} ,	
			в	I _{ст.норм.} , ма	МВт	t _(t_k) , °C	ом	I _{ст.1} , ма	ом	I _{ст.2} , ма	в	I _{пр.} , ма
58	2СМ211А		10-12	5	125	50	36	1	19	5		
59	Д811		10-12	5	280	50			15	5	1	50
60	Д811 ^Х		10-12	5	280	50	30	1	15	5	1	50
61	КС211Б	+20	11	10	280	50	30	5	15	10		
62	КС211В	-20	11	10	280	50	30	5	15	10		
63	КС211Г	15	11	10	280	50	30	5	15	10		
64	КС211Д	15	11	10	280	50	30	5	15	10		
65	2С213А		11,5-14	5	125	50	46	1	22	5		
66	2СМ213А		11,5-14	5	125	50	46	1	22	5		
67	Д813		11,5-14	5	280	50			18	5	1	50
68	Д813 ^Х		11,5-14	5	280	50	35	1	18	5	1	50
69	КС213Б	(0,9)	13	5	150	50	45	3	25	5		

СТАБИЛИТРОНЫ

№ пп.	Тип прибора	$\Delta U_{\text{ст.норм.}}$, $\pm \%$ (В)	U _{ст.норм.} ,		P _{макс.} ,		R _{D₁} ,		R _{D₂} ,		U _{пр.} ,	
			в	I _{ст.норм.} , ма	МВт	t _(t_k) , °C	ом	I _{ст.} , ма	ом	I _{ст.2} , ма	в	I _{пр.} , ма
70	2С433А	10	3,3	60	1	35	180	3	14	60		
71	2С439А	10	3,9	51	1	35	180	3	12	51		
72	2С447А	10	4,7	43	1	35	180	3	10	43		
73	2С456А	10	5,6	36	1	35	145	3	7	36		
74	2С468А	10	6,8	29	1	35	70	3	5	29		
75	2С482А	10	8,2	24	1	35	32	3	5	24		
76	Д814А		7-8,5	5	0,34	25	15	5	6	5	1	50
77	Д814А ^Х		7-8,5	5	0,34	25	12	1	6	5	1	50
78	Д814Б		8-9,5	5	0,34	25	18	5	10	5	1	50
79	Д814Б ^Х		8-9,5	5	0,34	25	18	1	10	5	1	50
80	Д814В		9-10,5	5	0,34	25	25	5	12	5	1	50
81	Д814В ^Х		9-10,5	5	0,34	25	25	1	12	5	1	50
82	2С510А	10	10	20	1	35	32	3	8	20		
83	Д814Г		10-12	5	0,34	25	30	5	15	5	1	50
84	Д814Г ^Х		10-12	5	0,34	25	30	1	15	5	1	50

МАЛОЙ МОШНОСТИ

ТКН, 10 ⁻² %/°C	R _t , °C/вт	Пределевые режимы								Мате- риал Техно- логия	Чертеж №	
		I _{ст} ,		I _{пр.имп.макс} ,			I _{авар} ,		Интервал температура, °C			
		мин	макс	I _{пр.ср}	τ _U ,	ма	ма	сек	ма	сек		
(мв/°C)	°C/вт	ма	ма	ма	сек	ма	ма	сек	°C	—60—+120	Si C	103
9,5		10							—60—+120	Si C	103	
9,5		3	23						—55—+100	Si C	30	
9,5			23						—60—+120	Si C	35	
+2		5	33						—60—+120	Si C	81	
-2		5	33						—60—+120	Si C	81	
±1		5	33						—60—+120	Si C	81	
±0,5		5	33						—60—+120	Si C	81	
9,5		9							—60—+120	Si C	18	
9,5		9							—60—+120	Si C	103	
9,5		3	20						—55—+100	Si C	30	
9,5			20						—60—+120	Si C	35	
8		3	10						—55—+100	Si C	83	

СРЕДНЕЙ МОШНОСТИ

ТКН, 10 ⁻² %/°C	R _t , °C/вт	Пределевые режимы								Мате- риал Техно- логия	Чертеж №	
		I _{ст} ,		I _{пр.имп.макс} ,			I _{авар} ,		Интервал температура, °C			
		мин	макс	ма	I _{пр.ср}	τ _U ,	ма	сек	ма	сек		
(мв/°C)	°C/вт	ма	ма	ма	ма	сек	ма	ма	°C	—60—+125	Si C	30
-10		10	191						—60—+125	Si C	30	
-10		10	170						—60—+125	Si C	30	
-8 + 3		10	159						—60—+125	Si C	30	
+5		10	139						—60—+125	Si C	30	
+6,5		10	119						—60—+125	Si C	30	
8		3	96						—60—+125	Si C	30	
7	300	3	40						—55—+100	Si C	31	
7	300	3	40						—60—+125	Si C	31	
8	300	3	36						—55—+100	Si C	31	
8	300	3	36						—60—+125	Si C	31	
9	300	3	32						—55—+100	Si C	31	
9	300	3	32						—60—+125	Si C	31	
10		3	79						—60—+125	Si Э	30	
9,5	300	3	29						—55—+100	Si C	31	
9,5	300	3	29						—60—+125	Si C	31	

СТАБИЛИТРОНЫ

№ пп.	Тип прибора	$\Delta U_{\text{ст.ном}}$, $\pm \%$	U _{ст.ном} ,		P _{макс} , вт	t _{окр.ср} (t _K), °C	R _{D₁} , ом		R _{D₂} , ом		U _{пр} , в	
			(в)	I _{ст.ном} , ма			I _{ст.₁} , ма	I _{ст.₂} , ма	I _{пр} , ма	I _{пр} , ма		
85	2C512A	10	12	17	1	35	32	3	11	17		
86	Д814Д		11,5-14	5	0,34	25	35	5	18	5	1	50
87	Д814Д ^x		11,5-14	5	0,34	25	35	1	18	5	1	50
88	2C515A	10	15	13	1	35	36	3	17	13		
89	2C518A	10	18	11	1	35	48	3	22	11		
90	2C522A	10	22	9	1	35	60	3	29	9		
91	Д816А	15	22	150	5	70	240	10	10	150	1,5	500
92	Д816А ^x	10	22	150	5	75	120	10	7	150	1,5	500
93	2C527A	10	27	7,5	1	35	72	3	40	7,5		
94	Д816Б	15	27	150	5	70	300	10	12	150	1,5	500
95	Д816Б ^x	10	27	150	5	75	150	10	8	150	1,5	500
96	Д816В	15	33	150	5	70	300	10	15	150	1,5	500
97	Д816В ^x	10	33	150	5	75	150	10	10	150	15	500
98	Д816Г	15	39	150	5	70	300	10	18	150	1,5	500
99	Д816Г ^x	10	39	150	5	75	150	10	12	150	1,5	500
100	Д816Д	15	47	150	5	70	300	10	22	150	1,5	500
101	Д816Д ^x	10	47	150	5	75	150	10	15	150	1,5	500
102	Д817А	15	56	50	5	70	400	5	52	50	1,5	500
103	Д817А ^x	10	56	50	5	75	200	5	35	50	1,5	500
104	Д817Б	15	68	50	5	70	400	5	60	50	1,5	500
105	Д817Б ^x	10	68	50	5	75	200	5	40	50	1,5	500
106	Д817В	15	82	50	5	70	600	5	67	50	1,5	500
107	Д817В ^x	10	82	50	5	75	300	5	45	50	1,5	500
108	Д817Г	15	100	50	5	70	800	5	75	50	1,5	500
109	Д817Г ^x	10	100	50	5	75	300	5	50	50	1,5	500
110	KC620A	15	120	50	5	70	1000	5	150	50	1,5	500
111	2C920A	10	120	50	5	75	500	5	100	50	1,5	500
112	KC630A	15	130	50	5	70	1000	5	180	50	1,5	500
113	2C930A	10	130	50	5	75	800	5	120	50	1,5	500
114	KC650A	15	150	25	5	70	2400	5	255	25	1,5	500
115	2C950A	10	150	25	5	75	1200	2,5	170	25	1,5	500
116	KC680A	15	180	25	5	70	3000	5	330	25	1,5	500
117	2C980A	10	180	25	5	75	1500	2,5	220	25	1,5	500

СРЕДНЕЙ МОЩНОСТИ

ТКН, 10 ^{-2%} /°C (мВ/°C)	R _t , °C/вт	Предельные режимы							Материал Техноло- гия	Чертеж №		
		I _{ст} ,		I _{пр.имп.} макс,			I _{авар.}					
		мин	макс	ма	I _{пр.ср} , ма	τ _U , сек	ма	τ _U , сек				
		ма										
10		3	87						-80 - +125	Si Э 30		
9,5	300	3	24						-55 - +100	Si C 31		
9,5	300	3	24						-80 - +125	Si C 31		
10		3	53						-80 - +125	Si Э 30		
11		3	45						-80 - +125	Si Э 30		
11		3	37						-80 - +125	Si Э 30		
15		10	280				460	1	-60 - +100к	Si C 92		
12		10	280				460	1	-60 - +130к	Si C 92		
11		3	30						-60 - +125	Si Э 30		
15		10	180				360	1	-60 - +100к	Si C 92		
12		10	180				360	1	-60 - +130к	Si C 92		
15		10	150				300	1	-60 - +100к	Si C 92		
12		10	150				300	1	-60 - +130к	Si C 92		
15		10	130				260	1	-60 - +100к	Si C 92		
12		10	130				260	1	-60 - +130к	Si C 92		
15		10	110				220	1	-60 - +100к	Si C 92		
12		10	110				220	1	-60 - +130к	Si C 92		
18		5	90				180	1	-60 - +100к	Si C 92		
14		5	90				180	1	-60 - +130к	Si C 92		
18		5	76				150	1	-60 - +100к	Si C 92		
14		5	76				150	1	-60 - +130к	Si C 92		
18		5	60				120	1	-60 - +100к	Si C 92		
14		5	60				120	1	-60 - +130к	Si C 92		
18		5	50				100	1	-60 - +100к	Si C 92		
14		5	50				100	1	-60 - +130к	Si C 92		
20		5	42				84	1	-60 - +100к	Si C 92		
18		5	42				84	1	-60 - +130к	Si C 92		
20		5	38				76	1	-60 - +100к	Si C 92		
18		5	38				72	1	-60 - +130к	Si C 92		
20		2,5	33				66	1	-60 - +100к	Si C 92		
16		2,5	33				66	1	-60 - +130к	Si C 92		
20		2,5	28				56	1	-60 - +100к	Si C 92		
16		2,5	28				56	1	-60 - +130к	Si C 92		

СТАБИЛИТРОНЫ

№ п.п.	Тип прибора	$\Delta U_{ст.ном}$, $\pm\%$	$U_{ст.ном}$,		$P_{макс}$, вт	$t_{окр.ср} (t_K)$, $^{\circ}\text{C}$	R_{D_1} ,		R_{D_2} ,	$U_{пр}$,	
			(в)	в			ма	ом		ма	в
118	Д815И	15	4,7	1000	8	(70)	40	50	0,9	1000	1,5 500
119	Д815А	15	5,6	1000	8	(70)	40	50	0,9	1000	1,5 500
120	Д815А ^x	10	5,6	1000	8	(75)	20	50	0,8	1000	1,5 500
121	Д815Б	15	8,8	1000	8	(70)	30	50	1,2	1000	1,5 500
122	Д815Б ^x	10	8,8	1000	8	(75)	15	50	0,8	1000	1,5 500
123	Д815В	15	8,2	1000	8	(70)	16	50	1,5	1000	1,5 500
124	Д815В ^x	10	8,2	1000	8	(75)	8	50	1	1000	1,5 500
125	Д815Г	15	10	500	8	(70)	30	25	2,7	500	1,5 500
126	Д815Г ^x	10	10	500	8	(75)	15	25	1,8	500	1,5 500
127	Д815Д	15	12	500	8	(70)	40	25	3	500	1,5 500
128	Д815Д ^x	10	12	500	8	(75)	20	25	2	500	1,5 500
129	Д815Е	15	15	500	8	(70)	50	25	3,8	500	1,5 500
130	Д815Е ^x	10	15	500	8	(75)	25	25	2,5	500	1,5 500
131	Д815Ж	15	18	500	8	(70)	60	25	4,7	500	1,5 500
132	Д815Ж ^x	10	18	500	8	(75)	30	25	3	500	1,5 500

ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЕ ДИОДЫ

№ п.п.	Тип прибора	Предельные режимы		$U_{пр}$, в	$I_{пр}$, ма	$I_{обр. при U_{обр. макс} t = 25^{\circ}\text{C}}$, мка	$I_{обр.}$		
		$U_{обр. макс}$, в	$I_{пр.ср.макс}$, ма				$U_{обр.}$, в	T , $^{\circ}\text{C}$	
133	1645 ^x	10		0,57	0,1	0,1	1	1	+80
134	Д10	10	16			100	200	10	+80
135	Д10А	10	16			200	400	10	+80
136	Д10Б	10	16			200	400	10	+80
137	ГД107	10	20	1	10	20	200	10	+80
138	Д9Б	10	40	1	80	250	1000	10	+80
139	Д9Б ^x	10	40	1	80	250	1000	10	+70
140	Д2Б	30	16	1	5	100	400	10	+80
141	Д2Б ^x	30	16	1	5	100	400	10	+70
142	Д9В	30	20	1	10	250	800	20	+80

БОЛЬШОЙ МОЩНОСТИ

ТКН , $10^{-2\%}/^{\circ}\text{C}$ (мВ/ $^{\circ}\text{C}$)	R_t , $^{\circ}\text{C}/\text{вт}$	Предельные режимы						Материал Технология	Чертеж №		
		I _{ст} ,		I _{пр.имп.макс} ,		I _{авар} ,					
		мин	макс	a	I _{пр.ср.} ма	τ_u , сек.	a	τ_u , сек			
ма	ма										
5,6	50	1400					2,8	1	-60-+100к	Si C 92	
5,6	50	1400					2,8	1	-60-+100к	Si C 92	
4,5	50	1400					2,8	1	-60-+130к	Si C 92	
6,2	50	1150					2,3	1	-60-+100к	Si C 92	
5	50	1150					2,3	1	-60-+130к	Si C 92	
8,8	50	950					1,9	1	-60-+100к	Si C 92	
7	50	950					1,9	1	-60-+130к	Si C 92	
10	25	800					1,8	1	-60-+100к	Si C 92	
8	25	800					1,8	1	-60-+130к	Si C 92	
11	25	650					1,3	1	-60-+100к	Si C 92	
9	25	650					1,3	1	-60-+130к	Si C 92	
13	25	550					1,1	1	-60-+100к	Si C 92	
10	25	550					1,1	1	-60-+130к	Si C 92	
14	25	450					0,9	1	-60-+100к	Si C 92	
11	25	450					0,9	1	-60-+130к	Si C 92	

МАЛОЙ МОЩНОСТИ

Предельные режимы					Материал Техноло- гия	Чер- теж №
I _{пр.пер.макс} , а	τ_u , мксек	I _{макс} , а	τ_u , сек	I _{пр.} макс. ампл, ма		
				f, КГц	Интервал температур, $^{\circ}\text{C}$	
					-50 - + 60	Si 3
				100	-55 - + 60	Ge T 4
				100	-55 - + 60	Ge T 4
				100	-55 - + 60	Ge T 4
				100	-55 - + 60	Ge T 4
				125	100	-55 - + 60
				125	100	-60 - + 70
				50	100	-55 - + 60
				50	100	-60 - + 70
				62	100	-55 - + 60

ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЕ ДИОДЫ

№ пп.	Тип прибора	Предельные режимы		U _{пр,}		I _{обр.} при U _{обр.} макс t = 25°C,	I _{обр,}	
		U _{обр.макс,} в	I _{пр.ср.макс,} ма	I _{пр,} в	I _{пр,} ма		U _{обр,} в	T, °C
143	Д9В ^х	30	20	1	10	250	800	20 + 70
144	Д11	30	20	1	100	250	1000	30 + 60
145	Д9Г	30	30	1	30	250	800	20 + 60
146	Д9Г ^х	30	30	1	30	250	800	20 + 70
147	Д9Д	30	30	1	60	250	800	20 + 60
148	Д9Д ^х	30	30	1	60	250	800	20 + 70
149	Д9И	30	30	1	30	120	500	20 + 60
150	Д9И ^х	30	30	1	30	120	500	30 + 70
151	Д9К	30	30	1	60	60	400	20 + 60
152	Д9К ^х	30	30	1	60	60	400	20 + 70
153	Д9М ^х	30	30	1	60	250	800	20 + 70
154	Д103	30	30	2	2	80	100	30 + 100
155	Д103А	30	30	1	1	30	100	30 + 100
156	Д2В	40	25	1	9	250	1000	30 + 60
157	Д2В ^х	40	25	1	9	250	1000	30 + 70
158	Д9Е	50	20	1	30	250	600	30 + 60
159	Д9Е ^х	50	20	1	30	250	600	30 + 70
160	Д12	50	20	1	50	250	1000	50 + 60
161	Д12А	50	20	1	100	250	1000	50 + 60
162	Д102	50	30	2	2	10	100	50 + 100
163	Д102А	50	30	1	1	10	100	50 + 100
164	Д223	50	50	1	50	1	50	50 + 100
165	Д223 ^х	50	50	1	50	1	50	50 + 120
166	1842 ^х	50	50	1	50	1	50	50 + 125
167	КД103А	50	100	1	50	1	50	50 + 100
168	КД103Б	50	100	1,2	50	1	50	50 + 100
169	Д7А	50	300	0,5	300	100	1000	25 + 70
170	Д2Г	75	16	1	2	250	1000	50 + 60
171	Д2Г ^х	75	16	1	2	250	1000	50 + 70
172	Д2Д	75	16	1	4,5	250	1000	50 + 60
173	Д2Д ^х	75	16	1	4,5	250	10000	50 + 70
174	Д13	75	20	1	100	250	1000	75 + 60

МАЛОЙ МОЩНОСТИ

Пределевые режимы							Материал Технология	Чертеж №
I _{пр.пер.макс,} а	I _{макс,} а	I _{пр.} макс. ампл, ма	f , кГц	Интервал температур, °C				
		62	100	-60 - + 70	Ge	T	4	
		100		-55 - + 60	Ge	T	4	
		98	100	-55 - + 60	Ge	T	4	
		98	100	-60 - + 70	Ge	T	4	
		98	100	-55 - + 60	Ge	T	4	
		98	100	-60 - + 70	Ge	T	4	
		98	100	-55 - + 60	Ge	T	4	
		98	100	-60 - + 70	Ge	T	4	
		98	100	-55 - + 60	Ge	T	4	
		98	100	-60 - + 70	Ge	T	4	
		98	100	-60 - + 70	Ge	T	4	
		98	100	-60 - + 70	Ge	T	4	
		98	100	-55 - + 100	Si	T	24	
				-55 - + 100	Si	T	24	
		78		-55 - + 60	Ge	T	24	
		78	100	-60 - + 70	Ge	T	24	
		62		-55 - + 60	Ge	T	4	
		62	100	-60 - + 70	Ge	T	4	
		100		-55 - + 60	Ge	T	4	
		100		-55 - + 60	Ge	T	4	
		100		-55 - + 100	Si	T	24	
		100		-55 - + 100	Si	T	24	
		0,5	(1+2)10 ⁶	20·10 ³	-55 - + 100	Si	MC	1
		0,5	(1+2)10 ⁶	20·10 ³	-60 - + 120	Si	MC	1
				20·10 ³	-50 - + 125	Si	MC	1,21
2	10				-55 - + 100	Si	МД	106
2	10				-55 - + 100	Si	МД	106
			2		-55 - + 70	Ge	C	21
		50			-55 - + 60	Ge	T	24
		50	100		-60 - + 70	Ge	T	24
		50			-55 - + 60	Ge	T	24
		50	100		-60 - + 70	Ge	T	24
		100			-55 - + 60	Ge	T	4

ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЕ ДИОДЫ

№ пп.	Тип прибора	Предельные режимы		U _{пр} , в	I _{пр} , ма	I _{обр.} при U _{обр.} макс. t=25°C, мка	I _{обр} ,		
		U _{обр.макс} , в	I _{пр.ср.макс} , ма				U _{обр} , в	T, °C	
175	Д101	75	30	2	2	10	150	75	+100
176	Д101А	75	30	1	1	10	150	75	+100
177	1631А ^х	75	30	2	2	30	75	50	+100
178	1632А ^х	75	30	2	2	30	75	50	+100
179	1631АТ ^х	75	30	2	2	30	75	50	+ 80
180	1631Б	75	30	1	1	30	75	50	+100
181	1632Б	75	30	1	1	30	75	50	+100
182	1631БТ	75	30	1	1	30	75	50	+ 80
183	2Д103А	75	100	1	50	1	50	75	+120
184	Д9Ж	100	15	1	10	250	500	45	+ 80
185	Д9Ж ^х	100	15	1	10	250	500	45	+ 70
186	Д9Л	100	15	1	30	250	500	45	+ 60
187	Д9Л ^х	100	15	1	30	250	500	45	+ 70
188	Д2Е	100	16	1	4,5	250	700	60	+ 60
189	Д2Е ^х	100	16	1	4,5	250	700	60	+ 70
190	Д2И	100	16	1	2	250	700	60	+ 60
191	Д2И ^х	100	16	1	2	250	700	60	+ 70
192	Д14	100	20	1	30	250	1000	100	+ 80
193	Д14А	100	20	1	100	250	1000	100	+ 60
194	Д223А	100	50	1	50	1	50	100	+ 100
195	Д223А ^х	100	50	1	50	1	50	100	+ 120
196	1643	100	50	1	50	1	50	100	+ 125
197	Д206	100	100	1	100	100	200	100	+ 100
198	Д206 ^х	100	100	1	100	50	100	100	+120
199	Д7Б	100	300	0,5	300	100	1000	35	+ 70
200	Д7Б ^х	100	300	0,5	300	100	1000	50	+ 70
201	Д226Д	100	300	1	300	100	300	70	+ 80
202	Д2Ж	150	8	1	2	250	700	80	+ 60
203	Д2Ж ^х	150	8	1	2	250	700	80	+ 70
204	Д223Б	150	50	1	50	1	50	150	+100
205	Д223Б ^х	150	50	1	50	1	50	150	+120
206	1644	150	50	1	50	1	50	150	+125

МАЛЫЙ МОЩНОСТИ

Предельные режимы							Материал Техноло- гия	Чер- теж №	
$I_{\text{пр.пер.макс.}}$	τ_u , мкsec	$I_{\text{макс.}}$	$I_{\text{пр.}}$ макс. ампл, ма	f , кГц	Интервал температур, °C				
					-55 - + 100	Si	T	24	
					-55 - + 100	Si	T	24	
		100	$150 \cdot 10^3$		-50 - + 100	Si	T	25	
		100	$150 \cdot 10^3$		-50 - + 100	Si	T	6	
		100	$150 \cdot 10^3$		-50 - + 80	Si	T	25	
		100	$150 \cdot 10^3$		-50 - + 100	Si	T	25	
		100	$150 \cdot 10^3$		-50 - + 100	Si	T	6	
		100	$150 \cdot 10^3$		-50 - + 80	Si	T	25	
2	10			20	-60 - + 120	Si	МД	106	
				48	100	-55 - + 60	Ge	T	4
				48	100	-60 - + 70	Ge	T	4
				48	100	-55 - + 60	Ge	T	4
				48	100	-60 - + 70	Ge	T	4
				50	100	-55 - + 60	Ge	T	24
				50	100	-60 - + 70	Ge	T	24
				50	100	-55 - + 60	Ge	T	24
				50	100	-60 - + 70	Ge	T	24
				100	-55 - + 60	Ge	T	24	
				100	-55 - + 60	Ge	T	4	
	0,5	$(1-2)10^6$		$20 \cdot 10^3$	-55 - + 100	Si	MC	1	
	0,5	$(1-2)10^6$		$20 \cdot 10^3$	-60 - + 100	Si	MC	1	
				$20 \cdot 10^3$	-50 - + 120	Si	MC	1,21	
				1	-55 - + 100	Si	C	21	
	0,6			1	-60 - + 120	Si	C	21	
				2	-55 - + 70	Ge	C	21	
				2,4	-60 - + 70	Ge	C	21	
				1	-60 - + 80	Si	C	22	
				25	100	-55 - + 80	Ge	C	24
				25	$20 \cdot 10^3$	-60 - + 70 -55 - + 100	Ge	T	24
	0,5	$(1-2)10^6$				Si	T	1	
	0,5	$(1-2)10^6$		$20 \cdot 10^3$	-60 - + 120	Si	MC	1	
				$20 \cdot 10^3$	-50 - + 126	Si	MC	1,21	

ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЕ ДИОДЫ

№ пп.	Тип прибора	Предельные режимы		U _{пр} ,		I _{обр.} при U _{обр.} макс t = 25°C, мка	I _{обр.} , U _{обр} , T,
		U _{обр. макс} , в	I _{пр.ср.макс} , ма	в	ма		
207	Д7В	150	300	0,5	300	100	1000 50 + 70
208	Д207	200	100	1	100	100	200 50 + 100
209	Д207 ^х	200	100	1	100	50	100 200 + 120
210	Д237А ^х	200	300	1	300	50	100 200 + 125
211	КД105А	200	300	1	300	100	300 200 + 85
212	Д226Г	200	300	1	300	100	300 150 + 80
213	Д226Е ^х	200	300	1	300	50	100 150 + 80
214	МД226Е ^х	200	300	1	300	50	100 150 + 80
215	Д7Г	200	300	0,5	300	100	1000 150 + 70
216	Д7Г ^х	200	300	0,5	300	100	1000 65 + 70
217	1602А	200	300	0,5	300	100	1000 100 + 70
218	КД102А	250	100	1	50	0,1	50 250 + 100
219	2Д102А	250	100	1	50	0,1	50 250 + 120
220	КД104А	300	10	1	10	3	100 250 + 70
221	2Д104А	300	10	1	10	3	100 300 + 70
222	Д208	300	100	1	100	100	200 300 + 100
223	Д208 ^х	300	100	1	100	50	100 300 + 120
224	КД102Б	300	100	1	50	3	100 300 + 100
225	2Д102Б	300	100	1	50	3	100 300 + 120
226	Д7Д	300	300	0,5	300	100	1000 80 + 70
227	Д7Д ^х	300	300	0,5	300	100	1000 130 + 70
228	Д226В	300	300	1	300	100	300 200 + 80
229	Д226А ^х	300	300	1	300	50	100 200 + 80
230	МД226А ^х	300	300	1	300	50	100 200 + 80
231	1602Б	300	300	0,5	300	100	1000 130 + 70
232	Д7Е	350	300	0,5	300	100	1000 110 + 70
233	Д7Е ^х	350	300	0,5	300	100	1000 140 + 70
234	Д209	400	100	1	100	100	200 400 + 100
235	Д209 ^х	400	100	1	100	50	100 400 + 120
236	Д7Ж	400	300	0,5	300	100	1000 130 + 70
237	Д7Ж ^х	400	300	0,5	300	100	1000 150 + 70
238	Д226Б	400	300	1	300	100	300 300 + 80
239	Д226 ^х	400	300	1	300	50	100 300 + 80

МАЛОЙ МОЩНОСТИ

Предельные режимы							Материал Техноло- гия	Чер- теж №
I _{пр.пер.макс,}	I _{макс,}	I _{пр.} макс. ампл,	f ,	Интервал температур,				
a	τ_u , мкsec	a	τ_u , сек	ма	кгц	°C		
10	100	5	$30 \cdot 10^{-3}$		2	-55-+ 70	Ge C	21
					1	-55-+100	Si C	21
					1	-60-+120	Si C	21
		15	0,02		1	-60-+125	Si D	21
					1	-60-+185	Si D	27
					1	-60-+80	Si C	22
		2,5	3 + 4 пер		1	-60-+80	Si C	22
		2,5	3 + 4 пер		1	-60-+80	Si D	21
					2	-50-+70	Ge C	21
					2,4	-60-+ 70	Ge C	21
		1	0,1		2,4	-60-+70	Ge C	21
0,5	10					-55-+100	Si МД	108
0,5	10				3	-60-+120	Si МД	108
1	$1 \cdot 10^8$				20	-60-+ 70	Si МД	107
1	$1 \cdot 10^8$				20	-60-+ 70	Si МД	107
					1	-55-+100	Si C	21
			0,6		1	-60-+120	Si C	21
0,5	10					-55-+100	Si МД	108
0,5	10				3	-60-+120	Si МД	108
					2	-55-+ 70	Ge C	21
					2,4	-60-+ 70	Ge C	21
					1	-60-+ 80	Si C	22
		2,5	3+4 пер		1	-60-+ 80	Si C	22
		2,5	3+4 пер		1	-60-+ 80	Si D	21
		1	0,1		2,4	-60-+ 70	Ge C	21
					2	-55-+ 70	Ge C	21
					2,4	-60-+ 70	Ge C	21
					1	-55-+100	Si C	21
		0,8			1	-60-+120	Si C	21
					2	-55-+ 70	Ge C	21
					2,4	-55-+ 70	Ge C	21
					1	-60-+ 80	Si C	22
		2,5	3+4 пер		1	-60-+ 80	Si C	22

ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЕ ДИОДЫ

№ пп.	Тип прибора	Пределевые режимы		$U_{\text{пр.}}$ в	$I_{\text{пр.}}$ ма	$I_{\text{обр.}}$ при $U_{\text{обр.}}$ макс $t = 25^\circ\text{C}$, мка	$I_{\text{обр.}}$ мка	$I_{\text{обр.}}$	
		$U_{\text{обр.макс.}}$ в	$I_{\text{пр.ср.макс.}}$ ма					$U_{\text{обр.}}$ в	T $^\circ\text{C}$
240	МД226 ^x	400	300	1	300	50	100	300	+ 80
241	КД105Б	400	300	1	300	100	300	300	+ 85
242	Д237Б ^x	400	300	1	300	50	100	400	+125
243	1802В	400	300	0,5	300	100	1000	150	+ 70
244	Д210	500	100	1	100	100	200	500	+100
245	Д210 ^x	500	100	1	100	50	100	500	+120
246	КД205Е	500	300	1,5	300	100	200	500	+ 70
247	Д237В ^x	600	100	1	100	100	100	600	+125
248	Д211	600	100	1	100	100	200	600	+100
249	Д211 ^x	600	100	1	100	50	100	600	+120
250	КД105В	600	300	1	300	100	300	450	+ 85
251	Д217	800	100	1	100	75	150	800	+100
252	Д217 ^x	800	100	0,7	100	50	150	800	+120
253	МД217	800	100	1	100	75	150	800	+100
254	МД217 ^x	800	100	0,7	100	50	150	800	+120
255	КД105Г	800	300	1	300	100	300	800	+ 85
256	Д218	1000	100	1	100	75	150	1000	+100
257	Д218 ^x	1000	100	0,7	100	50	150	1000	+120
258	МД218	1000	100	1	100	75	150	1000	+100
259	МД218 ^x	1000	100	0,7	100	50	150	1000	+120

МАЛОЙ МОЩНОСТИ

Пределевые режимы							Материал Технология	Чертеж №
$I_{\text{пр.пер.макс'}}$	τ_u , мксак	$I_{\text{макс'}}$	τ_u , сек	$I_{\text{пр.}}макс.ампл.,$ ма	f , кГц	Интервал температур, °C		
10	100	2,5	3+4 пер	1	-	-60-+ 80	Si Д	21
		15	0,02	1	-	-60-+ 85	Si Д	27
		5	$30 \cdot 10^{-3}$	1	-	-60-+125	Si Д	21
		1	0,1	2,4	-	-60-+ 70	Ge С	21
				1	-	-55-+100	Si С	21
		0,8		1	-	-60-+120	Si С	21
10	100			1	-	-40-+ 70	Si С	72
		5	$30 \cdot 10^{-3}$	1	-	-60-+125	Si Д	21
				1	-	-55-+100	Si С	21
		0,8		1	-	-60-+120	Si С	21
		15	0,02	1	-	-60-+ 85	Si Д	49
				1	-	-40-+100	Si С	21
		0,8		1	-	-60-+120	Si С	21
				1	-	-40-+100	Si Д	21
		0,8		1	-	-60-+120	Si Д	21
		15	0,02	1	-	-60-+ 85	Si Д	49
				1	-	-40-+100	Si С	21
		0,8		1	-	-60-+120	Si С	21
		0,8		1	-	-40-+100	Si Д	21

ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЕ ДИОДЫ

№ пп.	Тип прибора	Пределевые режимы		U _{пр.ср,}		I _{обр.ср,} при U _{обр.макс} t = 25°C,	I _{обр,}	U _{обр,}		T, °C
		U _{обр. макс,} в	I _{пр.ср. макс,} а	в	а			ма	в	
260	КД202Б	50	1	1	1	1	1	50	+120	
261	КД202А	50	3	1	3	1	1	50	+120	
262	Д305	50	10	0,35	10	2,5	20	50	+ 70	
263	Д305 ^x	50	10	0,35	10	2,5	20	50	+ 70	
264	Д229В	100	0,4	1	0,4	0,3	0,5	100	+ 85	
265	Д202	100	0,4	1	0,4	0,5	0,5	100	+ 85	
266	Д202 ^x	100	0,4	1	0,4	0,5	0,5	100	+125	
267	КД205Д	100	0,5	1	0,5	0,1	0,2	100	+ 70	
268	КД202Г	100	1	1	1	1	1	100	+120	
269	2Д202Г	100	3	1	3	1	1	100	+120	
270	КД202В	100	3	1	3	1	1	100	+120	
271	2Д202В	100	3	1	3	1	1	100	+120	
272	Д304	100	5	0,3	5	2	10	50	+ 70	
273	Д304 ^x	100	5	0,3	5	2	10	50	+ 70	
274	Д214Б ^x	100	5	1,5	5	3	3	100	+120	
275	Д242Б	100	5	1,5	5	3	3	100	+120	
276	2Д201А	100	5	1	5	3	3	100	+120	
277	2Д201Б	100	10	1	10	3	3	100	+120	
278	Д242	100	10	1,25	10	3	3	100	+120	
279	Д242А	100	10	1	10	3	3	100	+120	
280	Д214 ^x	100	10	1,20	10	3	3	100	+120	
281	Д214А ^x	100	10	1	10	3	3	100	+120	
282	Д303	150	3	0,35	3	1	3	50	+ 70	
283	Д303 ^x	150	3	0,35	3	1	4	50	+ 70	
284	Д303А	150	3	0,35	3	1,2	4	50	+ 55	
285	Д203	200	0,4	1	0,4	0,5	0,5	200	+ 85	
286	Д 203 ^x	200	0,4	1	0,4	0,5	0,5	200	+125	
287	Д 229Г ^x	200	0,4	1	0,4	0,3	0,5	200	+ 85	
288	Д 229А ^x	200	0,4	1	0,4	0,05	0,25	200	+120	
289	КД205Г	200	0,5	1	0,5	0,1	0,2	200	+ 70	
290	Д302 ^x	200	1	0,3	1	0,8	3	50	+ 70	
291	Д302 ^x	200	1	0,3	1	0,8	3	50	+ 70	
292	Д302А	200	1	0,3	1	1,2	3,7	50	+ 55	
293	КД202Е	200	1	1	1	1	1	200	+120	
294	КД202Д	200	3	1	3	1	1	200	+120	
295	2Д202Д	200	3	1	3	1	1	200	+120	
296	2Д202Е	200	3	1	3	1	1	200	+120	
297	Д243Б ^x	200	5	1,5	5	3	3	200	+120	
298	Д215Б ^x	200	5	1,5	5	3	3	200	+120	
299	2Д201В	200	5	1	5	3	3	200	+120	
300	2Д201Г	200	10	1	10	3	3	200	+120	
301	Д243	200	10	1,25	10	3	3	200	+120	
302	Д215 ^x	200	10	1,2	10	3	3	200	+120	
303	Д243А ^x	200	10	1	10	3	3	200	+120	
304	Д215А ^x	200	10	1	10	3	3	200	+120	
305	Д204	300	0,4	1	0,4	0,5	0,5	300	+ 85	
306	Д204 ^x	300	0,4	1	0,4	0,5	0,5	300	+125	
307	Д229Д	300	0,4	1	0,4	0,3	0,5	300	+ 85	
308	КД205В	300	0,5	1	0,5	0,1	0,2	300	+ 70	

СРЕДНЕЙ МОЩНОСТИ

Предельные режимы							Материал Технология	Чертеж №
I _{пр.пер.макс,} а	τ _u , мкsec	I _{макс,} а	τ _u , сек	I _{пр. макс, ампл,} ма	f , кГц	Интервал температур, °C		
9	1,5	9	1,5	1,2	1,2	-60 -+ 130к	Si	Д 91
9	1,5	9	1,5	1,2	1,2	-60 -+ 130к	Si	Д 91
				.		-60 -+ 70	Ge	С 90
						-60 -+ 70	Ge	С 88,89
				1		-55 -+ 85	Si	Д 37,95
				20		-55 -+ 85	Si	Д 94
				20		-60 -+ 125	Si	Д 94
				1		-40 -+ 70	Si	С 72
9	1,5	9	1,5	1,2	1,2	-60 -+ 130к	Si	Д 91
9	1,5	9	1,5	1,2	1,2	-60 -+ 120	Si	Д 91
9	1,5	9	1,5	1,2	1,2	-60 -+ 130	Si	Д 91
9	1,5	9	1,5	1,2	1,2	-60 -+ 120	Si	Д 91
						-60 -+ 70	G	С 90
						-60 -+ 70	Ge	С 88,89
15	1,5	15	1,5	1	1	-60 -+ 130к	Si	Д 93
						-60 -+ 130к	Si	Д 93
						-60 -+ 130к	Si	Д 93
						-60 -+ 130к	Si	Д 93
				1		-60 -+ 130к	Si	Д 93
15	1,5	15	1,5	1		-60 -+ 130к	Si	Д 93
15	5	15	5	1		-60 -+ 130к	Si	Д 93
				1		-60 -+ 130к	Si	Д 93
						-60 -+ 70	Ge	С 90
						-60 -+ 70	Ge	С 88,89
						-55 -+ 55	Ge	С 90
					20	-55 -+ 85	Si	Д 94
					20	-60 -+ 125	Si	Д 94
					1	-55 -+ 85	Si	Д 37,95
1,0	100	10	10.10 ⁻³	1	1	-60 -+ 120	Si	Д 37
					1	-40 -+ 70	Si	С 72
						-60 -+ 70	Si	С 90
						-60 -+ 70	Si	С 88,89
						-55 -+ 55	Si	С 90
9	1,5	9	1,5	1,2		-60 -+ 130к	Si	Д 91
9	1,5	9	1,5	1,2		-60 -+ 130к	Si	Д 91
9	1,5	9	1,5	1,2		-60 -+ 130к	Si	Д 91
9	1,5	9	1,5	1,2		-60 -+ 130к	Si	Д 91
				1		-60 -+ 130к	Si	Д 93
-15	1,5	-15	1,5	1		-60 -+ 130к	Si	Д 93
						-60 -+ 130к	Si	Д 93
						-60 -+ 130к	Si	Д 93
					1	-60 -+ 130к	Si	Д 93
15	1,5	15	1,5	1		-60 -+ 130к	Si	Д 93
				1		-60 -+ 130к	Si	Д 93
15	1,5	15	1,5	1		-60 -+ 130к	Si	Д 93
				20		-55 -+ 85	Si	Д 94
				20		-60 -+ 125	Si	Д 94
				1		-55 -+ 85	Si	Д 37,94а
				1		-40 -+ 70	Si	С 72

ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЕ ДИОДЫ

№ пп.	Тип прибора	Пределевые режимы		U _{пр.ср,}		I _{обр.ср. при U_{обр.макс} t = 25°C}	I _{обр,}			
		U _{обр. макс,} в	I _{пр.ср. макс,} а	в	а		ма	ма	в	Т, °C
309	КД202И	300	1	1	1	1	1	1	300	+120
310	КД202Ж	300	3	1	1	1	1	1	300	+120
311	2Д202Ж	300	3	1	1	1	1	1	300	+120
312	2Д202И	300	3	1	3	3	3	3	300	+120
313	Д231Б ^х	300	5	1,5	5	3	3	3	300	+120
314	Д245Б	300	5	1,5	5	3	3	3	300	+120
315	Д245	300	10	1,25	10	3	3	3	300	+120
316	Д245А	300	10	1	10	3	3	3	300	+120
317	Д231 ^х	300	10	1	10	3	3	3	300	+120
318	Д231А [*]	300	10	1	10	3	3	3	300	+120
319	Д205	400	0,4	1	0,4	0,5	0,5	0,5	400	+ 85
320	Д205 ^х	400	0,4	1	0,4	0,5	0,5	0,5	400	+125
321	Д229Е	400	0,4	1	0,4	0,3	0,5	0,5	400	+ 85
322	Д229Б ^х	400	0,4	1	0,4	0,05	0,25	0,25	400	+120
323	КД205Б	400	0,5	1	0,5	0,1	0,2	0,2	400	+ 70
324	КД202Л	400	1	1	1	1	1	1	400	+120
325	2Д202Л	400	3	1	3	1	1	1	400	+120
326	2Д202К	400	3	1	3	1	1	1	400	+120
327	2Д202К	400	3	1	3	1	1	1	400	+120
328	Д232Б ^х	400	5	1,5	5	3	3	3	400	+120
329	Д246Б	400	5	1,5	5	3	3	3	400	+120
330	Д246	400	10	1,25	10	3	3	3	400	+120
331	Д246А	400	10	1	10	3	3	3	400	+120
332	Д232 ^х	400	10	1	10	3	3	3	400	+120
333	Д232А ^х	400	10	1	10	3	3	3	400	+120
334	КД205А	500	0,5	1	0,5	0,1	0,2	0,2	500	+ 70
335	КД202Н	500	1	1	1	1	1	1	500	+120
336	2Д202Н	500	3	1	3	1	1	1	500	+120
337	КД202Н	500	3	1	3	1	1	1	500	+120
338	2Д202 М	500	3	1	3	1	1	1	500	+120
339	Д247Б	500	5	1,5	5	3	3	3	500	+120
340	Д233Б ^х	500	5	1,5	5	3	3	3	500	+120
341	Д233 ^х	500	10	1	10	3	3	3	500	+120
342	Д247	500	10	1,25	10	3	3	3	500	+120
343	КД202С	600	1	1	1	1	1	1	600	+120
344	2Д202С	600	3	1	3	1	1	1	600	+120
345	КД202Р	600	3	1	3	1	1	1	600	+120
346	2Д202Р	600	3	1	3	1	1	1	600	+120
347	Д248Б	600	5	1,5	5	3	3	3	600	+120
348	Д234Б ^х	600	5	1,5	5	3	3	3	600	+120
349	КД203А	600	10	1	10	1,5	1,5	1,5	600	+100
350	2Д203А	600	10	1	10	1,5	1,5	1,5	600	+100
351	КД203Б	800	10	1	10	1,5	1,5	1,5	800	+100
352	2Д203Б	800	10	1	10	1,5	1,5	1,5	800	+100
353	КД203В	800	10	1	10	1,5	1,5	1,5	800	+100
354	2Д203В	800	10	1	10	1,5	1,5	1,5	800	+100
355	КД203Г	1000	10	1	10	1,5	1,5	1,5	1000	+100
356	2Д203Г	1000	10	1	10	1,5	1,5	1,5	800	+100
357	КД203Д	1000	10	1	10	1,5	1,5	1,5	1000	+100
358	2Д203Д	1000	10	1	10	1,5	1,5	1,5	800	+100

СРЕДНЕЙ МОЩНОСТИ

Пределевые режимы							Материал Технология	Чертеж №
I _{пр.пер.макс,}	I _{макс,}	I _{пр.} макс. ампл,	f ,	Интервал температур,				
a	τ_u , мкsec	a	τ_u , сек	ма	кГц	°C		
		9	1,5		1,2	-60-+130к	Si Д	91
		9	1,5		1,2	-60-+130к	Si Д	91
		9	1,5		1,2	-60-+130к	Si Д	91
		9	1,5		1,2	-60-+130к	Si Д	91
		15	1,5		1	-60-+130к	Si Д	93
					1	-60-+130к	Si Д	93
					1	-60-+130к	Si Д	93
					1	-60-+130к	Si Д	93
		30	1,5		1	-60-+130к	Si Д	93
		30	1,5		1	-60-+130к	Si Д	93
					20	-55-+85	Si Д	94
					20	-60-+125	Si Д	94
					1	-55-+85	Si Д	37,94а
1,0	100	10	$10 \cdot 10^{-3}$		1	-60-+120	Si Д	37
					1	-40-+70	Si С	72
		9	1,5		1,2	-60-+130к	Si Д	91
		9	1,5		1,2	-60-+130к	Si Д	91
		9	1,5		1,2	-60-+130к	Si Д	91
		9	1,5		1,2	-60-+130к	Si Д	91
					1	-60-+130к	Si Д	93
					1	-60-+130к	Si Д	93
					1	-60-+130к	Si Д	93
		30	1,5		1	-60-+130к	Si Д	93
		30	1,5		1	-60-+130к	Si Д	93
					1	-40-+70	Si С	72
		9	1,5		1,2	-60-+130к	Si Д	91
		9	1,5		1,2	-60-+130к	Si Д	91
		9	1,5		1,2	-60-+130к	Si Д	91
		9	1,5		1,2	-60-+130к	Si Д	91
					1	-60-+130к	Si Д	93
		15	1,5		1	-60-+130к	Si Д	93
		15	1,5		1	-60-+130к	Si Д	93
					1	-60-+130к	Si Д	93
		9	1,5		1,2	-60-+130к	Si Д	91
		9	1,5		1,2	-60-+130к	Si Д	91
		9	1,5		1,2	-60-+130к	Si Д	91
		9	1,5		1,2	-60-+130к	Si Д	91
					1	-60-+130к	Si Д	93
		30	1,5		1	-60-+130к	Si Д	93
		30	1,5		1	-55-+100к	Si Д	93
		30	1,5		1	-60-+130к	Si Д	93
		30	1,5		1	-55-+100к	Si Д	93
		30	1,5		1	-60-+130к	Si Д	93
		30	1,5		1	-55-+100к	Si Д	93
		30	1,5		1	-60-+130к	Si Д	93
		30	1,5		1	-55-+100к	Si Д	93
		30	1,5		1	-60-+130к	Si Д	93
		30	1,5		1	-55-+100к	Si Д	93
		30	1,5		1	-60-+130к	Si Д	93

ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЕ

№ пп.	Тип прибора	Предельные режимы		U _{пр.ср,}		I _{обр.ср} при U _{обр.макс} t = 25°C,	I _{обр.ср,}	
		U _{обр.} макс, в	I _{пр.ср.} макс, ма	I _{пр.ср,} в	I _{пр.ср,} ма		U _{обр,} в	T, °C
358	Д1011А ^x	500 ^x	300 ^x	2,5 ^x	300 ^x	100 ^x	300 ^x	500 ^x +70
360	Д1011А ^x	500 ^x	300 ^x	1,5 ^x	300 ^x	100 ^x	300 ^x	500 ^x +80
361	2Ш101А	700	10	8,3	50	10	100	700 +70
362	2Ш102А	800	100	1,5	100	50	150	800 +120
363	Д1009А ^x	1000 ^x	100 ^x	3 ^x	100 ^x	100 ^x	300 ^x	1000 ^x +70
364	Д1009А ^x	1000 ^x	100 ^x	1,75 ^x	100 ^x	100 ^x	300 ^x	1000 ^x +80
365	2Ш102Б	1000	100	1,5	100	150	150	1000 +120
366	Д1010А ^x	1000 ^x	300 ^x	5 ^x	300 ^x	100 ^x	300 ^x	1000 ^x +70
367	Д1010А ^x	1000 ^x	300 ^x	3 ^x	300 ^x	100 ^x	300 ^x	1000 ^x +80
368	2Ш102В	1200	100	1,5	100	50	150	1200 +120
369	Д1004	2000	100	6	100	100	250	2000 +100
370	Д1004 ^x	2000	100	5	100	100	250	2000 +125
371	Д1009	2000	100	4	100	100	300	2000 +70
372	Д1009 ^x	2000	100	3,5	100	100	300	2000 +80
373	Д1010	2000	300	8	300	100	300	2000 +70
374	Д1010 ^x	2000	300	6	300	100	300	2000 +80
375	Д1005А	4000	50	6	50	100	250	4000 +100
376	Д1005А ^x	4000	50	5	50	100	250	4000 +125
377	Д1005Б	4000	100	11	100	100	250	4000 +100
378	Д1005Б ^x	4000	100	10	100	100	250	4000 +125
379	Д1006	6000	100	11	100	100	250	6000 +100
380	Д1006 ^x	6000	100	10	100	100	250	6000 +125
381	Д1006А ^x	6000	500	10	500	100	250	6000 +120
382	Д1006А	6000	500	11	500	100	250	6000 +100
383	Д1007	8000	75	11	75	100	250	8000 +100
384	Д1007 ^x	8000	75	10	75	100	250	8000 +125
385	Д1007А ^x	8000	500	10	500	100	250	8000 +120
386	Д1007А	8000	500	11	500	100	250	8000 +100
387	Д1008	10000	50	11	50	100	250	10000 +100
388	Д1008 ^x	10000	50	10	50	100	250	10000 +125
389	Д1008А ^x	10000	500	10	500	100	250	10000 +120
390	Д1008А	10000	500	11	500	100	250	10000 +100

СТОЛЫ

Пределевые режимы					Материал Технология	Чер- теж
$I_{\text{пр.пер.макс}},$ а	$I_{\text{макс}},$ а	$I_{\text{пр.макс.ампл}},$ ма	$f,$ кГц	Интервал температур, °C		
1	1,8	1	-40 -+70	Si C	68	
	1,8	1	-60 -+80	Si C	68	
	20	-60 -+70	Si C	57		
	2,5	3 + 4пер	1	-60 -+120	Si МД	8
	0,8	1	-40 -+70	Si C	67	
	0,8	1	-60 -+80	Si C	67	
	2,5	3 + 4пер	1	-60 -+120	Si C	8
	1,8	1	-40 -+70	Si C	66	
	1,8	1	-60 -+80	Si C	66	
	2,5	3 + 4пер	1	-60 -+120	Si C	8
	0,8	1	-40 -+100	Si C	61	
	0,8	1	-60 -+125	Si C	61	
	0,8	1	-40 -+70	Si C	65	
	0,8	1	-60 -+80	Si C	65	
	1,8	1	-40 -+70	Si C	64	
	1,8	1	-60 -+80	Si C	64	
	0,3	1	-40 -+100	Si C	61	
	0,3	1	-60 -+125	Si C	61	
	0,8	1	-40 -+100	Si C	62	
	0,8	1	-60 -+125	Si C	62	
	0,8	1	-40 -+100	Si C	62	
	0,8	1	-60 -+125	Si C	62	
	3,0	1	-60 -+120	Si C	63	
	3,0	1	-40 -+100	Si C	63	
	0,45	1	-40 -+100	Si C	62	
	0,45	1	-60 -+125	Si C	62	
	3,0	1	-60 -+120	Si C	63	
	3,0	1	-40 -+100	Si C	63	
	0,3	1	-40 -+100	Si C	62	
	0,3	1	-60 -+125	Si C	62	
	3,0	1	-60 -+120	Si C	63	
	3,0	1	-40 -+100	Si C	63	

ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЕ БЛОКИ

№ пп.	Тип прибора	Схема соединения	Предельные режимы				U _{пр.ср,} в	I _{пр.ср,} ма		
			U _{обр.макс,} в		I _{пр.ср.макс,} ма			I _{пр.ср,} ма		
			I плечо	II плечо	I плечо	II плечо		I плечо	II плечо	
391	KЦ401A	удвоитель напряжения	500	500	400	300	2,5	400	300	
392	KЦ402Б	мост	500		500		2,5		500	
		удвоитель напряжения	500	500	400	400	2,5	400	400	
393	KЦ401B	мост	400		500		2,5		500	
		удвоитель напряжения	400	400	400	400	2,5	400	400	

ИМПУЛЬСНЫЕ

№ пп.	Тип прибора	U _{обр} макс, в	(Q _п), (нк), нсек	τ _{восст,}			C _{д,} пф	U _{пр} , в	I _{пр} , ма
				I _{пр} ,	U _{обр.} имп, в	I _{обр.} отсч, ма			
394	ГД508А	8	(20)	10	5		0,75	0,5	0,7
395	1Д508А	8	(20)	10	5		0,75	0,5	0,7
396	ГД508Б	8	(20)	10	5		0,75	0,5	0,65
397	КД503В	10	50	10	10	2	6	0	1,3
398	ГД511А	12	(0,1)	10	10		1	5	0,6
399	ГД511Б	12	(0,05)	10	10		1	5	0,6
400	ГД511В	12	(0,1)	10	10		1	5	0,6
401	КД512А	15	1	10	10	2	1	5	1
402	МД3	15	100	20	10	1	1	5	1
403	ДММЗ	15	100	20	10	1	1	5	1
404	ДММЗВП ^x	15 ^x	100	20	10	1	1	5	1
405	1ДМ505А	15 ^x	100	20	10	1	1	5	1
406	Д18	20	100	50	10	1	0,5	3	1
407	Д18 ^x	20	100	50	10	1	0,5	3	1
408	Д20	20					0,5	3	1
									20

СРЕДНЕЙ МОЩНОСТИ

I обр.ср. при U обр.макс t = 20±5°C, мка	мка	I обр.ср,		T, °C	f, кГц	Интервал температуры, °C	Материал Технология	Чертеж №
		U обр., в	I плечо II плечо					
100	100	500	500	+60	1	-55 - +60	Si C	69
100	100	500		+60	1	-55 - +60	Si C	70
100	100	500	500	+60	1	-55 - +60	Si C	71
100	100	400		+60	1	-55 - +60	Si C	71
100	100	400	400					

ДИОДЫ

I обр. при U обр макс,	U пр.имп. макс, в	Предельные режимы					Материал Технология	Чер- теж №
		R имп. макс, ом	I пр. имп., ма	I пр.ср. макс, ма	I пр.имп.макс, ма	Интервал температуры, °C		
60	1,5	30	10	30	10	-40 - +55	Ge MC	7
60	1,5	30	10	30	10	-60 - +70	Ge MC	7
100	1,5	30	10	30	10	-40 - +55	Ge MC	7
1		10				-0 - +50	Si П	7
50	0,6	5	15	50	1	-55 - +70	Ge T	4
100	0,6	5	15	50	1	-55 - +70	Ge T	4
200	0,6	5	15	50	1	-55 - +70	Ge T	4
5		20	200		10	-40 - +85	Si П	7
100	3,5	20	12	50	10	-60 - +73	Ge MC	9
100	3,5	20	12	50	10	-55 - +70	Ge MC	104
100	3,5	20	12 ^x	50 ^x	10	-60 - +73	Ge MC	104
100	3,5	20	12 ^x	50 ^x	10	-60 - +73	Ge MC	105
50	5	50	18	50	10	-40 - +60	Ge T	5
50	5	50	18	50	10	-60 - +70	Ge T	5
100			18			-40 - +60	Ge T	5

ИМПУЛЬСНЫЕ

№ пп.	Тип прибора	U обр. макс, в	(Q _n), нсек	τ _{восст} ,			C _д , пф	U обр., в	U _{пр} ,	
				I _{пр} , ма	U обр. имп, в	I _{обр.} отсч, ма			I _{пр} , ма	
409	ГД507А	20	100	20	10	1	0,8	5	0,5	5
410	1Д507А	20	100	20	10	1	0,8	5	0,5	5
411	Д310	20	300	500	20	10	15	20	0,55	500
412	Д310 ^x	20	300	500	20	10	15	20	0,55	500
413	КД503А	30	10	10	10	2	5	0	1	10
414	2Д503А	30	10	10	10	2	5	0	1	10
415	КД503Б	30	10	10	10	2	2,5	0	1,2	10
416	2Д503Б	30	10	10	10	2	2,5	0	1,2	10
417	Д311	30	50	50	10	1	1,5	5	0,4	10
418	Д311 ^x	30	50	50	10	1	1,5	5	0,4	10
419	Д311А	30	50	50	10	1	3	5	0,4	10
420	Д311А ^x	30	50	50	10	1	3	5	0,4	10
421	2Д101А	30						1	100	
422	2ДМ101А	30						1	100	
423	2Д502А	30	500	30	30	0,4	20	5	1	10
424	2ДМ502А	30	500	30	30	0,4	20	5	1	10
425	2Д502Б	30	500	30	30	0,4	20	5	1	50
426	2ДМ502Б	30	500	30	30	0,4	20	5	1	50
427	КД504	40	(10)	300	30		25	5	1,2	100
428	2Д504А	40	(10)	300	30		20	5	1,2	100
429	КД509А	50	4	10	10	2	4	0	1,1	100
430	2Д509А	50	4	10	10	2	4	0	1,1	100
431	КД510А	50	4	10	10	2	4	0	1,1	200
432	2Д510А	50	4	10	10	2	4	0	1,1	200
433	КД513А	50	4	10	10	2	4	0	1,1	100
434	Д219С							1	50	
435	Д220С							1,5	50	
436	Д220	50	500	30	30	0,4	15	5	1,5	50
437	Д220 ^x	50	500	30	30	0,4	15	5	1,5	50
438	КД103А	50	4000	50	20	1	20	5	1	50
439	КД103Б	50	4000	50	20	1	20	5	1,2	50
440	Д219А	70	500	30	30	0,4	15	5	1	50
441	Д219А ^x	70	500	30	30	0,4	15	5	1	50
442	Д220А	70	500	30	30	0,4	15	5	1,5	50
443	Д220А ^x	70	500	30	30	0,4	15	5	1,5	50
444	Д312А	75	500	50	10	1	3	5	0,5	10
445	Д312А ^x	75	500	50	10	1	3	5	0,5	10
446	2Д103А	75	4000	50	20	1	20	5	1	50
447	Д220Б	100	500	30	30	0,4	15	5	1,5	50
448	Д220Б*	100	500	30	30	0,4	15	5	1,5	50
449	Д312	100	500	50	10	1	3	5	0,5	10
450	Д312 [*]	100	500	50	10	1	3	5	0,5	10
451	2Д502В	100	500	30	30	0,4	20	5	1	10
452	2ДМ502В	100	500	30	30	0,4	20	5	1	10
453	2Д502Г	100	500	30	30	0,4	20	5	1	50
454	2ДМ502Г	100	500	30	30	0,4	20	5	1	50

ДИОДЫ

I обр. при U обр. макс, мка	U пр.имп. макс,	Предельные режимы						Материал Технология	Чер- теж №	
		R имп. макс, ом	I пр. имп., ма	I пр.ср. макс, ма	I пр.имп.макс, ма	τ имп., мкsec	Интервал температур, °C			
50	4		50	16	100	10	-40 -+80	Ge	МС	7
50	3,5		50	16	200	1	-60 -+70	Ge	МС	7
20		3	800	250			-55 -+80	Ge	МД	2
20		3	800	250	800	10	-60 -+70	Ge	МД	2/оп/
10	2,5		50	20	200	10	-40 -+70	Si	П	7
4	2,5		50	20	200	10	-60 -+120	Si	П	7
10	3,5		50	20	200	10	-40 -+70	Si	П	7
4	3,5		50	20	200	10	-60 -+120	Si	П	7
100	1,25		50	40	500	10	-40 -+80	Ge	МД	3
100	1,25		50	40	500	10	-60 -+70	Ge	МД	3
100	1		50	80	600	10	-40 -+80	Ge	МД	3
100	1		50	80	600	10	-60 -+70	Ge	МД	3
5			20	200	10	-60 -+80	Si	МС	16	
5			20	200	10	-60 -+80	Si	МС	102	
5	3,5		50	20	200	10	-60 -+80	Si	МС	16
5	3,5		50	20	200	10	-60 -+80	Si	МС	102
5	2,5		50	20	200	10	-60 -+80	Si	МС	16
5	2,5		50	20	200	10	-60 -+80	Si	МС	102
2	2		500	240	240	10	-55 -+100	Si	МС	2
2	2		500	240	240	10	-60 -+120	Si	МС	2
5			100	1500	10	-55 -+85	Si	П	7	
5			100	1500	10	-60 -+120	Si	П	7	
5			200	1500	10	-60 -+85	Si	П	3	
5			200	1500	10	-55 -+120	Si	П	3	
5			100	1500	10	-55 -+85	Si	П	82	
			50	500	10	-60 -+120	Si	МС	1	
			50	500	10	-60 -+120	Si	МС	1	
1	3,75		50	50	500	10	-55 -+100	Si	МС	1
1		75	50	50	500	10	-60 -+100	Si	МС	1
1	5		2000	100	2000	10	-55 -+100	Si	МД	106
1	5		2000	100	2000	10	-55 -+100	Si	МД	106
1	2,5		50	50	500	10	-55 -+100	Si	МС	1
1		50	50	500	10	-60 -+100	Si	МС	1	
1	8,75		50	50	500	10	-55 -+100	Si	МС	1
1		75	50	50	500	10	-60 -+100	Si	МС	1
100	1,25		50	50	500	10	-40 -+80	Ge	МС	3
100	1,25		50	50	500	10	-60 -+70	Ge	МС	3
1	5		500	100	2000	10	-60 -+120	Si	МД	106
1	3,75		50	50	500	10	-55 -+100	Si	МС	1
1		75	50	50	500	10	-60 -+100	Si	МС	1
100	1,25		50	50	500	10	-40 -+60	Ge	МД	3
100	1,25		50	50	500	10	-60 -+70	Ge	МД	3
5	3,5		50	20	200	10	-60 -+80	Si	МС	16
5	3,5		50	20	200	10	-60 -+80	Si	МС	102
5	2,5		50	20	200	10	-60 -+80	Si	МС	16
5	2,5		50	20	200	10	-60 -+80	Si	МС	102

ТУННЕЛЬНЫЕ

№ пп.	Тип прибора	I _п , ма	ΔI _п , ма	C _д ,		I _п /I _в	U _п ,		U _в ,		U _{pp} ,		f _{макс} , Гц
				мин	макс		мин	макс	мин	макс	мин	макс	
				ПФ			МВ		МВ		МВ		
455	ЗИ101А	1	0,25		3	5		160					
456	АИ101А	1	0,25		4	5		160					
457	ЗИ101Б	1	0,25	2	6	5		160					
458	А'И101Б	1	0,25	2	8	5		160					
459	ИИ102А	1,5	0,25	0,9	1,8	5	70	100	320	400			10
460	ИИ102Б	1,5	0,25	1,4	2,2	5	70	100	320	400			8
481	ИИ102В	1,5	0,25	1,8	3	5	70	100	320	400			5
462	ИИ102Г	2	0,3	1	2	5		90	320	400			10
463	ИИ102Д	2	0,3	1,6	2,6	5		90	320	400			8
464	ИИ102Е	2	0,3	2,2	3,2	5		90	320	400			5
485	ЗИ101В	2	0,3		2	6		160					
486	ЗИ101Г	2	0,3	1	3,7	6		160					
487	АИ101В	2	0,3		5	6		160					
468	ЗИ101Д	2	0,3	2,5	6	6		160					
489	ЗИ306Г	2	0,2		8	8		170					850
470	АИ101Д	2	0,3	2,5	10	6		160					
471	АИ301А	2	0,4		12	8		180					850
472	ЗИ306Е	2	0,2	4	12	8		170					850
473	ГИ307А	2	0,2	4	20	7	70						400
474	ИИ102Ж	2,7	0,4	1,2	2,2	5	70	90	320	400			10
475	ИИ102И	2,7	0,4	1,8	2,7	5	70	90	320	400			8
476	ИИ102К	2,7	0,4	2,3	3,5	5	70	90	320	400			5
477	ИИ304А	4,5-			20	5		75					420
		5,1											
478	ГИ304А	4,5-			20	5		75					420
		5,1											
479	ИИ304Б	4,9-			20	5		75					420
		5,5											
480	ГИ304Б	4,9-			20	5		75					420
		5,5											
481	ЗИ101Е	5	0,5		3	6		180					
482	ЗИ101Ж	5	0,5	2	6	6		180					
483	АИ101Е	5	0,5	2	8	6		180					
484	ЗИ101И	5	0,5	4,5	10	6		180					
485	АИ101И	5	0,5	4,5	13	6		180					
486	ЗИ306Ж	5	0,5		15	8		170					850
487	АИ301Б	5	0,5		25	8		180					850
488	АИ301В	5	0,5		25	8		180					1000
489	ЗИ306К	5	0,5	8	25	8		170					850
490	ИИ305А	9,1-			30	5		85					430
		10,1											
491	ГИ305А	9,1-			30	5		85					430
		10,1											
492	ИИ305Б	9,8-			30	5		85					430
		11											
493	ГИ305Б	9,8-			30	5		85					430
		11											

диоды

ТУННЕЛЬНЫЕ

№ пп.	Тип прибора	I _П , ма	ΔI _П , ма	C _д ,		I _П /I _В	U _П , мин макс		U _В , мин макс		U _{pp} , мин макс		f _{макс,} Гц
				мин	макс		мин	макс	мин	макс	мин	макс	
				пФ			МВ		МВ		МВ		
494	ЗИ201А	10	1		3,5	10		200					
495	ЗИ201Б	10	1	2,5	6	10		180					
496	АИ201А	10	1		8	10		180					
497	ЗИ201В	10	1	4,5	10	10		180					
498	ЗИ306Л	10	1		12	8		170					850
499	АИ201В	10	1	5	15	10		180					
500	ЗИ306М	10	1		30	8		170					850
501	ЗИ306Н	10	1	15	50	8		170					850
502	АИ301Г	10	1		50	8		180					800
503	ЗИ202А	10	10		3	10		200					
504	ЗИ202Б	10	10	1,5	3	10		200					
505	ЗИ202В	10	10	2,3	4,8	10		200					
506	ЗИ201Г	20	2		4	10		210					
507	ЗИ201Д	20	2	3	7	10		200					
508	АИ201Г	20	2		10	10		200					
509	ЗИ201Е	20	2	5	12	10		200					
510	АИ201Е	20	2	6	20	10		200					
511	ЗИ202Г	20	10		4	10		220					
512	ЗИ202Д	20	10	2	4	10		220					
513	ЗИ202Е	20	10	3	6	10		220					
514	ЗИ202Ж	30	10		5	10		240					
515	ЗИ202Н	30	10	4	8	10		240					
516	ЗИ202К	50	10		10	10		260					
517	ЗИ201Ж	50	5		8	10		260					
518	АИ201Ж	50	5		15	10		260					
519	ЗИ201И	50	5	6,5	15	10		260					
520	АИ201И	50	5	10	30	10		260					
521	ЗИ201К	100	10		15	10		330					
522	АИ201К	100	10		20	10		330					
523	ЗИ201Л	100	10	10	40	10		330					
524	АИ201Л	100	10	10	50	10		330					

ДИОДЫ

$L_{\text{корп}} (L_d)$		R_d		Предельные режимы						Интервал температур, °C	Материал Техно-логия	Чертеж №	
мин	макс	мин	макс	I_{CM} , ма	$I_{\text{пр. макс}}, \text{ма}$	$I_{\text{пр.имп. макс}}, \text{ма}$	$t_u, \text{мксек}$	$I_{\text{обр. макс}}, \text{ма}$	$I_{\text{обр.имп. макс}}, \text{ма}$	$t_u, \text{мксек}$			
НГН		ом											

(1)	8	150									-60→+100	GaAs	C	19
(1)	8	150									-60→+100	GaAs	C	19
(1)	8	100									-60→+85	GaAs	C	19
(1)	8	150									-60→+100	GaAs	C	19
(1)	8	100	4	4							-60→+100	GaAs	C	19
			4	4							-60→+85	GaAs	C	19
			9	12							-60→+100	GaAs	C	19
(1,5)	0,5	5									-60→+70	GaAs	C	19
	0,5	4									-60→+85	GaAs	C	12
	0,5	4									-60→+85	GaAs	C	12
	0,5	5	5	150							-60→+100	GaAs	C	19
	0,5	5	5	150							-60→+100	GaAs	C	19
(1)	5	100									-60→+85	GaAs	C	19
	4	150									-60→+100	GaAs	C	19
(1)	4	100									-60→+85	GaAs	C	19
0,5	4										-60→+85	GaAs	C	12
0,5	3										-60→+85	GaAs	C	12
0,5	3										-60→+85	GaAs	C	12
0,5	3										-60→+85	GaAs	C	12
0,5	3										-60→+85	GaAs	C	12
0,5	2										-60→+85	GaAs	C	12
(1)	2,5	250									-60→+100	GaAs	C	19
(1)	2,5	220									-60→+85	GaAs	C	19
	2,5	250									-60→+100	GaAs	C	19
(1)	2,5	220									-60→+85	GaAs	C	19
	2,2	250									-60→+100	GaAs	C	19
(1)	2,2	220									-60→+85	GaAs	C	19
	2,2	250									-60→+100	GaAs	C	19
(1)	2,2	220									-60→+85	GaAs	C	19

ТУННЕЛЬНЫЕ ОБРА

№ пп.	Тип прибора	I_{Π} , ма	C_d , пФ	r_{Π} , ом	$U_{\text{пр}}$		$U_{\text{обр}}$	
					$I_{\text{пр}}$, ма	в	$I_{\text{пр}}$, ма	в
525	ЗИ402А	2		18	100	0,6	0,1	0,25
526	ГИ401А	2,5				0,33	0,1	0,09
527	1И401А	2,5				0,33	0,1	0,09
528	ЗИ402Д	3,5				0,6	0,2	0,25
529	ЗИ402Б	1,5– 3,5		16	100	0,6	0,1	0,25
530	АИ402Б	0,1		4		0,6	0,1	0,25
531	ГИ401Б			5		0,33	0,1	0,09
532	1И401Б			5		0,33	0,1	0,09
533	ЗИ402В		2,7–5	14	100	0,6	0,1	0,25
534	ЗИ402Г			8		0,6	0,1	0,25
535	ЗИ402И			8		0,6	0,4	0,25
536	ЗИ402Е			2–6		0,6	0,2	0,25
537	АИ402Г	0,1		8		0,6	0,1	0,25
538	АИ402Е	0,2		8		0,6	0,2	0,25
539	АИ402И	0,4		10		0,6	0,4	0,25
540	ГИ403А	100		8		0,12	3	0,35
								0,1

ЩЕННЫЕ ДИОДЫ

Пределевые режимы						Материал Техно- логия	Чер- теж №
I _{пр.макс,} ма	I _{пр.имп.макс,} ма	τ _и , мкsec	I _{обр.макс,} ма	I _{обр.имп.макс,} ма	τ _и , мкsec		
0,3		2			-60→+100	GaAs	C 19
0,3		4			-55→+70	Ge	C 20
		4			-60→+70	Ge	C 20
		4			-60→+100	GaAs	C 19
		2			-60→+100	GaAs	C 19
0,5		1			-60→+85	GaAs	C 19
0,5		5,6			-55→+70	Ge	C 20
		5,6			-60→+70	Ge	C 20
		2			-60→+100	GaAs	C 19
		2			-60→+100	GaAs	C 19
		8			-60→+100	GaAs	C 19
		4			-60→+100	GaAs	C 19
		1			-60→+85	GaAs	C 19
		2			-60→+85	GaAs	C 19
		4			-60→+85	GaAs	C 19
10	10		10	10	-40→+60	Ge	C 17

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

№ пп.	Тип прибора	U _{обр.} макс., в	τ восст,			U _{пр} , в	I _{пр} , ма	I _{обр} , мка	C _д , пф
			I _{пр} , ма	U _{обр} , в	I _{отсч} , ма				
541	ГД404АР	3				0,4*	1-		
							10*		
542	ГД403А	5							
543	ГД403Б	5							
544	ГД403В	5							
545	ГД402А	15							
546	1Д402А	15							
547	ГД402Б	15							
548	1Д402Б	15							
549	Д106	30							
550	Д106*	30							
551	Д106А	30							
552	Д106А*	30							
553	Д105	50							
554	Д105А	50							
555	Д104	75							
556	Д104А	75							
557	Д105*	75							
558	Д105А	75							
559	КД401А	75	2	10	30	1	1	5	75
560	2Д401А	75	2	10	30	1	1	5	75
561	КД401Б	75	2	10	30	1	1	10	5
562	2Д401Б	75	2	10	30	1	1	10	5
563	Д104*	100					2	2	10
564	Д104А*	100					1	1	10
									100
									0,7
									0,3
									0,7
									0,3

ДИОДЫ

R_D , ом	R_{BX} ,			К _{ДЛ}		$U_{ОСТ}$ МВ	Пределевые режимы				Материал Технология	Чертеж №
	I _{пр} , ма	КОМ	КГЦ	f, МВ	КГЦ		U _{ЭФФ} МВ	I _{пр.ср.} ма	I _{пр.имп. макс.} ма	Интервал температуры, °C		
15-30	465					3	0,7	3		-55-+60	Ge T	73
15-30	465	75	0,33- 0,47	465	75			5		-55-+55	Ge МД	3
11-24	465	75	0,4- 0,56	465	75			5		-55-+55	Ge МД	3
8-20	465	75	0,47- 0,66	465	75			5		-55-+55	Ge МД	3
4,5 15						25	100	10	-55-+80	Ge МД	7	
4,5 15						30	100	10	-60-+70	Ge МД	7	
6 15						25			-55-+60	Ge МД	7	
6 15						30			-60-+70	Ge МД	7	
						30			-55-+100	Si T	1	
						30			-60-+120	Si T	1	
						30			-55-+100	Si T	1	
						30			-60-+120	Si T	1	
						30			-55-+100	Si T	1	
						30			-60-+120	Si T	1	
						30			-55-+100	Si MC	1	
						30			-60-+120	Si MC	1	
						30			-55-+100	Si MC	1	
						30			-60-+120	Si MC	1	
						30			-60-+120	Si T	1	
						30			-60-+120	Si T	1	

ДИОДНЫЕ

№ пп.	Тип прибора	U обр. макс, в	τ _{восст} ,			U _{пр₁} ,		U _{пр₂} ,		I _{обр.} при U обр. макс, мка	C _д , пф	U _{обр} , в	
			нсек	I _{пр} , ма	U _{обр} , в	I _{отсч} , ма	в	ма	в				
565	2Д910А	5	5	5	5	2	0,5	0,05	0,8	1	0,5	1,5	0
566	2Д910Б	5	5	5	5	2	0,5	0,05	0,8	1	0,5	1,5	0
567	2Д910В	5	5	5	5	2	0,5	0,05	0,8	1	0,5	1,5	0
568	КД902Д	5	10	5	5	1	0,55	0,01	0,85	1	0,2	2	0,1
569	КД902Е	5	10	5	5	1	0,55	0,01	0,85	1	0,2	2	0,1
570	КД902Ж	5	10	5	5	1	0,55	0,01	0,85	1	0,2	2	0,1
571	КД902И	5	10	5	5	1	0,55	0,01	0,85	1	0,2	2	0,1
572	2Д911А	5	30	5	5	5	0,62	0,05	0,85	1	0,5		
573	2Д911Б	5	100	5	5	5	0,55	0,05	0,85	1	0,5		
574	КД904А	10	10	5	5	1	0,45	0,01	0,8	1	0,2	2,5	0,1
575	2Д904А	10	10	5	5	1	0,45	0,01	0,8	1	0,2	2	0,1
576	КД904Б	10	10	5	5	1	0,45	0,01	0,8	1	0,2	2,5	0,1
577	2Д904Б	10	10	5	5	1	0,45	0,01	0,8	1	0,2	2	0,1
578	КД904В	10	10	5	5	1	0,45	0,01	0,8	1	0,2	2,5	0,1
579	2Д904В	10	10	5	5	1	0,45	0,01	0,8	1	0,2	2	0,1
580	КД904Г	10	10	5	5	1	0,45	0,01	0,8	1	0,2	2,5	0,1
581	2Д904Г	10	10	5	5	1	0,45	0,01	0,8	1	0,2	2	0,1
582	КД904Д	10	10	5	5	1	0,45	0,01	0,8	1	0,2	2,5	0,1
583	2Д904Д	10	10	5	5	1	0,45	0,01	0,8	1	0,2	2	0,1
584	КД904Е	10	10	5	5	1	0,45	0,01	0,8	1	0,2	2,5	0,1
585	2Д904Е	10	10	5	5	1	0,45	0,01	0,8	1	0,2	2	0,1
586	КД901А	10	20	5	10	2	0,4	0,01	0,7	1	0,2	4	0,1
587	2Д901А	10	20	5	10	2	0,4	0,01	0,7	1	0,2	4	0,1
588	КД901Б	10	20	5	10	2	0,4	0,01	0,7	1	0,2	4	0,1
589	2Д901Б	10	20	5	10	2	0,4	0,01	0,7	1	0,2	4	0,1
590	КД901В	10	20	5	10	2	0,4	0,01	0,7	1	0,2	4	0,1
591	2Д901В	10	20	5	10	2	0,4	0,01	0,7	1	0,2	4	0,1
592	КД901Г	10	20	5	10	2	0,4	0,01	0,7	1	0,2	4	0,1
593	2Д901Г	10	20	5	10	2	0,4	0,01	0,7	1	0,2	4	0,1
594	КД903А	20	0,15	300	10	1	1,2	75			0,5	10	5
595	КД903Б	20	0,15	300	10	1	1,2	75			0,5	10	5
596	1Д905А	40	0,25	30	30	3	0,6	30			10	15	5
597	1Д905Б	40	0,25	30	30	3	0,6	30			10	15	5
598	1Д905В	40	0,25	30	30	3	0,6	30			10	15	5
599	1Д905Г	40	0,25	30	30	3	0,6	30			10	15	5
600	КД907А	40	4	10	10	2	1	50			6	4	0
601	КД907Б	40	4	10	10	2	1	50			6	4	0
602	КД907В	40	4	10	10	2	1	50			6	4	0
603	КД907Г	40	4	10	10	2	1	50			6	4	0
604	2Д906А	75	3000	50	20	1	1	50			2	20	5

МАТРИЦЫ

U _{уст} , V ma		U _{пр.имп.} макс, V ma		Предельные режимы				Mатериал Техно- логия	Кол- во эле- мен- тов	Чер- теж №	
I _{имп'} ма	I _{имп'} ма	I _{выпр.} ср. (I _{пр.} макс), ма	I _{пр.имп. макс,} ма	τ _{имп} , сек	Q	U _{обр.имп.} макс, V мкsec	Интервал температур, °C				
(10)						-60→+80	Si П	1	110		
(10)						-60→+80	Si П	2	110		
(10)						-60→+80	Si П	3	110		
5						-60→+85	Si П	1	77		
5						-60→+85	Si П	2	77		
5						-60→+85	Si П	3	77		
5						-60→+85	Si П	4	77		
10						-60→+80	Si П	1-3	111		
10						-60→+80	Si П	1-3	111		
5				12	2	-60→+85	Si П	1	77		
5				12	2	-60→+85	Si П	1	78		
5				12	2	-60→+85	Si П	2	77		
5				12	2	-60→+85	Si П	2	78		
5				12	2	-60→+85	Si П	3	77		
5				12	2	-60→+85	Si П	3	78		
5				12	2	-60→+85	Si П	4	77		
5				12	2	-60→+85	Si П	4	78		
5				12	2	-60→+85	Si П	3	77		
5				12	2	-60→+85	Si П	3	78		
5				12	2	-60→+85	Si П	4	77		
5				12	2	-60→+85	Si П	4	78		
5				12	2	-60→+85	Si П	4	78		
5				12	2	-60→+85	Si П	4	78		
5				12	2	-60→+85	Si П	1	76		
5				12	2	-60→+85	Si П	1	76		
5				12	2	-60→+85	Si П	2	76		
5				12	2	-60→+85	Si П	2	76		
5				12	2	-60→+85	Si П	3	76		
5				12	2	-60→+85	Si П	3	76		
5				12	2	-60→+85	Si П	4	76		
5				12	2	-60→+85	Si П	4	76		
2,3	300	75	350	$3 \cdot 10^{-6}$		-60→+70	Si П	8	75		
2,3	300	75	350	$3 \cdot 10^{-6}$		-60→+70	Si П	8	75		
		80	400	1	4800	-60→+70	Si Д	10	87		
		80	400	1	4800	-60→+70	Si Д	9	87		
		80	400	1	4800	-60→+70	Si Д	10	87		
		80	400	1	4800	-60→+70	Si Д	9	87		
		50	700	$2 \cdot 10^{-6}$		60	10	-60→+85	Si ПЭ	1	79
		50	700	$2 \cdot 10^{-6}$		60	10	-60→+85	Si ПЭ	2	79
		50	700	$2 \cdot 10^{-6}$		60	10	-60→+85	Si ПЭ	3	79
		50	700	$2 \cdot 10^{-6}$		60	10	-60→+85	Si ПЭ	4	79
2	2000	5	2000	100	2000	10	100	10	-60→+125	Si ПЭ	74

№№ пп.	Тип прибора	C _{ном} , пФ			K _C	Q _D ,	U _{обр. пост,} в
			U _{обр.} пост, в	f, МГц			
605	Д902	6-12	4	50		30	4
606	КВ 102А	14-28	4	1-10		40	4
607	2В102Г	14-22	4	1-10	3	50	4
608	КВ106Б	15-35	4	1-10		60	4
609	2В106Б	15-35	4	1-10		60	4
610	КВ103А	18-32	4	1-10		50	4
611	2В103А	18-32	4	1-10	3,5	50	4
612	2В102Д	19-28	4	1-10	3	100	4
613	2В102Ж	19-28	4	1-10	4	50	4
614	КВ102Б	19-30	4	1-10		40	4
615	КВ102Г	19-30	4	1-10		100	4
616	КВ102Д	19-30	4	1-10		40	4
617	2В102А	20-25	4	1-10	3	40	4
618	КВ106А	20-50	4	1-10		40	4
619	2В106А	20-50	4	1-10		40	4
620	2В102Б	22-27	4	1-10	3	40	4
621	Д901А	22-32	4	50	4	25	4
622	Д901А*	22-32	4	50	4	25	4
623	Д901Б	22-32	4	50	3	30	4
624	Д901Б*	22-32	4	50	3	30	4
625	2В102В	25-37	4	1-10	3	50	4
626	2В102Е	25-37	4	1-10	3	100	4
627	КВ102В	25-40	4	1-10		40	4
628	Д901В	28-38	4	50	4	25	4
629	Д901В*	28-38	4	50	4	25	4
630	Д901Г	28-38	4	50	3	30	4
631	Д901Г*	28-38	4	50	3	30	4
632	КВ103Б	28-48	4	1-10		40	4
633	2В103Б	28-48	4	1-10	3,5	40	4
634	Д901Д	34-44	4	50	4	25	4
635	Д901Д*	34-44	4	50	4	25	4
636	Д901Е	34-44	4	50	3	30	4
637	Д901Е*	34-44	4	50	3	30	4
638	КВ104А	80-120	4	1-10		100	4
639	2В104А	80-120	4	1-10	3	100	4
640	КВ104Г	95-143	4	1-10		100	4
641	2В104Г	95-143	4	1-10	4	100	4
642	КВ104Б	106-144	4	1-10		100	4
643	2В104Б	106-144	4	1-10	3	100	4
644	КВ104В	128-182	4	1-10		100	4
645	2В104В	128-182	4	1-10	3	100	4
646	КВ104Д	128-182	4	1-10		100	4
647	2В104Д	128-182	4	1-10	4	100	4
648	КВ101А	180-240	0,8	1-10		12	0,8
649	2В105А	400-600	4	1	4	500	4
650	2В105Б	400-600	4	1	3	500	4

КАПЫ

f, МГц	P _{макс,} МВт	Предельные режимы			Материал Технология	Чертеж №
		t (t _K), °C	U _{макс,} В	Интервал температур, °C		
50		25	25	-40-+100	Si С	1
50	90	50	45	-40-+85	Si Д	108
50	90	50	45	-60-+120	Si Д	108
50	5	(75)	90	-55-+100	Si ЭД	97
50	5	(75)	90	-60-+120	Si ЭД	98
50	5000	(50)	80	-40-+85к	Si Д	96
50	5000	(75)	80	-60-+130к	Si Д	96
50	90	50	45	-60-+120	Si Д	109
50	90	50	80	-60-+120	Si Д	109
50	90	50	45	-40-+85	Si Д	109
50	90	50	45	-40-+85	Si Д	109
50	90	50	80	-40-+85	Si Д	109
50	90	50	45	-60-+120	Si Д	109
50	7	(75)	120	-55-+100	Si ЭД	97
50	7	(75)	120	-60-+120	Si ЭД	98
50	90	50	45	-60-+120	Si Д	109
50	250	25	80	-55-+85	Si С	1,33
50	250	25	80	-60-+120	Si С	1,32
50	250	25	45	-55-+85	Si С	1,33
50	250	25	45	-60-+120	Si С	1,32
50	90	50	45	-60-+120	Si Д	109
50	90	50	45	-60-+120	Si Д	109
50	90	50	45	-40-+85	Si Д	109
50	250	25	80	-55-+85	Si С	1,33
50	250	25	80	-60-+120	Si С	1,32
50	250	25	45	-55-+85	Si С	1,33
50	250	25	45	-60-+120	Si С	1,32
50	5000	(50)	80	-40-+85к	Si Д	96
50	5000	(75)	80	-60-+130к	Si Д	96
50	250	25	80	-55-+85	Si С	1,33
50	250	25	80	-60-+120	Si С	1,32
50	250	25	45	-55-+85	Si С	1,33
50	250	25	45	-60-+120	Si С	1,32
10	100	50	45	-40-+85	Si Д	108
10	100	50	45	-60-+120	Si Д	108
10	100	50	80	-40-+85	Si Д	108
10	100	50	80	-60-+120	Si Д	108
10	100	50	45	-40-+85	Si Д	108
10	100	50	45	-60-+120	Si Д	108
10	100	50	45	-40-+85	Si Д	108
10	100	50	45	-60-+120	Si Д	108
10	100	50	80	-40-+85	Si Д	108
10	100	50	80	-60-+120	Si Д	108
10			4	-10-+55	Si Д	15
1	150	50	90	-60-+120	Si С	23
1	150	50	50	-60-+120	Si С	23

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬНЫЕ

№ пп.	Тип прибора	Диапазон длин волн, см	K	L _п ,	L _з ,	τ _{уст} ,	τ _{восст} , (τ _{пер})	f _{пр} ,	U _(пр) ,	(C _д) [*] , C _{корп} ,	τ _в [*] , τ _н Δ, τ _{пр} ,	λ,
				дб	дб	мк- сек	мк- сек	ГГц	в	пф	ом	см
651	1A501А	3,2–3,5	150	0,8						0,12–0,18		3,2
652	1A501Б	3,2	150	0,8						0,12–0,18		3,2
653	1A501В	3,2	150	0,8						0,12–0,18		3,2
654	1A501Г	3,9–3,7	150	0,8						0,12–0,18		3,9
655	1A501Д	3,9–3,7	150	0,8						0,12–0,18		3,9
656	1A501Е	3,9	150	0,8						0,12–0,18		3,9
657	1A501Ж	3,2	150	0,8						0,12–0,18		3,9
658	1A501И	3,2	150	0,8						0,12–0,18		3,9
659	1A504В	3,9	200	0,8						(0,8–0,8)		3,9
660	1A504А	3,9	500	0,5				(40·10 ⁻³)				3,9
661	2A508	2–20	600	0,4				(40·10 ⁻³)		(0,8–0,8)		3,9
662	2A505А			0,4				6 40				

22

6 60

663 2A505Б 0,4

18

6 60

СВЧ диоды

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬНЫЕ

№№ пп.	Тип прибора	Диапазон длин волн, см	K	L _п , дб	L _з , дб	τ _{уст} , мкsec	τ _{восст} , (τ _{пер}), мкsec	f _{пр} , Гц	U _(пр) , в	(C _д) C _{корп} , пФ	τ _в , τ _н , τ _{пр} , ом	λ, см
664	2A505B		0,6									
							18					
									6 60			
665	2A506A		0,4				22					
									6 60			
666	2A506Б		0,4				18					
									6 60			
667	2A506B		0,4				22					
									6 60			
668	2A506Г		0,4				18					
									6 60			
669	2A506Д		0,7				22					
									6 60			
670	2A507A							150				4
									500 (0,8+1,2)			
671	2A507Б							150			1,5	7
									(0,8+1,2)			4
672	2A509A							150			1,5	7
									300			7
									200 (0,9+1,2)			
673	2A509Б							150			1,5	7
									200 (0,7+1)			7
674	2A510A										1,5	7
									30			
											1,5	
											15Δ	
675	2A510Б										(0,7+1,4)	
												9Δ
676	2A510В										(1,2+1,4)	
												1,5
											5Δ	
677	2A503A										(2,2+3,4)	
												3,3
678	2A503Б							6 60			0,365 - 0,435	
												5,0
								6 60			0,365 - 0,435	

СВЧ диоды

Режим				Предельные режимы						Материал Технология	Чертеж №
P _{под} , МВт	I _{см} , ма	U _{обр} , в	f, МГц	P _{имп. макс,} вт	P _{рас макс,} МВт	W _{п.} , эрг	U _{см} , в	U _{пик} , в	Интервал температур, °C		
1 1	0 100			9800	$2 \cdot 10^3$		100		-60--+125	Si C	28
				9000-							
				9800							
1				9000-							
				9800							
1 1	0 100			$9800+50$	$2 \cdot 10^3$		100		-60--+125	Si C	58,
				9800+50							59
1				9800+50							
1 1	0 100			$9800+50$	$2 \cdot 10^3$		100		-60--+125	Si C	58,59
				9800+50							
1				9800+50							
1 1	0 100			9800+50	$2 \cdot 10^3$		100		-60--+125	Si C	58,59
				9100+50							
1				9100+50							
1 1	0 100			9100+50	$2 \cdot 10^3$		100		-60--+125	Si C	58,59
				9100+50							
1 1	0 100			$13700+50$	$2 \cdot 10^3$		100		-60--+125	Si C	58,59
				13700+50							
1	100	100			5000*		200	500	-60--+100	Si Э	47
		100									
1	100	100			5000*		200	300	-60--+100	Si Э	47
		100									
1	25	100			2000*		150	175	-60--+100	Si Э	47
		100									
1 1	25 25	100 100			2000*		150	175	-60--+100	Si Э	47
1	25				1000*		25		-60--+125	Si Э	47
		100									
1				4500							
				10							
1	100			1000*			25		-60--+125	Si Э	47
1				4500							
				10							
1	100			1000*			25		-60--+125	Si Э	47
1				4500							
				10							
5 1	100			10^3	$1 \cdot 10^3$				-60--+125	Si C	60,10
				3000							
5 1	100			10^3	$1 \cdot 10^3$				-60--+125	Si C	60,10
				3000							

ВИДЕО-ДЕТЕКТОРНЫЕ

№№ пп.	Тип прибора	M, Вт $\frac{1}{2}$	β , а/Вт	R,		R _o ,		K _{св}	$t_{ш}$ (R _ш), дБ (ком)	L, $\frac{1}{2}$ В•Вт	λ , см
				мин	макс	мин	макс				
				ом		ом					
679	Д601А*	15				2000			3		
680	Д601Б*	15				2000			3		
681	Д601В*	15				2000			3		
682	Д602А*	15	1,5	200	600				3,2	(12)	2,7-60
683	ДК-В8*	15				1500			8		1,8-3,2
684	Д602Б*	20	1,5	200	600				3,2	(12)	2,7-60
685	ДЗА*	22				300	950		2,5		2,9-30
686	Д607*	30		400	1200				3		
687	Д607А*	30		400	1200				3		
688	Д608*	30		400	1200				3		
689	Д608А*	30		400	1200				3		
690	Д604*	35	2,5	500	900				1,8	8	2,7-4
691	ДЗБ*	40				300	950		2,5		2,9-30
692	2A202A	40	2,5	400	1000				1,5		3-8
693	Д603*	45	4	300	900				2	10	6-60
694	2A201A	80	5,5	400	1000				1,5		8-60
695	Д609*	80		1000	2000				1,6		
696	ДК-И2М*		0,2								10-3
697	ДК-В3		0,4			15000					3
698	ДК-В7М		0,4			10000					3
699	ДК-И1М*		0,5								10-3
700	ДК-В1		0,8			15000					10
701	ДК-В4		0,8			10000					3
702	ДК-В5М		0,8			10000					10
703	ДК-В6М		0,8			5000	25000				10
704	ДК-В2		1,2			10000					10
705	ДК-В11*		1,5			10000	2,5				
706	Д605*										14
707	Д606*										14

СВЧ ДИОДЫ

Режим					Предельные режимы				Материал Технология	Чертеж №		
λ , см	P _{подв.} , мквт	R _н , ом	P _{имп} , мвт	I _{см} , мка	P _{свч имп} ,		U _{макс} , в	Интервал температур, °C				
					длит. возд.	кратк. возд.						
					мвт		мвт	в				
10									-60-+125	Si T 55		
10									-60-+125	Si T 55		
10									-60-+125	Si T 55		
10									-60-+125	Si T 55		
10									-60-+125	Ge T 51		
3,2	20				150	50			-60-+85	Ge T 51		
3,2	20								-60-+70	Ge T 51		
1,8; 3,2	20	20				50						
3,2	20				150	50			-60-+85	Ge T 51		
3,2	10	20	20			50			-60-+70	Si T 51		
2,9	10		20									
3,8												
	15				50	100	300	5	-60-+125	Si T 56		
	15				50	100	300	5	-60-+125	Si T 56		
	15				50	150	500	7	-60-+125	Si T 56		
	15				50	200	500	7	-60-+125	Si T 56		
3,2	10	20			50	300	1000	10	-60-+100	Si T 39		
9,8	10	20	20			50			-60-+70	Si T 51		
8;	10		20									
3,2	10	30			50	300	500	20	-60-+125	Si T 26		
10	4	15			50	200			-60-+100	Si T 39		
8	5				50	300	500	20	-60-+125	Si T 26		
	10	60			20		250	2	-60-+100	Si T 38		
3,2	20	1000				200			-60-+100	Si T 39		
3,2	20		200			50			-50-+70	Si T 51		
3,2	20					200			-60-+100	Si T 39		
8; 8	20	1000				200			-60-+100	Si T 39		
9,8	20		200			50			-50-+70	Si T 51		
3,2	20		100			50			-50-+70	Si T 51		
9,8	20					200			-60-+100	Si T 39		
9,8	20					200			-60-+100	Si T 39		
9,8	20		100			50			-50-+70	Si T 51		
	20						50		-60-+70	Si T 52		
3,2	150; 110							10	-60-+100	Si T 39		
	20; 15;								100	5 -60-+85 Ge T 14		

ПАРАМЕТРИЧЕСКИЕ

№ пп.	Тип прибора	C _п ,			C _{корп} ,		L _д ,		U _(пп) ,	
		пф	U _{см} , в	f, МГц	пф	f, МГц	НГН	f, МГц	в	I _{обр} , мка
708	ЗА406В	0,06- 0,19	0	30±2	0,15- 0,19	0,465- ±0,009	1,7-2,3	3000- +50		
709	1А403Г	0,08- 0,22	20	60	0,20- 0,25		1-2	10000	50	70- 100
710	1А403Д	0,08- 0,22	20	60	0,20- 0,25		1-2	10000	50	70- 100
711	1А404Б	0,09- 0,14	5	60	0,18- 0,25		1,3-1,8	2000	10- 15	70- 100
712	АА406К	0,1- 0,22	0	30±2	0,15- 0,19	0,465- ±0,009	2,3	3000- +50		
713	ГА401Д	0,1- 0,5	10	30	0,18 0,22		0,15	2000	19	30
714	1А404А	0,11	5	60	0,18- 0,25		1,3-1,8	2000	10- 15	70- 100
715	1А404В	0,11- 0,16	5	60	0,18- 0,25		1-2	2000	10- 15	70- 100
716	1А401В	0,12- 0,33	10	30	0,18- 0,25		2	2000	20	10-30
717	1А402Б	0,16	10	30	0,23- 0,29	30	2	9375	15	10
718	1А402Г	0,16	10	30	0,23- 0,29	30	2	9375	15	10
719	1А404Г	0,13- 0,23	5	60	0,19- 0,25		1-2	2000	10-15	70-100
720	1А402А	0,3	10	30	0,23- 0,29	30	2	9375	15	10
721	1А402В	0,13- 0,3	10	30	0,23- 0,29	30	2	9375	15	10
722	ЗА406Б	0,14- 0,3	0	30±2	0,15- 0,19	0,465- ±0,009	1,7-2,3	3000 +50		
723	АА406И	0,16- 0,32	0	30±2	0,15- 0,19	0,465- ±0,009	2,3	3000 +50		
724	1А404Д	0,17- 0,28	5	60	0,19- 0,25		1-2	2000	10-15	70-100
725	1А405А	0,18- 0,25	5	60	0,19- 0,25		1-2	2000- 2500	8-15	70-100
726	1А403В	0,18- 0,30	20	60	0,20- 0,25		1-2	10000	50	70-100
727	1А404Е	0,22- 0,36	5	60	0,19- 0,25		1-2	2000	10-15	70-100
728	1А405Б	0,22- 0,40	5	60	0,19- 0,25		1-2	2000- 2500	8-15	70-100
729	ЗА406А	0,26	0	30±2	0,15- 0,19	0,465- +0,009	1,7-2,3	3000- +50		
730	1А403Б	0,26- 0,40	20	60	0,20- 0,25		1-2	10000	50	70-100

СВЧ ДИОДЫ

λ , см	τ , псек	U_{cm} , в		f , МГц		Предельные режимы						Материал Технология	Чер- теж №	
						P_{max} , длит. возд.		P_{imp} , крат. возд.		W, эрГ	Интервал температур, °C			
		мВт	вт	длнт. возд.	крат. возд.									
2	1,1	2	9375- +20	10	30		300	0,05	-269-+85	GaAs	T	48		
	1,6	20	2100	400	600	15	25		-60-+70	Ge	D	42		
	1,3	20	2100	400	600	15	25		-60-+70	Ge	D	42		
3	0,85	5	2000- 2500	40	60	1	2	0,3	-65-+70	Ge	MД	42		
2	1,1	2	9375- +80	10	30		300	0,05	-269-+85	GaAs	T	48		
	2		2000	160	350	4	8		-40-+55	Ge	D	42		
3	0,85	5	2000- 2500	40	60	1	2	0,3	-65-+70	Ge	MД	42		
3	0,85		2000- 2500	40	60	1	2	0,3	-65-+70	Ge	MД	42		
	1,7	10	2000	200	400	5	10		-60-+70	Ge	D	42		
3-6	0,9	10	2000	50	100	2,5	5	0,7	-60-+70	Ge	D	46		
3-6	0,75	10	2000	50	100	2,5	5	0,7	-60-+70	Ge	D	46		
3	0,85	5	2000- 2500	40	60	1	2	0,3	-65-+70	Ge	MД	42		
3-6	1,2	10	2000	50	100	2,5	5	0,7	-60-+70	Ge	D	46		
3-6	0,75	10	2000	50	100	2,5	5	0,7	-60-+70	Ge	D	46		
2	1,3	2	9375- +20	10	30		300	0,05	-269-+85	GaAs	T	48		
2	1,4	2	9375- +80	10	30		300	0,05	-269-+85	GaAs	T	48		
3	0,85	5	2000- 2500	40	60	1	2	0,3	-65-+70	Ge	MД	42		
3	1,2	5	2000			0,5	1		-65-+70	Ge	MД	42		
	1,6	20	2100	400	600	15	25		-60-+70	Ge	D	42		
3	0,85	5	2000- 2500	40	60	1	2	0,3	-65-+70	Ge	MД	42		
3	1,2	5	2000- 2500			0,5	1		-65-+70	Ge	MД	42		
2	1,5	2	9375- +20	10	30		300	0,05	-265-+85	GaAs	T	48		
1,6	20	2100	400	600	15	25		-60-+70	Ge	D	42			

ПАРАМЕТРИЧЕСКИЕ

№ пп.	Тип прибора	C _п			C _{корп} ,		L _{д,} НГн	U(пр)	
		пФ	U _{см} , в	f, МГц	пФ	f, МГц		I _{обр} , мка	
731	1A401Б	0,26– 0,44	10	30	0,18– 0,25	2	2000	20	10–30
732	1A404Ж	0,3–0,45	5	60	0,18– 0,25	1–2	2000	10–15	70–100
733	AA406Ж	0,3–0,6	0	30±2	0,15– 0,19	0,465– 0,009	2,3	3000– +50	
734	1A403А	0,32– 0,50	20	60	0,20– 0,25		1–2	10000	50
735	1A401А	0,36– 0,55	10	30	0,18– 0,25		2	2000	20
736	ГА401Г	0,4–0,8	10	30	0,18– 0,22		0,15	2000	18
737	1A401	0,45– 0,87	10	30	0,18– 0,25	2	2000	20	10–30

СМЕСИТЕЛЬНЫЕ

№ пп.	Тип прибора	λ, см	L, дб	t _ш , дб	F _ш N _ш , дб	K _{св}	R _{вых} , ом	Pe	
								I _{выпр} , ма	λ, см
738	Д405Б,БП*	3	6		8,5				3,2 3,2
							300–450		
739	1608Б,БП*		6	1,7	8,5	1,4		1	3,2
740	2A104А,АР	8–80	6,5			1,4		1	3,2
						1,5		0,5	8
							340+560		8
741	Д405А,АП*	3	6,5		8,5	1,7		1	3,2
							300+500		3,2
742	1608А,АП*		6,5	2		1,7		1	3,2
743	ДК–С2М	10	6,5	2					9,8
									3,2
744	2A105Б,БР	3–8	6,7			3		0,4	9,8
						1,5		0,8	3,2
745	Д405*	3	7		9		250+450		3,2
						2		1	3,2
746	Д406А,АП*	2	7	2,2			250+550		3,2
				2			240+460	0,7	3,2
						2,1			

СВЧ ДИОДЫ

λ , см	t , псек			Предельные режимы								Материал Технология	Чертеж №		
				$P_{\text{макс}}$,		$P_{\text{имп. макс}}$,		W , эрГ	Интервал температур, $^{\circ}\text{C}$						
				дл.т. возд.	дл.т. возд.	дл.т. возд.	крат. возд.								
				МВт		Вт									
6+80	1,8	10	2000	200	400	5	10		-60--+70		Ge	D	42		
3	0,85	5	2000- 2500	40	60	1	2	0,3	-60--+70		Ge	MД	42		
2	1,7	2	9375- +80	10	30		300	0,05	-269--+85		GaAs	T	48		
	2	20	2100	400	600	15	25		-60--+70		Ge	D	42		
6+80	2	10	2000	200	400	5	10		-60--+70		Ge	D	42		
6+80	2,5		2000	160	350	4	8		-40--+55		Ge	D	42		
6+80	2,2	10	2000	200	400	5	10		-60--+70		Ge	D	42		

СВЧ ДИОДЫ

ЖИМ		Предельные режимы							Материал Технология	Чер- теж №		
$P_{\text{подв}}$, МВт	R_H , ом	$P_{\text{имп. макс}}$,		W , эрГ	$P_{\text{непр. макс}}$,		Интервал температур, $^{\circ}\text{C}$					
		дл.т. возд.	кратк. возд.		дл.т. возд.	кратк. возд.						
		МВт		МВт	МВт							
1		300		0,3	5		-60--+100		Si	T	39	
1	100											
1	50						-60--+100		Si	T	39	
1	50						-60--+125		Si	T	26	
0,5	430			0,5	20		150					
0,5	100											
0,5												
1	350	300		0,3	20		-60--+100		Si	T	39	
1	50											
1	100											
1	50						-60--+100		Si	T	39	
1	400	300		0,3			-60--+100		Si	T	39	
1												
1	350						-60--+125		Si	T	26	
1	350	300		0,5	20		100					
1	100											
1	350						-60--+100		Si	T	39	
1	50											
1	100						-60--+100		Si	T	39	
1	350	100		0,2			-60--+100		Si	T	38(***)	
1	100											
0,5	100											

СМЕСИТЕЛЬНЫЕ СВЧ

№ пп.	Тип прибора	λ , см	L, дб	$t_{\text{ш}}$	$F_{\text{ш}}$ $N_{\text{ш}}^*$, дб	$K_{\text{СВ}}$	$R_{\text{вых}}$, ом	$I_{\text{выпр}}$, ма	Pe
									λ , см
747	2A105A,AP	3-8	7			1,5		0,8	3,2
748	Д408А,АП*	3	7,5	2,1	10	1,7	250+500	3,2	3,2
749	ДК-С7М*	3-12	7,5		7,5		350+575	0,2+0,5	3,2
							250+700	3	3,2
750	2A107A	2	7,5		2	2			3,2
					9	1,5		0,3	3,2
751	Д403Б,В,ВП*	3-12	8,5			3	175+375	0,4	3,2
					11		200+800		2,05
752	Д404		8,5		2,5		280+520		3,2
753	ДК-С1М	10	8,5			2,5			9,8
						3,5		0,4	9,8
754	2A101Б		9		2,7				3,2
					2			0,5	
755	2A103Б,БР		9			3			0,5
					2		200+550		
756	2A101A		10		2	3			0,5
						3			
757	2A103A,AP		10		2		250+550		0,5
						3			
758	Д402*		10		2,5		200+550		
						3	250+650		
759	Д407*		12		6				
760	1A106B,BP	2-3	12,5		19	2	400+1500	0,12	
761	1A106A,AP	2-3	13,5		22	1,2	160+300		0,1
762	1A106B,BP	2-3	13,5		19	3	160+300		0,1
763	2A102A	10-30			8,5	1,5	160+300	1,2	15,5
							250+450		10
764	Д408,П*	4,5-10			7,8	1,3	290+390	0,8	10

ДИОДЫ

жим		Предельные режимы							Материал Технология	Чер- теж №		
P _{подв.} МВт	R _H , ом	P _{им п.макс.}		W, эрг	P _{непр.макс}		Интервал температур, С					
		длит. возд.	кратк. возд.		длит. возд.	кратк. возд.						
		МВт			МВт							
1	350	300	500	0,5	20	100	-60-+125	Si T	26			
1	100											
1												
0,2	100	300		0,3			-60-+100	Si T	39			
0,7	400											
0,7												
0,05	350											
0,5	100	300	100		20	50	-60-+85	Si Э	43			
0,05												
1	400	150		0,3			-60-+100	Ge T	51			
1	100											
1												
1	400	15		0,02			-60-+85	Si T	14			
1	100											
1	100											
1	400	300		0,3			-60-+100	Si T	39			
1	350											
1												
1	400	250	300	0,2			-60-+100	Si T	56			
1	100											
1	100											
1	400	250	300	0,2	15	100	-65-+100	Si T	56			
1	100											
1												
1	100											
1	100											
1	400	150	200	0,06			-60-+100	Si T	56			
1	100											
1	100											
1	400	150	200	0,06	10	75	-65-+100	Si T	56			
1	100											
1	100											
1	400	15		0,02			-60-+85	Si T	14			
1	100											
1	100											
1	600	20		0,02			-60-+80	Si T	13			
1	100											
200	100		100	0,05	6	30	-60-+70	Ge C	46			
200	100											
200	100		100	0,05	6	30	-60-+70	Ge C	46			
200	100											
200	100		100	0,05	6	30	-60-+70	Ge C	46			
200	100											
1	100	500	6000		30		-60-+100	Si T	39			
0,5	100											
0,5	100	500		0,5			-60-+125	Si T	39			

УМНОЖИТЕЛЬНЫЕ

№№ пп.	Тип прибора	P_3 гар, МВт	P_8 гар, МКВт	$U_{(пр)}$, в	$\Delta I_{обр}$, мка	С, пФ	f макс, Гц	Режим		
								$U_{обр}$, в	λ , см	f осн, мГц
765	Д501 ^к			300					25,6	
766	2А601А	7								2940
767	3А603А			45		0,5		45	30	
							0,8- 1,5		8	
								35	6	
768	3А603Б			45		0,5		45	30	
							0,6- 1,3		6	
								60	6	
769	3А603В			30		0,5		30	20	
							0,5-1		6	
								100	6	
770	2А602А			60			4,7- 8,7		6	
									15	
771	2А602Б						2,7- 4,7		6	
				60					25	
772	2А602В						1,7- 2,7		6	
					45				35	
773	2А602Г						1,2- 1,7		6	
					45				50	
774	2А602Д						1-1,3		6	
				30					60	

СВЧ ДИОДЫ

			Предельные режимы					Материал Технология	Чер- теж №		
I обр, мка	P осн, мВт	f, МГц	P _{макс} ,		P _{свч} длит. возд, вт	U = U _{см} + U _т , в	I _{пр} , ма	Интервал температур, °C			
			длит. возд.	кратк. возд.							
			мВт								
10 1	130 75		100 75	200 150		0,5	45	1	-60--+100 -60--+100 -60--+100	Si Si T GaAs D	39 40 50
10 1						0,5	45	1	-60--+100	GaAs D	50
10 1						0,5	30	1	-60--+100	GaAs D	50
100										Si ПЭ	49
100	10 3000				2,5				-60--+100		
100	10				1,5				-60--+100	Si ПЭ	49
100	3000					1			-60--+100	Si ПЭ	49
100	10 5000				0,7				-60--+100	Si ПЭ	49
100	10 5000				0,5				-60--+100	Si ПЭ	49

ГЕНЕРАТОРНЫЕ

№ пп.	Тип прибора	f, Гц	Δf , МГц	P, мВт	ΔP , дБ	P _{ИМП} , вт	I _{обр} , мка	Режим					
								ΔI	U _{обр} , в	U _{имп.} , в	λ ,	I, ма	
775	АА702А	1-1,5				0,5- 1,1					70		
776	АА702Б	1-1,5				0,9- 2,1					70		
777	АА702В	1-1,5				1,9					70		
778	1A701А			10	2			$\pm 5\% I_o$			2	1,2,3	I _H
					3			0,5			10		
779	1A701Б			10	1,5			0,5	$\pm 5\% I_o$		10	2	
					5			0,5			10	1; 2; 3	I _H
780	1A701В			10	2			0,5	$\pm 5\% I_o$		10	5	
					3			0,5			10	4; 5; 6	I _H
781	1A701Г			10	1,5			0,5	$\pm 5\% I_o$			5	
					5			0,5				4; 5; 6	I _H
782	1A701Д			20	1,5			0,5	$\pm 5\% I_o$		10	7	
					3			0,5			10	7,8	I _H

МОДУЛ

№ пп.	Тип прибора	Диапазон длин волн , см	P _{вых} , мВт	L _{свч} , дБ	L _{мод} , дБ	I _{выпр. к.з.} , ма
783	Д401	7-10	15	13	13	
784	Д401А*	7-10	2,5			

6,5-11

СВЧ ДИОДЫ

		Предельные режимы							Материал Технология	Чер- теж №	
F_u , кГц	τ_u , мкsec	$I_{\text{доп.макс.}}$	$P_{\text{имп.макс.}}$, вт	$I_{\text{пр.макс.}}$, ма	$U_{\text{амп.}}$, в	$\tau_{\text{имп.}}$, мкsec	F_u , кГц	Интервал температур, °C			
5	0,2				75	0,3	7	-80-+85	GaAs	MД	50
5	0,2				75	0,3	7	-80-+85	GaAs	MД	50
5	0,2				75	0,3	7	-80-+85	GaAs	MД	50
		1,2 I_H	0,5	50				-60-+60	Ge	MД	41
		1,2 I_H	0,5	50				-60-+60	Ge	MД	41
		1,2 I_H	0,5	50				-60-+60	Ge	MД	41
		1,2 I_H	0,5	50				-60-+60	Ge	MД	41

ЯТОРНЫЕ СВЧ ДИОДЫ

Режим						Предельные режимы		Материал Техноло- гия	Чер- теж №
$P_{\text{свч.}}$, мвт	$P_{\text{пром.}}$, мвт	$f_{\text{свч.}}$, мГц	$f_{\text{мод.}}$, мГц	$R_{\text{см.}}$, ком	$U_{\text{пром.}}$, в	Интервал температур, °C			
300	300	3000 2500	150 70	1		+5-+50	Ge T	54	
300	300	3450 3450	150 0	1 2		+5-+50	Ge T	54	

ДИОДНЫЕ

№ пп.	Тип прибора	I _{пр.макс,} ма	U _{пр.макс,} в	I _{ут,} мка	I _{ут.обр,} мка	U _{ост,} в	U _{пуск,} в	U _{пом,} в	I _{выкл,} ма	U _{выкл,} в	мкsec
785	КН102А	200	5	250	0,5	1,5	20	2	0,1-15	2	40
786	2Н102А	200	5	80	0,5	1,5	20	2	0,1-15	2	40
787	КН102Б	200	7	250	0,5	1,5	28	3	0,1-15	2	40
788	2Н102Б	200	7	80	0,5	1,5	28	3	0,1-15	2	40
789	2Н101А	20	7,5	250	0,5	1,6	40	4	0,1-10	3	3
790	КН102В	200	10	250	0,5	1,5	40	4	0,1-15	2	40
791	2Н102В	200	10	80	0,5	1,5	40	4	0,1-15	2	40
792	КН102Г	200	14	250	0,5	1,5	56	6	0,1-15	2	40
793	2Н102Г	200	14	80	0,5	1,5	56	6	0,1-15	2	40
794	2Н101Б	20	15	250	0,5	1,6	60	6	0,1-10	3	3
795	2Н101Е	20	15	250	0,5	1,6	35	3,5	0,1-10	3	3
796	КН102Д	200	20	250	0,5	1,5	80	8	0,1-15	2	40
797	2Н102Д	200	20	80	0,5	1,5	80	8	0,1-15	2	40
798	2Н101В	20	30	250	0,5	1,6	75	7,5	0,1-10	3	3
799	2Н101Г	20	30	250	0,5	1,6	120	12	0,1-10	3	3
800	2Н102Е	200	30	80	0,5	1,5	75	7,5	0,1-15	2	40
801	КН102Ж	200	30	250	0,5	1,5	120	12	0,1-15	2	40
802	2Н102Ж	200	30	80	0,5	1,5	120	12	0,1-15	2	40
803	2Н101Ж	20	35	250	0,5	1,6	70	7	0,1-10	3	3
804	КН102И	20	50	250	0,5	1,5	150	15	0,1-15	2	40
805	2Н101Д	20	50	250	0,5	1,6	150	15	0,1-10	3	3
806	2Н101И	20	50	250	0,5	1,6	100	10	0,1-10	3	3
807	2Н102И	200	50	80	0,5	1,5	150	15	0,1-15	2	40

ТИРИСТОРЫ

			$C_{\text{П}}$ при $U_{\text{CM}} = 0$, пф	Предельные режимы					Материал	Чер- теж №	
$U_{\text{пр}}$, в	$I_{\text{пр}}$, а	$t_{\text{имп.}}$, мкsec		$U_{\text{обр. макс}}$, в	ма	$I_{\text{пр.имп.макс}}$,	$I_{\text{пр.ср.}}$, ма	$t_{\text{имп.}}$, сек			
40	1	10		10	2000	5	0,1	-40-+70	Si	СД	21
	1	10	80	10	2000	5	0,1	-60-+100	Si	СД	21
	1	10		10	2000	7	0,1	-40-+70	Si	СД	21
	1	10	80	10	2000	7	0,1	-60-+100	Si	С	21
		100		10	60	7,5	0,2	-60-+85	Si	С	80
	1	10		10	2000	10	0,1	-40-+70	Si	СД	21
	1	10	80	10	2000	10	0,1	-60-+100	Si	СД	21
	1	10		10	2000	14	0,1	-40-+70	Si	СД	21
	1	10	80	10	2000	14	0,1	-60-+100	Si	СД	21
		100		10	60	15	0,2	-60-+85	Si	С	80
60		100		10	60	15	0,2	-60-+85	Si	С	80
	35		100	10	60	15	0,2	-60-+85	Si	С	80
	1	10		10	2000	20	0,1	-40-+70	Si	СД	21
	1	10	80	10	2000	20	0,1	-60-+100	Si	СД	21
		100		10	60	30	0,2	-60-+85	Si	С	20
75		100		10	60	30	0,2	-60-+85	Si	С	80
	120		100	10	60	30	0,2	-60-+85	Si	С	80
	1	10	80	10	2000	30	0,1	-60-+100	Si	СД	21
	1	10		10	2000	30	0,1	-40-+70	Si	СД	21
	1	10	80	10	2000	20	0,1	-60-+100	Si	СД	21
70		100		10	60	35	0,2	-60-+85	Si	С	80
	1	10		10	2000	50	0,1	-40-+70	Si	СД	21
		100		10	60	50	0,2	-60-+85	Si	С	80
150		100		10	60	50	0,2	-60-+85	Si	С	80
	100		100	10	60	50	0,2	-60-+85	Si	С	80
	1	10	80	10	2000	50	0,1	-60-+100	Si	СД	21

ТИРИСТОРЫ

№ пп.	Тип прибора	$I_{пр. макс.}$ ма	$U_{пр. макс.}$ ($U_{пр. ампл.}$) в	$I_{ут.}$ ма	$I_{ут. обр.}$ ма	$I_{спр.}$ ($I_{спр. имп.}$) ма	τ_U мк-сек	$U_{ост.}$ в	$U_{спр.}$ в	$I_{выкл.}$ ма	$I_{зап.имп.}$ ма	$I_{пом. спр.имп.}$ ма	$\tau_{зап.имп.}$ мк-сек	$\tau_{вкл.}$ мк-сек	$\tau_{выкл.}$ мк-сек
808	КУ101А	75	50	0,3	0,3	0,05– 7,5 14		2,5		0,5– 25			2	35	
809	2У101А	75	50	0,15		0,1–5			1,5–8				2	35	
810	КУ101Б	75	50	0,3	0,3	0,05– 7,5 14		2,5		0,5– 25			2	35	
811	2У101Б	75	50	0,15	0,15	0,1–5 14			1,5–8				2	35	
812	2У101И	75	50	0,15	0,15	0,1–5 14			0,25– 4,5				2	35	
813	2У101Ж	75	50	0,15		0,1–5			0,25– 4,5				2	35	
814	КУ101Г	75	80	0,3	0,3	0,05– 7,5 14		2,5		0,5– 25			2	35	
815	2У101Г	75	80	0,15	0,15	0,1–5 14			0,25– 4,5				2	35	
816	2У101Д	75	150	0,15	0,15	0,1–5			1,5– 8				2	35	
817	КУ101Е	75	150	0,3	0,3	0,05– 7,5 14		2,5		0,5– 25			2	35	
818	2У101Е	75	150	0,15		0,1–5 0,15			0,25– 4,5				2	35	
819	КУ103А		(150)	0,3	0,3			6							
820	КУ103Б		(150)	0,3	0,3			6							
821	КУ103Г		(250)	0,35	0,35			6							
822	КУ103Е		(250)	0,35	0,35			6							
823	2У103А		(300)	0,25	0,25			3							
824	2У103Б		(300)	0,25	0,25			3							
Запираемые															
825	2У102А	50	50	0,1		(20)	5	2,5		20	20	0,2	5	5	
826	2У102Б	50	100	0,1		(20)	5	2,5		20	20	0,2	5	5	
827	2У102В	50	150	0,1		(20)	5	2,5		20	20	0,2	5	5	
828	2У102Г	50	200	0,1		(20)	5	2,5		20	20	0,2	5	5	

МАЛОЙ МОЩНОСТИ

$\tau_{зап}$, мк- сек	U _{упр} ,	Предельные режимы											Мате- риал Техно- логия	Чер- теж №	
		$t_{запуск}$ запир., мк- сек	I _{упр} ,	I _{пр.амп} ,	P _{макс} ,	I _{упр.} макс	U _{упр} пр.	U _{упр} обр.	U _{зап.} имп.	P _{упр.имп.} макс	t_U , мк- сек	dV dt	Интервал температу- р, °C		
			в	ма	ма	мВт	ма	в	в	вт	в/мкsec				
			1000	10	150	15	2			0,5	10		-55-+85	Si СД	85
			1000	10	150	15	2			0,5	10	100	-60-+120	Si СД	85
			1000	10	150	15	2			0,5	10	-55-+85	Si СД	85	
			1000	10	150	15	2			0,5	10	100	-60-+120	Si СД	85
			1000	10	150	15	2			0,5	10	100	-60-+120	Si СД	85
			1000	10	150	15	2			0,5	10	-55-+85	Si СД	85	
			1000	10	150	15	2			0,5	10	100	-60-+120	Si СД	85
			1000	10	150	15	2			0,5	10	100	-60-+120	Si СД	85
			1000	10	150	15	2			0,5	10	-55-+85	Si СД	85	
			1000	10	150	15	2			0,5	10	100	-60-+120	Si СД	85
			1000	10	150	15	2			0,5	10	-55-+85	Si СД	85	
			1000	10	150	15	2			0,5	10	100	-60-+120	Si СД	85
			1000	10	150	15	2			0,5	10	-55-+85	Si СД	85	
			1000	10	150	15	2			0,5	10	100	-60-+120	Si СД	85
0,3-7	10	1		150	40		2					-40-+55	Si Д	85	
4,5-	10	1		150	40		2					-40-+55	Si Д	85	
10															
0,3-7	10	1		150	40		2					-40-+55	Si Д	85	
4,5-	10	1		150	40		2					-40-+55	Si Д	85	
10															
0,4-		1		150	40		2					-60-+70	Si Д	85	
6,5															
5-9		1		150	40		2					-60-+70	Si Д	85	
тиристоры															
20	20		5000	10	0,16			15		200	-60-+110	Si СД	86		
20	20		5000	10	0,16			15		200	-60-+110	Si СД	86		
20	20		5000	10	0,16			15		200	-60-+110	Si СД	86		
20	20		5000	10	0,16			15		200	-60-+110	Si СД	86		

ТИРИСТОРЫ

№ пп.	Тип прибора	I _{пр} макс, а	U _{пр} макс, в	I _{ут} , ма	t _{ут.} обр, ма	I _{спр.} (I _{спр.имп.}), ма	t _U , мкsec	U _{спр.} (U _{спр.имп.}), в	t _U , мкsec	U _{ост} , в	t _{ВКЛ} , мкsec	t _{выкл} , мкsec	I _{зап} имп, ма	U _{зап} имп, в	I _{выкл} , ма
829	КУ201А	2	25	5	5	100	7			2	10	100			100
830	2Y201A	2	25	5	5	100	6			2	10	100			100
831	КУ201Б	2	25	5	5	100	7			2	10	100			100
832	2Y201B	2	25	5	5	100	8			2	10	100			100
833	Д235А	2	40	2		50	(5)	5	2	5	35				
834	Д235А [*]	2	40	2		30	(5)	5	2	5	35				
835	Д235В	2	40	2	2	50	(5)	5	2	5	35				
836	Д235В [*]	2	40	2	2	30	(5)	5	2	5	35				
837	КУ201В	2	50	5	5	100	7			2	10	100			100
838	2Y201B	2	50	5	5	100	6			2	10	100			100
839	КУ201Г	2	50	5	5	100	7			2	10	100			100
840	2Y201G	2	50	5	5	100	8			2	10	100			100
841	Д235Б	2	80	2		50	(5)	5	2	5	35				
842	Д235Б [*]	2	80	2		30	(5)	5	2	5	35				
843	Д235Г	2	80	2	2	50	(5)	5	2	5	35				
844	Д235Г [*]	2	80	2	2	30	(5)	5	2	5	35				
845	КУ201Д	2	100	5	5	100	7			2	10	100			100
846	2Y201D	2	100	5	5	100	6			2	10	100			100
847	КУ201Е	2	100	5	5	100	7			2	10	100			100
848	2Y201E	2	100	5	5	100	6			2	10	100			100
849	КУ201Ж	2	200	5	5	100	7			2	10	100			100
850	2Y201J	2	200	5	5	100	6			2	10	100			100
851	КУ201И	2	200	5	5	100	7			2	10	100			100
852	2Y201I	2	200	5	5	100	6			2	10	100			100
853	КУ201К	2	300	5	5	100	7			2	10	100			100
854	2Y201K	2	300	5	5	100	6			2	10	100			100
855	КУ201Л	2	300	5	5	100	7			2	10	100			100
856	2Y201L	2	300	5	5	100	6			2	10	100			100
857	2Y203A	5	50	20	20	(450)	3	(5)	8	2	8	7			
858	2Y203D	5	50	20	20	(450)	3	(5)	3	2	3	7			
859	2Y203B	5	100	20	20	(450)	3	(5)	3	2	3	7			
860	2Y203E	5	100	20	20	(450)	3	(5)	3	2	3	7			
861	2Y203B	5	150	20	20	(450)	3	(5)	3	2	3	7			

СРЕДНЕЙ МОЩНОСТИ

Предельные режимы												Материал Техноло- гия	Чертеж №
I пр.ампл., а	P макс, вт	I ано- да зап. макс, а	I упр.пр.макс (I упр.имп), ма	I упр. обр. макс, ма	U упр.пр. макс (U упр.имп), в	U упр. обр. макс, в	P упр.макс (P упр.имп), вт	dU/dt, в/ мкsec	Интервал температур, °C				
10	10	4	200	5	10	10	1		-55-+70к	Si	Д	99	
10	10	4	200	5	10	10	1	5	-60-+110к	Si	Д	99	
10	10	4	200	5	10	10	1		-55-+70к	Si	Д	99	
10	10	4	200	5	10	10	1	5	-60-+110к	Si	Д	99	
10	10	4	150						-40-+85к	Si	СД	101	
			(350)	5									
10	10	4	150						-60-+100к	Si	СД	101	
			(350)	5									
10	10	4	150						-40-+85к	Si	СД	101	
			(350)	5									
10	10	4	150						-60-+100к	Si	СД	101	
			(350)	5									
10	10	4	200	5	10	10	1		-55-+70к	Si	Д	99	
10	10	4	200	5	10	10	1	5	-60-+110к	Si	Д	99	
10	10	4	200	5	10	10	1		-55-+70к	Si	Д	99	
10	10	4	200	5	10	10	1	5	-60-+110к	Si	Д	99	
10	10	4	150						-40-+85к	Si	СД	101	
			(350)	5									
10	10	4	150						-60-+100к	Si	СД	101	
			(350)	5									
10	10	4	150						-40-+85к	Si	СД	101	
			(350)	5									
10	10	4	150						-60-+100к	Si	СД	101	
			(350)	5									
10	10	4	200	5	10	10	1		-55-+70к	Si	Д	99	
10	10	4	200	5	10	10	1	5	-60-+110к	Si	Д	99	
10	10	4	200	5	10	10	1		-55-+70к	Si	Д	99	
10	10	4	200	5	10	10	1	5	-60-+110к	Si	Д	99	
10	10	4	200	5	10	10	1		-55-70к	Si	Д	99	
10	10	4	200	5	10	10	1	5	-60-+110к	Si	Д	99	
10	10	4	200	5	10	10	1		-55-+70к	Si	Д	99	
10	10	4	200	5	10	10	1	5	-60-+110к	Si	Д	99	
10	10	4	200	5	10	10	1		-55-+70к	Si	Д	99	
10	10	4	200	5	10	10	1	5	-60-+110к	Si	Д	99	
10	10	4	200	5	10	10	1		-55-+70к	Si	Д	99	
10	10	4	200	5	10	10	1	5	-60-+110к	Si	Д	99	
10	10	4	200	5	10	10	1		-55-+70к	Si	Д	99	
100	50	20	(1200)	3		(10)	3	1,75	20	-60-+120	Si	СД	84
				350									
100	50	20	350			(10)	3	1,75	20	-60-+120	Si	СД	84
			(1200)	3									
100	50	20	350			(10)	3	1,75	20	-60-+120	Si	СД	84
			(1200)	3									
100	50	20	350			(10)	3	1,75	20	-60-+120	Si	СД	84
			(1200)	3									
100	50	20	350			(10)	3	1,75	20	-60-+120	Si	СД	84
			(1200)	3									

ТИРИСТОРЫ

№ пп.	Тип прибора	$I_{пр.}$ макс,	$U_{пр.}$ макс,	$I_{ут.}$	$I_{ут.}$ обр,	$I_{спр.}$ ($I_{спр.имп.}$),		$U_{спр.}$ ($U_{спр.имп.}$),		$U_{ост.}$	$\tau_{вкл.}$	$\tau_{выкл.}$	$I_{зап.}$ имп,	$U_{зап.}$ имп,	$I_{выкл.}$
		а	в	ма	ма	ма	мкsec	в	мкsec						
862	2У203Ж	5	150	20	20	(450)	3	(5)	3	2	3	7			
863	2У203Г	5	200	20	20	(450)	3	(5)	3	2	3	7			
864	2У203И	5	200	20	20	(450)	3	(5)	3	2	3	7			
865	КУ202А	10	25	10	10	100		5		2	10	150		300	
866	КУ202Б	10	25	10	10	100		5		2	10	150		300	
867	КУ202В	10	50	10	10	100		5		2	10	150		300	
868	КУ202Г	10	50	10	10	100		5		2	10	150		300	
869	Д238А	10	50	20	20	(150)	10	(8)	10	2	10	35			
870	Д238А*	10	50	30	30	(150)	10	(8)	10	2	10	35			
871	Д238Г	10	50	20	20	(150)	10	(8)	10	2	10	35			
872	Д238Г*	10	50	30	30	(150)	10	(8)	10	2	10	35			
873	Д238Б	10	100	20	20	(150)	10	(8)	10	2	10	35			
874	Д238Б*	10	100	30	30	(150)	10	(8)	10	2	10	35			
875	Д238Д	10	100	20	20	(150)	10	(8)	10	2	10	35			
876	Д238Д*	10	100	30	30	(150)	10	(8)	10	2	10	35			
877	КУ202Д	10	100	10	10	100		5		2	10	150		300	
878	2У202Д	10	100	10	10	200		7		1,5	10	150		300	
879	КУ202Е	10	100	10	10	100		5		2	10	150		300	
880	2У202Е	10	100	10	10	200		7		1,5	10	150		300	
881	Д238В	10	150	20	20	(150)	10	(8)	10	2	10	35			
882	Д238В*	10	150	30	30	(150)	10	(8)	10	2	10	35			
883	Д238Е	10	150	20	20	(150)	10	(8)	10	2	10	35			
884	Д238Е*	10	150	30	30	(150)	10	(8)	10	2	10	35			
885	КУ202Ж	10	200	10	10	100		5		2	10	150		300	
886	2У202Ж	10	200	10	10	200		7		1,5	10	150		300	
887	КУ202И	10	200	10	10	100		5		2	10	150		300	
888	2У202И	10	200	10	10	200		7		1,5	10	150		300	
889	КУ202К	10	300	10	10	100		5		2	10	150		300	
890	2У202К	10	300	10	10	200		7		1,5	10	150		300	

СРЕДНЕЙ МОЩНОСТИ

Предельные режимы												Материал Технология	Черт- еж №
I _{пр.ампл.} , а	P _{макс.} , вт	I _{ано- да зап. макс., а}	I _{упр.пр.макс (упр.имп.)} , ма	I _{упр. обр. макс., ма}	U _{упр.пр.макс (У_{упр.имп.})} , в	U _{упр. обр. макс., в}	P _{упр.макс. (У_{упр.имп.})} , вт	dU/dt, в/ мкsec	Интервал температур, °C				
100	50	20	350 (1200)	3	(10)	3	1,75	20	-60--+120	Si СД	84		
100	50	20	350 (1200)	3	(10)	3	1,75	20	-60--+120	Si СД	84		
100	50	20	350 (1200)	3	(10)	3	1,75	20	-60--+120	Si СД	84		
30	10	20	300 (500)	50	5	10	1,5	5	-55--+70к	Si Д	100		
30	10	20	300 (500)	50	5	10	1,5	5	-55--+70к	Si Д	100		
30	10	20	300 (500)	50	5	10	1,5	5	-55--+70к	Si Д	100		
30	10	20	300 (500)	50	5	10	1,5	5	-55--+70к	Si Д	100		
100	50	20	350						-55--+85к	Si СД	84		
100	50	20	350						-60--+100к	Si СД	84		
100	50	20	350						-55--+85к	Si СД	84		
100	50	20	350						-60--+100к	Si СД	84		
100	50	20	350						-55--+85к	Si СД	84		
100	50	20	350						-60--+100к	Si СД	84		
100	50	20	350						-55--+85к	Si СД	84		
100	50	20	350						-60--+100к	Si СД	84		
30	10	20	300 (500)	50	5	10	1,5	5	-55--+70к	Si Д	100		
30	10	20	300 (500)	50	5	10	10	5	-60--+110к	Si Д	100		
30	10	20	300 (500)	50	5	10	1,5	5	-55--+70к	Si Д	100		
30	10	20	300 (500)	50	5	10	10	5	-60--+110к	Si Д	100		
100	50	20	350						-55--+85к	Si СД	84		
100	50	20	350						-60--+100к	Si СД	84		
100	50	20	350						-55--+85к	Si СД	84		
100	50	20	350						-60--+100к	Si СД	84		
30	10	20	300 (500)	50	5	10	1,5	5	-55--+70к	Si Д	100		
30	10	20	300 (500)	50	5	10	10	5	-60--+110к	Si Д	100		
30	10	20	300 (500)	50	5	10	1,5	5	-55--+70к	Si Д	100		
30	10	20	300 (500)	50	5	10	10	5	-60--+110к	Si Д	100		
30	10	20	300 (500)	50	5	10	1,5	5	-55--+70к	Si Д	100		
30	10	20	300 (500)	50	5	10	10	5	-60--+110к	Si Д	100		
30	10	20	300 (500)	50	5	10	10	5	-60--+110к	Si Д	100		

ТИРИСТОРЫ

№ пп.	Тип прибора	$I_{пр}$ макс, а	$U_{пр}$ макс, в	$I_{ут},$ ма	$I_{ут.обр.}$ ма	$I_{спр.}$ ($I_{спр.имп.}$), ма	$\tau_U,$ мкsec	$U_{спр.}$ ($U_{спр.имп.}$), в	$\tau_U,$ мкsec	$U_{ост.}$ в	$\tau_{вкл.}$ мкsec	$\tau_{выкл.}$ мкsec	$I_{зап.имп.}$ ма	$U_{зап.имп.}$ в	$I_{выкл.}$ ма
891	КУ202Л	10	300	10	10	100	5			2	10	150			300
892	2У202Л	10	300	10	10	200	7			1,5	10	150			300
893	КУ202М	10	400	10	10	100	5			2	10	150			300
894	2У202М	10	400	10	10	200	7			1,5	10	150			300
895	КУ202Н	10	400	10	10	100	5			2	10	150			300
896	2У202Н	10	400	10	10	200	7			1,5	10	150			300
Запираемые															
897	КУ204А	50	5			(150)		(5)		3,2			400	36	
898	КУ204Б	100	5			(150)		(5)		3,2			400	36	
899	КУ204В	200	5			(150)		(5)		3,2			400	36	

СРЕДНЕЙ МОЩНОСТИ

Предельные режимы													Материал Техноло- гия	Чер- теж №
I пр.ампл., а	R макс, мкsec	I ана- да зап., макс, а	I упр.пр.макс (I упр.имп.), ма	I упр. обр. макс, мкsec	U упр.пр. (Uупр.имп.), в	I упр. обр. макс, мкsec	U упр. обр. макс, в	P упр.макс (Pупр.имп.), вт	d(I/dt), в/ мкsec	Интервал температур, °C				
30	10	20	300 (500)	50	5	10		1,5 (20)	10	5	-55→+70к	Si Д	100	
30	10	20	300 (500)	50	5	10	10	2,5 (20)	10	5	-60→+110к	Si Д	100	
30	10	20	300 (500)	50	5	10		1,5		5	-55→+70к	Si Д	100	
30	10	20	300 (500)	50	5	10	10	2,5 (20)	10	5	-60→+110к	Si Д	100	
30	10	20	300 (500)	50	5	10		1,5		5	-55→+70к	Si Д	100	
30	10	20	300 (500)	50	5	10	10	2,5 (20)	10	5	-60→+110к	Si Д	100	

тиристоры													Материал Техноло- гия	Чер- теж №
8	2	(600)	10					100	1,7	10	-25→+70к	Si СД		
8	2	(600)	10					100	1,7	10	-25→+70к	Si СД	99	
8	2	(600)	10					100	1,7	10	-25→+70к	Si СД	99	

СВЕТОДИОДЫ

№ пп.	Тип прибора	B ₁		U _{пр} , в	I _{пр} , ма	I _{пр} , ма	Предельные режимы			Материал Техноло- гия	Чер- теж №
		I _{пр} , нат	ma				I _{пр} макс, ма	U _{обр} макс, в	Интервал температу- р, °C		
900	АЛ102А	5	5	3,2	5	10	6	-60→+70		GaP ЭС	112
901	АЛ102Б	40	20	4,5	20	20	6	-60→+70		GaP ЭС	112
902	АЛ102В	50	30	5	30	30	6	-60→+70		GaP ЭС	112
903	КЛ101А	10	10	5,5	10	10		-10→+70		Si(CO ₃) ₂ Д	113
904	КЛ101Б	15	20	5,5	20	20		-10→+70		Si(CO ₃) ₂ Д	113
905	КЛ101В	20	40	5,5	40	40		-10→+70		Si(CO ₃) ₂ Д	113
906	2Л101А	10	10	5,5	10	10		-10→+70		Si(CO ₃) ₂ Д	113
907	2Л101Б	15	20	5,5	20	10		-10→+70		Si(CO ₃) ₂ Д	113

900	АЛ102А	5	5	3,2	5	10	6	-60→+70		GaP ЭС	112
901	АЛ102Б	40	20	4,5	20	20	6	-60→+70		GaP ЭС	112
902	АЛ102В	50	30	5	30	30	6	-60→+70		GaP ЭС	112
903	КЛ101А	10	10	5,5	10	10		-10→+70		Si(CO ₃) ₂ Д	113
904	КЛ101Б	15	20	5,5	20	20		-10→+70		Si(CO ₃) ₂ Д	113
905	КЛ101В	20	40	5,5	40	40		-10→+70		Si(CO ₃) ₂ Д	113
906	2Л101А	10	10	5,5	10	10		-10→+70		Si(CO ₃) ₂ Д	113
907	2Л101Б	15	20	5,5	20	10		-10→+70		Si(CO ₃) ₂ Д	113

ЧАСТЬ II

ТРАНЗИСТОРЫ

ТРАНЗИСТОРЫ

№ пп.	Тип прибора	$P_c \text{ max}$	f_{h21e}^{Δ}	R_{thja}	t_{amb}	Пределевые режимы при $t_{amb} = +20^{\circ}\text{C}$				I_{CBO}	$h - па$		
						$U_{CB \text{ max}}$	$I_{CBM \text{ max}}$	$U_{CE \text{ max}}$	$I_{CEM \text{ max}}$	$U_{BE \text{ max}}$	$I_{BFM \text{ max}}$	$I_C \text{ max}$	$I_{CM \text{ max}}$
		$\mu\text{вт}$	МГц	$^{\circ}\text{C}/\mu\text{вт}$	$^{\circ}\text{C}$	μ	μ	μ	μ	μ	μ	μ	μ

Германиевые

1	ГТ310А	20	160*	2	-25÷+55	12	10*			10	5	5
2	ГТ310Б	20	160*	2	-25÷+55	12	10*			10	5	5
3	ГТ310В	20	120*	2	-25÷+55	12	10*			10	5	5
4	ГТ310Г	20	120*	2	-25÷+55	12	10*			10	5	5
5	ГТ310Д	20	80*	2	-25÷+55	12	10*			10	5	5
6	ГТ310Е	20	80*	2	-25÷+55	12	10*			10	5	5
7	П27	30	1,0		-55÷+60	5	5			6	3	5
8	П27А	30	1,0		-55÷+60	5	5			6	3	5
9	П28	30	5,0		-55÷+60	5	5			6	3	5
10	П29	30	5,0		-55÷+60	12*	12*	12*	12*	100*	4	0,5
11	П29А	30	5,0		-55÷+60	12*	12*	12*	12*	100*	4	0,5
12	П30	30	10,0		-55÷+60	12*	12*	12*	12*	100*	4	0,5
13	П27*	30	1,0		-60÷+70	5	5			6	3	5
14	П27А*	30	1,0		-60÷+70	5	5			6	3	5
15	П27Б*	30	3,0		-60÷+70	5	5			6	3	5
16	П28*	30	5,0		-60÷+70	5	5			6	3	5
17	П29*	30	5,0		-60÷+70	12*	12*	12*	12*	100*	4	0,5
18	П29А*	30	5,0		-60÷+70	12*	12*	12*	12*	100*	4	0,5
19	П30*	30	10,0		-60÷+70	12*	12*	12*	12*	100*	4	0,5
20	1Т102	30	1,0		-60÷+70	5	5			6	10	5
21	1Т102А	30	1,0		-60÷+70	5	5			6	10	5
22	ГТ109А	30	1,0	1,8	-20÷+55	10	6*			20	5	5
23	ГТ109Б	30	1,0	1,8	-20÷+55	10	6*			20	5	5
24	ГТ109В	30	1,0	1,8	-20÷+55	10	6*			20	5	5
25	ГТ109Г	30	1,0	1,8	-20÷+55	10	6*			20	5	5
26	ГТ109Д	30	3,0	1,8	-20÷+55	10	6*			20	2	1,2
27	ГТ109Е	30	5,0	1,8	-20÷+55	10	6*			20	2	1,2
28	ГТ109Ж	30		1,8	-20÷+55	10	6*			20	1	1,5
29	ГТ109И	30	1,0	1,8	-20÷+55	10	6*			20	5	5
30	1Т101	50	2		-60÷+70	15	15*	15	15	10	15	5
31	1Т101А	50	2		-60÷+70	15	15*	15	15	10	15	5
32	1ТМ115А	50*	1	0,6	-60÷+73	50	40*	50	100*	50	1	
33	1ТМ115Б	50*	1	0,6	-60÷+73	50	40*	50	100*	50	1	
34	1ТМ115В	50*	1	0,6	-60÷+73	70	55*	50	100*	50	1	
35	1ТМ115Г	50*	1	0,6	-60÷+73	70	55*	50	100*	50	1	
36	ГТ115А	50	1		-20÷+45	20				30	0,04	1
37	ГТ115Б	50	1		-20÷+45	30				30	0,04	1
38	ГТ115В	50	1		-20÷+45	20				30	0,04	1
39	ГТ115Г	50	1		-20÷+45	30				30	0,04	1
40	ГТ115Д	50	1		-20÷+45	20				30	0,04	1
41	ГТ309А	50	120*		-25÷+55		10*			10	5	5
42	ГТ309Б	50	120*		-25÷+55		10*			10	5	5
43	ГТ309В	50	80*		-25÷+55		10*			10	5	5

МАЛОЙ МОЩНОСТИ

Параметры				U_{CEsat}	t_S	C_c	$r_b' \cdot C_c$	F	Техно-логия	Чер-теж №
ЖИМ	h_{21e}	h_{22e}	h_{11e}	r_{CEsat}	I_C	t_S	C_c	$r_b' \cdot C_c$	F	
I_E	h_{21E}	mkm	μA	om	μA	μsek	$n\phi$	$nsek$	$\partial\delta$	
1	20 - 70	3	38			4	300	3	СД	37
1	60 - 180	3	38			4	300	3	СД	37
1	20 - 70	3	38			5	300	4	СД	37
1	60 - 180	3	38			5	300	4	СД	37
1	20 - 70	3	38			5	500	4	СД	37
1	60 - 180	3	38			5	500	4	СД	37
0,5	20-100	2				50		10	С	15
0,5	20-170	1				50		5	С	15
0,5	20-200	1				50		5	С	15
20	20 - 50			0,2	20	20	6000		С	15
20	40 - 100			0,2	20	20	6000		С	15
20	80 - 180			0,2	20	20	6000		С	15
0,5	20-90	2				50		10	С	15
0,5	20-60	1				50		5	С	15
0,5	42-126	1				50		5	С	15
0,5	33-100	1				50		5	С	15
20	20 - 50			0,2	20	20	6000		С	15
20	40 - 100			0,2	20	20	6000		С	15
20	80 - 180			0,2	20	20	6000		С	15
1	20	2						7	С	27
1	20	2						12	С	27
1	20-50	3,3				30	5000		С	37
1	35-80	3,3				30	5000		С	37
1	60-130	3,3				30	5000		С	37
1	110-250	3,3				30	5000		С	37
0,1	20-70					40	5000		С	37
0,1	50-100					40	5000		С	37
10	100								С	37
1	20-80	3,3				30	5000	12	О	37
1	30-60	2				50	12500		С	27
1	20-40	2				50	12500		С	27
25	20-60			0,200	100	2,5	50	6500	С	11
25	50-150			0,150	100	2,5	50	6500	С	11
25	20-60			0,200	100	2,5	50	6500	С	11
25	50-150			0,150	100	2,5	50	6500	С	11
25	20-80								С	22
25	20-80								С	22
25	60-150								С	22
25	60-150								С	22
25	125-250								С	22
1	20 - 70	5	38			10	500		Д	21
1	60 - 180	5	38			10	500	6	Д	21
1	20 - 70	5	38			10	1000		Д	21

ТРАНЗИСТОРЫ

№ пп.	Тип прибора	P_c max при $+20^\circ\text{C}$	P_{av}^* $\mu\text{вт}$	f_{h21e}^Δ $\mu\text{Гц}$	R_{thja} $^\circ\text{C}/\text{мвт}$	t_{amb} $^\circ\text{C}$	Предельные режимы при $t_{amb} = +20^\circ\text{C}$					I_{CBO}	I_{CES}^*	I_{CEV}^*	$h - pa$				
							U_{CB} max $\mu\text{В}$	U_{CE} max $\mu\text{В}$	U_{CEM} max $\mu\text{В}$	U_{BE} max $\mu\text{В}$	I_C max $\mu\text{А}$								
44	ГТ309Г	50	80*			-25++55	10*				10	5	5						
45	ГТ309Д	50	40*			-25++55	10				10	5	5						
46	ГТ309Е	50	40*			-25++55	10				10	5	5						
47	ГТ322А	50	80*	0,7		-25++55	15	15*			5	4	5						
48	ГТ322Б	50	80*	0,7		-25++55	15	15*			5	4	5						
49	ГТ322В	50	50*	0,7		-25++55	15	15*			5	4	5						
50	ГТ322Г	50	50*	0,7		-25++55	15	15*			5	4	5						
51	ГТ322Д	50	50*	0,7		-25++55	15	15*			5	4	5						
52	ГТ322Е	50	50*	0,7		-25++55	15	15*			5	4	5						
53	ГТ328А	50	400*			-25++55	15	15		0,25	10	10	5						
54	ГТ328Б	50	300*			-25++55	15	15		0,25	10	10	5						
55	ГТ328В	50	300*			-25++55	15	15		0,25	10	10	5						
56	П417	50	200*	0,5		-40++60	10	8	0,7		10	3	5						
57	П417А	50	200*	0,5		-40++60	10	8	0,7		10	3	5						
58	П417Б	50	200*	0,5		-40++60	10	8	0,7		10	3	5						
59	П417*	50	200*	0,5		-60++70	10	8	0,7		10	3	5						
60	П417А*	50	200*	0,5		-60++70	10	8	0,7		10	3	5						
61	П418Г*	50	400*	0,5		-60++70	10	8	0,3		10	3	1						
62	П418Д*	50	400*	0,5		-60++70	10	8	0,3		10	3	1						
63	П418Е*	50	400*	0,5		-60++70	10	8	0,3		10	3	1						
64	П418Ж*	50	400*	0,5		-60++70	10	8	0,3		10	3	1						
65	П418И*	50	200*	0,5		-60++70	10	8	0,3		10	3	1						
66	П418К*	50	200*	0,5		-60++70	10	8	0,3		10	3	1						
67	П418Л*	50	200*	0,5		-60++70	10	8	0,3		10	3	1						
68	П418М*	50	200*	0,5		-60++70	10	8	0,3		10	3	1						
69	П422	50	60*			-20++55	10*				10	5	5						
70	П423	50	120*			-20++55	10*				10	5	5						
71	ТМ-2А*	75*	3	0,8		-60++73	15	15	10	50	20*	1							
72	ТМ-2Б*	75*	3	0,8		-60++73	15	15	10	50	20*	1							
73	ТМ-2В*	75*	9	0,8		-60++73	10	10	10	50	15*	1							
74	ТМ-2Г*	75*	9	0,8		-60++73	10	10	10	50	15*	1							
75	ТМ-2Д*	75*	20	0,8		-60++73	10	10	10	50	15*	1							
76	ТМ-4А*	75*	50*	0,8		-60++73	15	15	1,5	40	6	1							
77	ТМ-4Б*	75*	50*	0,8		-60++73	15	15	1,5	40	6	1							
78	ТМ-4В*	75*	50*	0,8		-60++73	15	15	1,5	40	6	1							
79	ТМ-4Г*	75*	80*	0,8		-60++73	15	15	1,5	40	6	1							
80	ТМ-4Д*	75*	80*	0,8		-60++73	15	15	1,5	40	6	1							
81	ТМ-4Е*	75*	80*	0,8		-60++73	15	15	1,5	40	6	1							
82	М-4А	75	50*	0,8		-60++73	15	15	1,5	40	6	1							
83	М-4Б	75	50*	0,8		-60++73	15	15	1,5	40	6	1							
84	М-4В	75	50*	0,8		-60++73	15	15	1,5	40	6	1							
85	М-4Г	75	80*	0,8		-60++73	15	15	1,5	40	6	1							
86	М-4Д	75	80*	0,8		-60++73	15	15	1,5	40	6	1							
87	М-4Е	75	80*	0,8		-60++73	15	15	1,5	40	6	1							
88	ТМ-5А*	75	1	0,8		-60++73	15	15	10	70	20	1							
89	ТМ-5Б*	75	1	0,8		-60++73	15	15	10	70	20	1							
90	ТМ-5В*	75	2	0,8		-60++73	15	15	10	70	20	1							

МАЛОЙ МОЩНОСТИ

Параметры				r_{CEsat}	U_{CEsat}	t_s	C_c	$r_b \cdot C_c$	F	Технология	Чертеж №
ЖММ	I_E	h_{21e}	h_{22e}	h_{11e}	ом	в	ма	мксек	нФ	псек	дБ
1	60	-180	5	38				10	1000	6	Д 21
1	20	-70	5	38				10	1000	6	Д 21
1	60	-180	5	38				10	1000	6	Д 21
1	20	-70	1	34				1,8	200	4	СД 35
1	50	-120	1	34				1,8	200	4	СД 35
1	20	-70	1	34				2,5	200	4	СД 35
1	50	-120	1	34				2,5	200	4	СД 35
1	20	-70	1	34				1,8	200	4	СД 35
1	50	-120	1	34				1,8	200	4	СД 35
3	20	-200						1,5	5	ЭП	32;35
3	40	-200						1,5	10	ЭП	32;35
3	10	-50						1,5	10	ЭП	32;35
5	24-100	0,1	10					5	400	Д	30
5	65-200	0,1	10					5	400	Д	30
5	75-250	0,1	20					6	400	Д	30
5	24-100	0,1	10					5	400	Д	30
5	65-200	0,1	10					5	400	Д	30
10	8-70	0,1	10					3	50	СД	51
10	8-70	0,1	10					3	100	СД	51
10	60-170	0,1	10					3	50	СД	51
10	60-170	0,1	10					3	100	СД	51
10	60-170	0,1	10					4	100	СД	51
10	60-170	0,1	10					4	200	СД	51
10	8-70	0,1	10					4	100	СД	51
10	8-70	0,1	10					4	200	СД	51
1	24-100	5	38					10	1000	10	Д 29
1	24-100	5	38					10	500	10	Д 29
10	20-60			0,15	10	2	25		3000	С	10
10	50-150			0,15	10	2	25		3000	С	10
10	30-90			0,15	10	2	25		3000	С	10
10	70-210			0,15	10	2	25		4000	С	10
10	80-250			0,15	10	2	25		4000	С	10
10	20-75			0,5	10	3	8,5		1500	Д	10
10	50-120			0,5	10	3	8,5		1500	Д	10
10	90-200			0,5	10	3	8,5		1500	Д	10
10	20-75			0,5	10	3	8,5		500	Д	10
10	50-120			0,5	10	3	8,5		500	Д	10
10	90-200			0,5	10	3	8,5		500	Д	10
10	20-75			0,5	10	3	8,5		1500	Д	21
10	50-120			0,5	10	3	8,5		1500	Д	21
10	90-200			0,5	10	3	8,5		1500	Д	21
10	20-75			0,5	10	3	8,5		500	Д	21
10	50-120			0,5	10	3	8,5		500	Д	21
10	90-200			0,5	10	3	8,5		500	Д	21
10	20-50			0,15	10	2	30		2500	С	10
10	35-80			0,15	10	2	30		3000	С	10
10	60-130			0,15	10	2	30		3000	С	10

ТРАНЗИСТОРЫ

№ пп.	Тип прибора	P_c max	f_{h21e}^{Δ}	R_{thja}	t_{amb}	Предельные режимы при $t_{amb} = +20^{\circ}\text{C}$					I_{CBO}	I_{CES}^*	I_{CEV}^*	$h - pa$
						U_{CB} max	U_{CE} max	U_{CEM} max	U_{BE} max	I_C max				
		мвт	Мгц	°C/мвт	°C	в	в	в	в	ма	мкв	в	в	в
91	TM-5Г*	75	3	0,8	-60++73	15	15	10	70	20	1			
92	TM-5Д*	75	1	0,8	-60++73	25	15	10	70	20	1			
93	ГТ108А	75	0,5 Δ	0,8	-20++55	10			50	10	5			
94	ГТ108Б	75	1 Δ	0,8	-20++55	10			50	10	5			
95	ГТ108В	75	1 Δ	0,8	-20++55	10			50	10	5			
96	ГТ108Г	75	1 Δ	0,8	-20++55	10			50	10	5			
97	ГТ305А	75	140*	0,8	60	15	15	1,5	40		1			
98	ГТ305Б	75	160*	0,8	60	15	15	1,5	40		1			
99	ГТ305В	75	160*	0,8	60	15	15	1,5	40		1			
100	1Т305А	75	140*	0,8	-60++73	15	15	1,5	40		1			
101	1Т305Б	75	160*	0,8	-60++73	15	15	1,5	40		1			
102	1Т305В	75	160*	0,8	-60++73	15	15	0,5	40		1			
103	1ТМ305А	75	140*	0,8	-60++73	15	15	1,5	40		1			
104	1ТМ305Б	75	160*	0,8	-60++73	15	15	1,5	40		1			
105	1ТМ305В	75	160*	0,8	-60++73	15	15	0,5	40		5			
106	T1A*	100	3,0	0,8	-60++100	7	7	5	50	8	1			
107	T1Б*	100	2,0	0,8	-60++100	7	7	5	50	6	1			
108	T2A*	100	3,0	0,8	-60++100	14	15	15	50	7	1			
109	T2Б*	100	2,0	0,8	-60++100	14	15	15	50	7	1			
110	T2B*	100	7,0	0,8	-60++100	14	15	15	50	7	1			
111	T2K*	100		0,8	-60++100	14			50	5				
112	T3A*	100	1,0	0,8	-60++100	14	20	15	50	8	1			
113	T3Б*	100	1,0	0,8	-60++100	14	20	15	50	8	1			
114	ГТ313А	100	300*		-20++55	15	12*		10	5	5			
115	ГТ313Б	100	450*		-20++55	15	12*		10	5	5			
116	1Т313А*	100	300*	0,43	-60++70	12	12	0,2	50	5	5			
117	1Т313Б*	100	450*	0,43	-60++70	12	12	0,2	50	5	5			
118	1Т313В*	100	450*	0,43	-60++70	12	12	0,2	50	5	5			
119	П401	100	30*		-50++60	10	10*	1	20	10	5			
120	П402	100	60*		-50++60	10	10*	1	20	5	5			
121	П403	100	120*		-50++60	10	10*	1	20	5	5			
122	П403А	100	120*		-50++60	10	10*	1	20	5	5			
123	П401*	100	30*		-60++70	10	10*	1	20	5	5			
124	П402*	100	60*		-60++70	10	10*	1	20	5	5			
125	П403*	100	120*		-60++70	10	10*	1	20	5	5			
126	П410*	100	200*		-60++70	5	8		20	2	5			
127	П410А*	100	200*		-60++70	5	8		20	2	5			
128	П411*	100	400*		-60++70	5	8		20	2	5			
129	П411А*	100	400*		-60++70	5	8		20	2	5			
130	П416	100	40*	0,4	-55++60		12*	3	25	3	5			
131	П416А	100	60*	0,4	-55++60		12*	3	25	3	5			
132	П416Б	100	80*	0,4	-55++60		12*	3	25	3	5			
133	П416*	100	40*	0,4	-60++70		12*	3	25	3	5			
134	П416А*	100	60*	0,4	-60++70		12*	3	25	3	5			
135	П416Б*	100	80*	0,4	-60++70		12*	3	25	3	5			
136	МП13*	150	0,5		-60++70	15	15	15	20	30*	5			

МАЛОЙ МОЩНОСТИ

Параметры												
ЖИМ	h_{21e}	h_{22e}	h_{11e}	r_{CEsat}	U_{CEsat}	I_C	t_S	C_c	$r_b' C_c$	F	Технология	Чертеж №
I_E	h_{21e}	h_{22e}	h_{11e}	r_{CEsat}	U_{CEsat}	I_C	t_S	C_c	$r_b' C_c$	F		
I_C	h_{21e}											
I_B												
I_{ma}												
10	110-250				0,15	10	2	30	3500		С	10
10	20-60				0,15	10	2	30	2500		С	10
1	20-50	3,3						50	5000		С	23
1	35-80	3,3						50	5000		С	23
1	60-130	3,3						50	5000		С	23
1	110-250	3,3						50	5000		С	23
10	25-80				0,5	10	3	7	500		Д	21
10	60-180				0,5	10	3	7	500		Д	21
10	40-120	$5 \cdot 10^6$						5,5	300	6*	Д	21
10	25-80				0,5	10	3	7	500		Д	21
10	60-180				0,5	10	3	7	500		Д	21
10	40-120							5,5	300	6*	Д	21
10	25-80				0,5	10	3	7	500		Д	10
10	60-180				0,5	10	3	7	500		Д	10
5*	40-120	5						5,5	300	6*	Д	10
10*	20-50	10			0,2	20	1	18	3000		С	17
10	40-150	10			0,2	20	1	18	3000		С	17
10*	20-50	10			0,2	20	1	18	3000		С	17
10*	40-150	10			0,2	20	1	18	3000		С	17
10*	20-150	10			0,2	20	1	18	3000		С	17
10*	10-40	10			0,2	20	1	18	3000		С	17
10*	30-150	10			0,4	20	1	18	3000		С	17
5	20-250							2,5	75		МДС	32
5	20-250							2	40	7*	МДС	32
5	20-250				0,7	15		2,5	75		МДС	32
5	20-80				0,7	15		2,5	40		МДС	32
5	60-250				0,7	15		2,5	40	7*	МДС	32
5	16-300	5						15	3500		Д	29
5	16-250	5						10	1000		Д	29
5	30-100	5						10	500		Д	29
5	16-200	5						10	500		Д	29
5	16-300	5						15	3500		Д	29
5	16-250	5						10	1000		Д	29
5	30-100	5						10	500		Д	29
5	27-120	10						5	300		Д	52
5	80-250	10						5	300		Д	52
5	27-120	10						5	200		Д	52
5	80-250	10						5	200		Д	52
5	20-80	5			2	50	1	8,0	500		Д	29
5	60-125	5			2	50	1	8	500		Д	29
5	90-250	5			2	50	1	8	500		Д	29
5	25-80	5			2	50	1	8	500		Д	29
5	60-125	5			2	50	1	8	500		Д	29
5	90-200	5			2	50	1	8	500		Д	29
1	12	2,5					0,9	50	7500		С	26

ТРАНЗИСТОРЫ

№ пп.	Тип прибора	P_c max при $+20^\circ\text{C}$	P_{av}^* при $+20^\circ\text{C}$	f_{h21e}^*	R_{thja}	t_{amb}	Предельные режимы при $t_{amb} = +20^\circ\text{C}$						I_{CBO}	I_{CES}^*	I_{CEV}^*	$h - па$	
											U_{CB} max	U_{CE} max	U_{BE} max	I_C max	P_e		
							$M\omega\text{т}$	$M\mu\text{и}$	$^\circ\text{C}/M\omega\text{т}$	$^\circ\text{C}$	в	в	в	ма	мкА		
137	МП13Б [*]	150	1,0			-60++70	15	15	15	20	10 [*]					5	
138	МП14 [*]	150	1,0			-60++70	15	15	15	20	30 [*]					5	
139	МП14А [*]	150	1,0			-60++70	30	30	30	20	30 [*]					3	
140	МП14Б [*]	150	1,0			-60++70	30	30	30	20	50 [*]					5	
141	МП14И [*]	150	1,0			-60++70	30	30	30	20						5	
142	МП14Я [*]	150				-60++70	30	25	10	20	100 [*]					5	
143	МП15 [*]	150	2,0			-60++70	15	15	15	20	30 [*]					5	
144	МП15А [*]	150	2,0			-60++70	15	15	15	20	30 [*]					5	
145	МП15И [*]	150				-60++70	30	30 [*]	30	20	100 [*]						
146	МП16Я1 [*]	150				-60++70		15 [*]	15 [*]	300 [*]	50 [*]				10		
147	МП16Я [*] Г [*]	150				-60++70		15 [*]	15 [*]	300 [*]	50 [*]				10		
148	МП20А	150	2	0,33		-55++60	30	20		300 [*]	50				5		
149	МП20Б	150	1,5	0,33		-55++60	30	20		300 [*]	50				5		
150	МП21В	150	1,5	0,33		-55++60	60	35		300 [*]	50				5		
151	МП21Г	150	1	0,33		-55++60	40	30		300 [*]	50				5		
152	МП21Д	150	1,0	0,33		-55++60	50	30		300 [*]	50				5		
153	МП21Е	150	0,7	0,33		-55++60	70	35		300 [*]	50				5		
154	МП20 [*]	150	1	0,33		-60++70	50	30 [*]	50	300 [*]	50				5		
155	МП21 [*]	150	1	0,33		-60++70	70	35 [*]	50	300 [*]	50				5		
156	МП21А [*]	150	1	0,33		-60++70	70	35 [*]	50	300 [*]	50				5		
157	МП21Б [*]	150	0,465	0,33		-60++70	70	40 [*]	50	300 [*]	50				5		
158	МП39	150	0,5	0,2		-20++60	10	10 [*]	5		15				5	5	
159	МП39Б	150	0,5	0,2		-20++60	10	10 [*]	5		15				5		
160	МП40	150	1,0	0,2		-20++60	10	10 [*]	5		15				5		
161	МП40А	150	1,0	0,2		-20++60	30	30 [*]	5		15				5		
162	МП41	150	1,0	0,2		-20++60	10	10 [*]	5		15				5		
163	МП41А	150	1,0	0,2		-20++60	10	10 [*]	5		15				5		
164	ГТ308А	150	90 [*]	0,25		-55++60	20	12 [*]	3		50	2			1		
165	ГТ308Б	150	120 [*]	0,25		-55++60	20	12 [*]	3		50	2			1		
166	ГТ308В	150	120 [*]	0,25		-55++60	20	12 [*]	3		50	2			1		
167	1T308A	150	90 [*]	0,25		-60++70	20	12 [*]	3		50	1			1		
168	1T308Б	150	120 [*]	0,25		-60++70	20	12 [*]	3		50	1			1		
169	1T308В	150	120 [*]	0,25		-60++70	20	12 [*]	3		50	1			1		
170	1609А [*]	150	1	0,2		-60++70	10	10	10	20	30				5		
171	1609Б [*]	150	1	0,2		-60++70	10	10	10	20	30				5		
172	1610 [*]	150	1	0,2		-60++70	10	10	10	20	30				5		
173	1610А [*]	150	1	0,2		-60++70	20	20	20	20	30				5		
174	1610Б [*]	150	1	0,2		-60++70	20	20	20	20	30				5		
175	1611 [*]	150	2	0,2		-60++70				20	30				5		
176	1T116A	150				-60++70		15 [*]	18	250	30 ϕ				1		
177	1T116Б	150				-60++70		15 [*]	18	250	30 ϕ				1		
178	1T116В	150				-60++70		15 [*]	18	250	30 ϕ				1		
179	1T116Г	150				-60++70		15 [*]	18	250	30 ϕ				1		
180	1T335A	150	300 [*]			-60++70	20	3	17	150	15	20					
181	1T335Б	150	300 [*]			-60++70	20	3	17	150	15	20					
182	1T335В	150	300 [*]			-60++70	20	3	14	150	15	20					

МАЛОЙ МОЩНОСТИ

Параметры				r_{CEsat}	U_{CEsat}	t_s	C_c	$r_b' C_c$	F	Технология	Чертеж №
ЖМ	h_{21e}	h_{22e}	h_{11e}	ом	в	I_C	$\mu\text{сек}$	$n\phi$	$\mu\text{сек}$	дб	
1	20-80	2,5				0,9	50	7500	12	C	26
1	20-40	2,5				0,9	50	7500		C	26
1	20-40	2,5				0,9	50	7500		C	26
1	30-60	2,5				0,9	50	7500		C	26
1	20-80	2,5				0,9	50	7500		C	26
1	20-80					0,9				C	26
1	30-60	2,5				0,9	50	7500		C	26
1	50-100	2,5				0,9	50	7500		C	26
						0,9				C	26
100*	20*-70*		100			1*				C	26
100*	10*-70*		200			1*				C	26
25	50-150			2						C	26
25	80-200			2						C	26
25	20-100			1						C	26
25	20-80			1						C	26
25	60-200			2						C	26
25	30-150			1						C	26
25	50-150				0,3	300				C	26
25	20-60				0,3	300				C	26
25	50-150				0,3	300				C	26
25	20-80				0,3	300				C	26
1	12	3,3					60	13200		C	26
1	20-60	3,3					60	13200	12	C	26
1	20-40	3,3					60	13200		C	26
1	20-40	3,3					60	13200		C	26
1	30-60	3,3					60	13200		C	26
1	50-100	3,3					60	13200		C	26
10	20*-75*				1,5	50	1	8	400	D	29
10	50*-120*				1,2	50	1	8	400	D	29
10	80*-200*				1,2	50	1	8	500	D	29
10	25*-75*				1,5	50	1	8	400	D	29
10	50*-120*				1,2	50	1	8	400	D	29
10	80*-150*				1,2	50	1	8	500	D	29
1	30-60	2,5					50	7500		C	26
1	15-45	2,5					50	7500	12	C	26
1	20-40	2,5					50	7500		C	26
1	25-50	2,5					50	7500		C	26
1	40-80	2,5					50	7500		C	26
1	40-90	2,5					50	7500		C	26
100*	15*-65*				0,25	150				C	26
100*	15*-65*				0,25	150				C	26
100*	20*-65*				0,25	150				C	26
100*	15*-65*				0,25	150				C	26
	40*-70*				2	250	0,1	8,5	700	СД	29
	60*-100*				2	250	0,1	8,5	700	СД	29
	40*-70				1,5	250	0,15	10	700	СД	29

ТРАНЗИСТОРЫ

№ пп.	Тип прибора	P_c max $\mu\text{вт}$	f_{h21e}^A $\mu\text{Гц}$	R_{thja} $^\circ\text{C}/\text{мвт}$	t_{amb} $^\circ\text{C}$	Предельные режимы при $t_{amb} = +20^\circ\text{C}$				I_{CBO} $\mu\text{А}$	I_{CES}^* $\mu\text{А}$	I_{CEV}^* $\mu\text{А}$	$h - па$ Pe U_{CE}
						U_{CB} max μ	U_{CBM} max μ	U_{CE} max U_{CER}^* U_{CEM} max μ	U_{BE} max U_{BEM} max μ	I_C max I_{CM} max μ			
183	1T335Г	150	300*		-60++70	20	3	14	150	15	20		
184	1T335Д	150	300*		-60++70	20	3	14	150	15	20		
185	ГТ321А	160*	60*	0,25	-55++60	60	50*	4	2000*	500	3		
186	ГТ321Б	160*	60*	0,25	-55++60	60	50*	4	2000*	500	3		
187	ГТ321В	160*	60*	0,25	-55++60	60	50*	4	2000*	500	3		
188	ГТ321Г	160*	60*	0,25	-55++60	45	40*	2,5	2000*	500	3		
189	ГТ321Д	160*	60*	0,25	-55++60	45	40*	2,5	2000*	500	3		
190	ГТ321Е	160*	60*	0,25	-55++60	45	40*	2,5	2000*	500	3		
191	1T321А	160*	60*	0,25	-60++70	60	50	4	2000*	500	3		
192	1T321Б	160*	60*	0,25	-60++70	60	50	4	2000*	500	3		
193	1T321В	160*	60*	0,25	-60++70	60	50	4	2000*	500	3		
194	1T321Г	160*	60*	0,25	-60++70	45	40	2,5	2000*	500	3		
195	1T321Д	160*	60*	0,25	-60++70	45	40	2,5	2000*	500	3		
196	1T321Е	160*	60*	0,25	-60++70	45	40*	2,5	2000*	500	3		
197	МП16*	200	1,0		-60++70		15*		300	25*	1		
198	МП16А*	200	1,0		-60++70		15*		300	25*	1		
199	МП16Б*	200	2,0		-60++70		15		300	25*	1		
200	МП25	200	0,2	0,2	-55++60	40	40	40	300	75	20		
201	МП25А	200	0,2	0,2	-55++60	40	40	40	400	75	20		
202	МП25Б	200	0,5	0,2	-55++60	40	40	40	400	75	20		
203	МП26	200	0,2	0,2	-55++60	70	70	70	300	75	35		
204	МП26А	200	0,2	0,2	-55++60	70	70	70	400	75	35		
205	МП26Б	200	0,5	0,2	-55++60	70	70	70	400	75	35		
206	МП25*	200	0,2	0,2	-60++70	40	40*	40	400	150	20		
207	МП25А*	200	0,2	0,2	-60++70	40	40*	40	400	150	20		
208	МП26Б*	200	0,5	0,2	-60++70	40	40*	40	400	150	20		
209	МП26*	200	0,2	0,2	-60++70	70	70	70	400	150	35		
210	МП26А*	200	0,2	0,2	-60++70	70	70	70	400	150	35		
211	МП26Б*	200	0,5	0,2	-60++70	70	70	70	400	150	35		
212	МП42	200	1,0	0,2	-60++70	15	15*		150	25*	1		
213	МП42А	200	1,0	0,2	-60++70	15	15*		150	25*	1		
214	МП42Б	200	1,0	0,2	-60++70	15	15*		150	25*	1		
215	ГТ320А	200	80*	0,2	-55++70	20	12*	3	150	10	1		
216	ГТ320Б	200	120*	0,2	-55++70	20	11*	3	150	10	1		
217	ГТ320В	200	160*	0,2	-55++70	20	9*	3	150	10	1		
218	1T320А	200	160*	0,2	-60++70	20	14*	3	200	8	1		
219	1T320Б	200	160*	0,2	-60++70	20	12*	3	200	8	1		
220	1T320В	200	200*	0,2	-60++70	20	10*	3	200	8	1		
													Германиевые
221	ТМ-3А*	75*	1	0,8	-60++73	15	15	10	50	20	1		
222	ТМ-3В*	75*	5	0,8	-60++73	15	15	10	50	20			
223	ТМ-3Г*	75*	5	0,8	-60++73	15	15	10	50	20			
224	ТМ-3Д*	75*	10	0,8	-60++73	15	15	10	50	20*			
225	МП9А*	150	1,0	0,2	-60++70	15	15	15	20	30*	5		

МАЛОЙ МОЩНОСТИ

Параметры				r_{CEsat}	U_{CEsat}	t_S	C_c	$r_b \cdot C_c$	F	Технология	Чертеж №
ЖМ	I_E	h_{21e}	h_{22e}	h_{11e}	ом	в	ма	мксек	нФ	нсек	дБ
500	60-100				1,5	250	0,15	10	700	СД	29
	50-100				1,5	250	0,15	10	700	СД	29
500	20-60				2,5	700	1	80	600	К	29
500	40-120				2,5	700	1	80	600	К	29
500	80-200				2,5	700	1	80	600	К	29
500	20-60				2,5	700	1	80	600	К	29
500	40-120				2,5	700	1	80	600	К	29
500	80-200				2,5	700	1	80	600	К	29
500	20-80				2,5	700	1	80	400	К	29
500	40-120				2,5	700	1	80	400	К	29
500	80-200				2,5	700	1	80	400	К	29
500	20-60				2,5	700	1	80	400	К	29
500	40-120				2,5	700	1	80	400	К	29
500	80-200				2,5	700	1	80	400	К	29
10	20-35									С	26
10	30-50									С	26
10	45-100									С	26
2,5	13-25				0,25	100				С	26
2,5	20-40				0,25	100				С	26
2,5	30-80				0,25	100				С	26
1,5	13-25				0,25	100				С	26
1,5	20-40				0,25	100				С	26
1,5	30-80				0,25	100				С	26
2,5	10-25	3,5					70	10500		С	26
2,5	20-25	3,5					70	10500		С	26
2,5	30-80	3,5					70	10500		С	26
1,5	10-25	3,5					50	7500		С	26
1,5	20-50	3,5					50	7500		С	26
1,5	30-80	3,5					50	7500		С	26
10	20-35	*			0,15	10				С	26
10	30-50	*			0,5	10				С	26
10	45-100	*			0,15	10				С	26
10	20-80	*			2	200	0,4	8	500	Д	29
10	50-160	*			2	200	0,5	8	500	Д	29
10	80-250	*			2	200	0,6	8	600	Д	29
10	40-100	*			1	200	0,2	8	500	Д	29
10	70-160	*			1	200	0,2	8	500	Д	29
10	100-250	*			1	200	0,2	8	500	Д	29
<hr/>											
п-р-п											
10	18-55				0,5	10	2,5	35	3000	С	10
10	20-60				0,5	10	2,5	35	3500	С	10
10	40-120				0,5	10	2,5	35	3500	С	10
10	40-160				0,5	10	2,5	35	3500	С	10
1	15-45	2,5						60	9000	10	С
											26

ТРАНЗИСТОРЫ

№ пп.	Тип прибора	$P_c \text{ max}$ P_{av}^* при $+20^\circ\text{C}$	f_{h21e}^Δ f_T^* f_{max}^* f_{h21b}	R_{thja}	t_{amb}	Предельные режимы при $t_{amb} = +20^\circ\text{C}$						I_{CBO}	$h - pa$				
						$U_{CB \text{ max}}$			$U_{CE \text{ max}}$								
						в	в	в	в	в	в	$I_C \text{ max}$	I_{CEV}				
226	МП10 [*]	150	1,0	0,2	-60 \pm 70	15	15	15	20	30 [*]	5						
227	МП10А [*]	150	1,0	0,2	-60 \pm 70	30	30	30	20	30 [*]	15						
228	МП10Б [*]	150	1,0	0,2	-60 \pm 70	30	30	30	20	100 [*]	15						
229	МП11 [*]	150	2,0	0,2	-60 \pm 70	15	15	15	20	30 [*]	5						
230	МП11А [*]	150	2,0	0,2	-60 \pm 70	15	15	15	20	30 [*]	5						
231	МП35	150	0,5	0,2	-55 \pm 60	15	15		20	30 [*]	5						
232	МП36А	150	1,0	0,2	-55 \pm 60	15	15		20	30 [*]	5						
233	МП37	150	1,0	0,2	-55 \pm 60	15	15		20	30 [*]	5						
234	МП37А	150	1,0	0,2	-55 \pm 60	30	30		20	30 [*]	15						
235	МП37Б	150	1,0	0,2	-55 \pm 60	30	30		20	30 [*]	15						
236	МП38	150	2,0	0,2	-55 \pm 60	15	15		20	30 [*]	5						
237	МП38А	150	2,0	0,2	-55 \pm 60	15	15		20	30 [*]	5						
238	ГТ311Е	150	250 [*]		-40 \pm 60	12	12	2	50	10	3						
239	ГТ311Ж	150	300 [*]		-40 \pm 60	12	12	2	50	10	3						
240	ГТ311И	150	450 [*]		-40 \pm 60	10	10	1,5	50	10	3						
241	1T311А	150	300 [*]		-60 \pm 70	12	12	2	50	5	3						
242	1T311Б	150	300 [*]		-60 \pm 70	12	12	2	50	5	3						
243	1T311Г	150	450 [*]		-60 \pm 70	12	12	2	50	5	3						
244	1T311Д	150	600 [*]		-60 \pm 70	12	12	2	50	5	3						
245	1T311К	150	450 [*]		-60 \pm 70	12	12	2	50	5	3						
Кремниевые																	
246	МП104 [*]	150	0,1		-60 \pm 120	60	60 [*]	30	10	1000 [*]	5						
247	МП105 [*]	150	0,1		-60 \pm 120	30	30 [*]	15	10	1000 [*]	5						
248	МП106 [*]	150	0,5		-60 \pm 120	15	15 [*]	10	10	1000 [*]	5						
249	2T104А	150 [*]	0,1	0,6	-60 \pm 120	30	30	10	60	1,0	5						
250	2T104Б	150 [*]	0,5	0,6	-60 \pm 120	15	15	10	50	1,0	5						
251	2T104В	150 [*]	0,5	0,6	-60 \pm 120	15	15	10	50	1,0	5						
252	2T104Г	150 [*]	0,1	0,6	-60 \pm 120	30	30	10	50	1,0	5						
253	2T104А	150 [*]	0,1	0,6	-60 \pm 120	30	30	10	50	1,0	5						
254	2T104Б	150 [*]	0,5	0,6	-60 \pm 120	15	15	10	50	1,0	5						
255	2T104В	150 [*]	0,5	0,6	-60 \pm 120	15	15	10	50	1,0	5						
256	2T104Г	150 [*]	0,1	0,6	-60 \pm 120	30	30	10	50	1,0	5						
257	МП114	150 [*]	0,1		-55 \pm 100	60	60 [*]	10	10	10	5						
258	МП115	150 [*]	0,1		-55 \pm 100	30	30 [*]	10	10	10	5						
259	МП116	150 [*]	0,5		-55 \pm 100	15	15 [*]	10	10	10	5						
Кремни																	
260	2T307А	15	250	3	-60 \pm 85	10	10	4	20	0,5	1						
261	2T307Б	15	250	3	-60 \pm 85	10	10	4	20	0,5	1						
262	2T307В	15	250	3	-60 \pm 85	10	10	4	20	0,5	1						
263	2T307Г	15	250	3	-60 \pm 85	10	10 [*]	4	20	0,5	1						
264	2T317А	15	100 [*]	4	-60 \pm 73	5	5 [*]	3,5	15	1	1						
265	2T317Б	15	100 [*]	4	-60 \pm 73	5	5 [*]	3,5	15	1	1						
266	2T317В	15	100 [*]	4	-60 \pm 73	5	5 [*]	3,5	15	1	1						

МАЛОЙ МОЩНОСТИ

параметры				r_{CEsat}	U_{CEsat}	t_s	C_c	$r_b' C_c$	F	Технология	Чертеж №
ЖИМ	h_{21e}	h_{22e}	h_{11e}	0м	в	I_C	мкsec	$n\phi$	nsec	дб	
1	15-30	2,5					60	9000		C	26
1	15-30	2,5					60	9000		C	26
1	25-50	2,5					60	9000		C	26
1	25-55	2,5					60	9000		C	26
1	45-100	2,5					60	9000		C	26
1	10-125	3,3					60	13200		C	26
1	15-45	3,3					60	13200	12	C	26
1	15-30	3,3					60	13200		C	26
1	15-30	3,3					60	13200		C	26
1	25-50	3,3					60	13200		C	26
1	25-55	3,3					60	13200		C	26
1	45-100	3,3					60	13200		C	26
15	15 ^x -80 ^x		0,3	15	0,05	2,5	75			П	32
15	50 ^x -200 ^x		0,3	15	0,05	2,5	100			П	32
15	100 ^x -300 ^x		0,3	15	0,05	2,5	100			П	32
15	15 ^x -180 ^x		0,3	15	0,05	2,5	50		7	П	32
15	30 ^x -180 ^x		0,3	15	0,05	2,5	100			П	32
15	30 ^x -80 ^x		0,3	15	0,05	2,5	75			П	32
15	60 ^x -180 ^x		0,3	15	0,05	2,5	75			П	32
15	60 ^x -180 ^x						2,5	75		П	32
Р-п-Р											
1	9	300								C	26
1	9-45	300	50							C	26
1	15-100	300								C	26
1	9-36	120	0,5	10			50			ЭП	10
1	20-80	120	0,5	10			50			ЭП	10
1	40-160	120					50			ЭП	10
1	15-60	120	0,5	10			50			ЭП	10
1	9-36	120	0,5	10			50			ЭП	22
1	20-80	120	0,5	10			50			ЭП	22
1	40-160	120	0,5	10			50			ЭП	22
1	15-60	120	0,5	10			50			ЭП	22
1	9	300								C	26
1	9-45	300	50							C	26
1	15-100	300								C	26
Вые п-р-п											
10 ^x	20 ^x		0,4	20	0,03	6				ЭП	5
10 ^x	40 ^x		0,4	20	0,03	6				ЭП	5
10 ^x	40 ^x		0,4	20	0,05	6				ЭП	5
10 ^x	80 ^x		0,4	20		6				ЭП	5
1	25 ^x -75 ^x		0,3	10	0,13	11				ЭП	2
1	35 ^x -120 ^x		0,3	10	0,13	11				ЭП	2
1	80 ^x -250 ^x		0,3	10	0,13	11				ЭП	2

ТРАНЗИСТОРЫ

№ пп.	Тип прибора	P_c max	f_{h21e}^{Δ}	R_{thja}	t_{amb}	Предельные режимы при $t_{amb} = +20^{\circ}\text{C}$						I_{CBO}	I_{CES}^*	I_{CEV}^*	$h - па$
						$U_{CB\max}$	$U_{CBM\max}$	$U_{CE\max}$	$U_{CEM\max}$	$U_{BE\max}$	$U_{BFM\max}$				P_e
		$\mu\text{вт}$	$M\mu$	$^{\circ}\text{C}/\mu\text{вт}$	$^{\circ}\text{C}$	μ	μ	μ	μ	μ	μ	$\mu\text{А}$	$\mu\text{А}$	$\mu\text{Вт}$	U_{CE}
267	KT319A	100 ^x			-60+-80	5	5 ^x	3,5	15	1	1				
268	KT319Б	100 ^x			-60+-80	5	5 ^x	3,5	15	1	1				
269	KT319В	100 ^x			-60+-80	5	5 ^x	3,5	15	1	1				
270	KT324А	15	800 ^x		-55+-85	10	10 ^x	4	20	0,5	1				
271	KT324Б	15	800 ^x		-55+-85	10	10 ^x	4	20	0,5	1				
272	KT324В	15	800 ^x		-55+-85	10	10 ^x	4	20	0,5	1				
273	KT324Г	15	600 ^x		-55+-85	10	10 ^x	4	20	0,5	1				
274	KT324Д	15	600 ^x		-55+-85	10	10 ^x	4	20	0,5	1				
275	KT324Е	15	600 ^x		-55+-85	10	10 ^x	4	20	0,5	1				
276	KT331А	15	250	4	125	15	15	3	20	0,2	5				
277	KT331Б	15	250	4	125	15	15	3	20	0,2	5				
278	KT331В	15	250	4	125	15	15	3	20	0,2	5				
279	KT331Г	15	400	4	125	15	15	3	20	0,2	5				
280	KT332А	15	250	4	125	15	15	3	20	0,2	5				
281	KT332Б	15	250	4	125	15	15	3	20	0,2	5				
282	KT332В	15	250	4	125	15	15	3	20	0,2	5				
283	KT332Г	15	500	4	125	15	15	3	20	0,2	5				
284	KT332Д	15	500	4	125	15	15	3	20	0,2	5				
285	KT336А	50	250 ^x		-60+-85	10	10 ^x	4	50 ^x		1				
286	KT336Б	50	250 ^x		-60+-85	10	10 ^x	4	50 ^x		1				
287	KT336В	50	250 ^x		-60+-85	10	10 ^x	4	50 ^x		1				
288	KT336Г	50	450 ^x		-60+-85	10	10 ^x	4	50 ^x		1				
289	KT336Д	50	450 ^x		-60+-85	10	10 ^x	4	50 ^x		1				
290	KT336Е	50	450 ^x		-60+-85	10	10 ^x	4	50 ^x		1				
291	2T336А	50	250 ^x		-60+-85	10	10 ^x	4	50 ^x		1				
292	2T336Б	50	250 ^x		-60+-85	10	10 ^x	4	50 ^x		1				
293	2T336В	50	250 ^x		-60+-85	10	10 ^x	4	50 ^x		1				
294	2T336Г	50	450 ^x		-60+-85	10	10 ^x	4	50 ^x		1				
295	2T336Д	50	450 ^x		-60+-85	10	10 ^x	4	50 ^x		1				
296	2T336Е	50	450 ^x		-60+-85	10	10 ^x	4	50 ^x		1				
297	2TM103А	75	3	1,0	-60+-120	120	120 ^x	1,5	15	7,5	20				
298	2TM103Б	75	3	1,0	-60+-120	120	120 ^x	1,5	15	7,5	20				
299	2TM103В	75	3	1,0	-60+-120	80	80 ^x	1,5	15	7,5	20				
300	2TM103Г	75	3	1,0	-60+-120	80	80 ^x	3	15	7,5	20				
301	2TM103Д	75	3	1,0	-60+-120	80	80 ^x	3	15	7,5	20				
302	TM10 ^x	150	20 ^x	0,6	-60+-120	20	20	3	10	15	10				
303	TM10A ^x	150	20 ^x	0,6	-60+-120	20	20	3	10	15	10				
304	TM10B ^x	150	20 ^x	0,6	-60+-120	30	30	3	10	15	10				
305	TM10B ^x	150	20 ^x	0,6	-60+-120	30	30	3	10	15	10				
306	TM10Г ^x	150	30 ^x	0,6	-60+-120	20	20	3	10	15	10				
307	TM10Д ^x	150	30 ^x	0,6	-60+-120	20	20	3	10	15	10				
308	TM10E ^x	150	30 ^x	0,6	-60+-120	20	20	3	10	15	10				
309	TM10Ж ^x	150	30 ^x	0,6	-60+-120	20	20 ^x	3	10	15	10				
310	МП101 ^x	150	0,5		-60+-120	20	20 ^x	20	20	3 ^x	5				
311	МП101А ^x	150	0,5		-60+-120	10	10 ^x	10	20	1	5				

МАЛОЙ МОЩНОСТИ

Параметры				r_{CEsat}	U_{CEsat}	t_S	C_c	$r_b' C_c$	F	Технология	Чертеж №
ЖАМ	I_E	h_{21e}	h_{22e}	h_{11e}	r_{CEsat}	I_C	t_S	C_c	$r_b' C_c$	F	
	I_E	h_{21e}	h_{22e}	h_{11e}	r_{CEsat}	I_C	t_S	C_c	$r_b' C_c$	F	
	I_C	h_{21E}			Ω	μA	$\mu\text{сек}$	$n\Phi$			
	I_P										
	I_{Ra}										
1	15 [*]				0,3	10	0,13	11		П	4
1	25 [*]				0,3	10	0,13	11		П	4
1	40 [*]				0,3	10	0,13	11		П	4
10 [*]	20-80							2,5		ЭП	6
10 [*]	40-120							2,5		ЭП	6
10 [*]	80-250							2,5		ЭП	6
10 [*]	40-120							2,5		ЭП	6
10 [*]	20-80							2,5	180	ЭП	6
10 [*]	60-250							2,5	180	ЭП	6
1	20 [*] -60 [*]							5	120	3 ^A	П 3
1	40 [*] -120 [*]							5	120	3 _A	П 3
1	80 [*] -220 [*]							5	120	3 _A	П 3
1	40 [*] -120 [*]							5	120	4 _A	П 3
1	20 [*] -60 [*]							5	300	8 _A	П 3
1	40 [*] -120 [*]							5	300	8 _A	П 3
1	80 [*] -220 [*]							5	300	8 _A	П 3
1	40 [*] -120 [*]							5	300	8 _A	П 3
1	80 [*] -220 [*]							5	300	8 _A	П 3
10	20 [*] -60 [*]				0,3	10	0,03	5		ЭП	1
10	40 [*] -120 [*]				0,3	10	0,03	5		ЭП	1
10	80 [*]				0,3	10	0,05	5		ЭП	1
10	20 [*] -60 [*]				0,3	10	0,015	5		ЭП	1
10	40 [*] -120 [*]				0,3	10	0,015	5		ЭП	1
10	80 [*]				0,3	10	0,015	5		ЭП	1
10	20 [*] -60 [*]				0,3	10	0,03	5		ЭП	1
10	40 [*] -120 [*]				0,3	10	0,5	5		ЭП	1
10	80 [*]				0,3	10	0,5	5		ЭП	1
10	20 [*] -60 [*]				0,3	10	0,15	5		ЭП	1
10	40 [*] -120 [*]				0,3	10	0,15	5		ЭП	1
10	80 [*]				0,3	10	0,15	5		ЭП	1
2	16-50				3,3	10		15		П	10
2	30-90				3,3	10		15		П	10
2	60-150				3,3	10		15		П	10
2	16-50				3,3	10		15		П	10
2	30-90				3,3	10		15		П	10
3	20-60	3			2,5	10		10		П	12
3	40-120	3			2,5	10		10		П	12
3	10-32	3			2,5	10		10		П	12
3	20-60	3			2,5	10		10		П	12
3	10-32	3			2,5	10		10		П	12
3	20-60	3			2,5	10		10		П	12
3	40-120	3			2,5	10		10		П	12
3	80	3			2,5	10		10		П	12
1	10-25	2	30 [*]					150		С	26
1	10-30	2	30 [*]					150		С	26

15

ТРАНЗИСТОРЫ

№ пп.	Тип прибора	$P_c \text{ max}$ мвт	f_{h21e}^* f_T^* f_{max}^* f_{h21b}^* M_2	R_{thja}	t_{amb} °C	Предельные режимы при $t_{\text{amb}} = +20^\circ\text{C}$				I_{CBO}	I_{CES}^*	I_{CEV}^*	$h - \text{па}$
						$U_{\text{CB max}}$ $U_{\text{CBM max}}$ в	$U_{\text{CF max}}$ U_{CFR} в	$U_{\text{CEM max}}$ U_{CEM} в	$I_{\text{BE max}}$ $I_{\text{BEM max}}$ ма	$I_{\text{C max}}$ $I_{\text{CM max}}$ мкА	U_{CE}		
312	МП101Б*	150	0,5		-60+-+120	20	20*		20	20	3*		5
313	МП102*	150	0,5		-60+-+120	10	10*		10	20	3*		5
314	МП103*	150	1,0		-60+-+120	10	10*		10	20	3*		5
315	МП103А*	150	1,0		-60+-+120	10	10*		10	20	3*		5
316	МП111	150	0,5		-55+-+100	20	20*		5	20	3*		5
317	МП111А	150	0,5		-55+-+100	10	10*		5	20	1		5
318	МП111Б	150	0,5		-55+-+100	20	20*		5	20	3		5
319	МП112	150	0,5		-55+-+100	10	10*		5	20	3		5
320	МП113	150	1,0		-55+-+100	10	10*		5	20	3		5
321	МП113А	150	1,2		-55+-+100	10	10*		5	20	3		5
322	КТ301	150	20*	0,6	-55+-+85	20	20		3		40	10	
323	КТ301А	150	20*	0,6	-55+-+85	20	20		3		40	10	
324	КТ301Б	150	20*	0,6	-55+-+85	30	30		3		40	10	
325	КТ301В	150	20*	0,6	-55+-+85	30	30		3		40	10	
326	КТ301Г	150	30*	0,6	-55+-+85	20	20		3		40	10	
327	КТ301Д	150	30*	0,6	-55+-+85	20	20		3		40	10	
328	КТ301Е	150	30*	0,6	-55+-+85	20	20		3		40	10	
329	КТ301Ж	150	30*	0,6	-55+-+85	20	20		3		40	10	
330	2Т301Г	150	30*	0,6	-60+-+120	30	30		3	10	30	10	
331	2Т301Д	150	30*	0,6	-60+-+120	30	30		3	10	30	10	
332	2Т301Е	150	30*	0,6	-60+-+120	20	20		3	10	30	10	
333	2Т301Ж	150	30*	0,6	-60+-+120	20	20		3	10	30	10	
334	КТ306А	150	300*		-55+-+100	15	10*		4	30	0,5		1
335	КТ306Б	150	500*		-55+-+100	15	10*		4	30	0,5		1
336	КТ306В	150	300*		-55+-+100	15	10*		4	30	0,5		1
337	КТ306Г	150	500*		-55+-+100	15	10*		4	30	0,5		1
338	КТ306Д	150	200*		-55+-+100	15	10*		4	30	0,5		1
339	2Т306А	150	300*		-60+-+120	15	10*		4	30	0,5		1
340	2Т306Б	150	500*		-60+-+120	15	10*		4	30	0,5		1
341	2Т306В	150	300*		-60+-+120	15	10*		4	30	0,5		1
342	2Т306Г	150	500*		-60+-+120	15	10*		4	30	0,5		1
343	КТ315А	150	250*		-55+-+100		25			100	1,0		10
344	КТ315Б	150	250*		-55+-+100		20			100	1,0		10
345	КТ315В	150	250*		-55+-+100		40			100	1,0		10
346	КТ315Г	150	250*		-55+-+100		35			100	1,0		10
347	КТ316А	150	600*		-55+-+100	10	10*		4	30	0,5		1
348	КТ316Б	150	800*		-55+-+100	10	10*		4	30	0,5		1
349	КТ316В	150	800*		-55+-+100	10	10*		4	30	0,5		1
350	КТ316Г	150	600*		-55+-+100	10	10*		4	30	0,5		1
351	КТ316Д	150	800*		-55+-+100	10	10*		4	30	0,5		1
352	2Т316А	150	600*		-60+-+130	10	10*		4	30	0,5		1
353	2Т316Б	150	800*		-60+-+130	10	10*		4	30	0,5		1
354	2Т316В	150	800*		-60+-+130	10	10*		4	30	0,5		1
355	2Т316Г	150	600*		-60+-+130	10	10*		4	30	0,5		1
356	2Т316Д	150	800*		-60+-+130	10	10*		4	30	0,5		1

МАЛОЙ МОЩНОСТИ

Параметры				r_{CEsat}	U_{CEsat}	t_S	C_c	$r_b' C_c$	F	Технология	Чертеж №
ЖММ	h_{21e}	h_{22e}	h_{11e}	ом	в	ма	мксек	нФ	нсек	дБ	
1	15-45	2	30 [*]					150			С 26
1	15-45	2	30 [*]					150			С 26
1	15-45	2	30 [*]					150			С 26
1	30-75	2	30 [*]					150			С 26
1	10-25	2	30 [*]					170			С 26
1	10-30	2	30 [*]					170		18	С 26
1	15-45	2	30 [*]					170			С 26
1	15-45	2	30 [*]					170			С 26
1	15-45	2	30 [*]					170			С 26
1	35-105	2	30 [*]					170			С 26
3	20-60	3					10	2000			Д 22
3	40-120	3					10	2000			Д 22
3	10-32	3					10	4500			Д 22
3	20-60	3					10	4500			Д 22
3	10-32	3					10	2000			Д 22
3	20-60	3					10	2000			Д 22
3	40-120	3					10	2000			Д 22
3	80-300	3					10	2000			Д 22
3	10-32	3					10	4500			П 22
3	20-60	3					10	4500			П 22
3	40-120	3					10	2000			П 22
3	80-300	3					10	2000			П 22
10 [*]	20 [*] -60 [*]						5				П 24
10 [*]	40 [*] -120 [*]						5				П 24
10 [*]	20 [*] -100 [*]	30					5	500			П 24
10 [*]	40 [*] -200 [*]	30					5	500			П 24
10 [*]	30 [*] -150 [*]	30					5	300			П 24
10 [*]	20 [*] -60 [*]		0,3	10	0,03		5				П 24
10 [*]	40 [*] -120 [*]		0,3	10	0,03		5				П 24
10 [*]	20 [*] -100 [*]						5	500			П 24
10 [*]	40 [*] -200 [*]						5	500			П 24
5	20 [*] -90 [*]		0,5	100			7	300		ЭП	7
5	70 [*] -350 [*]		0,5	100			7	500		ЭП	7
5	20 [*] -90 [*]		0,5	100			7	500		ЭП	7
5	70 [*] -350 [*]		0,5	100			7	500		ЭП	7
10 [*]	20 [*] -60 [*]		0,4	10	0,01		3			ЭП	24
10 [*]	40 [*] -120 [*]		0,4	10	0,01		3			ЭП	24
10 [*]	40 [*] -120 [*]		0,4	10	0,15		3			ЭП	24
10 [*]	20 [*] -100 [*]		0,4	10			3	150		ЭП	24
10 [*]	60 [*] -300 [*]		0,4	10			3	150		ЭП	24
10 [*]	20 [*] -60 [*]		0,4	10	0,01		3			ЭП	24,33
10 [*]	40 [*] -120 [*]		0,4	10	0,01		3			ЭП	24,33
10 [*]	40 [*] -120 [*]		0,4	10	0,15		3			ЭП	24,33
10 [*]	20 [*] -100 [*]		0,4	10			3	150		ЭП	24,33
10 [*]	60 [*] -300 [*]		0,4	10			3	150		ЭП	24,33

ТРАНЗИСТОРЫ

№ пп.	Тип прибора	$P_c \text{ max}$ P_{av}^* при $+20^\circ\text{C}$	f_{h21e}^* f_T^* f_{max}^* f_{h21b}^*	R_{thja}	t_{amb}	Предельные режимы при $t_{amb} = + 20^\circ\text{C}$				I_{CBO}	I_{CES}^*	I_{CEV}^*	$h - pa$
						$U_{CB \text{ max}}$ $U_{CBM \text{ max}}$	$U_{CE \text{ max}}$ U_{CER}^* $U_{CEM \text{ max}}$	$U_{BE \text{ max}}$ $U_{BEM \text{ max}}$	$I_C \text{ max}$ $I_{CM \text{ max}}$				P_e
357	KT312A	225	80 [*]	0,4	-40 \div +85	15	15 [*]	4	30	10	2		
358	KT312Б	225	120 [*]	0,4	-40 \div +85	30	30 [*]	4	30	10	2		
359	KT312В	225	120 [*]	0,4	-40 \div +85	15	15 [*]	4	30	10	2		
360	2T312A	225	80 [*]	0,4	-60 \div +120	15	15 [*]	4	30	1	2		
361	2T312Б	225	120 [*]	0,4	-60 \div +120	30	30 [*]	4	30	1	2		
362	2T312В	225	120 [*]	0,4	-60 \div +120	15	15 [*]	4	30	1	2		
363	KT325A	225	800 [*]		-55 \div +100	15	15 [*]	4	60	0,5	5		
364	KT325Б	225	800 [*]		-55 \div +100	15	15 [*]	4	60	0,5	5		
365	KT325В	225	1000 [*]		-55 \div +100	15	15 [*]	4	60	0,5	5		
366	П307	250	20 [*]		-40 \div +70	80	80 [*]	3	30	20	20		
367	П307А	250	20 [*]		-40 \div +70	80	80 [*]	3	30	20	20		
368	П307Б	250	20 [*]		-40 \div +70	80	80 [*]	3	15	20	20		
369	П307В	250	20 [*]		-40 \div +70	60	60 [*]	3	30	20	20		
370	П307Г	250	20 [*]		-40 \div +70	80	80 [*]	3	15	20	20		
371	П308	250	20 [*]		-40 \div +70	120	120 [*]	3	15	20	20		
372	П309	250	20 [*]		-40 \div +70	120	120 [*]	3	30	20	20		
373	П307 [*]	250	20 [*]		-60 \div +120	80	80 [*]	3	30	3	20		
374	П307А [*]	250	20 [*]		-60 \div +120	80	80 [*]	3	30	3	20		
375	П307Б [*]	250	20 [*]		-60 \div +120	80	80 [*]	3	15	3	20		
376	П307В [*]	250	20 [*]		-60 \div +120	60	60 [*]	3	30	3	20		
377	П307Г [*]	250	20 [*]		-60 \div +120	80	80 [*]	3	15	3	20		
378	П308 [*]	250	20 [*]		-60 \div +120	120	120 [*]	3	15	3	20		
379	П309 [*]	250	20 [*]		-60 \div +120	120	120 [*]	3	30	3	20		

ТРАНЗИСТОРЫ СРЕД

№ пп.	Тип прибора	R_{thjC} R_{thja}	$P_c \text{ max}$ $P_{C \text{ max}}$	t_{amb}	t_{amb}	Предельные режимы при $t_{amb} = + 20^\circ\text{C}$				I_{CBO}	I_{CES}^*	I_{CER}^*	ma
						$I_C \text{ max}$ $I_{CM \text{ max}}$	$I_B \text{ max}$ $I_{BM \text{ max}}$	$U_{CB \text{ max}}$	$U_{BE \text{ max}}$				

Германия

380	ГТ402А	100 [*]	0,6 [*]	25	-25 \div +55	0,5				0,35	25 [*]	0,025	
381	ГТ402Б	100 [*]	0,6 [*]	25	-25 \div +55	0,5				0,35	25 [*]	0,025	
382	ГТ403А	100 [*]	0,6 [*]	25	-40 \div +70	1,25	0,4	45	20	30	0,08		
383	ГТ403Б	100 [*]	0,6 [*]	25	-40 \div +70	1,25	0,4	45	20	30	0,05		
384	ГТ403В	100 [*]	0,6 [*]	25	-40 \div +70	1,25	0,4	60	20	45	0,05		

МАЛОЙ МОЩНОСТИ

Параметры				r_{CEsat}	U_{CEsat}	t_s	C_c	$r_b' C_c$	F	Технология	Чертеж №
ЖИМ	I_E	h_{21e}	h_{22e}	h_{11e}	ом	в	ма	мкsec	нф	нсек	дб
20	10 ^x -100 ^x				0,8	20		5	500		П 16
20	25 ^x -100 ^x				0,8	20		5	500		П 16
20	50 ^x -280 ^x				0,8	20		5	500		П 16
20	12 ^x -100 ^x				0,5	20		5	500		П 16
20	25 ^x -100 ^x				0,5	20		5	500		П 16
20	50 ^x -250 ^x				0,35	20		5	500		П 16
10	30-90							2,5	125	ЭП	36
10	70-210							2,5	125	ЭП	36
10	160-400							2,5	125	ЭП	36
10	16-50	70	150							Д	25,26
10	30-90	70	200							Д	25,26
10	50-150	70	330							Д	25,26
10	50-150	70	250							Д	25,26
10	16-50	70	250							Д	25,26
10	30-90	70	330							Д	25,26
10	16-50	70	200							Д	25,26
10	16-50	70	100							Д	25,26
10	30-90	70	130							Д	25,26
10	50-150	70	330							Д	25,26
10	50-150	70	130							Д	25,26
10	16-50	70	230							Д	25,26
10	30-90	70	330							Д	25,26
10	16-50	70	130							Д	25,26

НЕЙ МОЩНОСТИ

h_{21e}, h_{21E}^*				f_{h21e}^Δ	f_T^*	r_{CEsat}	U_{CEsat}	t_s	t_r^*	C_c	$r_b' C_c$	Технология	Чертеж №
Режим		мин	макс	f_{h21b}	Миг	ом	в	ма	мкsec	нф	нсек		
U_{CE}	I_C												
U_{CB}^*	I_E^*												
θ	a												

вые р-п-р

1	3 ^x	30 ^x	80 ^x	0,015 ^Δ								C 28
1	3 ^x	60 ^x	150 ^x	0,015 ^Δ								C 28
5	0,1	20	60	0,008 ^Δ			0,5	0,6				C 20
5	0,1	50	150	0,008 ^Δ			0,5	0,5				C 20
5	0,1	20	60	0,008 ^Δ			0,5	0,5				C 20

ТРАНЗИСТОРЫ

№ пп.	Тип прибора	R_{thjC} R_{thja}^*	$P_{C\max}$ $P_{C\max}^*$	t_{amb} t_{amb} °C	t_{amb} °C	Предельные режимы при $t_{amb} = +20^\circ C$					I_{CBO} I_{CER}^* ма	
						$I_C \max$ а	$I_{CM} \max$ I_{CM}^* а	$I_B \max$ а	$I_{BM} \max$ а	$U_{CB} \max$ в	$U_{BE} \max$ в	$U_{CE} \max$ в
385	ГТ403Г	100*	0,6*	25	-40++70	1,25	0,4	60	20	45	0,05	
386	ГТ403Д	100*	0,6*	25	-40++70	1,25	0,4	60	30	45	0,05	
387	ГТ403Е	100*	0,6*	25	-40++70	1,25	0,4	60	20	45	0,05	
388	ГТ403Ж	100*	0,6*	25	-40++70	1,25	0,4	80	20	60	0,07	
389	ГТ403И	100*	0,6*	25	-40++70	1,25	0,4	80	20	60	0,07	
390	ГТ403Ю	100*	0,6*	25	-40++70	1,25	0,4	45	20	30	0,05	
391	1T403А	100*	0,6*	25	-60++70	1,25	0,4	45	20	30	0,05	
392	1T403Б	100*	0,6*	25	-60++70	1,25	0,4	45	20	30	0,05	
393	1T403В	100*	0,6*	20	-60++70	1,25	0,4	60	20	45	0,05	
394	1T403Г	100*	0,6*	25	-60++70	1,25	0,4	60	20	45	0,05	
395	1T403Д	100*	0,6*	25	-60++70	1,25	0,4	60	30	45	0,05	
396	1T403Е	100*	0,6*	25	-60++70	1,25	0,4	60	20	45	0,05	
397	1T403Ж	100*	0,6*	25	-60++70	1,25	0,4	80	20	60	0,07	
398	1T403И	100*	0,6*	25	-60++70	1,25	0,4	80	20	60	0,07	
399	П211*	33 60*	0,75*	40	-60++70	0,5*		50			0,05	
400	П212*	33 60*	0,75*	40	-60++70	0,5*		70			0,05	
401	П212А*	33 60*	0,75*	40	-60++70	0,5*		70			0,05	
402	П212Б*	33 60*	0,75*	40	-60++70	0,5*		70			0,05	
403	П607	15	1,5	40	-50++60	0,3	0,15*	30	1,5	25*	0,3	
404	П607А	15	1,5	40	-50++60	0,3	0,15*	30	1,5	25*	0,3	
405	П608	15	1,5	40	-50++60	0,3	0,15*	30	1,5	25*	0,3	
406	П608А	15	1,5	40	-50++60	0,3	0,15*	30	1,5	25*	0,3	
407	П608Б	15	1,5	40	-50++60	0,3	0,15*	50	1,5	40*	0,5	
408	П609	15	1,5	40	-50++60	0,3	0,15*	30	1,5	25*	0,3	
409	П609А	15	1,5	40	-50++60	0,3	0,15*	30	1,5	25*	0,3	
410	П609Б	15	1,5	40	-50++60	0,3	0,15*	50	1,5	40*	0,5	
411	П607*	15	1,5	40	-60++70	0,3	0,15*	30	1,5	25*	1,3	
412	П607А*	15	1,5	40	-60++70	0,3	0,15*	30	1,5	25*	1,3	
413	П608*	15	1,5	40	-60++70	0,3	0,15*	30	1,5	25*	1,3	
414	П608А*	15	1,5	40	-60++70	0,3	0,15*	30	1,5	25*	1,3	
415	П608Б*	15	1,5	40	-60++70	0,3	0,15*	50	1,5	40*	0,5	
416	П609*	15	1,5	40	-60++70	0,3	0,15*	30	1,5	25*	0,3	
417	П609А*	15	1,5	40	-60++70	0,3	0,15*	30	1,5	25*	0,3	
418	П609Б*	15	1,5	40	-60++70	0,3	0,15*	50	1,5	40*	0,5	
Германия												
419	ГТ323А	100 200*	0,5 0,25*	50	-50++60	1*		20	2	10*	0,03	
420	ГТ323Б	100 200*	0,5 0,25*	50	-50++60	1*		20	2	10*	0,03	
421	ГТ323В	100 200*	0,5 0,25*	50	-50++60	1*		20	2	10*	0,03	

h_{21e}, h_{21E}^*				f_{h21e}^Δ	r_{CEsat}	U_{CEsat}	t_s	C_c	$r_{b'b}C_c$	Техноло-	Чер-	
Режим		мин	макс	f_T^*	Ω_m	σ	t_r^*	n_f	n_{sec}	гия	теж	
U_{CE}	I_C^*	I_E^*	a	f_{h21b}	M_u	a	I_C^*	I_B^*	a			
5	0,1	50	150	0,006 $^\Delta$		0,5	0,5			C	20	
5	0,1	50	150	0,006 $^\Delta$		0,5	0,5			C	20	
0,45	30 *			0,008 $^\Delta$		0,5	0,5			C	20	
5	0,1	20	60	0,008 $^\Delta$		0,5	0,5			C	20	
0,45	30 *			0,008 $^\Delta$		0,5	0,5			C	20	
5	0,1	30	60	0,008 $^\Delta$		0,5	0,5			C	20	
5	0,1	20	60	0,008 $^\Delta$		0,5	0,5			C	20	
5	0,1	50	150	0,008 $^\Delta$		0,5	0,5			C	20	
5	0,1	20	60	0,008 $^\Delta$		0,5	0,5			C	20	
5	0,1	50	150	0,006 $^\Delta$		0,5	0,5			C	20	
5	0,1	50	150	0,006 $^\Delta$		0,5	0,5			C	20	
0,45	30 *			0,008 $^\Delta$		0,5	0,5			C	20	
5	0,1	20	60	0,008 $^\Delta$		0,5	0,5			C	20	
0,45	30 *			0,008 $^\Delta$		0,5	0,5			C	20	
5	0,1	20	60	0,008 $^\Delta$		0,5	0,5			C	20	
0,45	30 *			0,008 $^\Delta$		0,5	0,5			C	20	
5	0,05	50	150	1		1				C	43	
5	0,05	20	60	1		1				C	43	
5	0,05	40	200	1		1				C	43	
5	0,05	40	200	0,1	1					C	43	
3	0,25	20 *	80 *	60 *		2	0,2	3	50	500	K	43
3	0,25	60 *	200 *	60 *		2	0,2	3	50	500	K	43
3	0,25	40 *	120 *	90 *		2	0,2	3	50	500	K	43
3	0,25	80 *	240 *	90 *		2	0,2	3	50	500	K	43
3	0,25	40 *	120 *	90 *		2	0,2	3	50	500	K	43
3	0,25	40 *	120 *	120 *		2	0,2	3	50	500	K	43
3	0,25	80 *	240 *	120 *		2	0,2	3	50	500	K	43
3	0,25	80 *	240 *	120 *		2	0,2	3	50	500	K	43
3	0,25	20 *	80 *	60 *		2	0,2	3	50	500	K	43
3	0,25	60 *	200 *	60 *		2	0,2	3	50	500	K	43
3	0,25	40 *	120 *	90 *		2	0,2	3	50	500	K	43
3	0,25	80 *	240 *	90 *		2	0,2	3	50	500	K	43
3	0,25	40 *	120 *	90 *		2	0,2	3	50	500	K	43
3	0,25	40 *	120 *	120 *		2	0,2	3	50	500	K	43
3	0,25	80 *	240 *	120 *		2	0,2	3	50	500	K	43
8	0,25	80 *	240 *	120 *		2	0,2	3	50	500	K	43
вывес п-р-п												
5	0,5	20 *	60 *	200 *		2,5	1	0,1 0,01 *	30	800	МП	31
5	0,5	40 *	120 *	200 *		2,5	1	0,1 0,01 *	30	300	МП	31
5	0,5	80 *	200 *	300 *		2,5	1	0,15 0,01 *	30	300	МП	31

ТРАНЗИСТОРЫ

№ пп.	Тип прибора	R_{thjC} R_{thja}^*	$P_{C\max}$ $P_{C\max}^*$	t_{amb} °C	t_{amb} °C		Предельные режимы при $t_{amb} = +20^\circ C$					I_{CBO} I_{CER}^* ма		
							$I_{C\max}$ а	$I_{CM\max}$ а	$I_{B\max}$ а	$I_{BM\max}$ а	$U_{CB\max}$ в	$U_{BE\max}$ в	$U_{CE\max}$ в	U_{CER}^* в
422	1T323A	100 200	0,5 0,25	50 25	-60+70		1				20	2	12	0,03
423	1T323Б	100 200	0,5 0,25	50 25	-60+70		1				20	2	12	0,03
424	1T323В	100 200	0,5 0,25	50 25	-60+70		1				20	2	10	0,03
425	ГТ404А	100 150	0,6 0,3	25 25	-25++55		0,5				0,3	25	0,025	
426	ГТ404Б	100 150	0,6 0,3	25 25	-25++55		0,5				0,3	25	0,025	
427	ГТ404В	100 150	0,6 0,3	25 25	-25++55		0,5				0,3	40	0,025	
428	ГТ404Г	100 150	0,6 0,3	25 25	-25++55		0,5				0,3	40	0,025	
Кремни														
429	KT601А		0,5 0,25	55 55	-40+55		0,03				100	2	100	0,5
430	KT608А	200	0,5	25	-40+85		0,4				60	4	60	0,025
431	KT608Б	200	0,5	25	-40+85		0,4				60	4	60	0,025
432	2T608А	200	0,5	50	-60+125		0,4				60	4	60	0,010
433	2T608Б	200	0,5	50	-60+125		0,4				60	4	60	0,01

ТРАНЗИСТОРЫ

№ пп.	Тип прибора	R_{thjC} R_{thja}^*	$P_{C\max}$ $P_{C\max}^*$	t_{amb} °C	t_{amb} °C		Предельные режимы при $t_{amb} = +20^\circ C$					I_{CBO} I_{CER}^* I_{CEV}		
							$I_{C\max}$ а	$I_{CM\max}$ а	$I_{B\max}$ а	$I_{BM\max}$ а	$U_{CB\max}$ в	$U_{BE\max}$ в	$U_{CE\max}$ в	U_{CER}^* в
434	П601И	15 50	3 0,5	25 60	-50+60		1,5				25	0,7	25	0,2
435	П601АИ	15 50	3 0,5	25 60	-50+60		1,5				30	0,7	30	0,1
436	П601БИ	15 50	3 0,5	25 60	-50+60		1,5				30	0,7	30	0,13
437	П602И	15	3 0,5	25 60	-50+60		1,5				30	0,7	30	0,1
438	П602АИ	15 50	3 0,5	25 60	-50+60		1,5				25	0,7	25	0,13
Германие														

СРЕДНЕЙ МОЩНОСТИ

h _{21e} , h _{21E} [*]				f _{h21e} ^Δ	r _{CEsat}	U _{CEsat}	t _S	C _c	r _{b'b} C _c	Техно-логия	Чер-теж №	
Режим		мин	макс	f _T [*]	ом	σ	t _r [*]	nф	nсек			
U _{CE}	I _C			f _{h21b}	Mиц	I _C I _B *	милсек					
U _{CE} U _{CB} σ	I _C I _E a											
5	0,5	20 [*]	60 [*]	200 [*]		2,5	1	0,1 0,01 [*]	30	250	МП	31
5	0,5	40 [*]	120 [*]	200 [*]		2,5	1	0,1 0,01 [*]	30	250	МП	31
5	0,5	80 [*]	200 [*]	300 [*]		2,5	1	0,1 0,01 [*]	30	250	МП	31
1	0,003	30 [*]	80 [*]	0,015 ^Δ							C	28
1	0,003	60 [*]	150 [*]	0,015 ^Δ							C	28
1	0,03	30 [*]	80 [*]	0,015 ^Δ							C	28
1	0,03	60 [*]	150 [*]	0,015 ^Δ							C	28
вые п-р-п												
20 [*]	0,01	16		40 [*]				15	600	K	26	
5 [*]	0,2 [*]	20 [*]	80 [*]	200 [*]		1	0,4	0,12	15		ЭП	26
5 [*]	0,2 [*]	40 [*]	160 [*]	200 [*]		1	0,4	0,12	15		ЭП	26
5 [*]	0,2 [*]	25 [*]	80 [*]	1000 [*]		1	0,4	0,1	15		ЭП	26
5 [*]	0,2 [*]	50 [*]	160 [*]	1000 [*]		1	0,4	0,1	15		ЭП	26

БОЛЬШОЙ МОЩНОСТИ

h _{21e} , h _{21E} [*]				f _{h21e} ^Δ	r _{CEsat}	U _{CEsat}	t _S	C _c	r _{b'b} C _c	Техно-логия	Чер-теж	
режим		мин	макс	f _T [*]	ом	σ	t _R t _f [*]	nф	nсек			
U _{CE}	I _C			f _{h21b}	Mиц	I _C I _B *	милсек					
U _{CE} U _{CB} σ	I _C I _E a											
3	0,5	20 [*]		20 [*]		2	0,06 [*]	0,4 [*] 6	170	750	K	46
3	0,5	40 [*]	100 [*]	20 [*]		2	0,06 [*]	0,4 [*] 4	170	750	K	46
3	0,5	80 [*]	200 [*]	20 [*]		2	0,06 [*]	0,4 [*] 5	170	750	K	46
3	0,5	40 [*]	100 [*]	30 [*]		2	0,06 [*]	0,4 [*] 4	170	750	K	46
3	0,5	80 [*]	200 [*]	80 [*]		2	0,06 [*]	0,4 [*] 5	170	750	K	46
вые р-а-р												

ТРАНЗИСТОРЫ

№ пп.	Тип прибора	R_{thjc} R_{thja}^*	$P_{C\max}$ $P_{C\max}^*$	t_{amb} °C t_{amb} °C	t_{amb} °C	Предельные режимы при $t_{amb} = +20^\circ C$					I_{CBO} I_{CER}^* I_{CEV} I_{CERM}^* I_{CERM}
						$I_{C\max}$ $I_{CM\max}^*$ a	$I_{B\max}$ $I_{BM\max}^*$ a	$U_{CB\max}$ $U_{BE\max}$ θ	$U_{CE\max}$ U_{CER}^* U_{CEM}^* θ		
439	П601И*	15 50*	3 0,5*	25 60	-60++70	1,5*		25	0,7	25*	0,2
440	П601АИ*	15 50*	3 0,5*	25 60	-60++70	1,5*		30	0,7	30*	0,1
441	П601БИ*	15 50*	3 0,5*	25 60	-60++70	1,5*		30	0,7	30*	0,13
442	П602И*	15 50*	3 0,5*	25 60	-60++70	1,5*		30	0,7	30*	0,1
443	П602АИ*	15 50*	3 0,5*	25 60	-60++70	1,5*		25	0,7	25*	0,13
444	П605	15 50*	3 0,5*	25 60	-50++60	1,5*	0,5*	45	1	40*	2
445	П605А	15 50*	3 0,5*	25 60	-50++60	1,5*	0,5*	45	1	40*	2
446	П606	15 50*	3 0,5*	25 60	-50++60	1,5*	0,5*	35	0,5	25*	2
447	П606А	15 50*	3 0,5*	25 60	-50++60	1,5*	0,5*	35	0,5	25*	2
448	П605*	15 50*	3 0,5*	25 60	-60++70	1,5*	0,5*	45	1	40*	2
449	П605А*	15 50*	3 0,5*	25 60	-60++70	1,5*	0,5*	45	1	40*	2
450	П606*	15 50*	3 0,5*	25 60	-60++70	1,5*	0,5*	35	0,5	25*	2
451	П606А*	15 50*	3 0,5*	25 60	-60++70	1,5*	0,5*	35	0,5	25*	2
452	ГТ905А	9 50*	6 1,2*	30 25	-55++60	3		75		75	2
453	ГТ905Б	9 50*	6 1,2*	30 25	-55++60	3		60		60	2
454	1Т905А	9 50*	6 1,2*	30 25	-60++70	3		75		75	2
455	П213А*	4	10	45	-60++70	5	0,5	45	10	30*	1,0
456	П213Б*	4	10	45	-60++70	5	0,5	45	10	30*	1,0
457	П214*	4	10	45	-60++70	5	0,5	60	15	55*	0,3
458	П214А*	4	10	45	-60++70	5	0,5	60	15	55*	0,3
459	П214В*	4	10	45	-60++70	5	0,5	60	10	55*	1,5
460	П214Г*	4	10	45	-60++70	5	0,5	60	10	55*	1,5
461	П215*	4	10	45	-60++70	5	0,5	80	15	70*	0,3
462	П201Э	3,5	10 1*	40 20	-55++60	1,5		45		30*	0,4
463	П201АЭ	3,5	10 1*	40 20	-55++60	1,5		45		30*	0,4
464	П202Э	3,5	10 1*	40 20	-55++60	2		70		55*	0,4
465	П203Э	3,5	10 1*	40 20	-55++60	2		70		55*	0,4

БОЛЬШОЙ МОЩНОСТИ

h_{21e} , режим		h_{21E}^*		$f_{h21e}\Delta$	r_{CEsat}	U_{CEsat}	t_S	C_e	$r_{bb}C_c$	Техно- логия	Чер- теж
U_{CE}	I_C	мин	макс	f_T^*	ом	\dot{v}	I_C	$n\delta$	$nsec$		
U_{CB}^*	I_{E*}	a		f_{h21b}	Миц		I_B^*				
3	0,5	20*			20*	2	0,06*	0,4*	170	750	K 46
3	0,5	40*	100*	20*		2	0,06*	0,4	170	750	K 46
3	0,5	80*	200*	20*		2	0,06*	0,4	170	750	K 46
3	0,5	40*	100*	30*		2	0,06*	0,4	170	750	K 46
3	0,5	80*	200*	30*		2	0,06*	0,4	170	750	K 46
3	0,5	20*	60*			2	0,5	0,8	130	500	K 46
3	0,5	40*	120*			2	0,5	0,35	130	500	K 46
3	0,5	20*	60*	30*		2	0,5	0,3*	130	500	K 46
3	0,5	40*	120*	30*		2	0,5	0,35*	130	500	K 46
3	0,5	20*	60*			2	0,06*	0,3*	130	500	K 46
3	0,5	50*	120*			2	0,08*	0,35*	130	500	K 46
3	0,5	20*	60*	30*		2	0,06*	0,3*	130	500	K 46
3	0,5	50*	120*	30*		2	0,03*	0,35*	130	500	K 46
10	3*	35*	100*							СД	47
10	3*	35*	100*	60*		0,5	3	4	200	300	СД 47
10	3*	35*	100*			0,5	3	0,3			
								0,2*			
								0,2*			
5*	0,2	20		0,1				0,3			C 42
5*	0,2	40		0,1							C 42
5*	0,2	20	60	0,1							C 42
5*	0,2	50	150	0,1							C 42
5*	0,2	20		0,1							C 42
5*	0,2			0,1							C 42
5*	0,2	20	150	0,1							C 42
10	0,2	20		0,1							C 45
10	0,2	40		0,2							C 48
10	0,2	20		0,1							C 48
				0,2							C 45
											C 45
											C 48

ТРАНЗИСТОРЫ

№ пп.	Тип прибора	R_{thjc} $* R_{thja}$	$P_{C\max}$ $P_{C\max}^*$	t_{amb}	t_{amb}	Предельные режимы при $t_{amb} = +20^\circ C$					I_{CBO} I_{CER}^* ϕ I_{CEV} I_{CERM}^* ma
						$I_{C\max}$	$I_{B\max}$	U_{CB}	U_{BE}	U_{CE}	
466	П201Э*		10 1*	50 20	-60++70	1,5		45	30*	0,4	
467	П201АЭ*		10	50	-60++70	1,5		45	30*	0,4	
468	П202Э*		10 1*	50 20	-60++70	2		70	55*	0,4	
469	П203Э*		10 1*	50 20	-60++70	2		70	55*	0,4	
470	П213*		11,5	45	-60++70	5	0,5	45	15	40	0,15
471	П214Б*	3,5	11,5	45	-60++70	5	0,5	60	15	55	0,15
472	ГТ804А	3,0	15	20	-25++60	10	2		100	12*	
473	ГТ804Б	3,0	15	20	-25++60	10	2		140	12*	
474	ГТ804В	3,0	15	20	-25++60	10	2		190	12*	
475	1T901А	2,5	15	37,5	-60++70	10	2	50	50	8	
476	1T901Б	2,5	15	37,5	-60++70	10	2	40	40	8	
477	П216Б*	2,5	24	25	-60++70	7,5	0,75	35	15	35	1,5
478	П216В*	2,5	24	25	-60++70	7,5	0,75	35	15	35	2,0
479	П216Г*	2,5	24	25	-60++70	7,5	0,75	50	15	50	2,5
480	П216Д*	2,5	24	25	-60++70	7,5	0,75	50	15	50	2
481	П217В*	2,5	24	25	-60++70	7,5	0,75	60	15	60	3,0
482	П217Г*	2,5	24	25	-60++70	7,5	0,75	60	15	60	3,0
483	П4АЭ	2,0	20 2*	40	-55++60	5	1,2	50		0,5	
484	П4АЭ*	2,0	20 2*	40	-60++70	5	1,2	50		0,5	
485	П4БЭ	2,0	25 3*	40	-55++60	5	1,2	60		0,4	
486	П4ВЭ	2,0	25 3*	40	-55++60	5	1,2	35		0,4	
487	П4ГЭ	2,0	25 3*	40	-55++60	5	1,2	50		0,4	
488	П4ДЭ	2,0	25 3*	40	-55++60	5	1,2	50		0,4	
489	П4БЭ*	2,0	25 3*	40	-60++70	5	1,2	60		0,4	
490	П4ВЭ*	2,0	25 3*	40	-60++70	5	1,2	35		0,4	
491	П4ГЭ*	2,0	25 3*	40	-60++70	5	1,2	50		0,4	
492	П4ДЭ*	2,0	25 3*	40	-60++70	5	1,2	50		0,4	
493	П216*	2,0	30	25	-60++70	7,5	1,2	40	15	30	0,5
494	П216А*	2,0	30	25	-60++70	7,5	1,2	40	15	30	0,5
495	П217*	2,0	30	25	-60++75	7,5	1,2	60	15	45	0,5
496	П217А*	2,0	30	25	-60++75	7,5	0,75	60	15	45	0,5
497	П217Б*	2,0	30	25	-60++75	7,5	0,75	60	15	45	0,5
498	1T806А	2,0	30	25	-60++75	20	3	75	1,5	75	12*

БОЛЬШОЙ МОЩНОСТИ

h_{21e} , режим		h_{21E}^*		$f_{h21e}\Delta$	r_{CEsat}	U_{CEsat}	t_S	C_C	$r_{bb}C_c$	Техно- логия	Чер- теж
U_{CE}	I_C	мин	макс	f_T^*	ом	σ	I_C	t_R^*	нсек	нсек	
U_{CB}^*	I_{E^*}			f_{h21b}	Миц		I_B^*	$t_f \phi$			
10	0,2	20				0,1				C	48
10	0,2	40				0,2				C	48
10	0,2	20				0,1				C	48
						0,2				C	48
5 [*]	1	20	50	0,1						C	42
5 [*]	0,2	20	150 [*]	0,1						C	42
10	5	20 [*]	150 [*]	10		0,4	10	1		СД	47
10	5	20 [*]	150 [*]	10		0,5	10	1		СД	47
10	5	20 [*]	150 [*]	10		0,6	10	1		СД	47
10	5 [*]	20	50			0,6	5	0,7 ^{*φ}		СД	50
10	5 [*]	40	100			0,6	5	0,7 ^{*φ}		СД	50
3	2	10								C	42
3	2	30								C	42
3	2	5								C	42
3	2	15	30							C	42
3	2	15	40							C	42
10	2	5		0,15						C	38
10	2	5		0,15						C	38
10	2	15	40	0,15						C	38
10	2	10		0,15						C	38
10	2	15	30	0,15						C	38
10	2	30		0,15						C	38
10	2	15	40	0,15						C	38
10	2	10		0,15						C	38
10	2	15	30	0,15						C	38
10	2	30		0,15						C	38
0,75	4	18 [*]								C	42
5	1	20 [*]	80							C	42
1	4	15 [*]								C	42
5	1	20	60							C	42
5	1	20 [*]								C	42
10	10 [*]					0,6	20	30 ^φ		СД	39

ТРАНЗИСТОРЫ

№ пп.	Тип прибора	$\frac{th\beta}{R_{thja}}$	$P_{C\max}$ $P_{C\max}^*$	t_{amb}	t_{amb}	Предельные режимы при $t_{amb} = +20^\circ C$					I_{CBO}
						$I_{C\max}$	$I_{B\max}$	$U_{CB\max}$	$U_{BE\max}$	$U_{CE\max}$ $U_{CE\max}^*$	
499	1T806Б	2,0	30	25	-60+75	20	3	100	1,5	100	12 ϕ
500	1T806В	2,0	30	25	-60+75	20	3	120	1,5	120	12 ϕ
501	ГТ701А	1,2	50	25	-55+70	12	0,15	15	55	6	
502	П210Ш*	1,0	15		-60+70	9		65	64	8	
		40*									
503	П210Б	1,0	45	25	-55+60	12		65	25	40	15
504	П210В	1,0	45	25	-55+60	12		45	25	40	15
505	П210А*	1,0	60	25	-60+70	12		65	25	65	8
		40*									
506	1T702A	0,3	150 5*	30 25	-60+70	30	5	60	4	60	12
507	1T702Б	0,3	150 5*	30 25	-60+70	30	5	60	4	60	12
508	1T702В	0,3	150 5*	30 25	-60+70	30	5	60	4	40	12
											Кремние
509	П302	10 100*	7 1*	50 20	-55+85	0,5	0,2	35		35	0,1
510	П302*	10 100*	7 1*	50 20	-60+120	0,5	0,2	35		35	0,1
511	П303	10 100*	10 1*	50 20	-55+85	0,5	0,2	60		60	0,1
512	П303A	10 100*	10 1*	50 20	-55+85	0,5	0,2	60		60	0,1
513	П304	10 100*	10 1*	50 20	-55+85	0,5	0,2	80		80	0,1
514	П306	10 100*	10 1*	50 20	-55+85	0,4		60		60	0,1
515	П306A	10 100*	10 1*	50 20	-55+85	0,4		80		80	0,1
516	П303*	10 100*	10 1*	50 20	-60+120	0,5	0,2	60		60	0,1
517	П303A*	10 100*	10 1*	50 20	-60+120	0,5	0,2	60		60	0,1
518	П304*	10 100*	10 1*	50 20	-60+120	0,5	0,2	80		80	0,1
519	П306*	10 100*	10 1*	50 20	-60+120	0,4		60		60	0,1
520	П306A*	10 100*	10 1*	50 20	-60+120	0,4		80		80	0,1
											Кремние
521	KT602A	45 150*	2,8 0,85*	25 25	-40+85	0,075		120	5	100*	0,07
522	KT602Б	45 150*	2,8 0,85*	25 25	-40+85	0,075		120	5	100*	0,07

•

БОЛЬШОЙ МОЩНОСТИ

h_{21e}		h_{21E}^*		$f_{h21e}\Delta$	r_{CEsat}	U_{CEsat}	t_S	C_C	$r_{b'b}C_c$	Техно-	Чер-	
режим				f_T^*	ом	I_C	t_R^*			логия	теж	
U_{CE}	I_C	I_E^*	мин	f_{h21b}		I_B^*	t_e^*	$n\phi$	$n\phi$			
δ	a		макс	MHz								
10	10 ^x					0,6	20	30 ^Φ		СД	39	
10	10 ^x					0,6	20	30 ^Φ		СД	39	
2	5	10 ^x		0,06						С	50	
1	7	15 ^x	60 ^x	0,1						С	49	
2	5	10 ^x		0,1						С	49	
2	5	10 ^x		0,1						С	49	
2	5	15 ^x		0,1						С	49	
1,5 ^x	30	15 ^x	100 ^x			0,6	30			С	53	
1,5 ^x	30	15 ^x	100 ^x			1,2	30			С	53	
1,5 ^x	30	20 ^x				0,6	30			С	53	
вывес р-п-р												
10	0,12 ^x	10 ^x		0,2						С	44	
10	0,12 ^x	10 ^x		0,2						С	44	
10	0,12 ^x	6 ^x		0,1	20					С	44	
10	0,12 ^x	6 ^x		0,1	20					С	44	
10	0,06 ^x	5 ^x		0,05						С	44	
10	0,1	7 ^x	80 ^x	0,05	20					С	44	
10	0,05	5 ^x	50 ^x	0,05						С	44	
10	0,12 ^x	6 ^x		0,1	20					С	44	
10	0,12 ^x	6 ^x		0,1	20					С	44	
10	0,06 ^x	5 ^x		0,05						С	44	
10 ^x	0,1	7 ^x	25 ^x	0,05	20					С	44	
10 ^x	0,05	5 ^x	35 ^x	0,05						С	44	
вывес п-р-п												
10 ^x	0,01 ^x	20 ^x	80 ^x	150 ^x		3	0,05			4	300 МД	19
10 ^x	0,01 ^x	50 ^x		150 ^x		3	0,05			4	300 МД	19

ТРАНЗИСТОРЫ

№ пп.	Тип прибора	R_{thjc} R_{thja}^*	$P_{C\max}$ $P_{C\max}^*$	t_{amb}	t_{amb}	Предельные режимы при $t_{amb} = +20^\circ C$					I_{CBO} I_{CER}^* ϕ I_{CEV} Δ I_{CERM} ma
						$I_{C\max}$	$I_{B\max}$	U_{CB} max	U_{BE} max	U_{CE} U_{CER}^* ϕ U_{CEM} σ	
523	KT602В	45 150*	2,8 0,85*	25	-40+85	0,075		80	5	70*	0,07
524	KT602Г	45 150*	2,8 0,85*	25	-40+85	0,075		80	5	70*	0,07
525	2T602А	45 150*	2,8 0,85*	25	-60+120	0,075		120	5	100*	0,07
526	2T602Б	45 150*	2,8 0,85*	25	-60+120	0,075		120	5	100*	0,07
527	KT603А	3 200*		50	-40+85	0,3		30	-3	30*	0,01
528	KT603Б	3 200*		50	-40+85	0,3		30	-3	30*	0,01
529	KT603В	3 200*		50	-40+85	0,3		15	3	15*	0,005
530	KT603Г	3 200*		50	-40+85	0,3		15	3	15*	0,005
531	KT603Д	3 200*		50	-40+85	0,3		10	3	10*	0,001
532	KT603Е	3 200*		50	-40+85	0,3		10	3	10*	0,001
533	2T603А	3 200*		50	-60+120	0,3		30	3	30*	0,003
534	2T603Б	3 200*		50	-60+120	0,3		30	3	30*	0,003
535	2T603В	3 200*		50	-60+120	0,3		15	3	15*	0,003
536	2T603Г	3 200*		50	-60+120	0,3		15	3	15*	0,008
537	KT606А	44	2,5	40	-60+125	0,4	0,1	60	4	60*	1,5*
538	KT606Б	44	2,5	40	-60+125	0,4	0,1	60	4	60*	1,5*
539	2T606А	44	2,5	40	-60+125						1
540	KT604А	40 150*	3 0,8*	25	-25+100	0,2		300	5	250*	0,05*
541	KT604Б	40 150*	3 0,8*	25	-25+100	0,2		300	5	250*	0,05*
542	KT605А	300*	3 0,4*	25	-25+100	0,2		300	5	250*	0,05*
543	KT605Б	300*	3 0,4*	25	-25+100	0,2		300	5	250*	0,05*
544	KT801А	20	5	55	-20+55	2	0,4		2,5	80	10*
545	KT801Б	20	5	55	-20+55	2	0,4		2,5	60	10*
546	KT904А	16	5		-40+85	0,8	0,2	60	4	60	1,5*
547	KT904Б	16	5		-40+85	0,8	0,2	60	4	60	1,5*
548	П701	10 85*	10 1*	50	-55+100	0,5		40	2	40	0,1
549	П701А	10 85*	10 1*	50	-55+100	0,5		60	2	60	0,1

БОЛЬШОЙ МОЩНОСТИ

h_{21e}		h^*_{21E}		$f_{h21e} \Delta$	r_{CEsat}	U_{CEsat}		t_S	C_C	$r_{bC} C_c$	Техно-	Чертеж
режим		мин	макс	f_T^*	ом	σ	I_C	t_R^*	$n\mu$	$nsec$	логия	
U_{CE}	I_C			f_{h21b}			I_B^*	t_f^ϕ				
U_{CB}^*	I_E^*	a	b	$M\mu$								
10 ^x	0,01 ^x	15 ^x	80 ^x	150 ^x		3	0,05		4	300	МД	19
10 ^x	0,01 ^x	50 ^x		150 ^x		3	0,05		4	300	МД	19
10 ^x	0,01 ^x	20 ^x	80 ^x	150 ^x		3	0,05		4	300	МД	19
10 ^x	0,01 ^x	50 ^x	200 ^x	150 ^x		3	0,05		4	300	МД	19
2 ^x	0,15 ^x	10 ^x	80 ^x	200 ^x		1	0,15	0,1	15	400	ЭП	26
2 ^x	0,15 ^x	60 ^x		200 ^x		1	0,15	0,1	15	400	ЭП	26
2 ^x	0,15 ^x	10 ^x	80 ^x	200 ^x		1	0,15	0,1	15	400	ЭП	26
2 ^x	0,15 ^x	80 ^x		200 ^x		1	0,15	0,1	15	400	ЭП	26
2 ^x	0,15 ^x	20 ^x	80 ^x	200 ^x		1	0,15	0,1			ЭП	26
2 ^x	0,15 ^x	60 ^x	200 ^x	200 ^x		1	0,15	0,1			ЭП	26
2 ^x	0,15 ^x	20 ^x	80 ^x	200 ^x		0,8	0,15	0,07	15	400	ЭП	26
2 ^x	0,15 ^x	60 ^x	180 ^x	200 ^x		0,8	0,15	0,07	15	400	ЭП	26
2 ^x	0,15 ^x	20 ^x	80 ^x	200 ^x		0,8	0,15	0,07	15	400	ЭП	26
2 ^x	0,15 ^x	60 ^x	180 ^x	200 ^x		0,8	0,15	0,07	15	400	ЭП	26
				350 ^x					10	10	ЭП	54
				350 ^x					10	12	ЭП	54
				350 ^x					10	10	ЭП	54
40	0,02 ^x	10 ^x	40 ^x	80 ^x		8	0,02		7		МП	18
40	0,02 ^x	30 ^x	120 ^x	80 ^x		8	0,02		7		МП	18
40 ^x	0,02 ^x	10 ^x	40 ^x	80 ^x		8	0,02		7		МП	13
40 ^x	0,02 ^x	30 ^x	120 ^x	80 ^x		8	0,02		7		МП	13
5	1	13 ^x	50 ^x	10 ^x		2	1				СД	19
5	1	20 ^x	100 ^x	10 ^x		2	1				СД	19
				350 ^x					12	15	ЭП	54
				300 ^x					12	20	ЭП	54
10	0,5	10 ^x	40 ^x	12,5 ^x		7	0,5				СД	41
10	0,2	15 ^x	60 ^x	12,5 ^x							СД	41

ТРАНЗИСТОРЫ

№ пп.	Тип прибора	R_{thjc} R_{thja}^*	$P_C \max$ $P_C^* \max$	t_{amb}	t_{amb}	Предельные режимы при $t_{amb} = +20^\circ C$					I_{CBO} I_{CER}^* I_{CEV}^* I_{CERM}^A
						$I_C \max$	$I_B \max$	$U_{CB} \max$	$U_{BE} \max$	$U_{CE} \max$ U_{CER}^* U_{CEM}^*	
		$^\circ C/\text{см}$	см	$^\circ C$	$^\circ C$						
550	П701Б	10 85 [*]	10 1 [*]	50	-55+100	0,5			35	2	85 0,1
551	П701 [*]	10 85 [*]	10 1 [*]	50 65	-60+120	0,5			40	2	40 0,1
552	П701А [*]	10 85 [*]	10 1 [*]	50 65	-60+120	0,5			60	2	60 0,1
553	КТ807А	10	70	-40+70	1,5 [*]	0,2			4	100 [*]	5
554	КТ807Б	10	70	-40+70	1,5 [*]	0,2			4	100 [*]	5
555	2Т907А	7,5	16	25	-60+125	1	0,4		4	65 [*]	2*
556	КТ805А	3,3	30	50	-55+100	5	2		5	160 [*]	60 ^A
557	КТ805Б	3,3	30	50	-55+100	5	2		5	135 [*]	60 ^A
558	КТ903А	3,33	30	25	-40+85	3			60	4	60 10 [*]
559	КТ903Б	3,33	30	25	-40+85	3			60	4	60 10 [*]
560	2Т903А	3,33	30	50	-60+125	3			60	4	60 2*
561	2Т903Б	3,33	30	50	-60+125	3			60	4	60 2*
562	КТ902А	3,3	30	50	-60+125	5	2		65	5	110 [*] 10
563	П702	2,5 33 [*]	40 4 [*]	50 20	-55+85	2	0,5		60	3	60 5
564	П702А	2,5 33 [*]	40 4 [*]	50 20	-55+85	2	0,5		60	3	60 2,5
565	П702 [*]	2,5 33 [*]	40 4 [*]	50 20	-60+120	2	0,5		60	3	60 5
566	П702А [*]	2,5 33 [*]	40 4 [*]	50 20	-60+120	2	0,5		60	3	60 2,5
567	КТ802А	2,5	50	25	-20+100	5	1	150	3	130 [*]	60 [*]
568	КТ803А		60	50	-40+100	10			4	60 [*]	5 [*]
569	2Т803А		60	50	-60+125	10			4	60 [*]	5 [*]

БОЛЬШОЙ МОЩНОСТИ

h_{21e}		h_{21E}^*		$f_{h21e} \Delta$	r_{CEsat}	U_{CEsat}		t_S	C_C	$r_{bb}C_c$	Техно-логия	Чер-теж
режим		мин	макс	f_T^*	ом	δ	I_C	t_R^*	нф	нсек		
U_{CE}	I_C			f_{h21b}		a	I_B^*	t_f^ϕ				
U_{CB}^*	I_{E^*}	a										
10	0,2	30 [*]	100 [*]	12,5 [*]							СД	41
10	0,5	10 [*]	40 [*]	12,5 [*]		7	0,5				СД	41
10	0,2	15 [*]	60 [*]	12,5 [*]		7	0,5				СД	41
5	0,5	15 [*]	45 [*]			1	0,5				МП	9
5	0,5	30	100			1	0,5				МП	9
10	2	15 [*]		350	20 [*]	2,5	5			20	15	54
10	2	15 [*]			20 [*]	5	5					
10	2	15 [*]	70 [*]	120 [*]		2,5	2				МП	39
10	2	40 [*]	180 [*]	120 [*]		2,5	2				МП	39
10	2	15 [*]	70 [*]	120 [*]		2	2				ДМП	39
10	2	40 [*]	180 [*]	120 [*]		2	2				ДМП	39
10	2	15 [*]		35 [*]		2	2				ДМП	39
10	1	25 [*]		4 [*]		2,5	1				Д	39
10	1	10 [*]		4 [*]		4	1				Д	39
10	1	25 [*]		4 [*]		2,5	1				Д	40
10	1	10 [*]		4 [*]		4	1				Д	39
10	2	15 [*]		10 [*]		5	5				Д	40
10	5	10 [*]	70 [*]	20 [*]		2,5	5				МП	39
10	5	10 [*]	50 [*]	20 [*]		2,5	5				МП	39

ТРАНЗИСТОРЫ

№ пп.	Тип прибора	Структура	Материал	Техноло- гия	t_{amb} $t_{amb\ max}^*$ °C			
570	КП102Е	p-n ; p	Si	ДП	-55-+70	I_D	-0,55ма	I_G $-15 \cdot 10^{-9}$ а
571	КП102Ж	p-n ; p	Si	ДП	-55-+70	I_D	-1 ма	I_G $-15 \cdot 10^{-9}$ а
572	КП102И	p-n ; p	Si	ДП	-55-+70	I_D	-1,8 ма	I_G $-15 \cdot 10^{-9}$ а
573	КП102К	p-n ; p	Si	ДП	-55-+70	I_D	-3 ма	I_G $-15 \cdot 10^{-9}$ а
574	КП102Л	p-n ; p	Si	ДП	-55-+70	I_D	-6 ма	I_G $-15 \cdot 10^{-9}$ а
575	2П102А	p-n ; p	Si	ДП	-60-+85	I_D	-0,5 ма	I_G $-9 \cdot 10^{-9}$ а
576	2П102Б	p-n ; p	Si	ДП	-60-+85	I_D	-0,9 ма	I_G $-9 \cdot 10^{-9}$ а
577	2П102В	p-n ; p	Si	ДП	-60-+85	I_D	-1,6 ма	I_G $-9 \cdot 10^{-9}$ а
578	2П102Г	p-n ; p	Si	ДП	-60-+85	I_D	-2,8 ма	I_G $-9 \cdot 10^{-9}$ а
579	2П102Д	p-n ; p	Si	ДП	-60-+85	I_D	-5 ма	I_G $-9 \cdot 10^{-9}$ а
580	КП101Г	p-n ; p	Si	П	+ 85 ^x	I_D	-2 ма	I_G $-10 \cdot 10^{-3}$ а
581	КП101Д	p-n ; p	Si	П	+ 85 ^x	I_D	-5 ма	I_G $-50 \cdot 10^{-3}$ а
582	КП101Е	p-n ; p	Si	П	+ 85 ^x	I_D	-5 ма	I_G $-50 \cdot 10^{-3}$ а
583	2П101А	p-n ; p	Si	П	-60-+120	I_D	-1 ма	I_G $-10 \cdot 10^{-9}$ а
584	2П101Б	p-n ; p	Si	П	-60-+120	I_D	-2,2 ма	I_G $-10 \cdot 10^{-9}$ а
585	2П101В	p-n ; p	Si	П	-60-+120	I_D	-5 ма	I_G $-50 \cdot 10^{-9}$ а

Параметры

U_{GS} (off) -2,8 в	U_n -10 мкв	Y_{21s} -0,7 ма/в	U_{GD} +15 в	U_{D5} -15 в	U_{G5} -10 в
U_{GS} (off) -4 в	U_n -10 мкв	Y_{21s} -0,9 ма/в	U_{GD} -15 в	U_{D5} -15 в	U_{G5} -10 в
U_{GS} (off) -5,5 в	U_n -10 мкв	Y_{21s} -1 ма/в	U_{GD} -15 в	U_{D5} -15 в	U_{G5} -10 в
U_{GS} (off) -7,5 в	U_n -10 мкв	Y_{21s} -1,2 ма/в	U_{GD} -15 в	U_{D5} -15 в	U_{G5} -10 в
U_{GS} (off) -10 в	U_n -10 мкв	Y_{21s} -1,3 ма/в	U_{GD} -15 в	U_{D5} -15 в	U_{G5} -10 в
U_{GS} (off) -2,5 в	U_n -10 мкв	Y_{21s} -0,8 ма/в	U_{GD} -10 в		
U_{GS} (off) -4 в	U_n -10 мкв	Y_{21s} -0,35 ма/в	U_{GD} -10 в		
U_{GS} (off) -5,5 в	U_n -10 мкв	Y_{21s} -0,4 ма/в	U_{GD} -10 в		
U_{GS} (off) -7,5 в	U_n -10 мкв	Y_{21s} -0,5 ма/в	U_{GD} -10 в		
U_{GS} (off) -10 в	U_n -10 мкв	Y_{21s} -0,7 ма/в	U_{GD} -10 в		
U_{GS} (off) -5 в	N_F -5 дб	Y_{21s} -0,15 ма/в	U_{GD} -10 в		
U_{GS} (off) -10 в	N_F -10 дб	Y_{21s} -0,8 ма/в	U_{GD} -10 в		
U_{GS} (off) -10 в	Y_{21s} 0,3 ма/в	U_{GD} -10 в			
U_{GS} (off) -5 в	N_F -5 дб	Y_{21s} -0,3 ма/в	U_{GD} -10 в		
U_{GS} (off) -5 в	N_F -5 дб	Y_{21s} -0,3 ма/в	U_{GD} -10 в		
U_{GS} (off) -8 в	N_F -10 дб	Y_{21s} -0,5 ма/в	U_{GD} -10 в		

ПРИЛОЖЕНИЕ

Указатель нормативных документов, действующих в полупроводниковой промышленности

№ пп.	Наименование документа	Обозначение документа	Срок введения доку- мента в действие
I. Организационно-методические документы			
1.	Временное положение о центральном бюро применения и нормализации полупроводниковых приборов (Ред. 1-66).	НаАО.336.020 12 мая 1966 г.	июнь 1966 г.
2.	Нормаль "Порядок разработки, согласования и представления на утверждение нормативных документов" (Ред. 1-67).	НаАО.336.026 6 мая 1967 г.	май 1967 г.
3.	Положение о базовом предприятии по надежности полупроводниковых приборов в полупроводниковой отрасли промышленности (Ред. 1-68).	НаАО.336.037 31 октября 1968 г.	ноябрь 1968 г.
4.	РТМ "Порядок согласования с ЦБПНПП применения и режимов использования полупроводниковых приборов" (Ред. 1-68).	НПО.005.058 18 июня 1968 г.	февраль 1969 г.
5.	Руководство по применению полупроводниковых приборов. (Пересмотрена. Утверждена. Находится в печати).	НО.332.004 30 декабря 1963 г.	январь 1964 г.
II. Общие и частные технические условия. Технические требования. Построение и изложение			
6.	Нормаль "Приборы полупроводниковые. Общие технические условия" (Ред. 3-68).	НаАО.336.001	январь 1969 г.
7.	Нормаль "Общие технические условия на полупроводниковые СВЧ-диоды (Ред. 1-61).	НаАО.336.002 5 августа 1961 г.	сентябрь 1962 г.
8.	Нормаль "Приборы полупроводниковые. СВЧ-диоды. Общие технические условия (Ред. 2-69).	НаАО.336.002 29 декабря 1969 г.	1 января 1970 г.
9.	Нормаль "Построение и изложение частных технических условий (ЧТУ) на полупроводниковые приборы" (Ред.2-69)	НаАО.336.003 28 апреля 1969 г.	май 1969 г.
10.	Нормаль "Форма частных технических условий на СВЧ-диоды (Ред. 1-62) приложение к ОТУ НаАО.336.002) Пересмотрена. Находится на утверждении.	НаАО.336.004 5 марта 1962 г.	март 1962 г.
11.	РТМ "Положение о входном контроле электрорадиоэлементов на предприятиях-изготовителях аппаратуры специального назначения, порядке рекламирования дефектных электрорадиоэлементов и порядке рассмотрения рекламации" (Ред.1-63).	НаАО.336.013 ноябрь 1963 г.	декабрь 1963 г.
12.	Дополнение к ОТУ на полупроводниковые приборы (диоды и транзисторы) НаАО.336.001, предназначенные для поставок на экспорт по заказам ГИУ (ред. 1-67).	НаАО.336.021 19 июня 1967 г.	1 августа 1967 г.
13.	Нормаль "Полупроводниковые приборы. Специальные общие технические условия" (Ред. 1-64).	НаАО.336.015 10 февраля 1964 г.	май 1964 г.
14.	Дополнение к действующим техническим условиям на приборы полупроводниковые (диоды и транзисторы), поставляемые в страны с тропическим климатом" (Ред. 1-65).	НаАО.336.016 18 сентября 1965 г.	октябрь 1965 г.
15.	Нормаль "Проверки внешнего вида полупроводниковых приборов" (Ред. 1-66).	НаАО.336.019 10 мая 1966 г.	май 1966 г.
16.	Нормаль "Форма паспорта на полупроводниковые приборы, поставляемые на экспорт по заказам МВТ"(Ред.1-68).	НаАО.336.025 20 февраля 1968 г.	март 1968 г.
17.	Инструкция "Проверка внешнего вида полупроводниковых приборов для устройств широкого применения"(Ред.1-67). Пересматривается.	НаАО.336.027 15 июня 1967 г.	июль 1967 г.
18.	ГОСТ "Приборы полупроводниковые. Диоды и транзисторы для устройств широкого применения" (Пересмотрен и находится на утверждении).	11630-65 7 декабря 1965 г.	1 января 1967 г.

№ пп.	Наименование документа	Обозначение документа	Срок введения доку- мента в действие
19.	"Полупроводниковые СВЧ-диоды. Технические условия" (Ред. 1-68)(Пересматривается).	НаАО.336.030 16 апреля 1968 г.	май 1968 г.
20.	"Полупроводниковые приборы. Технические условия" (Ред. 1-68)(Пересматривается).	НаАО.336.031 19 февраля 1968 г.	март 1968 г.
21.	"Селеновые выпрямители. Технические условия" (Ред. 1-68).	НаАО.336.035 28 декабря 1968 г.	январь 1969 г.
22.	Нормаль "Приборы полупроводниковые, предназначенные для поставок на экспорт по заказам МВТ, ГКЭС (кроме ГИУ и ГКЭС) и 23 отдела Технического содействия - иностранным государствам в строительстве" (Ред. 1-69).	НаАО.336.040 18 июня 1969 г.	июль 1969 г.

III. Классификация и состав электрических параметров. Условные обозначения. Термины. Определения

23.	Нормаль "Классификатор продукции электронной промышленности. Перечень шифров типов полупроводниковых приборов" (Ред. 1-68).	НаАО.336.028 29 марта 1968 г.	апрель 1968 г.
24.	Нормаль "Приборы селеновые. Выпрямители и стабилизаторы. Классификация и состав электрических параметров, включаемых в ТУ" (Ред. 1-68).	НаАО.336.029 19 апреля 1968 г.	май 1968 г.
25.	Нормаль "Классификация и состав электрических параметров, включаемых в ТУ на полупроводниковые диоды и транзисторы" (Ред. 1-64).	НаАО.336.014 20 апреля 1964 г.	май 1964 г.
26.	Нормаль "Классификация и состав электрических параметров, включаемых в ТУ на туннельные диоды" (Ред. 1-66).	НаАО.336.022 12 ноября 1966 г.	ноябрь 1966 г.
27.	Нормаль "Классификация и состав электрических параметров, включаемых в ТУ на полупроводниковые СВЧ-диоды" (Ред. 1-66).	НаАО.336.023 26 ноября 1966 г.	декабрь 1966 г.
28.	Нормаль "Классификация и состав электрических параметров, включаемых в ТУ на тиристоры" (Ред. 1-67).	НаАО.336.024 3 марта 1967 г.	март 1967 г.
29.	Нормаль "Полупроводниковые материалы. Условные обозначения параметров" (Ред. 1-61).	НОДО.029.000 3 марта 1961 г.	март 1961 г.
30.	ГОСТ "Приборы полупроводниковые для устройств широкого применения. Система обозначений" (Пересмотрен. Находится на утверждении).	10862-64 22 апреля 1964 г.	1 июля 1965 г.
31.	ГОСТ "Транзисторы. Перечень основных и справочных электрических параметров".	15172-70 12 января 1970 г.	1 июля 1970 г.
32.	ГОСТ "Приборы полупроводниковые. Термины и определения".	15133-69 12 декабря 1969 г.	1 июля 1970 г.
33.	Нормаль "Приборы полупроводниковые. Определения и обозначения условные буквенные электрических параметров" (Ред. 1-68).	НПО.336.001 2 августа 1967 г.	1 декабря 1968 г.
34.	ГОСТ "Диоды полупроводниковые. Ряды прямых и обратных напряжений и токов" (Пересмотрен. Находится на утверждении).	11148-65 4 февраля 1965 г.	1 июля 1965 г.

I V. Конструкции и размеры узлов, деталей полупроводниковых приборов. Корпуса. Микромодули.

35.	Нормаль "Наименование узлов и деталей полупроводниковых приборов".	НаАО.336.000 6 января 1965 г.	8 февраля 1965 г.
36.	РТМ "Унифицированные конструкции деталей и узлов корпусов транзисторов" (Ред. 1-63).	НаАО.336.012 5 января 1963 г.	январь 1963 г.
37.	РТМ "Диоды полупроводниковые в микромодульном оформлении. Корпуса. Конструкции и размеры" (Ред. 1-66).	НаАО.336.017 28 марта 1966 г.	апрель 1966 г.

№ пп.	Наименование документа	Обозначение документа	Срок введения доку- мента в действие
38.	РТМ "Диоды полупроводниковые СВЧ. Корпуса. Конст- рукции и размеры" (Ред. 1-66).	НаАО.336.018 28 марта 1966 г.	апрель 1966 г.
39.	РТМ "Методы и последовательность проведения анализа дефектов и выявления причин отказов залитых компаун- дов микромодулей и входящих в их состав микротран- зисторов и микродиодов" (Ред. 1-68).	НаАО.336.036 10 декабря 1968 г.	декабрь 1968 г.

V. Измерительные установки. Методы измерений и испытаний полупроводниковых приборов

40.	ГОСТ "Приборы и установки измерительные для про- верки параметров полупроводниковых приборов".	10863-70 12 января 1970 г.	1 июля 1970 г.
41.	Нормаль "Методика проведения испытаний на длительное хранение изделий электронной промышленности" (Ред. 1-65).	НПО.005.003 16 августа 1965 г.	январь 1966 г.
42.	РТМ "Метод расчета теплоотводящих радиаторов для транзисторов средней и большой мощности" (Ред. 1-63).	НаАО.336.011 22 апреля 1963 г.	май 1963 г.
43.	РТМ "Приборы полупроводниковые. Термические парамет- ры и методы отвода тепла" (Ред. 2-68).	НаАО.336.034 23 сентября 1968 г.	октябрь 1968 г.
44.	РТМ "Приборы полупроводниковые. Методика расчета погрешности аппаратуры для измерения электрических параметров полупроводниковых приборов" (Ред. 1-68).	НаАО.336.038 23 декабря 1968 г.	январь 1969 г.
45.	РТМ "Методы измерения электрических параметров полупроводниковых диодов и транзисторов" (Ред. 1-63).	НаАО.336.006 17 октября 1963 г.	ноябрь 1963 г.
46.	РТМ "Полупроводниковые приборы. Методика измерения пробивных напряжений транзисторов и диодов" (Ред. 1-68).	НаАО.336.032 22 августа 1968 г.	сентябрь 1968 г.
47.	РТМ "Полупроводниковые приборы. Методы контроля дрейфа (нестабильности) параметров" (Ред. 3-68).	НаАО.336.033 3 сентября 1968 г.	сентябрь 1968 г.

а) Транзисторы

48.	ГОСТ "Транзисторы. Метод измерения обратного тока коллектора" (I_{CBO}).	10864-68 18 июля 1968 г.	1 июля 1969 г.
49.	ГОСТ "Транзисторы. Метод измерения начального тока коллектора" (I_{CES}); (I_{CBS}); (I_{CER}).	10865-68 18 июля 1968 г.	1 июля 1969 г.
50.	ГОСТ "Транзисторы. Метод измерения тока коллектора закрытого транзистора" (I_{CEO}).	10866-68 18 июля 1968 г.	1 июля 1969 г.
51.	ГОСТ "Транзисторы. Метод измерения обратного тока эмиттера" (I_{EBO})	10867-68 18 июля 1968 г.	1 июля 1969 г.
52.	ГОСТ "Транзисторы. Метод измерения входного со- противления" (h_{11b} ; h_{11e} ; h_{11c} ; h_{11B} ; h_{11E} ; h_{11C}).	10868-68 18 июля 1968 г.	1 июля 1969 г.
53.	ГОСТ "Транзисторы. Метод измерения коэффициента обратной связи по напряжению" (h_{12b} ; h_{12e} ; h_{12c}).	10869-68 18 июля 1968 г.	1 июля 1969 г.
54.	ГОСТ "Транзисторы. Метод измерения коэффициента передачи тока" (h_{21b} ; h_{21e} ; h_{21c}).	10870-68 18 июля 1968 г.	1 июля 1969 г.
55.	ГОСТ "Транзисторы. Метод измерения выходной про- водимости" (h_{22}).	10871-68 18 июля 1968 г.	1 июля 1969 г.
56.	ГОСТ "Транзисторы. Метод измерения емкости колек- торного перехода" (C_C)	11071-68 18 июля 1968 г.	1 июля 1969 г.
57.	ГОСТ "Транзисторы. Метод измерения постоянной времени" (τ_{U_b} ; C_C)	11072-68 18 июля 1968 г.	1 июля 1969 г.

№ пп.	Наименование документа	Обозначение документа	Срок введения доку- мента в действие
58.	ГОСТ "Транзисторы. Методы измерения времени рас- сасывания" (Пересмотрен и находится на утвержде- нии) (t_S).	11156-65 12 февраля 1965 г.	1 июля 1969 г.
59.	ГОСТ "Транзисторы. Методы измерения статического коэффициента передачи тока" (h_{21B} ; h_{21E} ; h_{21C}).	11541-69 25 марта 1969 г.	1 июля 1969 г.
60.	ГОСТ "Транзисторы. Метод измерения плавающего по- тенциала эмиттера" (U_{EBfl})	13316-67 10 ноября 1967 г.	1 июля 1968 г.
61.	ГОСТ "Транзисторы. Методы измерения статической крутизны передаточной характеристики" (S).	13851-68 18 июля 1968 г.	1 июля 1969 г.
62.	ГОСТ "Транзисторы. Методы измерения напряжения насыщения коллектора и напряжения насыщения базы" (U_{CEsat} ; U_{BEsat}).	13852-68 18 июля 1968 г.	1 июля 1969 г.
63.	ГОСТ "Транзисторы типов МП 20А, МП 20Б, МП 21В, МП 21Г, МП 21Е для устройств широкого применения".	14073-68 22 сентября 1968 г.	1 января 1970 г.
б) Диоды			
64.	РТМ "Методы электрических измерений и испытаний полупроводниковых СВЧ-диодов" (Ред. 1-62). Пере- сматривается.	НаАО.336.005 24 апреля 1962 г.	июнь 1962 г.
65.	РТМ "Диоды полупроводниковые импульсные. Методы измерения импульсных параметров" (Ред. 1-69).	НаАО.336.041 13 июня 1969 г.	июль 1969 г.
66.	ГОСТ "Диоды полупроводниковые. Метод измерения постоянного прямого напряжения" (U_F).	10961-64 8 июля 1964 г.	1 июля 1965 г.
67.	ГОСТ "Диоды полупроводниковые. Метод измерения постоянного обратного напряжения" (U_R).	10962-64 8 июля 1964 г.	1 июля 1965 г.
68.	ГОСТ "Диоды полупроводниковые. Метод измерения постоянного обратного тока" (I_R).	10963-64 8 июля 1964 г.	1 июля 1965 г.
69.	ГОСТ "Диоды полупроводниковые. Метод измерения емкости" (C_{tot}).	10964-64 8 июля 1964 г.	1 июля 1965 г.
70.	ГОСТ "Диоды полупроводниковые. Метод измерения максимального импульсного прямого напряжения" (U_{FMmax}).	10965-64 8 июля 1964 г.	1 июля 1965 г.
71.	ГОСТ "Диоды полупроводниковые. Метод измерения напряжения стабилизации стабилитронов и стаби- сторов" (U_Z).	14093-68 29 сентября 1968 г.	1 июля 1969 г.
72.	ГОСТ "Диоды полупроводниковые. Метод измерения добротности варикапов" (Q).	14094-68 29 сентября 1968 г.	1 июля 1969 г.
в) Тиристоры			
73.	ГОСТ "Тиристоры. Методы измерения тока и напря- жения спрямления" (I_{GTM} ; U_{GTM}).	14879-69 11 августа 1969 г.	1 июля 1970 г.
74.	ГОСТ "Тиристоры. Метод измерения тока выключа- ния" (I_H).	14880-69 11 августа 1969 г.	1 июля 1970 г.
75.	ГОСТ "Тиристоры. Метод измерения тока утечки и обратного тока утечки" (I_D , I_R).	14881-69 11 августа 1969 г.	1 июля 1970 г.
76.	ГОСТ "Тиристоры. Метод измерения остаточного напряжения" (U_T).	14882-69 11 августа 1969 г.	1 июля 1970 г.

№ пп.	Наименование документа	Обозначение документа	Срок введения доку- мента в действие
----------	------------------------	--------------------------	---

V. Конкретные типы полупроводниковых приборов

а) Транзисторы

77. ГОСТ "Транзисторы типов МП 25, МП 25А, МП 25Б, МП 26, МП 26Б для устройств широкого применения". 14830-69 10 июля 1969 г. 1 января 1970
78. ГОСТ "Транзисторы типов МП 35, МП 36А, МП 37, МП 37А, МП 37Б, МП 38, МП 38А для устройств широкого применения". 14831-69 10 июля 1969 г. 1 января 1970 г.
79. ГОСТ "Транзисторы типов МП 114, МП 115, МП 116 для устройств широкого применения". 14874-69 6 августа 1969 г. 1 января 1970 г.
80. ГОСТ "Транзисторы типов П 210Б и П 210В для устройств широкого применения". 14875-69 6 августа 1969 г. 1 января 1970 г.
81. ГОСТ "Транзисторы типов П 416, П 416А, П 416Б для устройств широкого применения". 14876-69 6 августа 1969 г. 1 января 1970 г.
82. ГОСТ "Транзисторы типов П 607 – 609 для устройств широкого применения". 14883-69 11 августа 1969 г. 1 января 1970 г.
83. ГОСТ "Транзисторы типов МП 42, МП 42А, МП 42Б, МП 42В для устройств широкого применения". 14947-69 2 сентября 1969 г. 1 января 1970 г.
84. ГОСТ "Транзисторы типов МП 39, МП 39Б, МП 40, МП 40А, МП 41, МП 41А для устройств широкого применения". 14948-69 2 сентября 1969 г. 1 января 1970 г.
85. ГОСТ "Транзисторы типов МП 111, МП 111А, МП 111Б, МП 112, МП 113, МП 113А для устройств широкого применения". 14949-69 2 сентября 1969 г. 1 января 1970 г.
86. ГОСТ "Транзисторы типов ГТ 108А, ГТ 108Б, ГТ 108В, ГТ 108Г для устройств широкого применения". 15141-69 17 декабря 1969 г. 1 января 1970 г.
87. ГОСТ "Транзисторы типов ГТ 109А, ГТ 109Б, ГТ 109В, ГТ 109Д, ГТ 109Е, ГТ 109И для устройств широкого применения". 15142-69 17 декабря 1969 г.

б) Диоды

88. ГОСТ "Диоды полупроводниковые типов Д9Б, Д9В, Д9Г, Д9Е, Д9Ж, Д9И, Д9К, Д9Л для устройств широкого применения". 14341-69 25 марта 1969 г. 1 января 1970 г.
89. ГОСТ "Диоды полупроводниковые типов Д2Б, Д2В, Д2Г, Д2Е, Д2Ж, Д2И для устройств широкого применения". 14342-69 25 марта 1969 г. 1 января 1970 г.
90. ГОСТ "Диоды полупроводниковые типов Д223А, 223Б для устройств широкого применения". 14343-69 25 марта 1969 г. 1 января 1970 г.
91. ГОСТ "Диоды полупроводниковые типов Д 242, Д 242А, Д 242Б, Д 243, Д 243А, Д 243Б, Д 245, Д 245А, Д 245Б, Д 246, Д 246А, Д 246Б, Д 247, Д 247А, Д 248Б для устройств широкого применения". 14758-69 19 июня 1969 г. 1 января 1970 г.
92. ГОСТ "Столбы выпрямительные типов Д1004, Д1005А, Д1005Б, Д1006, Д1007, Д1008 для устройств широкого применения". 14912-69 19 августа 1969 г. 1 января 1970 г.
93. ГОСТ "Стабилитроны полупроводниковые типов Д 814А, Д 814Б, Д 814В, Д 814Г, Д 814Д. 14913-69 19 августа 1969 г. 1 января 1970 г.
94. ГОСТ "Блоки выпрямительные типов КЦ 401Б, КЦ 401В для устройств широкого применения". 14914-69 19 августа 1969 г. 1 января 1970 г.

№ пп.	Наименование документа	Обозначение документа	Срок введения доку- мента в действие
----------	------------------------	--------------------------	---

VI. ГОСТы со знаком качества

95.	ГОСТ "Диоды полупроводниковые типов ДЭБ, Д9В, Д9Г, Д9Е, Д9Ж, Д9И, Д9К для устройств широкого применения. Требования к качеству аттестованной продукции".	5.237-69 25 апреля 1969 г.	1 мая 1969 г.
96.	ГОСТ "Транзисторы типов ГТ 320А, ГТ 320Б, ГТ 320В для устройств широкого применения. Требования к качеству аттестованной продукции".	5.230-69 19 марта 1969 г.	1 мая 1969 г.
97.	ГОСТ "Транзисторы кремниевые типов КТ 805А, КТ 805Б для устройств широкого применения. Требования к качеству аттестованной продукции".	5.238-69 25 апреля 1969 г.	1 мая 1969 г.
98.	ГОСТ "Транзисторы типов МП 25, МП 25А, МП 25Б, МП 26, МП 26Б для устройств широкого применения. Требования к качеству аттестованной продукции".	5.275-69 11 августа 1969 г.	1 января 1970 г.
99.	ГОСТ "Транзисторы типов П 607, П 607А, П 608, П 608А, П 609, П 609А для устройств широкого применения. Требования к качеству аттестованной продукции".	5.341-70 16 января 1970 г.	1 февраля 1970 г.
100.	ГОСТ "Транзисторы типов МП 39, МП 39Б, МП 40, МП 40А, МП 41, МП 41А для устройств широкого применения. Требования к качеству аттестованной продукции".	5.342-70 16 января 1970 г.	1 марта 1970 г.
101.	ГОСТ "Транзисторы типов МП 42, МП 42А, МП 42Б для устройств широкого применения. Требования к качеству аттестованной продукции".	5.343-70 16 января 1970 г.	1 марта 1970 г.

Приборы снятые с производства и рекомендуемые замены

Тип прибора	Замена		
П8 П601М-П601СМ П601БМ; П602; П602СМ П33; П34; П604А,Б П24; П19; П409; П408 П406; П407 П31А; П32; П6А,Б,В,Г,Д П412; П413 П501; П502; П503 П209; П207; А; П298А П601,А,Б; П602,А,Б П404,А; П405,А	МП36А, МП37 МП39 ÷ МП41А КТ301 ÷ КТ301Ж П210Б, П210В	П414 – П415Б П110; П109; П108,А; П12,А П406; П407; 2Т106А÷Д П310; П311; 2Т401А П43; П5А÷Е П420; П421 Д228А÷И Д – 1 Д236А÷Г; Д227А÷И 1А502А÷Г; Д19 1600÷1604; 1601 ДК	П29, П30 П401, П402 П422, П423 2И102 Д9Б÷Ж 2И102

СИСТЕМА ОБОЗНА

ЭЛЕМЕНТЫ

Первый		Второй	Третий, четвертый и пятый, обозначающие тип или			
Обозначающий исходный материал приборов, предназначенный для устройств широкого и общепромышленного применения	ограниченного применения	Обозначающий подкласс или группу прибора	101–199	201–299	301–399	401–499
Г	1	Т транзисторы	малой мощности $P_{max} \leq 0,3 \text{ вт}$			
Германий, соединения германия			частоты $f_T \leq 3 \text{ Мгц}$	частоты $3 \text{ Мгц} < f_T \leq 30 \text{ Мгц}$	301–349 частоты $30 \text{ Мгц} < f_T \leq 300 \text{ Мгц}$	350–399 частоты $f_T > 300 \text{ Мгц}$
K	2	П транзисторы полевые	малой мощности $P_{max} \leq 0,3 \text{ вт}$			
Кремний, соединения кремния			частоты $f_{max} \leq 3 \text{ Мгц}$	частоты $3 \text{ Мгц} < f_{max} \leq 30 \text{ Мгц}$	301–349 частоты $30 \text{ Мгц} < f_{max} \leq 300 \text{ Мгц}$	350–399 частоты $f_{max} > 300 \text{ Мгц}$
A	3	Д диоды	выпрямительные			
Соединения галлия			малой мощности $I_{Fav} \leq 0,3 \text{ а}$	средней мощности $0,3 \text{ а} < I_{Fav} \leq 10 \text{ а}$	универсальные $f_{max} \leq 1000 \text{ Мгц}$	
		Ц выпрямительные столбы и блоки	выпрямительные столбы			
			малой мощности $I_{Fav} \leq 0,3 \text{ а}$	средней мощности $0,3 \text{ а} < I_{Fav} \leq 10 \text{ а}$	малой мощности $I_{Fav} \leq 0,3 \text{ а}$	средней мощности $0,3 \text{ а} < I_{Fav} \leq 10 \text{ а}$
		A сверхвысокочастотные диоды	смесительные			
			смесительные	детекторные	параметрические	
		B варикапы	умножительные (варакторы)			
			подстроечные	умножительные (варакторы)	обращенные	
		И туннельные диоды	усилительные			
			усилительные	генераторные	переключательные	обращенные
		Н диодные тиристоры	диодные			
			малой мощности $I_{Fmax} \leq 0,3 \text{ а}$	средней мощности $0,3 \text{ а} < I_{Fmax} \leq 10 \text{ а}$	переключаемые	
		У триодные тиристоры	невыключаемые			
			малой мощности $I_{Fmax} \leq 0,3 \text{ а}$	средней мощности $0,3 \text{ а} < I_{Fmax} \leq 10 \text{ а}$	малой мощности $I_{Fmax} \leq 0,3 \text{ а}$	средней мощности $0,3 \text{ а} < I_{Fmax} \leq 10 \text{ а}$
		Л излучатели	видимого диапазона (светодиоды)			
			$B \leq 500 \text{ нм}$	$B > 500 \text{ нм}$	инфракрасного диапазона	
		Г генераторы шума				
		Б приборы с объемным эффектом				
		К стабилизаторы тока				
		стабилитроны и стабисторы	Третий, четвертый и пятый элементы, обозначающие индекс мощности			
			101–199	210–299	300–399	401–499
			мощностью $P_{max} \leq 0,3 \text{ вт}$			
			$U_z < 10 \text{ в}$	$10 \text{ в} \leq U_z \leq 99 \text{ в}$	$100 \text{ в} \leq U_z \leq 199 \text{ в}$	$U_z < 10 \text{ в}$

П р и м е ч а н и е. При напряжении стабилизации менее 99 в последние две цифры обозначают номинальную разность между номинальным значением напряжения стабилизации и 100 в.

ЧЕНИЙ ПРИБОРОВ

Приложение 2

ОБОЗНАЧЕНИЙ

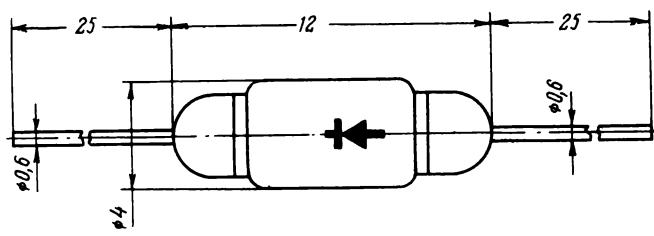
назначение прибора и порядковый номер разработки

Шестой

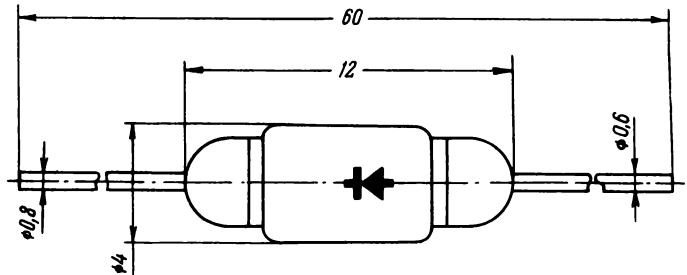
501-599	601-699	701-799	801-899	901-999	Обозначающий деление технологического типа на группы
средней мощности $0,3 \text{ вт} < P_{\max} \leq 1,5 \text{ вт}$					
частоты $3 \text{ МГц} < f_T \leq 30 \text{ МГц}$	601-649 частоты $30 \text{ МГц} < f_T \leq 300 \text{ МГц}$	650-699 частоты $f_T > 300 \text{ МГц}$	частоты $f_T \leq 3 \text{ МГц}$	частоты $3 \text{ МГц} < f_T \leq 30 \text{ МГц}$	901-949 частоты $30 \text{ МГц} < f_T \leq 300 \text{ МГц}$
средней мощности $0,3 \text{ вт} < P_{\max} \leq 1,5 \text{ вт}$					
частоты $3 \text{ МГц} < f_{\max} \leq 30 \text{ МГц}$	301-349 частоты $30 \text{ МГц} < f_{\max} \leq 300 \text{ МГц}$	350-399 частоты $f_{\max} > 300 \text{ МГц}$	частоты $f_{\max} \leq 3 \text{ МГц}$	частоты $3 \text{ МГц} < f_{\max} \leq 30 \text{ МГц}$	301-349 частоты $30 \text{ МГц} < f_{\max} \leq 300 \text{ МГц}$
импульсные					
$t_{tr} > 150 \text{ нсек}$	$150 \text{ нсек} \geq t_{tr} > 30 \text{ нсек}$	$30 \text{ нсек} \geq t_{tr} > 5 \text{ нсек}$	$5 \text{ нсек} \geq t_{tr} > 1 \text{ нсек}$	$t_{tr} \leq 1 \text{ нсек}$	
*					
регулирующие	умножительные	генераторные			
симметричные невыключаемые		симметричные выключаемые			
малой мощности $I_{F\max} \leq 0,3 \text{ а}$	средней мощности $0,3 \text{ а} < I_{F\max} \leq 10 \text{ а}$	малой мощности $I_{F\max} \leq 0,3 \text{ а}$	средней мощности $0,3 \text{ а} < I_{F\max} \leq 10 \text{ а}$		
ультрафиолетового диапазона					
ности и номинальное напряжение стабилизации					
510-599	600-699	701-799	810-899	900-999	Последовательность разработки
мощностью $0,3 \text{ вт} < P_{\max} \leq 5 \text{ вт}$					
10 \text{ в} \leq U_z \leq 99 \text{ в}	100 \text{ в} \leq U_z \leq 199 \text{ в}	$U_z < 10 \text{ в}$	$10 \text{ в} \leq U_z \leq 99 \text{ в}$	$100 \text{ в} \leq U_z \leq 199 \text{ в}$	от А до Я

ное значение напряжения стабилизации. При напряжении стабилизации 100 в и выше последние две цифры обоз-

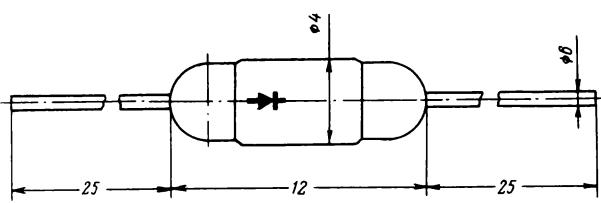
ГАБАРИТНЫЕ
ЧЕРТЕЖИ
ДИОДОВ



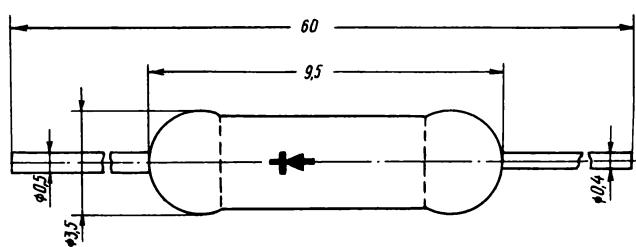
1



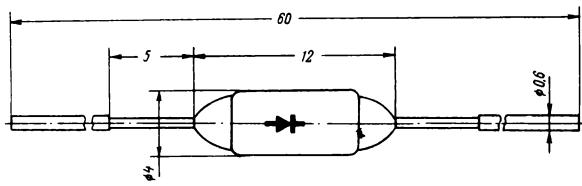
2



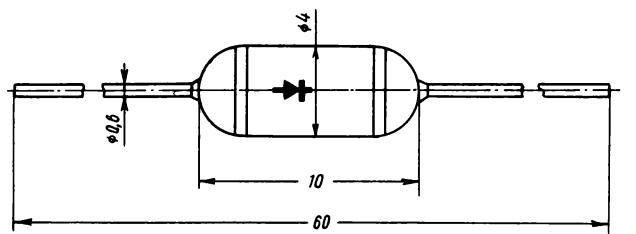
3



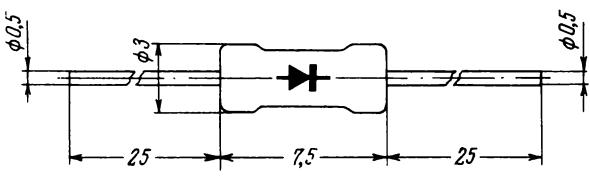
4



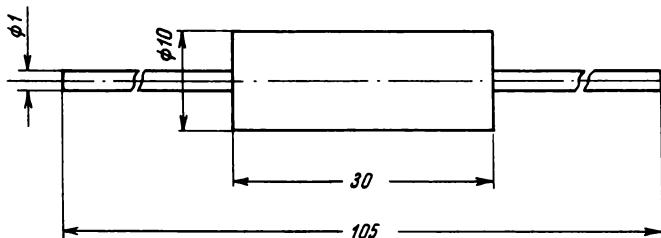
5



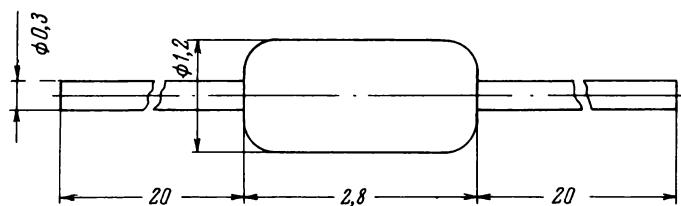
6



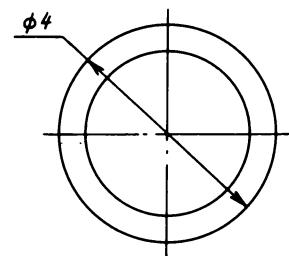
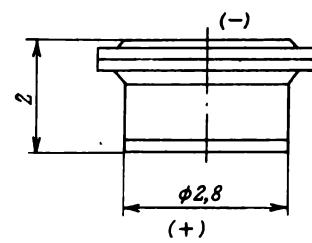
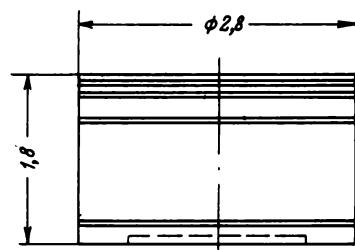
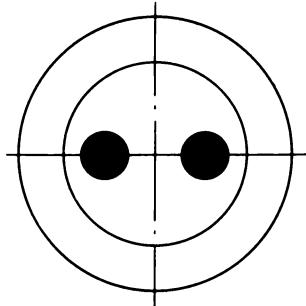
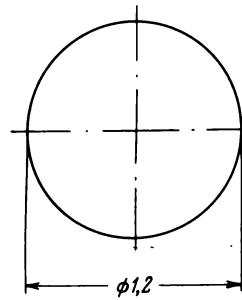
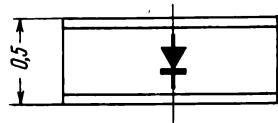
7



8



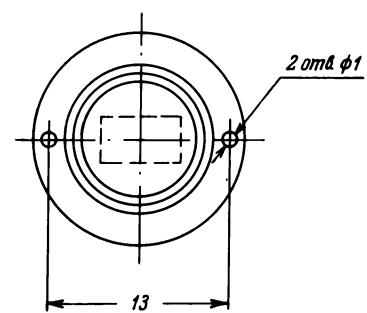
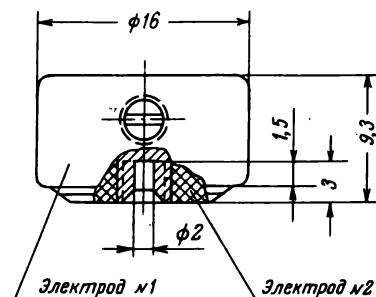
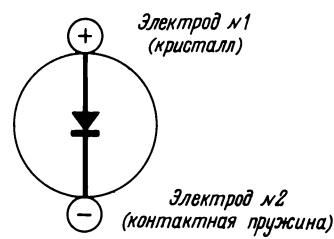
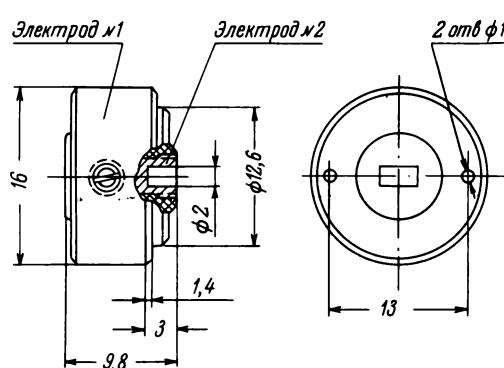
9



10

11

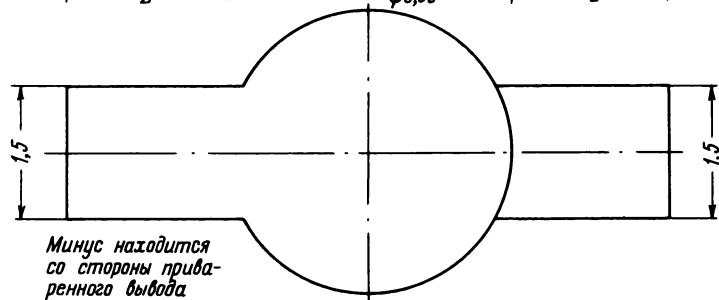
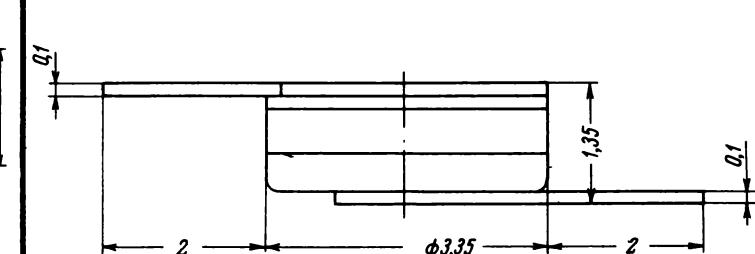
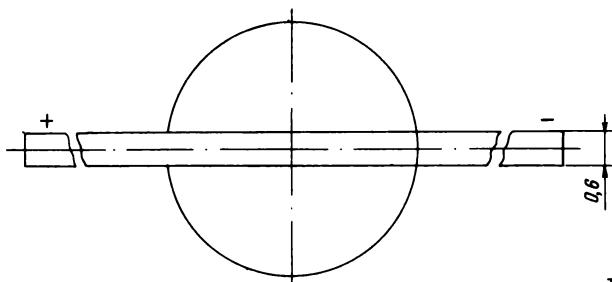
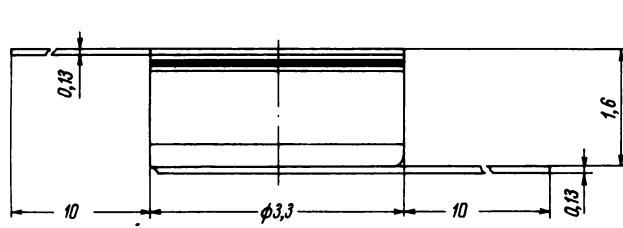
12



13

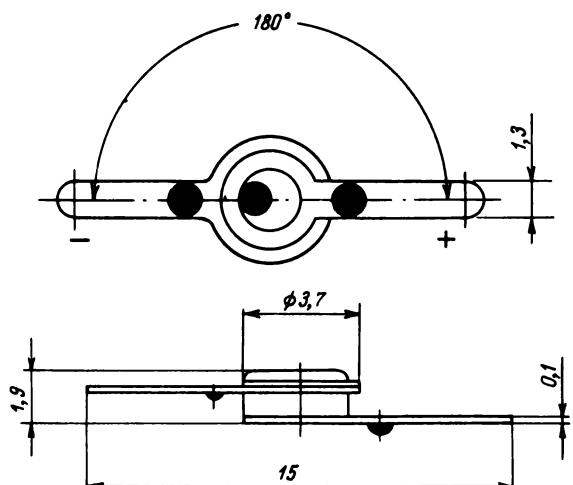
14

141

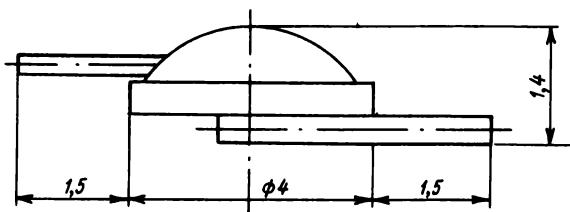


15

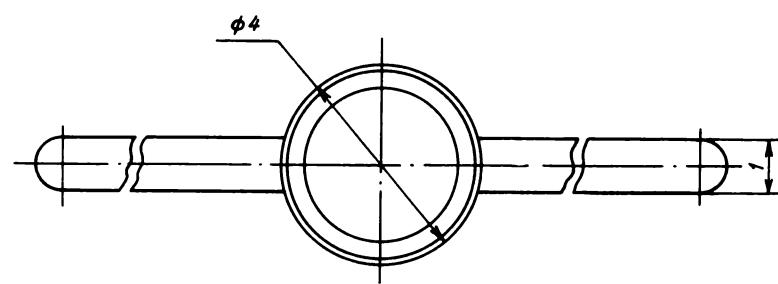
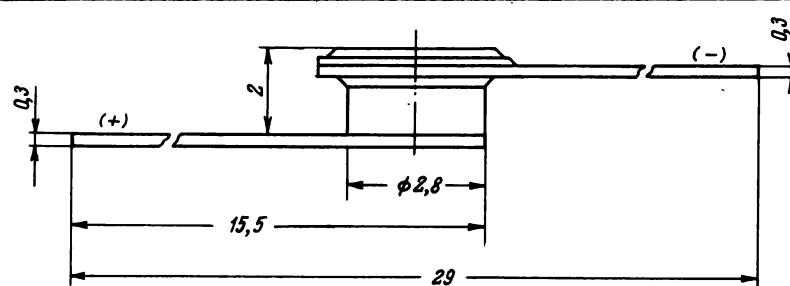
16



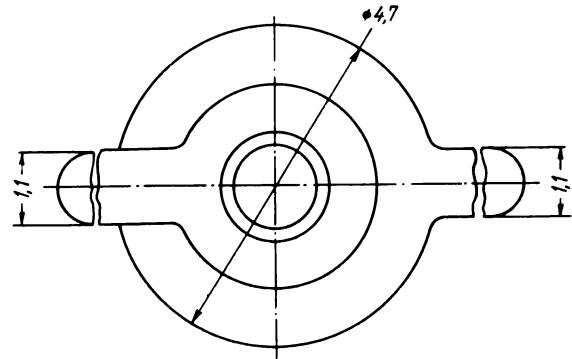
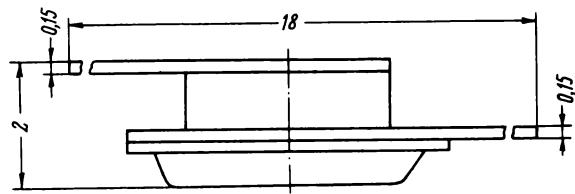
17



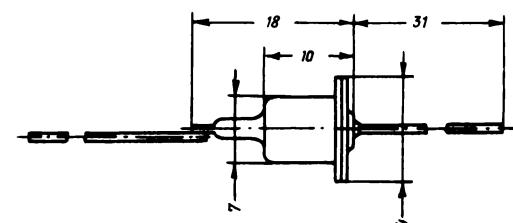
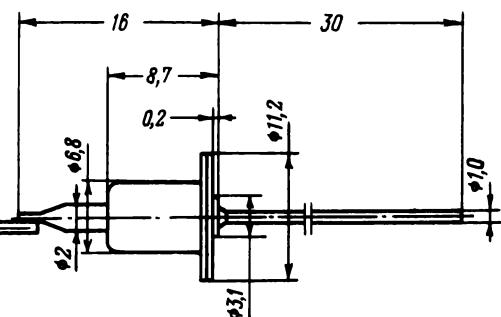
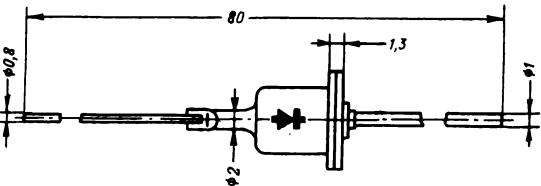
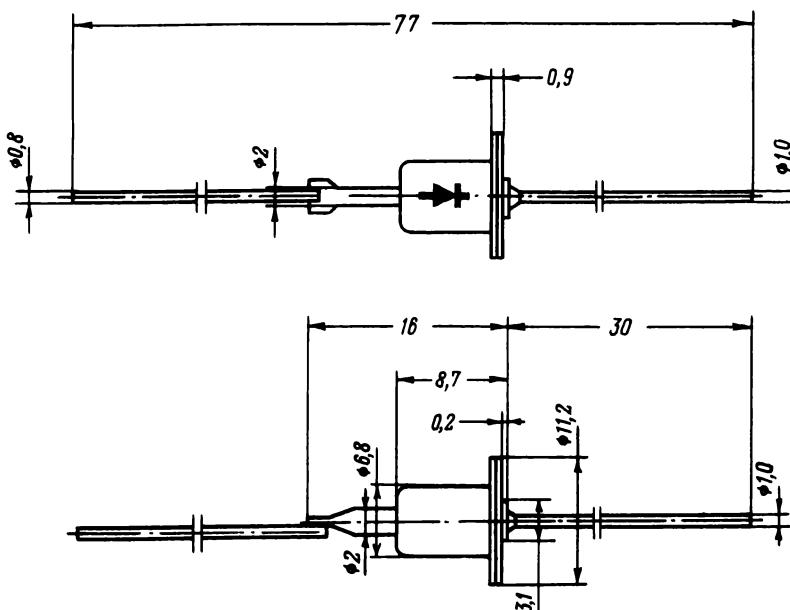
18



19

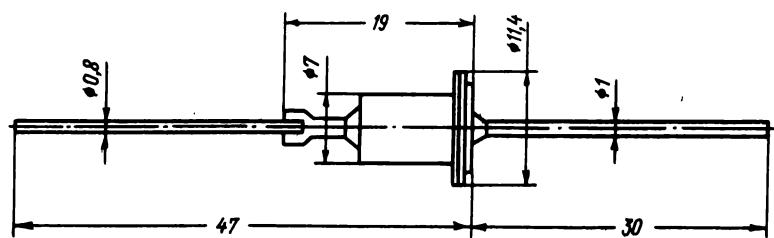


20

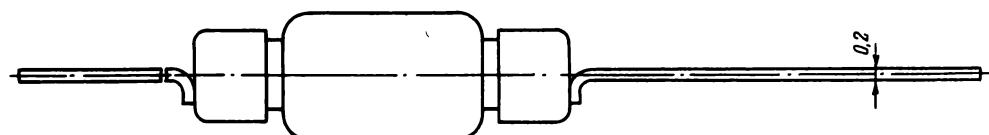
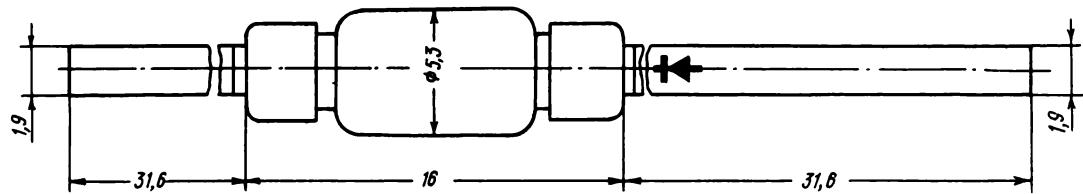


21

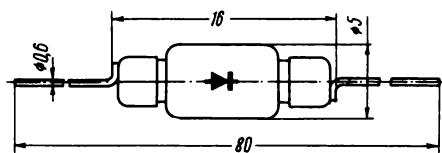
22



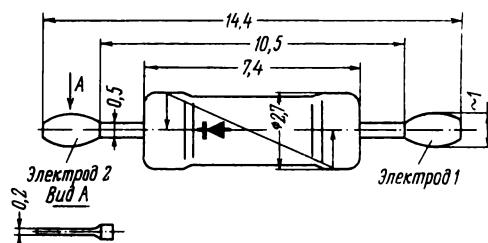
23



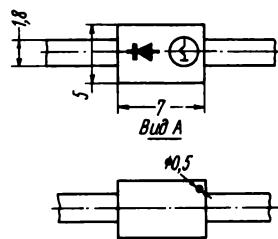
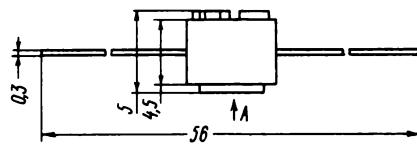
24



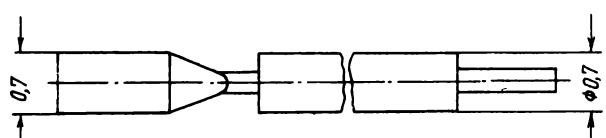
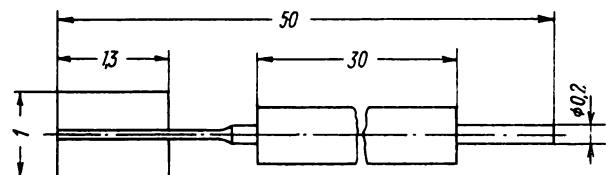
25



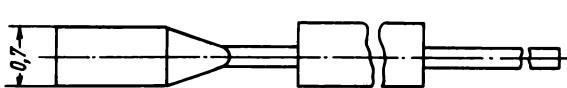
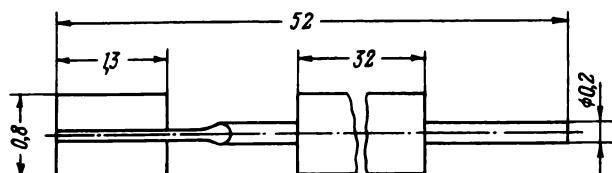
26



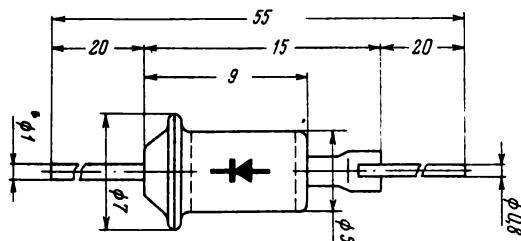
27



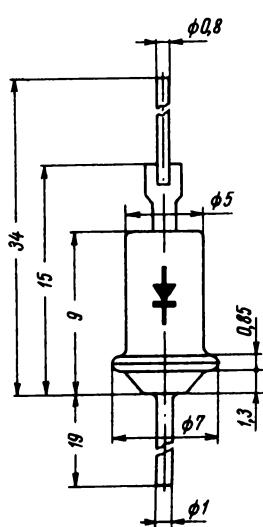
28



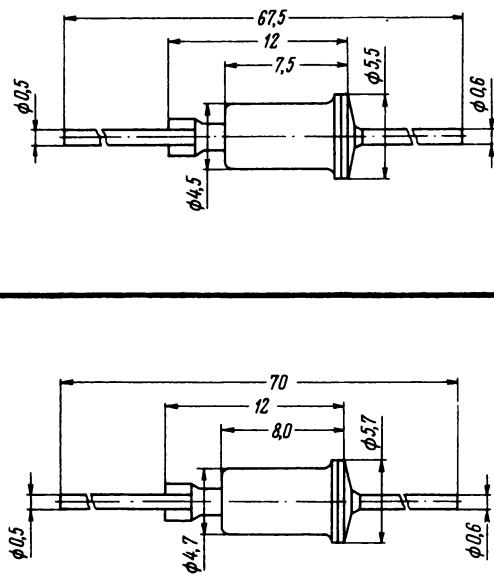
29



30

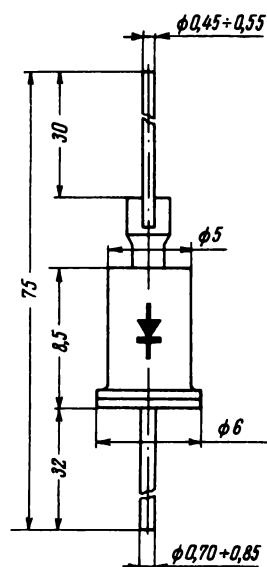


31

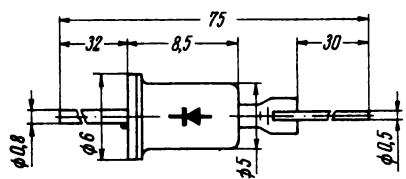


32

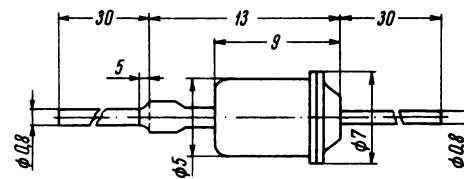
33



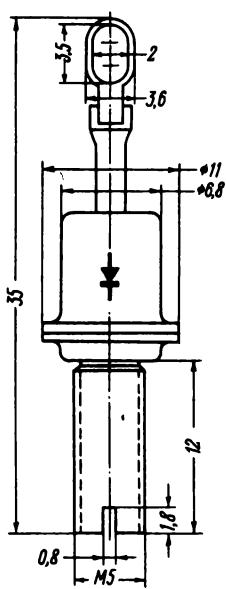
34



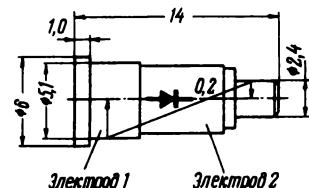
35



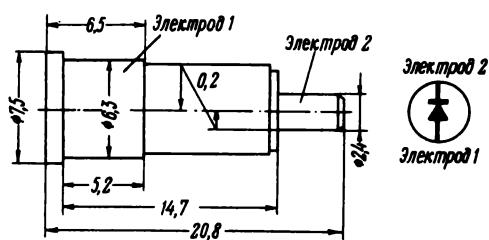
36



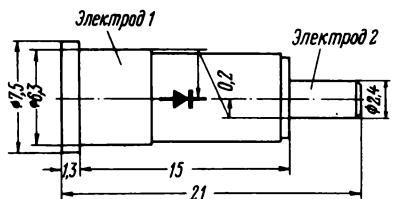
37



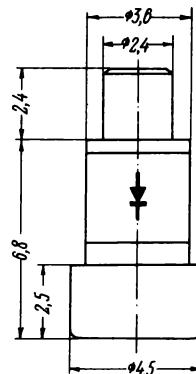
38



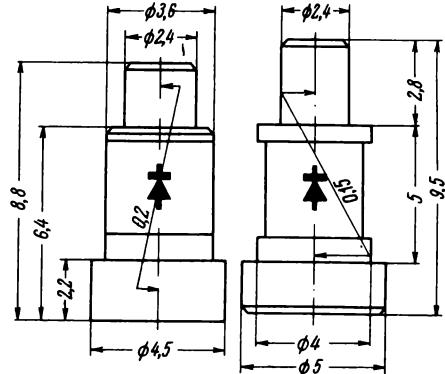
39



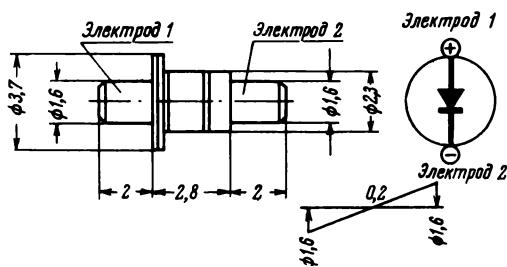
40



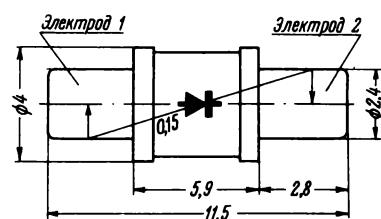
41



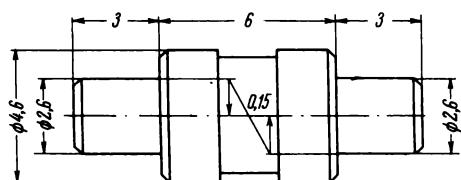
42



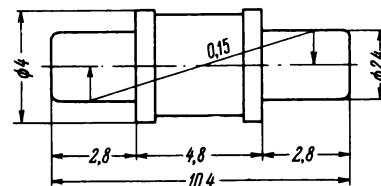
43



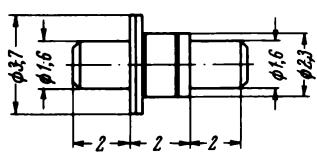
44



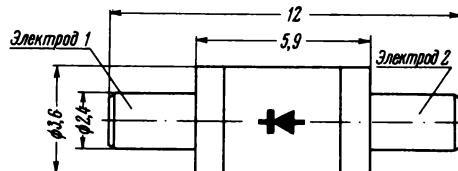
45



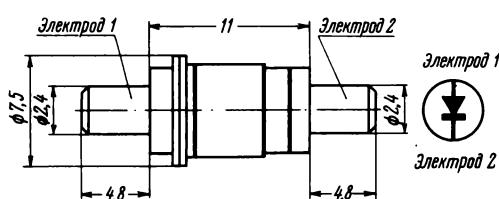
46



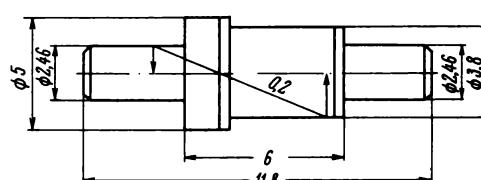
47



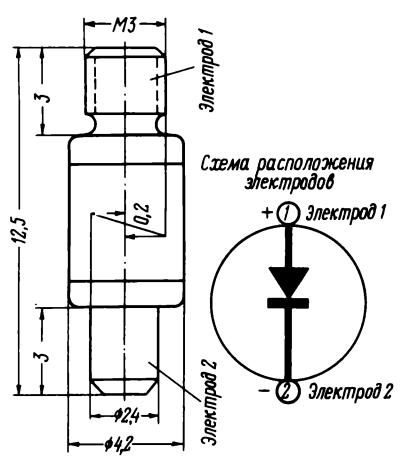
48



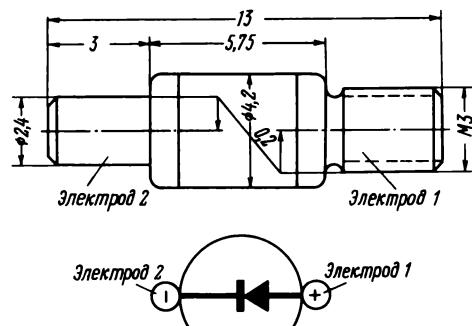
49



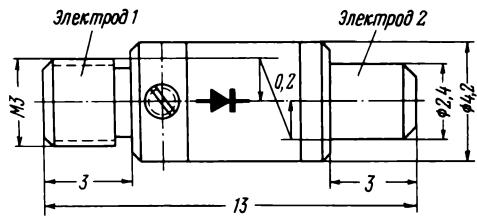
50



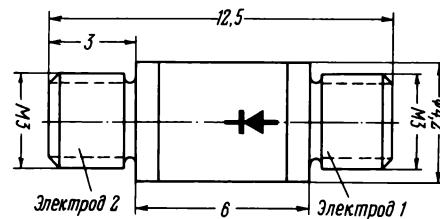
51



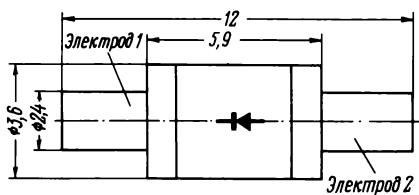
52



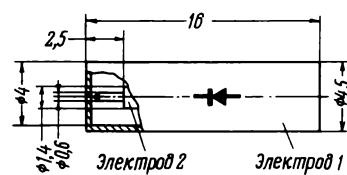
53



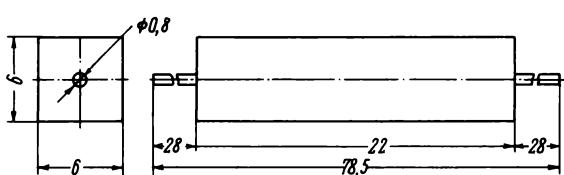
54



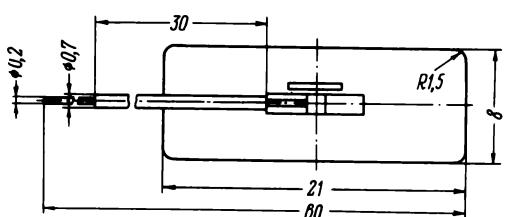
55



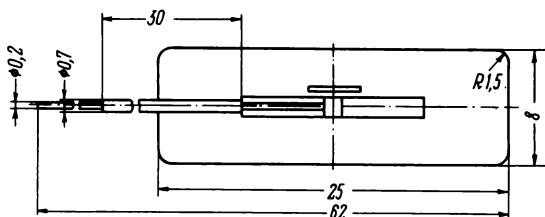
56



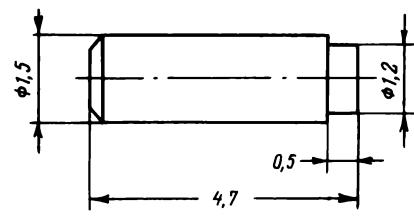
57



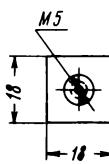
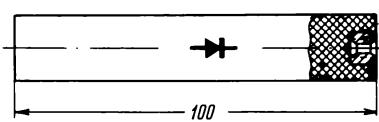
58



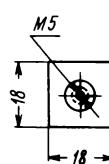
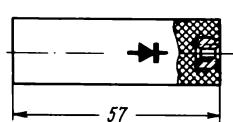
59



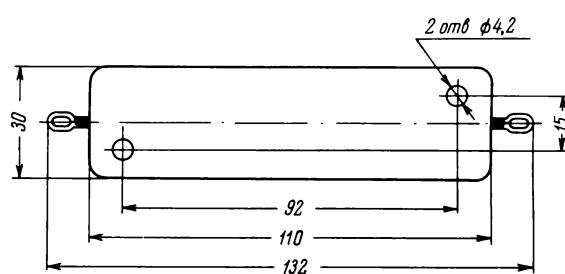
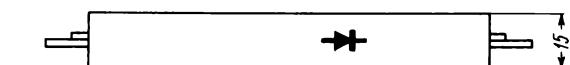
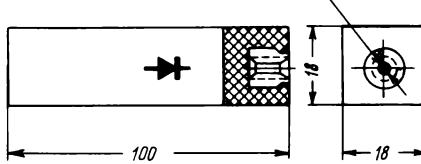
60



61

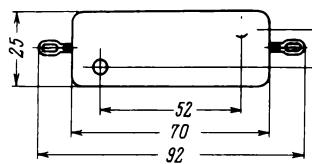


62

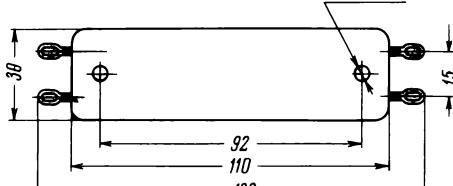
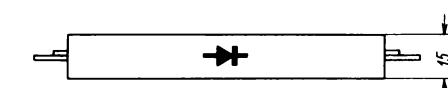


63

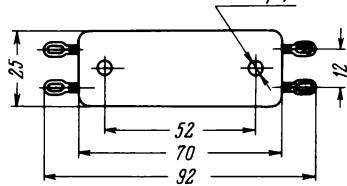
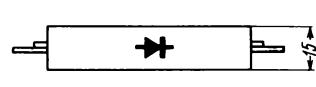
64



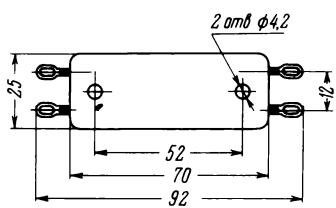
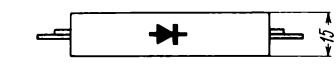
65



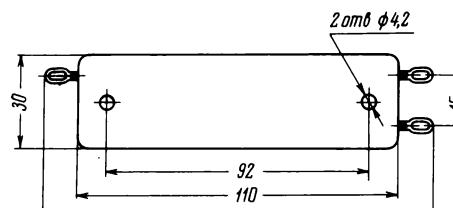
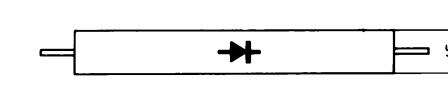
66



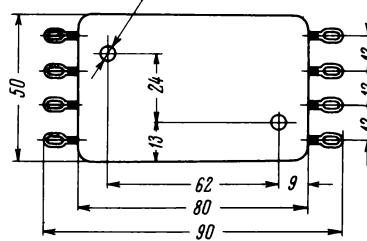
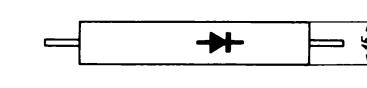
67



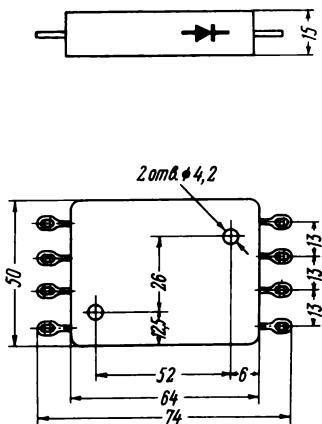
68



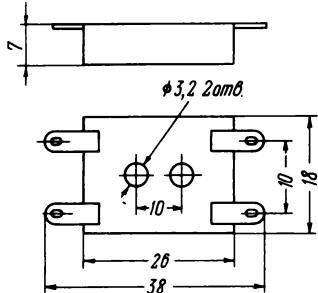
69



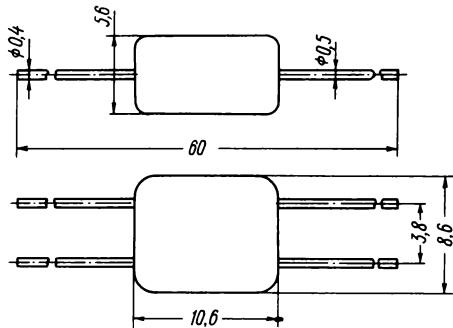
70



71



72



73

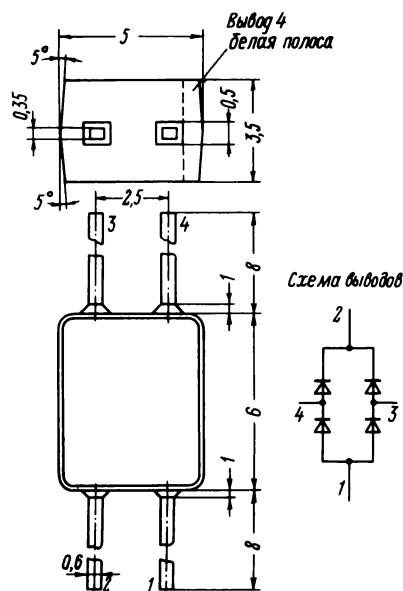
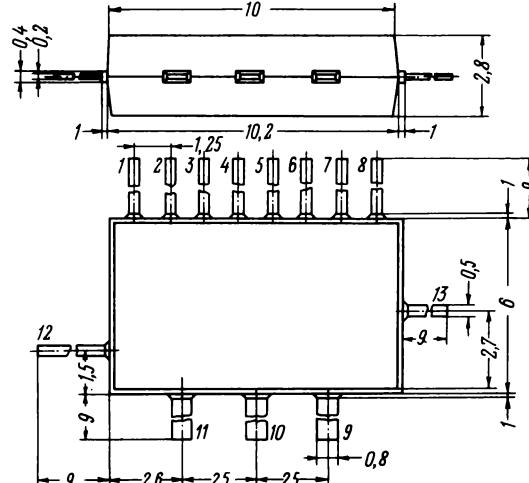
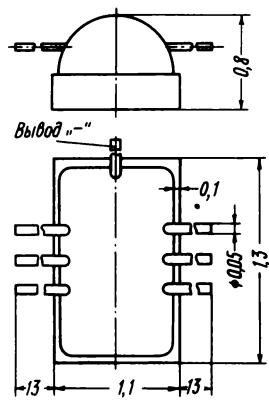


Схема выводов

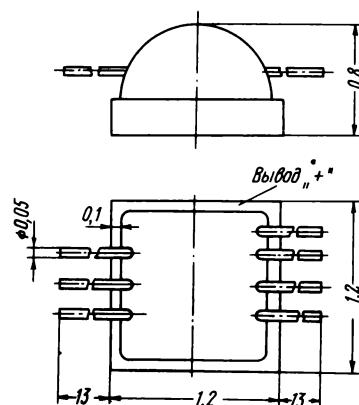
74



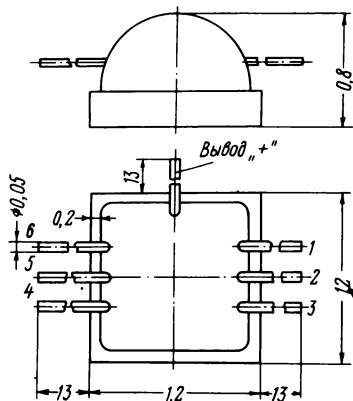
75



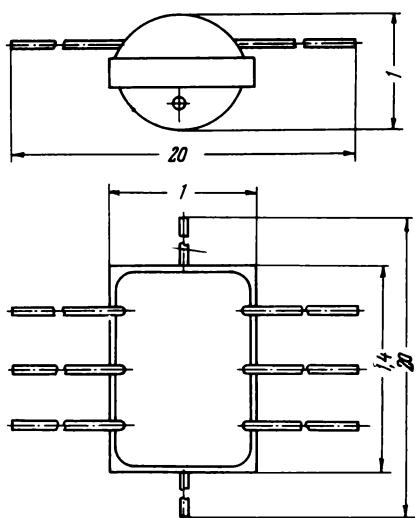
76



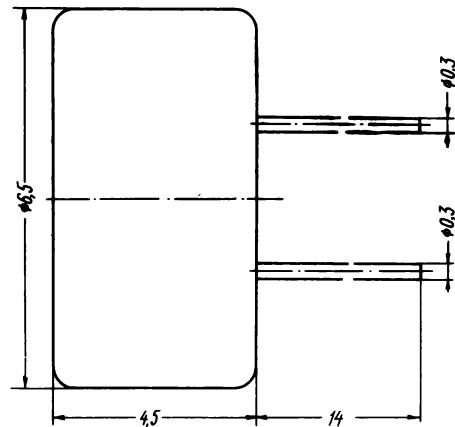
77



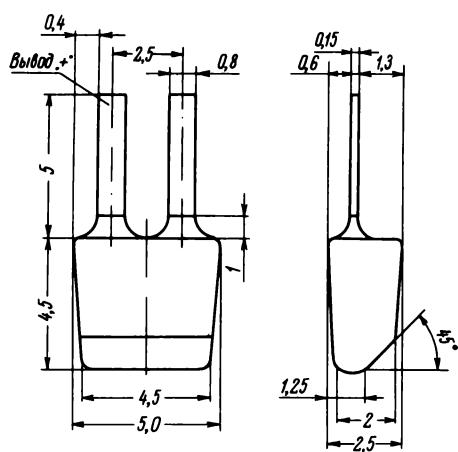
78



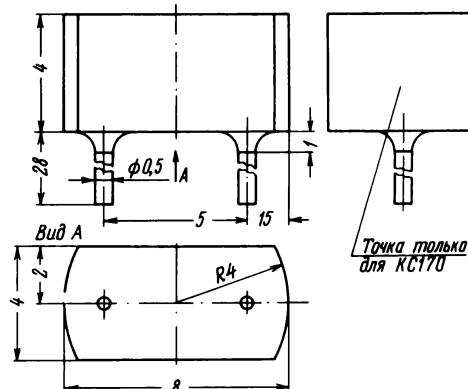
79



80

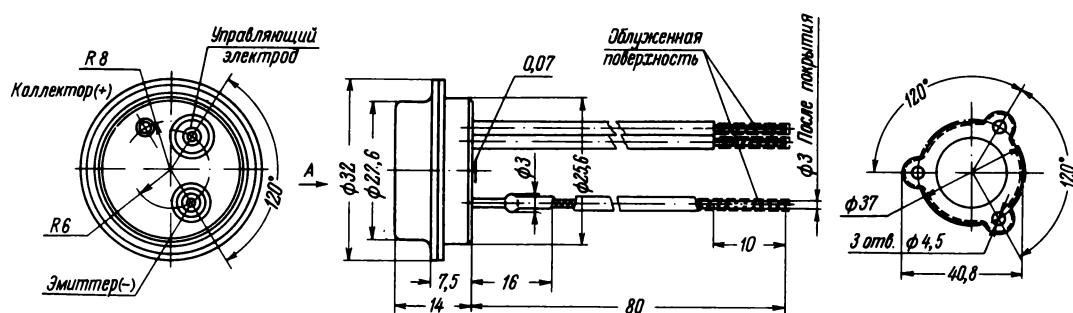


81

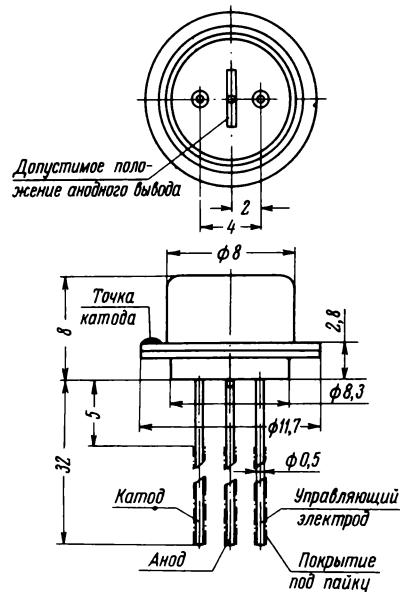


82

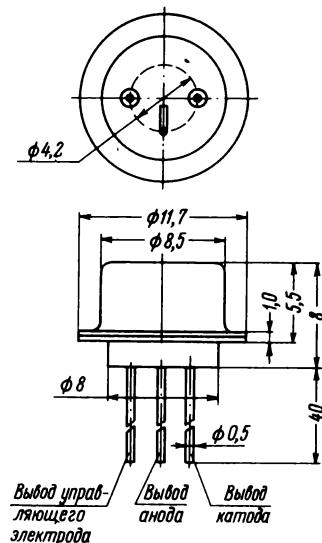
83



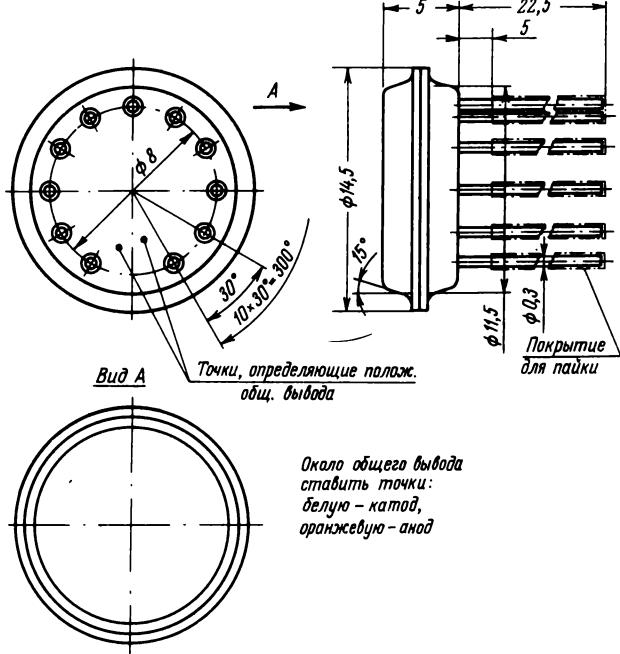
84



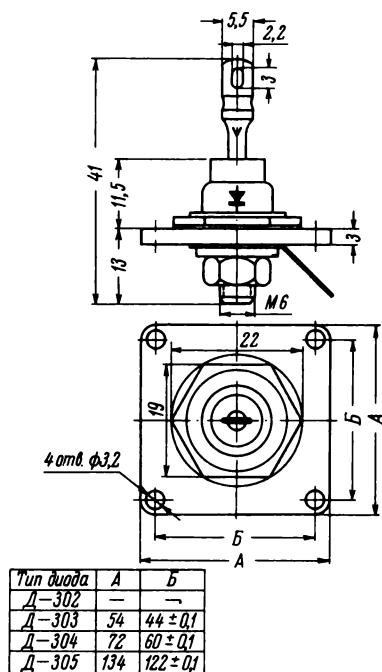
85



86

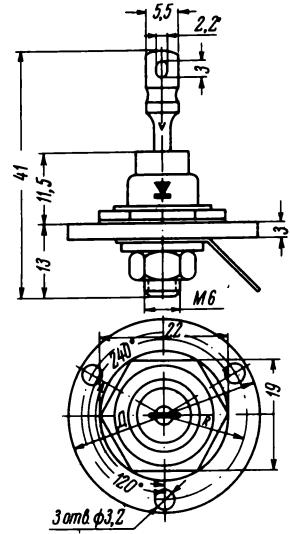


87

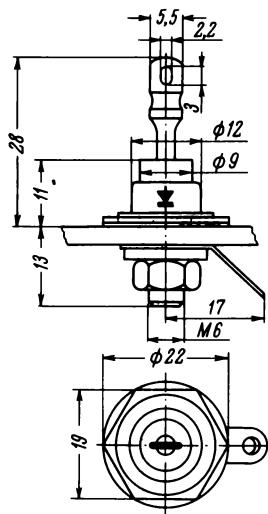


88

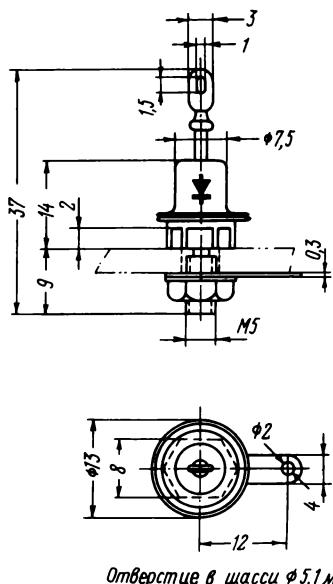
151



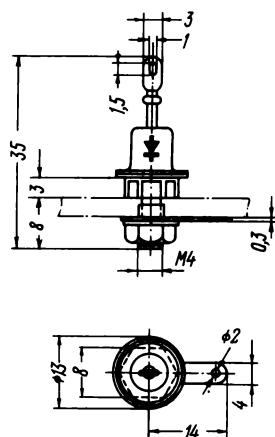
89



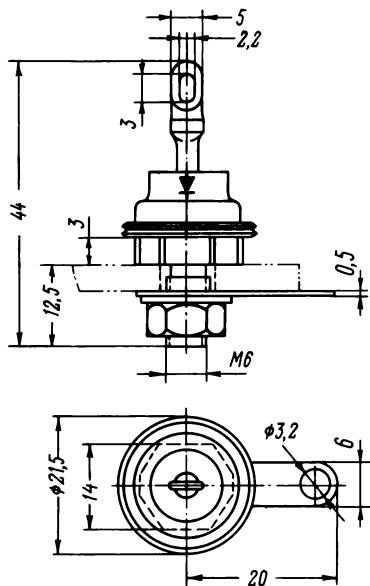
90



91

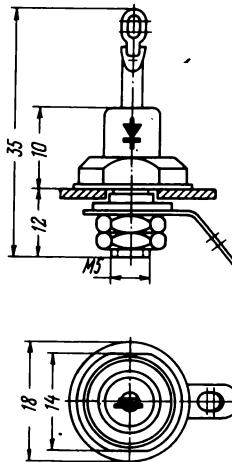


92

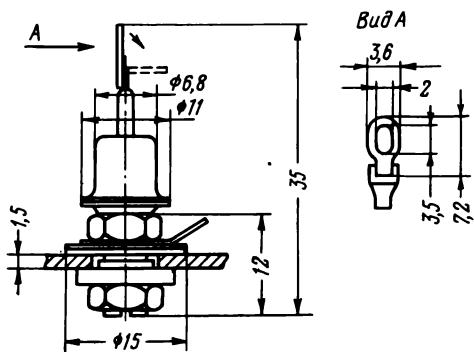


Отверстие в шасси $\phi 7$ мм

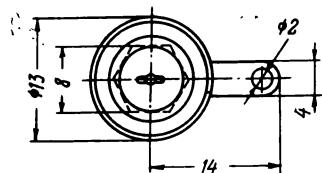
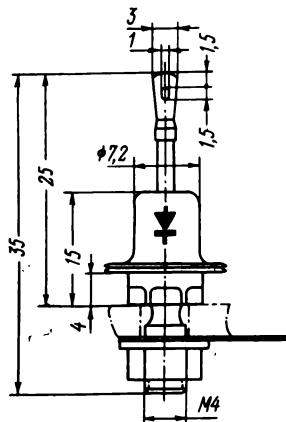
93



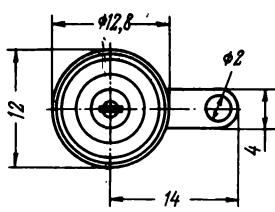
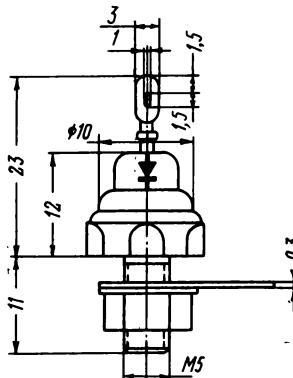
94



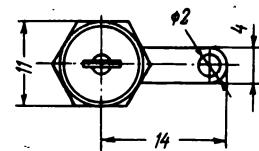
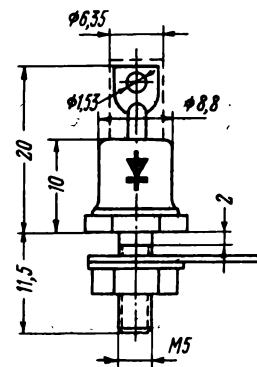
95



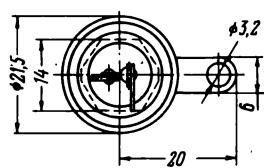
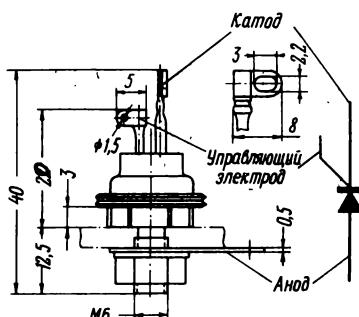
96



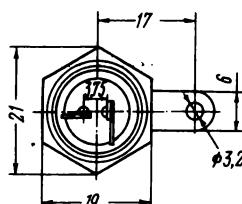
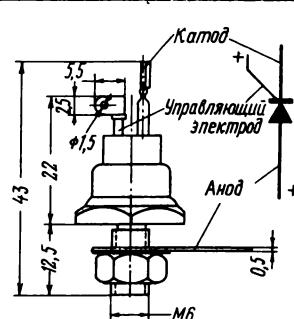
97



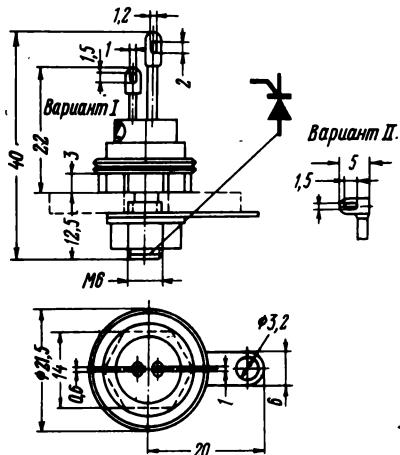
98



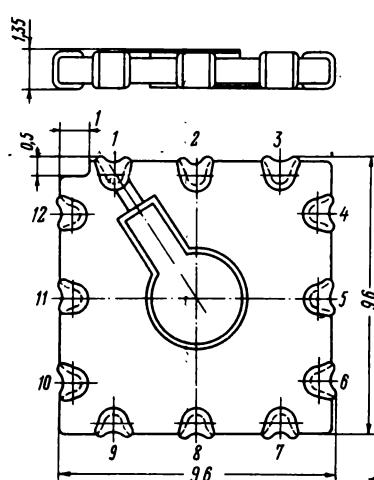
99



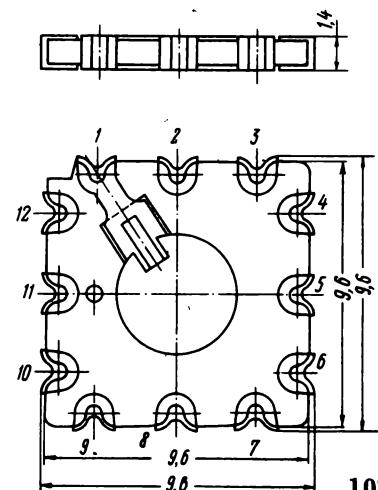
100



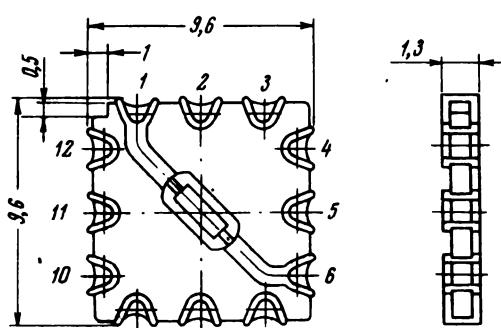
101



102

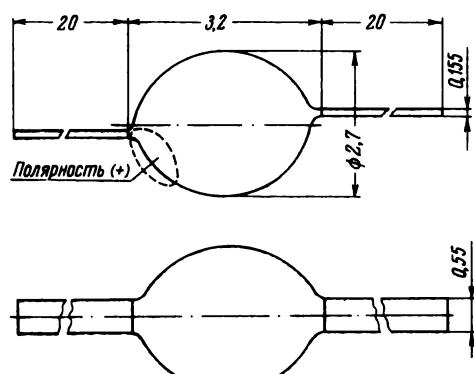


103



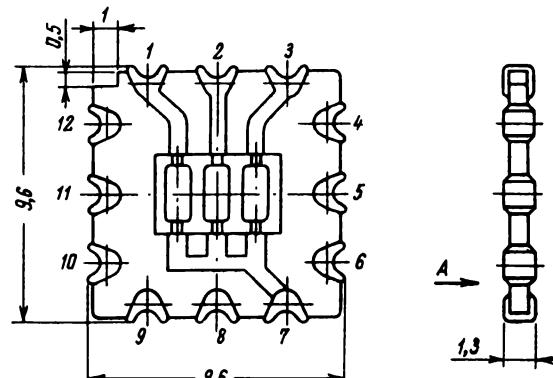
Плюс (+) на пазе №1
Минус (-) на пазе №6

104



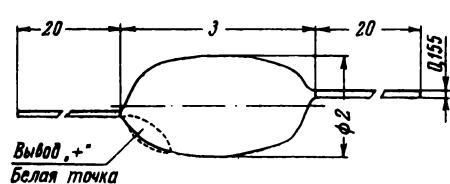
Полярность (+)

106

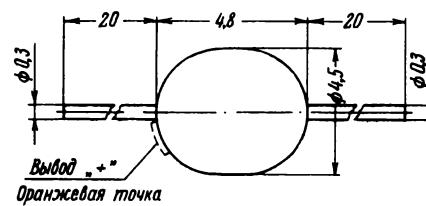


Плюс (+) на пазах:
№1, №2, №3
Минус (-) в пазе №7

105



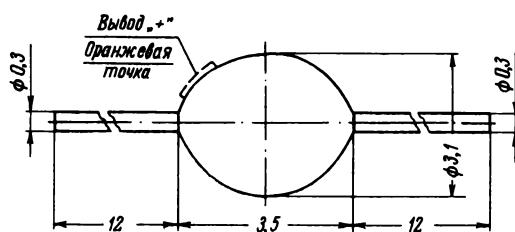
Выход „+“
белая точка



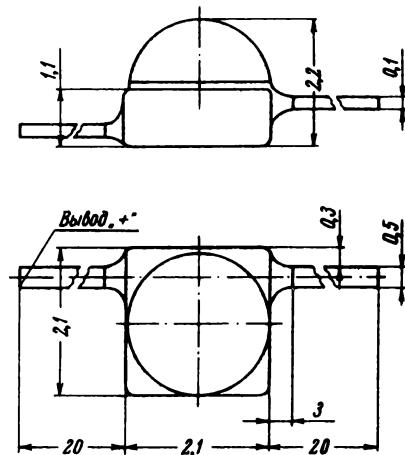
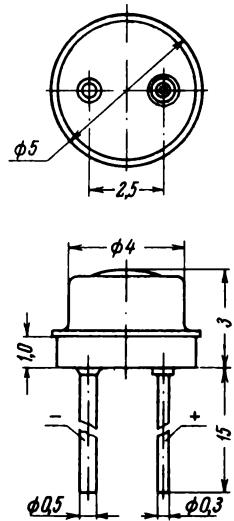
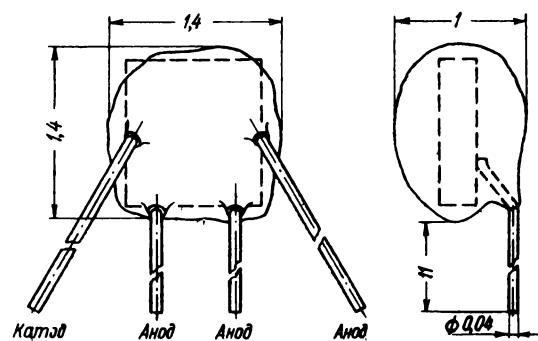
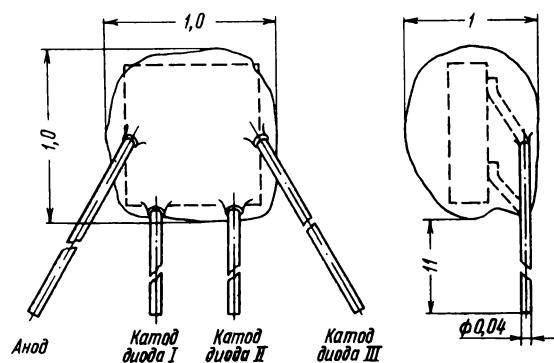
108



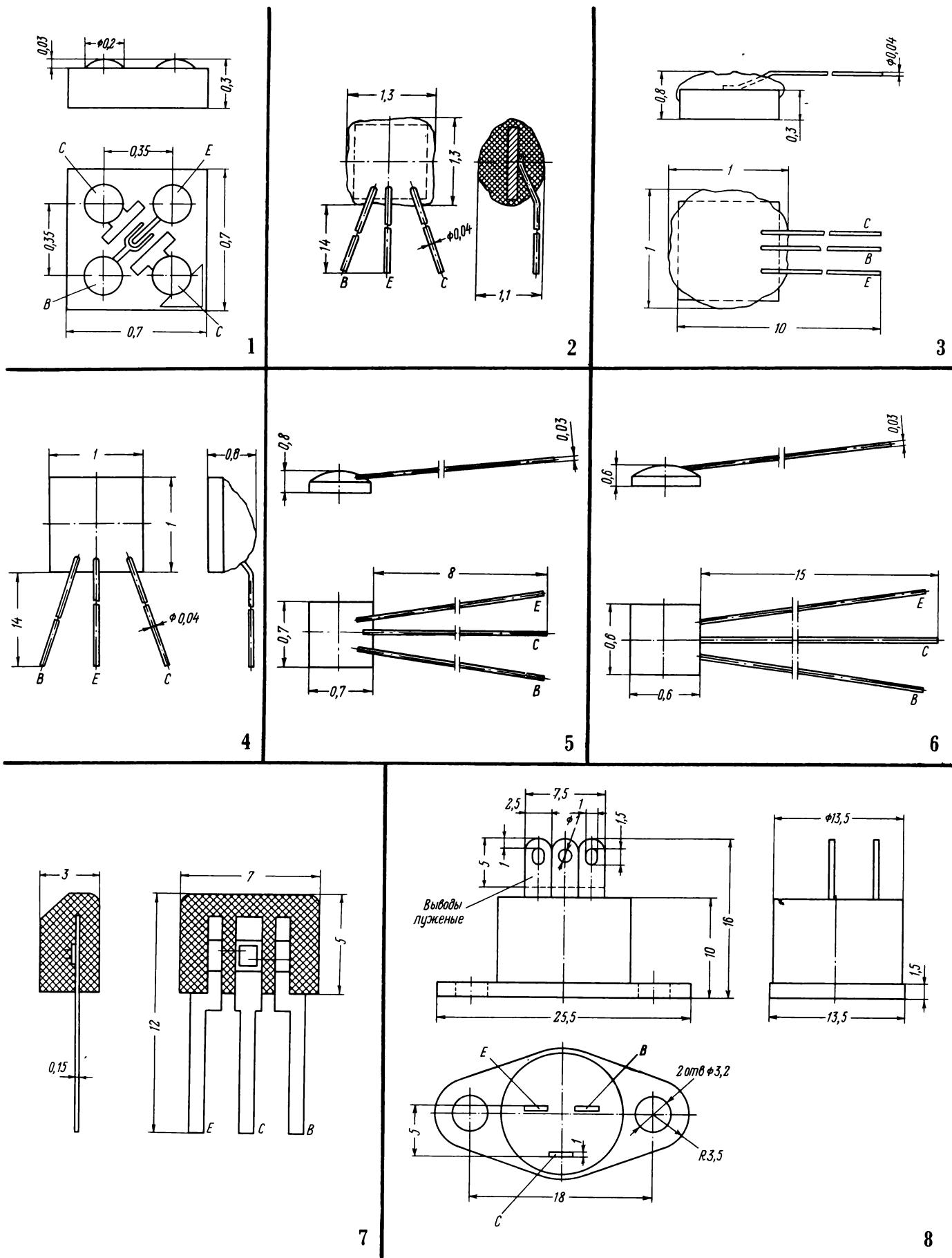
107

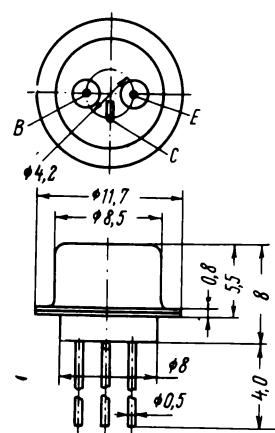
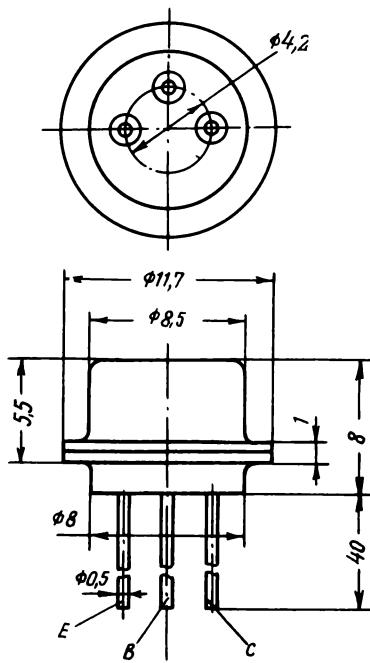
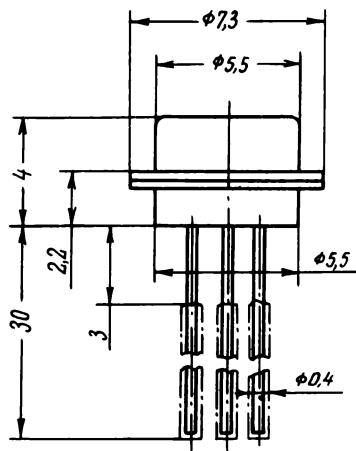
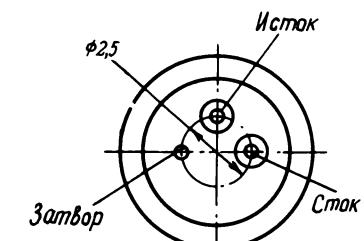
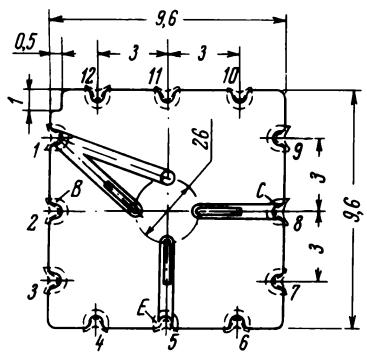
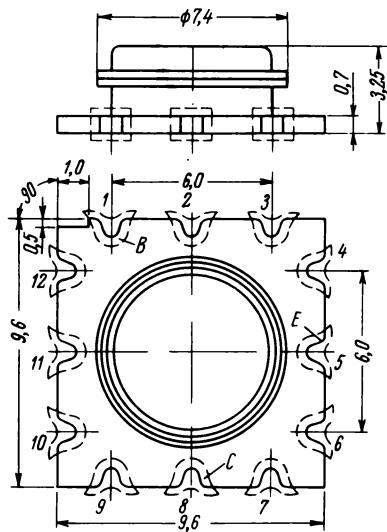
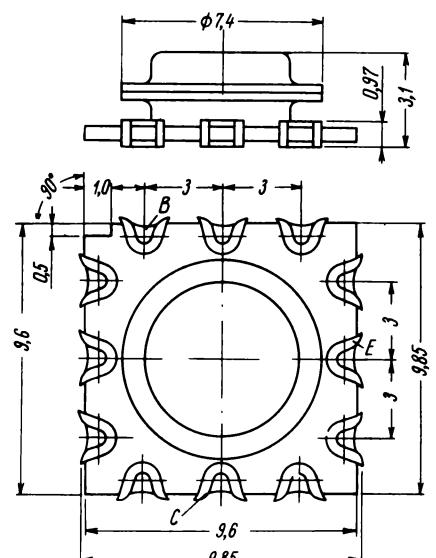
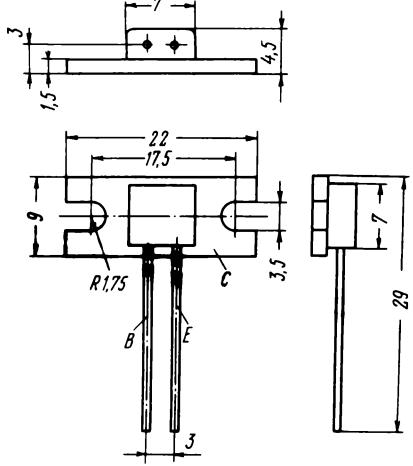


109



ГАБАРИТНЫЕ
ЧЕРТЕЖИ
ТРАНЗИСТОРОВ

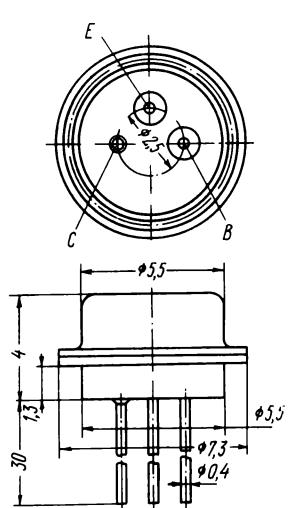




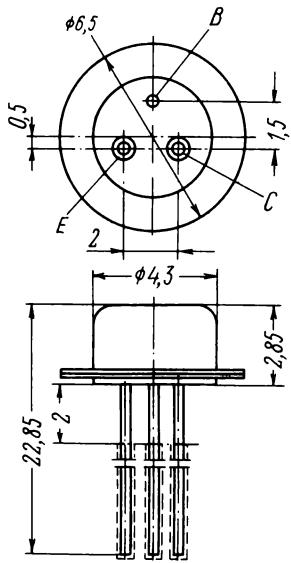
13

14

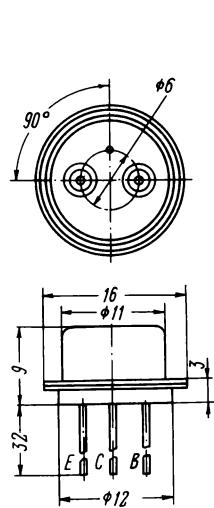
15



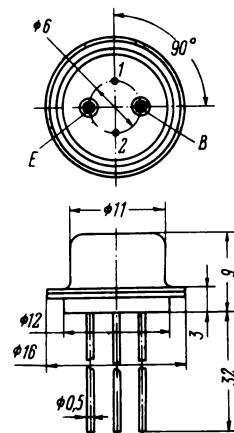
16



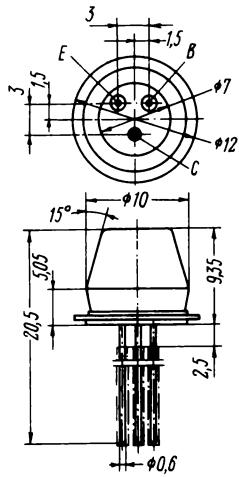
17



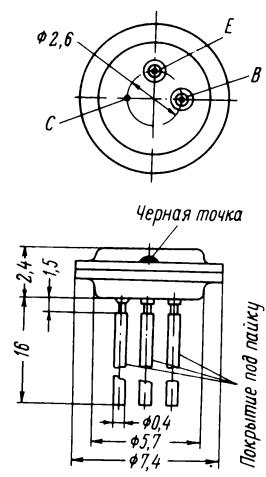
18



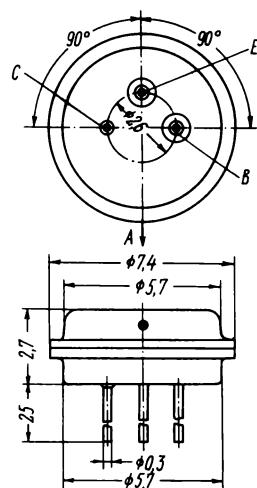
19



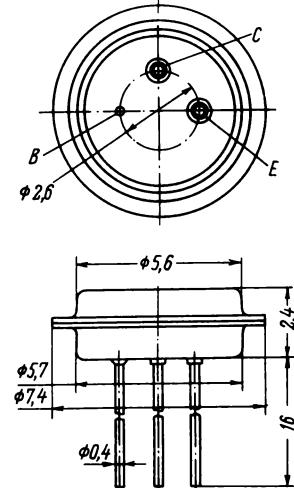
20



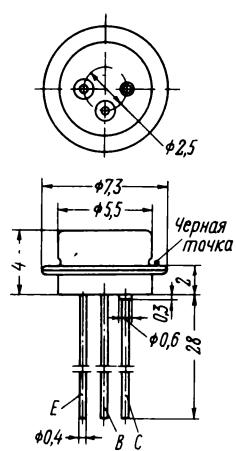
21



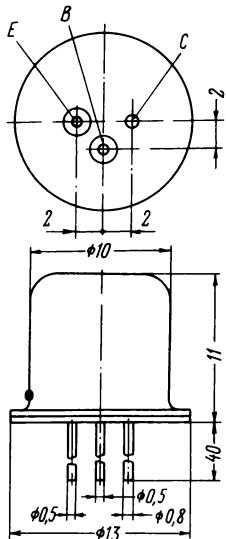
22



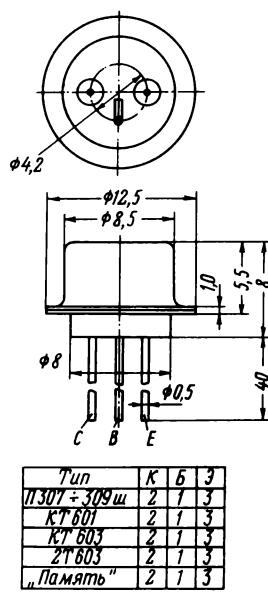
23



24

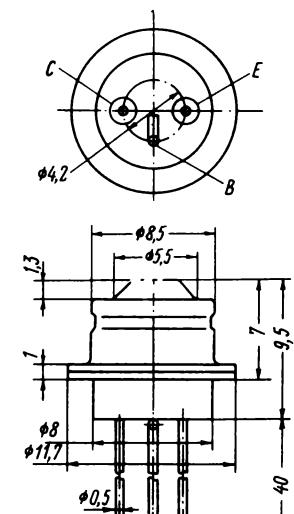


25

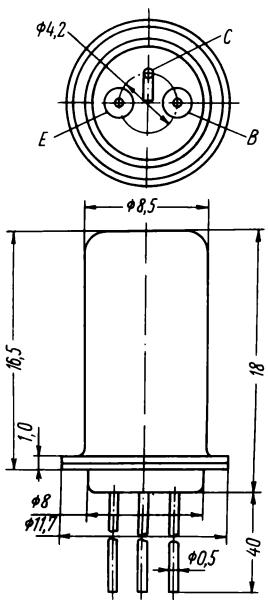


26

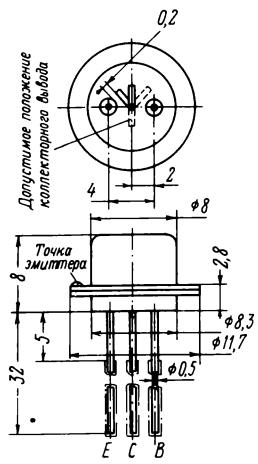
Тип	К	Б	З
И307÷309ш	2	1	3
КТ601	2	1	3
КТ603	2	1	3
2Т603	2	1	3
«Память»	2	1	3



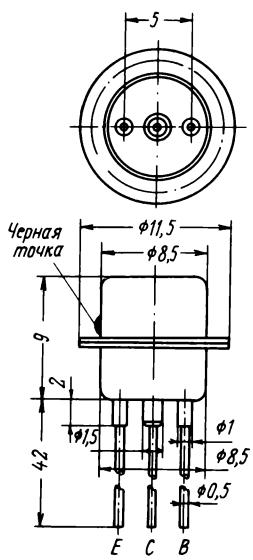
27



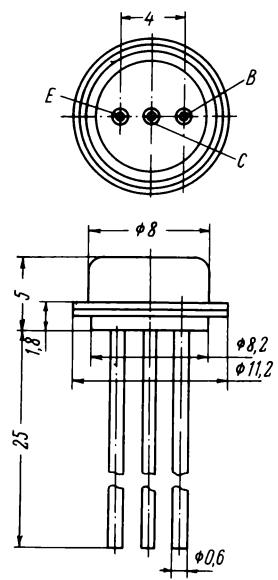
28



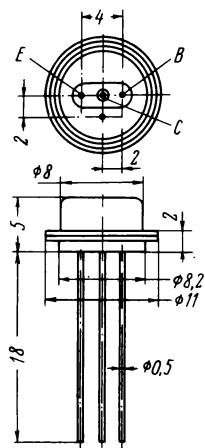
29



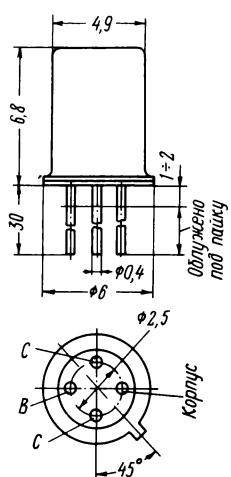
30



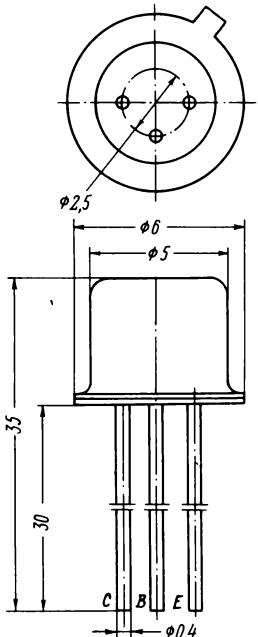
31



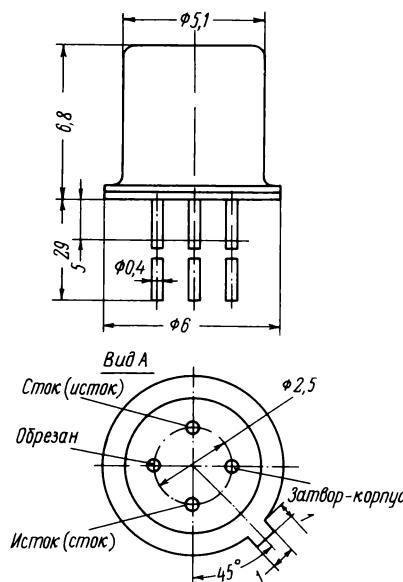
32



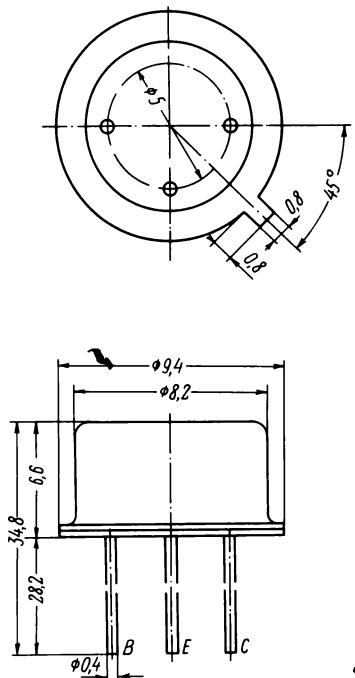
35



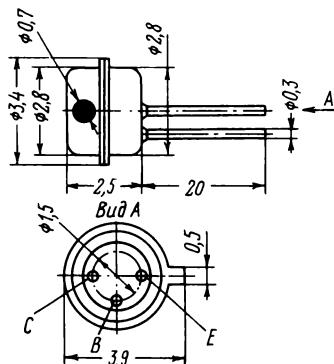
33



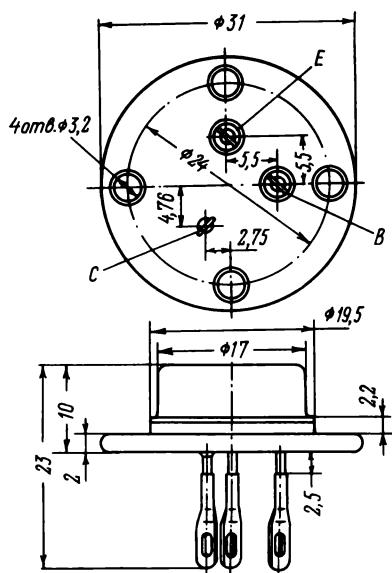
34



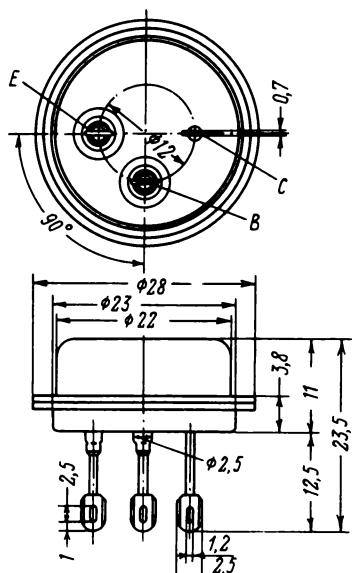
36



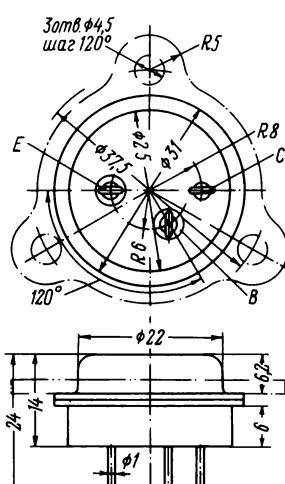
37



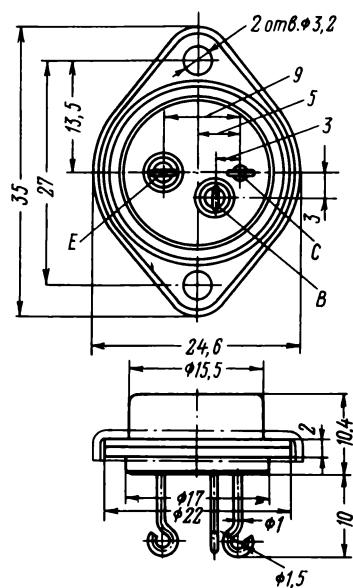
38



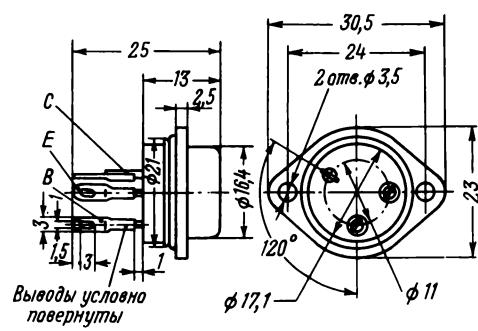
39



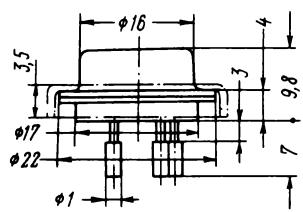
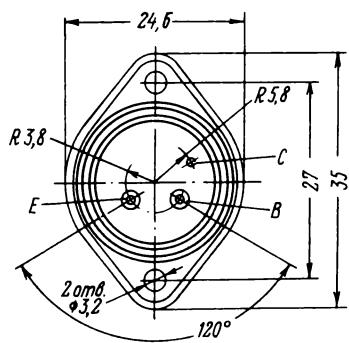
40



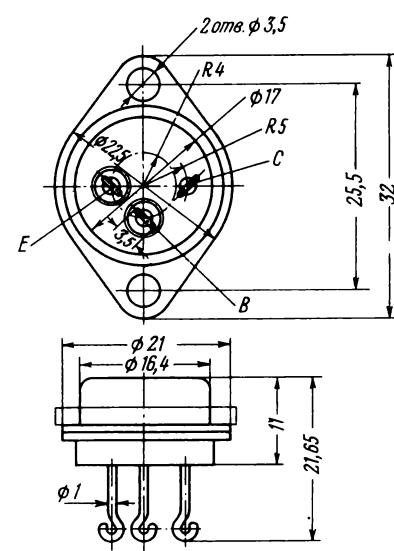
41



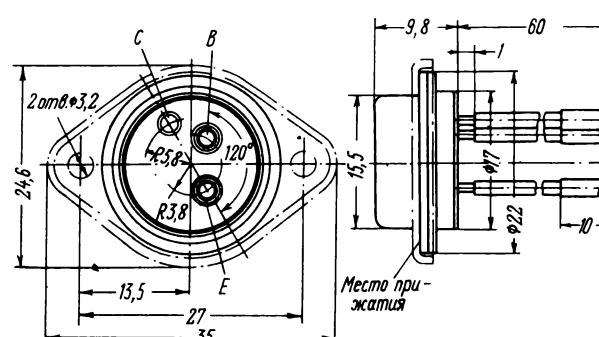
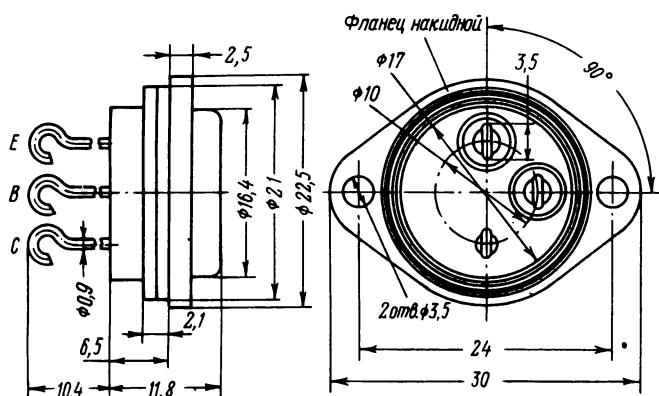
42



43

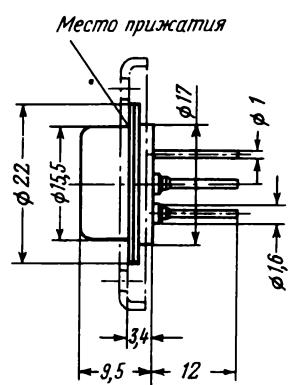
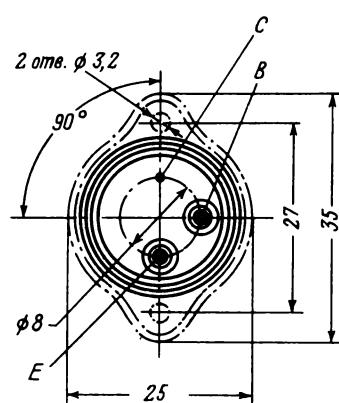


44

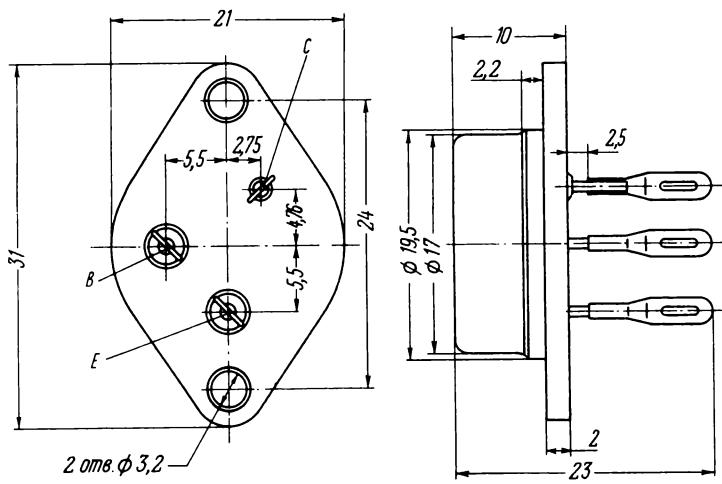


45

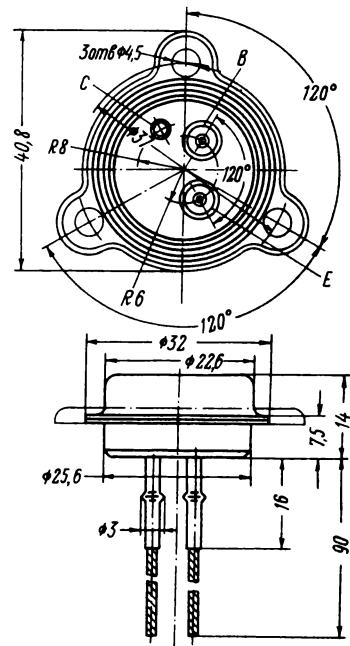
46



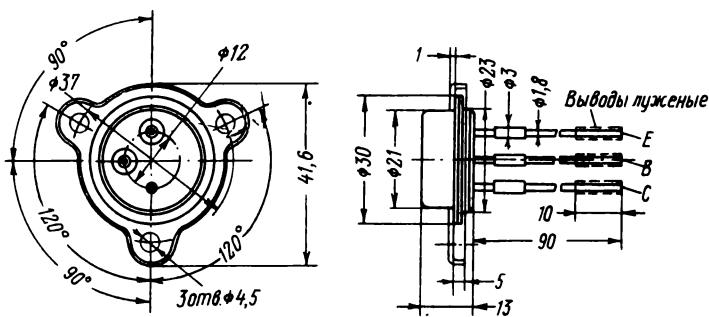
47



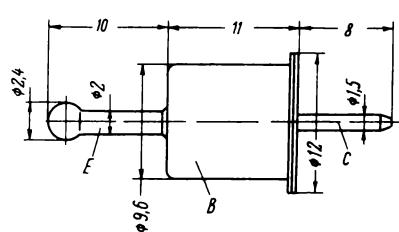
48



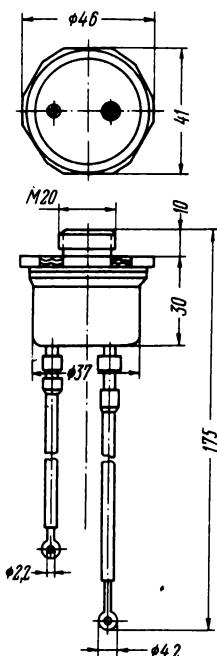
49



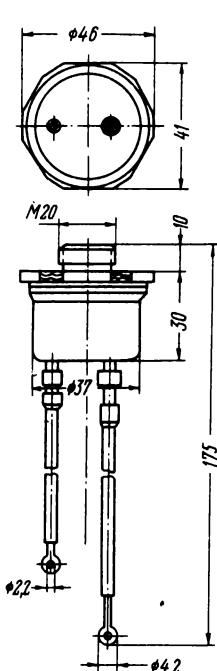
50



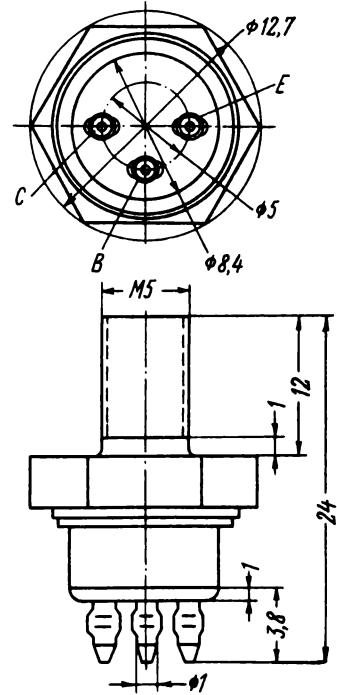
51



52



53



54

ЗАМЕЧЕННЫЕ ОПЕЧАТКИ

Напечатано	№ стр.	№ п/п	№ столбца	Следует читать	Напечатано	№ стр.	№ п/п	№ столбца	Следует читать
МС-меза-сплавная	14		2	МК-микро-сплавная	100	91	865+866, 877+880, 885+890	16	99
графа	14		2	графа	100	93	891+896	16	99
<i>fb 21B</i>			<i>Jh 21B</i>		100	93	891+896	16	99
31/0П	31	41+50	12	31	Д	93	891+896	16	99
30	33	70+75, 82	12	31	СД	93	897+899	15	99
30	35	85, 88+90, 93	12	31	ЭС	93	900+902	9	9
I, 2I	39	166	9	I		104	222	12	1
I, 2I	41	196, 206	9	I		108	267+269	3	15
T	41	177+182	8	MC	-604+80	108	267+269	6	-554+70
100	43	210	2	10^4	II	109	267+269	12	3II
100	45	242, 247	2	10^4	0,5	109	292	8	0,03
G	47	272	8	Ge	y_{21B}	129		2,3	y_{21S}
КД202К	48	326	2	КД202К	U_{D5}	129		5	U_{D5}
КИ402Б	52	392	2	КИ401Б	U_{G5}	129		6	U_{G5}
MC	55	421+426, 451+454	9	C	2И102	135		4	2И102
T	63	549+558, 563, 564	15	MC	46	140	3	40,6	40,6
77	65	574, 576, 578, 14 580, 582, 584	78		По состоянию на 1.01.1971г.				
II	67	606, 607, 612+ 6 +617, 620, 625+ +627, 638+647	6	ДС	Т) чертежи диодов №77, 97, 100 - аннулированы ;				
I, 32	67	608, 618	7	98	2) приборы типов: 2И101А+И, 2И103А, Б, ГД403А+В, III+Д14А, Д202+Д205, Д202* + + Д205*, КИ105А, КД902А+И, ГТ804А+В, П2И1* + П2И2*Б, П608Б, П609Б сняты с производства.				
Ge	73	683, 707	II	3I					
8, 6	76	739	6						
МД	83	778+782	10	II					
СД	85	785+788, 790+ +793, 796, 797, 800+802, 804, 807	10	Д					
Д	89	829+832, 837+ +840, 845+856	15						
Д	91	865+868, 877+ +880, 885+890	15	ПД					

